無線電製作

售價港幣 $2.00　　1975增刊 1

ALL JAPANESE TRANSISTOR DATA MANUAL

SECTION 1　LISTING OF ALL TRANSISTORS
SECTION 2　SUBSTITUTION GUIDE
SECTION 3　LISTING OF
FIELD EFFECT TRANSISTORS
(WITH AMERICAN TYPE INCLUDED);
APPLICATION CIRCUITS;
SUPPLEMENT TO SECTION 1;
TERMINATION DRAWINGS

全日本晶體管——場效應管
特性資料與換用手册

（上篇）

電子刊物出版社出版　香港政府民政司註册登記　中華民國僑務委員會登記証台教新字第472號

全港晶體管供應零售店索引

商號	地址及電話
恒達電子公司	九龍大埔道 140 號東廬大廈 B 座七樓 5 號室 電話：3-807964　3-818902
寶昌無綫電行	香港灣仔莊士敦道 33 號 A 地下 電話：5-280805
寶光無綫電行	九龍通菜街 65 號地下 電話：3-960304
安利無綫電行	九龍通菜街 83 號地下 電話：3-958826
偉音無綫電行	九龍油蔴地吳淞街 53 號 A 電話：3-840920
偉利無綫電行	香港灣仔灣仔道 156 號 A 地下 電話：5-749597
通用無綫電行	九龍青山道 8 號 A 地下 電話：3-807242
中明無綫電行	九龍新蒲崗康莊街 2 號後座商場 電話：3-205780
泰華無綫電行	九龍深水埗鴨寮街 156 號 電話：3-708908
華深電子公司	九龍爵祿街 70 號 電話：3-206259　3-208533
良益電業	九龍土瓜灣浙江街 24 號 電話：3-633882
寶林無綫電行	香港灣仔軒尼詩道 111 號 電話：5-275601
（分行）	九龍油蔴地吳淞街 119 號 電話：3-848015
三三無綫電行	九龍紅磡馬頭圍道 27 號 C 地 電話：3-652182
佳年無綫電行	九龍油蔴地吳淞街 8A 號地 電話：3-842241
登美洋行	九龍油蔴地庇利金街 38 號 電話：3-685648
發達無綫電行	九龍花園街 80 號地下 電話：3-959620　3-961
電子零件公司	紅磡黃埔街 1 號 A 地下 2 號 電話：3-331222
榮記無綫電行	香港灣仔軒尼詩道 274 號 E 電話：5-746350
麥氏無綫電行	九龍通菜街 75 號地下 電話：3-957838
通用電子店	上環急庇利街（港澳碼頭對 電話：3-457202
凱旋無綫電行	香港北角英皇道 315 號地下 電話：5-711735
寶森無綫電行	九龍旺角登打士街 34 號 A 電話：3-889859
寶生無綫電行	九龍深水埗青山道 433C 號 電話：3-717858
寶樹無綫電行	九龍旺角花園街 60 號地下 電話：3-852429　3-840
（分行）	九龍彌敦道 317 — 321 號 金漢大廈 L 座地下 電話：3-853564

全日本晶體管一場效應管
特性資料與換用手册

INTRODUCTION

Although primarily intended to provide technical imformation to assist in the using and identification of Japanese bipolar transistors and FET's, this book has a special interest to the professional engineer and technician as a general work of guidance in the selection of Japanese transistors for particular applications. The guide to possible alternatives of different manufactures in Section 2 is probably the most comprehensive.

The following colours are used in the printing of this book to assist in locating the required section.

Section	Contents	Colour
Section 1	Listing of All Bipolar Transistors	Black
Section 2	Substitution Guide of Bipolar Transistors	Blue
Section 3	Listing of FET's (with American type included)	Brown
	Application Circuits of FET;	Brown
	Suplement to Section 1;	Black
	Termmation Drawings of Transistor	Black

本書臚列了全部日製的普通晶體管之詳盡技術數據，足供一切專業上之使用及設計上之參考，全書分爲三大部份，並以不同顏色印刷，以便於索查。

上篇：全日本晶體管特性資料（黑色）

中篇：各廠晶體管的互換（藍色）

下篇：全日本場效應管特性資料及接脚識別（附美式管特性，棕色）；場效應管典型應用綫路(棕色)；晶體管特性補篇及接脚識別圖（黑色）。

ALL JAPANESE TRANSISTOR DATA MANUAL

SECTION 1 — LISTING OF ALL TRANSISTORS

（上篇）

晶 體 管 特 性 資 料

CHARACTERISTICS OF LISTINGS

This section lists all the bipolar transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. The Chinese — English translation key given below may help the user makes full use of the data provided in the listings.

晶體管規格表用法概覽

晶體管若能使用得的當，是可以保持其應有的長久使用壽命的；但若使用得超過其規格或使用不當，則會反較眞空管爲更差。基於此，在使用晶體管之前，或在購買前，能好好地調查一下其規格及特性，是很爲重要的。

本篇所刊載的，均爲在日本電子機械工業(簡稱EIAJ)會登記的晶體管，其中包括一些專用品種及作通訊、工業用的，故並非單純只用於無綫電的。當然，在敞方還在試製階段的，並不加以錄入。

下面是此規格一覽表各欄所用的記號及略號，並加以說明。

1 TYPE NUMBER
2 ORIGINAL MANUFACTURER
3 USES
4 MATERIAL AND STRUCTURE
5 MAXIMUM RATINGS

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)														外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)		
1	2	3	4	5					6		7			8						9	10		11	12

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})
7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)
* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
9 f_{ab} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.
10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (REAL)
11 OUTLINE
12 REMARKS
: 之對稱 : COMPLEMENTARY TO ………

[1] 是在EIAJ所登記的晶體管編號。
[2] 將此型名（編號）及規格在EIAJ登記的公司名稱。
[3] 在EIAJ登記時所說明的用途。但要注意並非除此以外即無別的用途。
[4] 晶體管的製造材料及構造。
[5] 晶體管的最大規格值。
[6] I_{CBO} 的最大值與在其測定條件時的V_{CB}值。
[7] 直流h_{FE}或脈冲h_{FE}的標準值，與在此測定條件下所用的V_{CE}、I_C各值。
[8] h參數的標準值與在此測定條件下所用的偏壓V_{CB}、I_E的值。
這通常爲射極接地時的數值，有*符號者則爲基極接地時之數值。
[9] 高頻特性的f_{ab}。有*符號時所指爲f_T值。
[10] 高頻特性的C_{ob}與$r_{bb'}$。$r_{bb'}$欄內有*時，則爲h_{ie}(real)的數值。
[11] 於本書下篇後面（黑色）所列出的接脚圖索引。
[12] 必要時的註釋。

晶體管規格表的看法

1 型號

每一晶體管是根據JIS（日本工業總會）所給予的命名方法而加以定名後，即將規格在EIAJ予以登記。EIAJ即電子機械工業會，以往簡稱之為CES型號，現在則叫EIAJ型號，正當的叫法應為JIS型號。型號的編排方法有如下的意義包括在內。

	2S	文字	數字	文字
(例)	2S	A	244	A

最先的2S表示為有效極數為3的半導體元件。諸如二極管為1S，有效電極為4的晶體管（四極晶體管）則為3S。

隨着2S後的文字是可用ABCD任何一個的，其使用法有如下述的分別：

A……… PNP型高頻用
B……… PNP型低頻用
C……… NPN型高頻用
D……… NPN型低頻用

高頻與低頻的分野，並無明確的界綫，只因是廠商在登記時指定其用途。其 f_T 為200MHz左右的為高頻用，相反的在50MHz左右的為低頻用，根據此一準則，便會是恰當的。跟隨於2S後的以表示構造的元素的文字，除了A、B、C、D外，還有其他文字，下面是其一個意義：

F……SCR
H……單結晶體管
J……P通道FET
K……N通道FET
M……TRIAC

其次，緊接於文字之後的數字，登記編號以11為開始。

最後的英文字母是表示改良品種，其文字有用到A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K等，它與第二項的文字是不相同的。

使用時，將改良品種代替於以前的品種，是必要而無碍的，但若把以前的品種代替於改良品種使用於電路中，那是不可以的。

如明白上述的命名原則，舉例如2SA244A的PNP型高頻晶體管，就是2SA244的一種改良品種。

2 廠名

一晶體管的型號與規格在EIAJ登記後，同時亦將製造者廠名加以記錄下來，這就是最原始的廠名登記。

在EIAJ登記完畢後，此一型號及其規格則為同業界所共有，可以在原始登記的廠家以外的廠家進行生產此一同型號的晶體管。

在本規格表有使用如下述的各廠家的商標：

富士通	富士通有限公司
日立	日立製作有限公司
松下	松下電子工業有限公司
三菱	三菱電機有限公司
日電	日本電氣有限公司
冲	冲電氣工業有限公司
SAK	Sanken 電氣有限公司
三洋	東京三洋電機有限公司
新電元	新電元工業有限公司
SON	SONY 有限公司
東芝	東京芝浦電氣有限公司
八歐	General 有限公司
協同	協同技術研究所有限公司
芝電	芝電氣有限公司
新日無	新日本無綫電有限公司
Alp	Alps Motorola 半導體有限公司
東洋電具	東洋電具製作所有限公司
ORG	Origin 半導體有限公司

3 用途

是在EIAJ所登記的用途。故在其他使用上是不論的。在本規格表上有如下的記述。

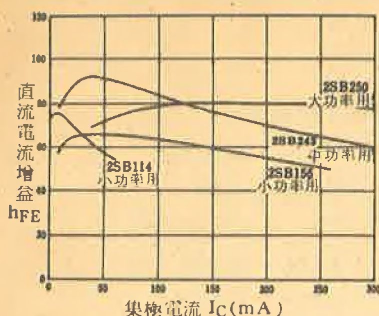
AF	低頻放大
Conv	變頻
Ch	Chopper
Diff	差動放大器
IF	中頻放大
LN	低雜音放大
Mix	混頻
Osc	振盪
PA	功率放大
RF	高頻放大
SN	Switching

4 構造

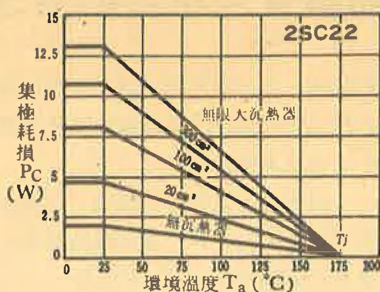
晶體管有鍺質及矽質的，同時亦記有接合的製作方法。

從使用晶體管的立場來看，接合的製作方法等等，究竟如何才是好的呢？而晶體管的各種特性及其偏置的依存性等，均與構造有關，因而可作大概的推斷，這裡不厭其詳將各種製作方法加以列明。

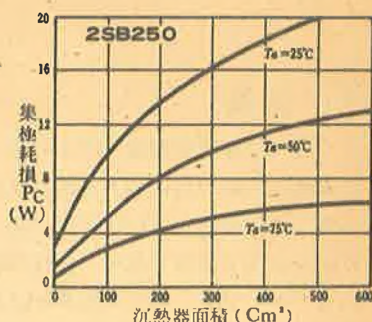
Ge	鍺質
Si	矽質
A	合金接合
AD	合金擴散
D	漂移
DB	基極擴散
DJ	擴散接合
E	外延
E_b	外延基極型
EMe	外延台面型
EP	外延平面型
G	成長接合
GD	成長擴散
MA	微型合金接合
MD	微型漂移
Me	台面型
P	平面型
TMe	三重擴散台面型
TP	三重擴散平面型
Pa	鈍化



圖（1） h_{FE}隨集極電流而改變的例子



圖（2） 沉熱器與T_a－P_c曲綫間的的變化關係



圖（3） 沉熱器面積與容許集極耗損之關係

5 最大規格

此為廠方開列出，當使用時超過此規格界限即屬危險的數字。因此，無論此為強性的晶體管或脆弱的晶體管，都不應超越此界限的。當然，也不會是全都立即損壞了的，但其性能變劣、壽命縮短則不能避免了。

本欄中有如下記號：

V_{CBO} 集極－基極間電壓

V_{EBO} 射極－基極間電壓

I_C 集極電流

P_C 集極損耗（通常有規定了周圍溫度T_a 及外殼溫度T_c，一般T_a=25°C）

T_j 結面溫度

一般V_{CBO}、V_{EBO} 等的耐壓係由PN結的擊穿電壓決定，故若不嚴格遵守此一電壓規定則是有危險的。

電流的最大規格有I_C，普通的破壞界限如圖（1），大電流的地方h_{FE}下降而失眞增加。在一般使用中，會在當放大元件已足夠而仍不能令工作滿意時，而略略增大其電流的，但是太大的電流則會使集極電壓下降，$V_{CE(sat)}$ 急劇增加，集極的消耗電力也會增加，這是要注意的。此外，在非常大電流的地方，會有二次擊穿現象引起，因急劇電壓下降而告損壞的。

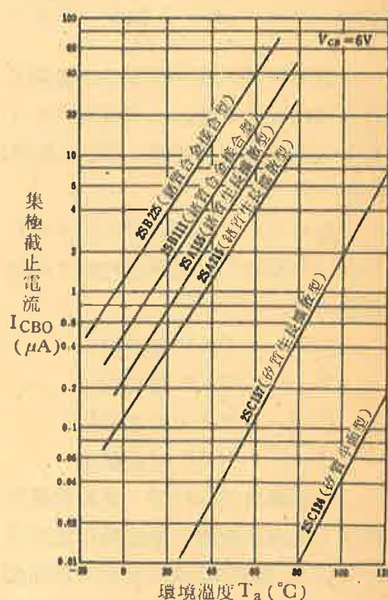
集極損耗有如眞空管之有屏極損耗，是在集極容許範圍內的一種電力損耗。將集極損耗而轉化為熱量，這使內部溫度上升。集極損耗 P_C 與晶體管內部工作時的接點溫度的界限T_j的關係，示如圖（2），也就是在25°C以上的溫度及在25°C時的 P_C 與 T_j 而構成此圖。由圖可見，P_C 的容許範圍是與所加散熱板大小成比例，而當取 T_j 為最大限度時，P_C 即降至為零點。但功率晶體管則常以外殼溫度作為基準。

所謂外殼溫度的25°C，是在周圍環境為25°C時加以無限大散熱板並以強力空氣吹動的情形下而作為理想值的，在實用上只是加以適當大的散熱板而已，故所能得到的 P_C 容許極限當應為較少的數值，此是可以理解的。圖（2）及圖（3）是其例子。

在本規格表是以通常的T_C=25°C為準則，若在其他條件時，在 P_C 欄則是全將此條件以小字體列於其側的。

6 集極截止電流 I_{CBO}

在集極－基極間加以反向電壓時的漏電流值以小為佳（圖4），矽晶體管的漏電流值很小，這具有很大的實用價值。當溫度上升10倍時只增加2倍，一般均以25°C時的值列在規格表上。在實際上的中心值，以鍺質弱訊號用小型晶體管為0.5～5μA，功率晶體管為100μA～5mA。在矽晶體管方面，小型的約為0.0001～



圖（4） I_{CBO} 的溫度特性之例子

0.001μA，功率晶體管為10μA～1mA左右。

在本規格表是於此欄的左側列 I_{CBO} 的最大值，而於右側註明在測定此 I_{CBO} 時的集極電壓V_{CB}。

7 直流電流放大率或脈冲電流放大率 h_{FE}

以直流測得的射極接地電流放大率，即為集極電流 I_C 與基極電流 I_B 的比率，故為 I_C/I_B。

開關用或功率用晶體管等，為要在大電流使用，是不可能以小訊號參數來設計的；進一步以大的電壓及電

流來測定時，由於偏壓的電力發熱而令致它損壞，故只能在極短的時間內以脈冲加入來進行測量，故無論何時要討論其 h_{FE} 之大小，必須要注意到其測定條件爲何才能得到合適的答案。

如圖(1)的弱電流品種，只要很小電流 h_{FE} 就會很快上升，而於大電流時反下降。而大電流用的品種則是 h_{FE} 上升得緩慢亦不會下跌，在設計上是具有良好的綫性。

本規格表是將 h_{FE} 標準值書於左側，右側是其測定條件如集極電壓 V_{CE} 與集極電流 I_C 。

8 h參數

h參數是包含了電流放大率 h_f，輸入阻抗 h_i，電壓回輸率 h_r，輸出導納 h_o 等四種參數，並把基極接地 b 或射極接地 e 分別註於各種項目之內以資識別。

h_{fe}　電流放大率(射極接地)

h_{fb}　電流放大率(基極接地)

h_{ie}　輸入阻抗(射極接地)

h_{ib}　輸入阻抗(基極接地)

h_{re}　電壓回輸率(射極接地)

h_{rb}　電壓回輸率(基極接地)

h_{oe}　輸出導納(射極接地)

h_{ob}　輸出導納(基極接地)

這方面，基極接地與射極接地之參數之間，可由下面公式來換算。

$$h_{ie}=\frac{h_{ib}}{1+h_{fb}} \qquad h_{ib}=\frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}$$

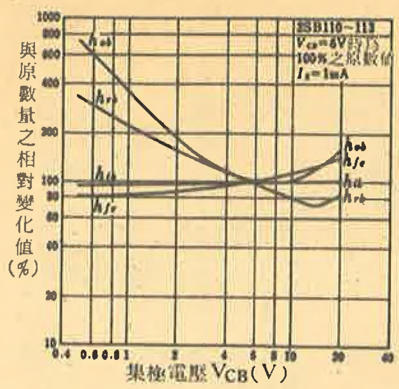
$$h_{fe}=\frac{-h_{fb}}{1+h_{fb}} \qquad h_{fb}=\frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}}$$

$$h_{re}=\frac{h_{ib}\times h_{ob}}{1+h_{fb}}-h_{rb} \qquad h_{rb}=\frac{h_{ie}\times h_{oe}}{1+h_{fe}}-h_{re}$$

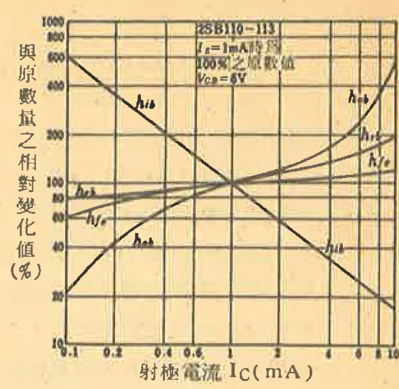
$$h_{oe}=\frac{h_{oe}}{1+h_{fb}} \qquad h_{ob}=\frac{h_{oe}}{1+h_{fe}}$$

兩種方式的偏壓都有較大的變化，圖(5)及圖(6)是典型的合金接合型晶體管的h參數的偏壓變化情形。

在本規格表於上欄內，首先有測



圖(5)　h參數之電流特性例子



圖(6)　h參數之電壓特性例子

定條件的集極電壓 V_{CB} 及射極電流 I_E 記入，其次則順序記入 h_{fe}、h_{ie}、h_{re}、h_{oe} 。通常都是射極接地的標準値，在有＊符號時則表示爲基極接地的數值。h參數一般是在 270Hz 或 1KHz 時的低頻實測值；但是在射極接地時的電流放大率 h_f，也會是用高頻時的實測值。此時高頻 h_{fe} 若無單位數值(倍率)時，則爲 dB，此點必須要注意。

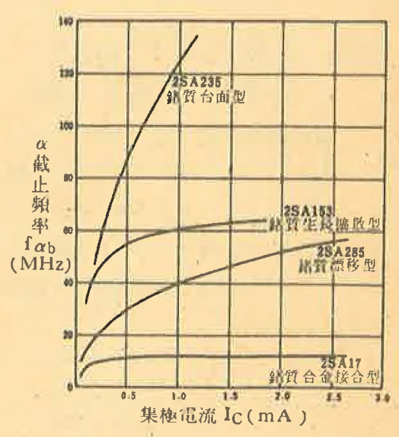
還有，當此欄h參數爲空欄時，則以工作的實際例子記入，如電力增益 PG＝25dB(f＝1MC)，或開關時間 $t_{on}<80nS$，$t_{stg}<200nS$，$t_{off}<400nS$ 等等。

這類記載大抵有如下的內容。

NF	雜音指數	
PG或GP	電力放大增益	工作例子
CG或Ge	電力變換增益	
P_o	輸出功率	
t_d	延遲時間	開關時間
t_r	上升時間	
t_s	存儲時間	
t_f	下落時間	
t_{on}	接通時間	
t_{off}	斷開時間	
t_{stg}	存儲時間	

9 截止頻率特性

截止頻率是有基極接地(圖7)的 $f_{\alpha b}$ 及射極接地的 $f_{\alpha e}$ 兩種。無論



圖(7)　$f_{\alpha b}$ 的電流特性例子

是那一種，此頻率時之電流放大率較低頻時的數值有3dB的低落。一般上是以 $f_{\alpha b}$ 來表示，但功率晶體管則會有用 $f_{\alpha e}$ 的。基極內部有漂移電場的晶體管(高頻用管幾乎均如此)，其相位回輸也大，以 $f_{\alpha b}$ 來決定高頻特性是不適當的，此時最好使用增益與波段寬乘積之 f_T 。f_T 也有寫作 f_1 的，此即射極接地在電流放大爲1(＝0dB)時的頻率。

晶體管的高頻率 h_{fe} 對於工作頻率的升高是會作每倍頻程6dB的低落的，故

f_T＝高頻 h_{fe}×測定頻率

即 f_T 又叫作增益波段寬積。$f_{\alpha b}$、$f_{\alpha e}$、f_T 間是有如下的關係存在，其中m是合金接合型的常數，微型合金接合型約0.21，其他高頻晶體管約爲

0.5～0.7。

$$f_{\alpha e}=\frac{f_T}{h_{fe}}=\frac{f_{\alpha b}\cdot(1+h_{fb})}{(1-h_{fb}\times m)}$$

這樣所示出的晶體管特性，當然是以高的數字爲佳，但在使用時並非意味着要把頻率數用到最高的值爲止。C_{ob}（正確爲C_o）與$r_{bb'}$的總合是決定了高頻特性的好或壞，$C_c\cdot r_{bb'}$若小，則可以補救了低的f_T。

在本規格表中，$f_{\alpha b}$是照原值記入，f_T則加印※符號。在極罕有的情形下，有把$f_{\alpha b}$作$\frac{f_{\alpha e}}{10KC}$的記載的。

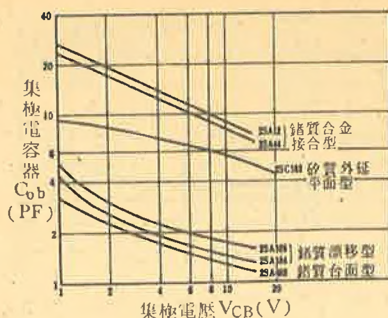
10 集極容量C_{OB}及基極擴展電阻$r_{bb'}$

基極擴展電阻$r_{bb'}$（base spreading resistance）與集極容量C_{ob}，係與f_T一起，爲決定晶體管高頻特性的重要參數。當功率增益爲0dB的頻率也即是最高振盪的可能頻率f_{max}是由

$$f_{max}=\sqrt{\frac{f_T}{8\pi\cdot C_{ob}\cdot r_{bb'}}}$$

示出，當然以C_{ob}及$r_{bb'}$小的爲佳。集極容量C_{ob}是集極電壓高時則變得小，此一趨勢見於圖（8）。

此一集極容量，正確的應爲集極一基極間的容量，這應記爲C_c，一般是將從外部測得的值作爲C_{ob}。在於C_{ob}本身而言，是包含了寄生元件的容量，甚至在外殼的浮游容量等。最近的C_c小的超高頻晶體管將上式之C_{ob}，以C_c來計算，是與實際會有出入的，此時就非要用到C_c與$r_{bb'}$或$C_c\cdot r_{bb'}$的積不可。



圖（8） 構造方式影響集極電容量的趨向例子

於EIAJ的登記上，高頻用晶體管的$r_{bb'}$是以h_{ie}（real）來代替，也就是射極接地高頻輸入阻抗的實數部份，在本規格表若爲h_{ie}（real）的數值，則會於$r_{bb'}$欄的數字附以*符號以作分別。此外，$C_c\cdot r_{bb}$時則會於$r_{bb'}$欄內作如$\frac{C_c\cdot r_{bb'}}{10pS}$的寫法。

11 晶體管的外形

晶體管的外形即使大多類似，但只要調查一下廠家的說明書，不難發現是頗有不同之處的。其中即使有，引入了RCA技術的日立、東芝、神戶工業、三洋等廠亦各自有其不同之處。

現在，日本廠家多已採用適合國際的統一標準尺寸，其中有不同的廠家，均已在本表內註上最大及最小及直徑等尺寸，以至引綫的長度等。功率晶體管的接脚均有固定的長度及脚孔位置尺寸，而個別廠家的不同出品，則是在一般標準尺寸上加有若干容許誤差，如4.2±0.2等。

12 備考

此欄係供註入各式事項，如

(1)現在的EIAJ名稱決定前的舊式名稱或試製名稱。

(2)在規格表上難以表明的特別特性，如正向AGC，雙向性等。

(3)特殊組合的複合元件
例如封入兩元件的複合管，然納二極管組合等。

(4)互補對稱的品種
如 $\frac{2SC828}{之對稱}$ 等記入

(5)在規格表左欄外有☆符號的，乃其廠家已指明爲保守型式或廢品種。



TRANSISTOR SPECIFICATIONS

晶體管特性表

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及静冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測定情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SA 12	日立	IF	Ge. A	−16	−0.5	−15	80	85	−6	−12				−6	1	60	PG = 31 dB (f = 455 kc)			8	10	70	12A	2N218 HJ22D
	〃 13	〃	〃	〃	−12	−0.5	−15	80	85	−10	−12				−6	1	55	PG = 31 dB (f = 455 kc)			8	10	70	12A	2N410 HJ 56
	〃 14	〃	〃	〃	−16	−0.5	−15	80	85	−6	−12				−6	1	50				4	10	90	12A	2S148 HJ 62
	〃 15	〃	Conv	〃	−16	−0.5	−15	80	85	−6	−12				−6	1	60	CG = 35 dB (f = 1.5 Mc)			12	10	70	12A	2N219 HJ23D
	〃 16	〃	〃	〃	−12	−0.5	−15	80	85	−10	−12				−6	1	60	CG = 35 dB (f = 1.5 Mc)			12	10	70	12A	2N412
	〃 17	〃	Mix	〃	−12	−0.5	−15	50	85	−6	−12				−6	1		CG = 20 dB (f = 12 Mc)			19	9.5	110	12A	2S145 HJ 60
	〃 18	〃	RF	〃	−21	−0.5	−15	80	85	−7	−23				−6	1					19	9.5	110	12A	2S146 HJ 62
★	〃 19	日電	IF	Ge. GD	−12	−0.5	−2	15	55	−10	−9				−6	1	20	PG = 36 dB (f = 455 kc)			50	1.5		19A	
★	〃 20	〃	〃	〃	−12	−0.5	−2	15	55	−10	−9				−6	1	30	PG = 39 dB (f = 455 kc)			56	1.5		19A	
★	〃 21	〃	〃	〃	−12	−0.5	−2	15	55	−10	−9				−6	1	50	PG = 42 dB (f = 455 kc)			55	1.5		19A	
	〃 22	富士通	RF. IF	Ge. A	−20		−20	100	70	−5	−20				−6	1	−0.98*	30*	6*	0.4*	12	12	120	76	2S125
	〃 23	〃	〃	〃	−20		−15	100	70	−5	−20				−6	1	−0.98*	30*	6*	0.4*	8	12	120	76	2S126
	〃 24	〃	RF	Ge. D	−30		−10	60	70	−5	−6				−6	1	−0.975*	27*	1*	0.2*	100	3.5	150	61	
★	〃 25	〃	〃	〃	−25		−15	50	70	−5	−6				−6	1	−0.975*	27*	1*	0.2*	100	3.5	100	61	
★	〃 26	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. A	−20	−15	−50	200	85	−12	−16				−6	1	60	30*	12	0.8	6	15	100	84A	ST20B ST20C
	〃 27	東芝	Conv	Ge. D	−18	−0.5	−5	55	75	−12	−18				−6	1					50	2	40	13A	2S60
	〃 28	〃	RF	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−8	−12				−6	1	75	h_{fe} = 8−44 (f = 1.5 Mc)				2	40	13A	2S92
	〃 29	〃	IF	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−12	−18				−6	1					35	2	35	23	2S93
	〃 30	富士通	Conv	Ge. A	−12	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−6	1	75	PG = 30 dB (f = 1.5 Mc)			10	10	65	4	2NJ8A 2S30
	〃 31	〃	IF	〃	−12	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−6	1	50	PG = 37 dB (f = 455 kc)			5	10	75	12A	2NJ5A 2S31
	〃 32	〃	RF. IF	〃	−20	−10	−50	100	70	−5	−20				−6	1	−0.985*	29*		0.4*	10	12	150	78	
	〃 33	〃	〃	〃	−20	−10	−25	100	70	−5	−20				−6	1	−0.985	29*		0.4*	6	12	150	78	
	〃 35	〃	Conv	〃	−16	−0.5	−15	80	85	−6	−12				−6	1	75	2570	4.23	32.7	10	10	85	12A	2S35
	〃 36	〃	IF	〃	−16	−0.5	−15	80	85	−6	−12				−6	1	50	1520	3.16	24.6	5	10	75	12A	2S36
	〃 37	東芝	Conv	〃	−18	−12	−5	25	75	−10	−18				−6	1	−0.985*	CG = 32 dB (f = 1 Mc)			7	10.5	80	5	
	〃 38	〃	IF	〃	−18	−12	−5	25	75	−10	−18				−6	1	−0.985*	h_{fe} = 18 (f = 455 kc)			10	10.5	80	5	
	〃 39	〃	〃	〃	−18	−12	−5	25	75	−10	−18				−6	1	−0.98*	h_{fe} = 9 (f = 455 kc)			5.5	10.5	80	5	
	〃 40	富士通	SW	〃	−25	−12	−50	80	85	−6	−12				−6	1	65	t_r = 0.3 μS, t_f = 0.2 μS, t_{stg} = 0.4 μS			6	10	<75	12A	
	〃 41	日立	RF	〃	−35	−20	−40	250 (放熱板付)	70	−6	−12				−6	1	45				6	10	95	64	2S191 HJ 41
	〃 42	〃	〃	〃	−45	−20	−40	250 (放熱板付)	70	−6	−12				−6	1	45				6	10	95	64	2S192 HJ 42
	2SA 43	富士通	RF	Ge. D	−35	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	60	PG = 24 dB (f = 10.7 Mc)			40	2.3	40	13A	2S 43
	〃 44	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. A	−15	−10	−10	80	75	−10	−10				−6	1	100	CG = 28 dB (f = 1 Mc)			15	10.5	110	20	OC 44
	〃 45	東芝	IF	〃	−18	−12	−5	60	75	−12	−18				−6	1		h_{fe} = 5 (f = 455 kc)				11	80	12A	2S 45
	〃 46	富士通	RF. IF	〃	−12	−0.5	−25	100	70	−10	−12				−6	1	−0.985*	29*		0.4*	10	12	150	78	
	〃 47	〃	〃	〃	−12	−0.5	−25	100	70	−10	−12				−6	1	−0.985*	29*		0.4*	6	12	150	78	
	〃 48	東芝	RF	〃	−18	−12	−5	60	75	−12	−18				−6	1		h_{fe} = 14 (f = 1.5 Mc)				11	80	12A	2S 48
	〃 49	〃	IF	〃	−18	−12	−5	60	75	−10	−18				−6	1	30~200	h_{fe} = 16 (f = 455 kc)				10.5	90	12A	2S 49
★	〃 50	〃	SW	〃	−18	−12	−24	60	75	−3	−12	100	−1	−24	−6	1					14	10	<150	12A	2S 50
	〃 51	〃	RF	〃	−18	−12	−5	60	75	−10	−18				−6	1	−0.985*	PG = 36 dB (f = 1 Mc)			14	10.5	90	12A	2S 51
	〃 52	〃	Conv	〃	−18	−12	−5	60	75	−10	−18				−6	1	25~180	h_{fe} = 8−22 (f = 1 Mc)				10.5	80	12A	2S 52
	〃 53	〃	IF	〃	−18	−12	−5	60	75	−10	−18				−6	1	20~140	h_{fe} = 9 (f = 455 kc)				10.5	90	12A	2S 53
★	〃 54	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	−20	−0.2	−5	75	85	−5	−12				−6	2	10	PG = 12 dB (f = 200 Mc)			400*	1.5	40	59	
	〃 55	松下	〃	Ge. A	−15	−10	−10	80	75	−10	−10				−6	1	50				6	10.5	75	20	OC 45
★	〃 56	日電	SW	Ge. Me	−15	−3.5	−50	150	100	−5	−5	40	−0.3	−10	−3	10		t_d = 22 nS, t_s = 65 nS, t_r = 28 nS, t_f = 45 nS			300*	5		49C	
	〃 57	東芝	RF	Ge. D	−18	−0.5	−5	55	75	−10	−18				−6	1	20~350	PG = 16 dB (f = 50 Mc)			85	2	45	13A	2S 57
	〃 58	〃	RF. Conv	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−10	−18				−6	1	20~350	PG = 24 dB (f = 20 Mc)			75	2	45	13A	2S 58
	〃 59	〃	Conv	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−12	−18				−6	1	70	CG = 23 dB (f = 18 Mc)			65	2	40	13A	2S 59
	〃 60	〃	〃	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−10	−18				−6	1	40~350	CG = 26 dB (f = 12 Mc)			55	2	40	13A	2S60A
	〃 61	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	−20	−0.5	−10	100	75	−13	−6				−6	1	80				70	2	50	12A	
	〃 64	富士通	SW	Ge. A	−16	−9	−40	80	85	−6	−12				−6	1	65	t_r = 0.2 μS, t_f = 1.5 μS, t_s = 0.35 μS			15	10	< 85	12A	2S 64
	〃 65	東芝	〃	〃	−18	−12	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r = 0.1 μS, t_f = 0.1 μS, t_s = 0.14 μS			6	<16	<140	12A	
	〃 66	〃	〃	〃	−18	−12	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r = 0.085 μS, t_f = 0.085 μS, t_s = 0.14 μS			10	<16	<140	12A	
	〃 67	〃	〃	〃	−18	−12	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r = 0.06 μS, t_f = 0.06 μS, t_s = 0.14 μS			14	<16	<140	12A	
	〃 68	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	−20	−0.5	−10	100	75	−13	−6				−6	1	80	g_{ie} 3 m℧	y_{fe} 20 m℧	g_{oe} 90 μ℧	70	Coe 5 pF		72A	
★	〃 69	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	100	75	−13	−6				−6	1	80	g_{ie} 3 m℧	y_{fe} 27 m℧	g_{oe} 90 μ℧	70	Coe 5 pF		72A	OC169
★	〃 70	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	100	75	−13	−6				−6	1	80	g_{ie} 2.5 m℧	y_{fe} 32 m℧	g_{oe} 60 μ℧	70	2	50	72A	OC170
★	〃 71	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	100	75	−13	−6				−6	1	80	g_{ie} 23 m℧	y_{fe} 14 m℧	g_{oe} 350 μ℧	100	2	50	72A	OC171
	〃 72	東芝	RF	Ge. D	−18	−0.5	−5	55	75	−12	−18				−6	1	50	h_{fe} = 19 (f = 1.5 Mc)			40	2	40	13A	
	〃 73	〃	Conv	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−12	−18				−6	1	50	h_{fe} = 15 (f = 1.5 Mc)			35	2	40	13A	
★	〃 74	〃	RF	〃	−50	−0.5	−50	120	75	−8	−12				−9	1	70	2000	0.3	15	70	2.2	30	13A	

			用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電氣的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉沖下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SA 75	東芝	RF	Ge. D	−20	−0.5	−50	120	75	−8	−12				−9	1	70	2000	0.3	15	30	2.2	30	13A	
	〃 76	〃	〃	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−15	−18				−6	1	20~350	PG = 13 dB (f = 100Mc)			130	1.7	40	13A	
	〃 77	〃	Osc	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−15	−18				−6	1	20~350	Vosc = 100mV (f = 110.7Mc)			110	1.7	40	13A	
	〃 78	〃	SW	〃	−40	−2	−400	125	75	−8	−12	60	−1	−400	−6	1		td=0.085μS, tf=0.75μS ts=0.085μS			40	< 6	<120	13A	
	〃 79	〃	〃	Ge. A	−20	−12	−200	60	75	−7	−12	70	−0.5	−100	−6	1					> 4	< 15	<140	12A	
	〃 80	日立	RF. Conv	Ge. D	−20	−0.5	−10	80	85	−20	−12				−9	1	80	PG = 16 dB (f = 12 Mc)			60	1.7	35	13A	2S140 HJ 70
	〃 81	〃	Osc	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−20	−12				−9	1	80				40	1.7	41	13A	2S141 HJ 71
	〃 82	〃	Mix	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−8	−12				−9	1	6	CG = 24 dB (f = 12 Mc)			40	1.7	25	13A	2S142 HJ 72
	〃 83	〃	IF	〃	−25	−0.5	−10	80	85	−8	−12				−9	1	60	PG = 39 dB (f = 455 kc)			30	1.7	25	13A	2S143 HJ 73
	〃 84	〃	Conv	〃	−25	−0.5	−10	80	85	−8	−12				−9	1	60	CG = 41 dB (f = 1.5Mc)			35	1.7	35	13A	2S144 HJ 74
	〃 85	〃	RF	〃	−25	−1	−10	80	85	−8	−12				−9	1	60	PG = 31 dB (f = 1.5Mc)			55	1.7	30	13A	2S145 HJ 75
	〃 86	〃	〃	〃	−45	−1	−50	225 (散熱板付)	85	−12	−12				−9	1	60				35	1.7	45	67	2S190 HJ 76
★	〃 87	〃	〃	〃	−30	−0.5	−10	80	85	−12	−12				−12	1.5	100				100	1.9	40	13A	
★	〃 88	〃	Osc	〃	−30	−0.5	−10	80	85	−12	−12				−12	1.5	60				100	1.9	60	13A	
★	〃 89	〃	Mix	〃	−30	−0.5	−10	80	85	−12	−12				−12	1.5	80				90	2.3	60	13A	
★	〃 90	〃	RF	〃	−30	−0.5	−20	200 (散熱板付)	85	−12	−12				−12	1.5	>20				>60	< 3	60	67	
	〃 92	東芝	Osc	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−10	−18				−6	1	40~350				50	1.9	40	13A	2S92A
	〃 93	〃	Mix	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−10	−18				−6	1	20~350	CG = 25 dB (f = 12 Mc)			45	1.9	30	13A	2S93A
	〃 94	日立	Conv	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−15	−9				−3	1					45	5	65	13A	
★	〃 95	富士通	RF	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1					50	2.3	50	72B	2S 95
★	〃 96	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1					45	2.3	50	72B	2S 96
★	〃 97	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1					40	2.3	50	72B	2S 97
★	〃 98	〃	Osc	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1					30	2.3	50	72B	2S 98
★	〃 99	〃	Mix	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1					20	2.3	50	72B	2S 99
	〃 100	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−40	−0.4	−10	60	75	−16	−10				−6	1	150			1.5*	20	1.7	100	12A	
	〃 101	〃	〃	〃	−40	−0.4	−10	60	75	−16	−10				−6	1	30			1.5*	15	1.7	30	12A	MC101
	〃 102	〃	〃	〃	−40	−0.4	−10	60	75	−16	−10				−6	1	40			1.5*	25	1.7	40	12A	MC102
	〃 103	〃	〃	〃	−40	−0.4	−10	60	75	−16	−10				−6	1	50			1.5*	35	1.7	50	12A	MC103
	〃 104	〃	〃	〃	−40	−0.4	−10	60	75	−16	−10				−6	1	60			1.7*	50	1.7	50	12A	MC104
	〃 105	富士通	Conv	〃	−6	−0.5	−10	80	85	−10	−6				−3	1	50	PG = 20 dB (f = 12 Mc)			75	3	50	13A	
	2SA106	富士通	Conv. Mix Osc	Ge. D	−6	−0.5	−10	80	85	−10	−6				−3	1	50	PG = 28 dB (f = 1.5Mc)			30	3	50	13A	
	〃 107	〃	IF	〃	−6	−0.5	−10	80	85	−10	−6				−3	1	40	PG = 40 dB (f = 455kc)			20	3	50	13A	
	〃 108	〃	RF	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	PG = 17 dB (f = 20 Mc)			50	2.3	50	13A	2S108
	〃 109	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	60	PG = 15 dB (f = 20 Mc)			45	2.3	50	13A	2S109
	〃 110	〃	Conv	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	60	PG = 20 dB (f = 12 Mc)			40	2.3	50	13A	2S110
	〃 111	〃	Osc	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	40	Vosc = 0.4 V (f = 12 Mc)			30	2.3	50	13A	2S111
	〃 112	〃	Mix	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	45	PG = 16 dB (f = 12 Mc)			20	2.3	50	13A	2S112
	〃 113	〃	Conv. Mix	〃	−34	−1	−10	80	85	−7	−12				−12	1	45	CG = 40 dB (f = 1 Mc)			20	2	50	13A	
	〃 114	〃	IF	〃	−34	−1	−10	80	85	−7	−12				−12	1	40	PG = 39 dB (f = 455kc)			20	2	50	13A	
	〃 115	〃	RF	〃	−34	−1	−10	80	85	−5	−12				−12	1	60	PG = 28 dB (f = 1.6Mc)			30	2	50	13A	
	〃 116	〃	〃	〃	−30	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−12	1.5	60	PG = 15 dB (f = 50 Mc)			120	2	50	13A	
	〃 117	〃	Osc	〃	−30	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−12	1.5	40	Vosc = 0.25V (f = 60.7Mc)			110	2	50	13A	
	〃 118	〃	Mix	〃	−30	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−12	1.5	60	PG = 15 dB (f = 50 Mc)			100	2	50	13A	
	〃 121	SON	RF. Conv Mix. Osc	Ge. GD	−15		−2	15	65	−8	−15				−6	1	−0.96*	50*	5*	0.25*	100	1.3		18	2S173 2T201
	〃 122	〃	〃	〃	−15		−2	15	65	−8	−15				−6	1	−0.96*	50*	5*	0.25*	100	1.3		18	2T201
	〃 123	〃	〃	〃	−15		−2	15	65	−8	−15				−6	1	−0.96*	50*	5*	0.25*	100	1.3		18	2T201
	〃 124	〃	〃	〃	−15		−2	15	65	−8	−15				−6	1	−0.97*	50*	5*	0.25*	120	1.3		18	2S138
	〃 125	〃	〃	〃	−15		−2	15	65	−2	−15				−6	1	−0.98*	40*	5*	0.25*	120	1.3		18	2S139
★	〃 126	日電	SW	Ge. Me	−12	−1	−50	150	100	−5	−5	40	−0.5	−10	−3	10		td = 22nS, ts = 65nS tr = 28nS, tf = 46nS				300*	5	49C	
★	〃 127	東芝	RF	Ge. D	−70	−0.5	−50	150	75	−50	−12				−6	1	−0.98*				25	15	40	13A	
★	〃 128	〃	SW	〃	−40	−2	−600	170	75	−50	−12	35	−1.5	−600	−6	1		tr = 0.35μS, tf = 1.1μS ts = 0.8μS			>15	<25	<70	13A	
★	〃 129	〃	〃	〃	−40	−2	−600	170	75	−50	−12	70	−1.5	−600	−6	1		tr = 0.35μS, tf = 1.1μS ts = 0.8μS			>15	<25	<70	13A	
	〃 130	日立	RF. Conv	Ge. Me	−9	−0.5	−10	80	85	−15	−9				−3	1	80	PG = 19 dB (f = 12 Mc)			65	4	55	13A	
	〃 131	〃	Osc	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−15	−9				−3	1	50				45	4	60	13A	
	〃 132	〃	Mix	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−15	−9				−3	1	80	CG = 25 dB (f = 12 Mc)			50	4	70	13A	
	〃 133	〃	IF	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−15	−9				−3	1	60	PG = 39 dB (f = 455kc)			40	4	110	13A	
★	〃 134	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	1					140	3	100	72A	
★	〃 135	〃	RF. Conv	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	1					150	3	80	72A	
	〃 136	富士通	Conv	Ge. A	−6	−0.5	−10	80	85	−10	−6				−3	1	75	CG = 35 dB (f = 1.5Mc)			10	13	85	12A	
	〃 137	〃	IF	〃	−6	−0.5	−10	80	85	−10	−6				−3	1	50	PG = 28 dB (f = 455kc)			5	13	75	12A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ (Ω)	外形	備考
	2SA138	富士通	SW	Ge. A	−20	−10	−25	80	85	−5	−20	70	−1	−10	−6	1					15	10	150	12A	
	〃139	〃	RF. IF	〃	−20	−10	−50	80	85	−5	−20	70	−1	−50	−6	1	−0.985*	29*		0.4*	8	12	150	12A	
★	〃141	三菱	IF	〃	−15	−1.5	−15	80	85	−5	−12				−6	1	70*	PG = 33 dB (f = 455kc)			4	12	60	12A	TJ 41
★	〃142	〃	Conv	〃	−15	−1.5	−15	80	85	−5	−12				−6	1	70	CG = 28 dB (f = 1 Mc)			8	12	60	12A	TJ 42
★	〃143	〃	RF. Conv	〃	−15	−1.5	−15	80	85	−5	−12				−6	1	70*	PG = 15dB (f = 1.5Mc)			15	12	60	12A	TJ 43
★	〃144	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−15	−10	−10	80	75	−10	−10				−6	1	100	CG = 28 dB (f = 1 Mc)			15	10.5	110	12B	OC 44
★	〃145	〃	〃	〃	−15	−10	−10	80	75	−10	−10				−6	1	50				6	10.5	75	12B	OC 45
★	〃146	三菱	IF	Ge. D	−20	−0.5	−10	60	85	−15	−12				−6	1	50	PG = 37 dB (f = 455kc)			20	2.5	40	13B	TJ 46
★	〃147	〃	Conv. Mix	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−15	−12				−6	1	70				30	2.5	40	13B	TJ 47
★	〃148	〃	Conv	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−15	−12				−6	1	70	CG = 36 dB (f = 1 Mc)			40	2.5	45	13B	TJ 48
★	〃149	〃	RF	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−15	−12				−6	1	70				50	2.5	50	13B	TJ 49
	〃151	日立	IF	Ge. A	−9	−0.5	−15	80	85	−5	−6				−3	1					6	13.5	90	12A	
	〃152	〃	Conv	〃	−9	−0.5	−15	80	85	−5	−6				−3	1					10	13.5	110	12A	
★	〃153	日電	Mix	Ge. GD	−15	−0.5	−4	20	65	−5	−9				−6	1	60	CG = 28 dB (f = 12 Mc)			60	1.3		19A	2S153 ST27B
★	〃154	〃	IF	〃	−15	−0.5	−4	20	65	−5	−9				−6	1	20	PG = 36 dB (f = 455kc)			50	1.5		19A	2S154 ST28A
★	〃155	〃	〃	〃	−15	−0.5	−4	20	65	−5	−9				−6	1	30	PG = 39 dB (f = 455kc)			55	1.5		19A	2S155 ST28B
★	〃156	〃	〃	〃	−15	−0.5	−4	20	65	−5	−9				−6	1	50	PG = 42 dB (f = 455kc)			55	1.5		19A	2S156 ST28C
★	〃157	〃	Osc	〃	−15	−0.5	−4	20	65	−5	−9				−6	1	50	Vosc = 3 V (f = 18. 455Mc)			65	1.5		19A	2S157 ST29
★	〃159	〃	Conv	Ge. GD	−15	−0.5	−4	20	65	−5	−9				−6	1	50	CG = 36 dB (f = 1.6 Mc)			55	1.5		19A	2S159 ST37E
★	〃160	〃	〃	〃	−15	−0.5	−4	20	65	−5	−9				−6	1	60	CG = 39 dB (f = 1.6Mc)			55	1.5		19A	2S160
	〃161	SONY	RF	Ge. Me	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.93*				400*	1.2	80	51	
	〃162	〃	〃	〃	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.96*				400*	1.2	80	51	
	〃163	〃	〃	〃	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.985*				400*	1.2	80	51	
	〃164	〃	Osc	〃	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.93*				400*	1.2	80	51	
	〃165	〃	〃	〃	−20		−15	50	85	−5	−15	24	−3	−1	−6	2	−0.96*	PG = 20 dB (f = 100Mc)			450*	1.7	80	51	
	〃166	〃	〃	〃	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.985*				400*	1.2	80	51	
★	〃167	日電	RF	Ge. A	−20	−10	−50	125	75	−8	−20				−6	1	70	28*	13*	0.8*	9	15	120	84A	2S167 ST20A
★	〃168	〃	〃	〃	−20	−10	−50	175	75	−8	−20				−6	1	70	28*	13*	0.8*	9	15	120	91	2S168 ST20AR
★	〃168A	〃	〃	〃	−20	−10	−50	175	75	−8	−20				−6	1	70	28*	13*	0.8*	9	15	120	91	
★	〃169	〃	SW	〃	−20	−10	−50	125	75	−8	−20	70	−1	−10	−6	1					15	11	250	84A	2S169 ST20E
★	2SA170	日電	SW	Ge. A	−20	−10	−50	175	75	−8	−20	70	−1	−10	−6	1					15	11	250	91	2S170 ST20ER
★	〃171	〃	〃	〃	−20	−10	−50	125	75	−8	−20	60	−1	−10	−6	1					8	11	230	84A	2S171
★	〃172	〃	〃	〃	−20	−10	−200	175	75	−8	−20	40	−0.35	−200	−6	1					8	11	230	91	2S172
★	〃173	〃	〃	〃	−20	−10	−50	125	75	−8	−20	60	−1	−10	−6	1					4	13	200	84A	2S173
★	〃174	〃	〃	〃	−20	−10	−50	175	75	−8	−20	60	−1	−10	−6	1					4	13	200	91	2S174
	〃175	東芝	RF	Ge. D	−18	−0.5	−5	55	75	−15	−18				−6	1	20 ~ 350	PG = 16 dB (f = 50 Mc)			85	2	40	13A	2S175
	〃176	〃	〃	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−12	−18				−6	1					85	2.5	45	13A	2S176
	〃178	〃	〃	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−12	−18				−6	1	h_{fe} = 13 (−1.5V, 1mA, f = 1.5Mc)					2	40	13A	
	〃180	三洋	Conv	Ge. A	−15	−15	−10	50	75	−10	−15				−6	1	−0.986*	28*	4.7*	0.3*	10	12	100	12A	
	〃181	〃	IF	〃	−15	−15	−10	50	75	−10	−15				−6	1	−0.979*	29*	2.8*	0.4*	5	12	80	12A	
	〃182	〃	〃	〃	−15	−15	−10	50	75	−10	−15				−6	1	−0.964*	29*	2.9*	0.5*	5	12	80	12A	
	〃183	〃	〃	〃	−15	−15	−10	50	75	−10	−6				−6	1	−0.988*	28*	6*	0.5*	16	12	120	12A	
	〃184	〃	〃	〃	−15	−15	−10	50	75	−10	−6				−6	1	−0.95*	29*	2.4*	0.5*	3	12	70	12A	
★	〃188	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−12	−0.5	−15	80	85	−10	−12				−6	1	70				10	10	150	12A	
★	〃189	〃	IF	〃	−12	−0.5	−15	80	85	−10	−12				−6	1	70				6	10	100	12A	
★	〃190	沖	Mix	Ge. D	−20	−0.5	−15	80	80	−20	−20				−6	1	60				40	2.6	60	13A	
	〃191	〃	〃	〃	−20	−0.5	−15	80	80	−20	−20				−6	1	25				20	2.6	50	13A	
	〃192	〃	Conv	〃	−20	−0.5	−15	80	80	−20	−20				−6	1					13	3.2	40	13A	
	〃193	〃	〃	Ge. A	−15	−12	−15	80	80	−12	−15				−6	1	50				13	10	100	12A	
	〃194	〃	IF	〃	−15	−12	−15	80	80	−12	−15				−6	1	40				7	10	90	12A	
	〃195	〃	〃	〃	−15	−12	−15	80	80	−12	−15				−6	1	30				4	10	75	12A	
	〃196	〃	〃	〃	−15	−12	−15	80	80	−12	−15				−6	1	25				2.5	10	60	12A	
	〃197	三洋	〃	〃	−15	−15	−10	50	75	−10	−15				−6	1		h_{fe} = 2.5 (f = 455kc)				12	55	12A	
	〃198	〃	〃	〃	−15	−5	−5	30	75	−25	−15				−6	1		h_{fe} = 4 ~ 50 (f = 455kc)				12	55	12A	
	〃199	〃	RF	〃	−15	−5	−5	30	75	−10	−15				−6	1		h_{fe} = 9 (f = 1.5 Mc)				11	95	12A	
	〃200	〃	〃	〃	−15	−5	−5	30	75	−10	−15				−6	1		h_{fe} = 9 (f = 1.5Mc)				11	95	6	
	〃201	〃	IF. Conv	〃	−15	−5	−15	100	75	−10	−15				−6	1	50	CG = 32 dB (f = 1 Mc)			8	11	65	12A	
	〃202	〃	〃	〃	−15	−5	−15	100	75	−10	−15				−6	1	55	PG = 34 dB (f = 455kc)			12	11	70	12A	
	〃203	〃	IF	〃	−15	−5	−15	100	75	−10	−15				−6	1	30	PG = 30.5 dB (f = 455kc)			5	11	55	12A	
★	〃204	日電	RF	〃	−30	−20	−200	150	85	−6	−10	60	−1	−10	−6	1	65	28*	12*	0.9*	6	15	130	84A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA205	日電	RF. SW	Ge. A	−30	−20	−200	200	85	−6	−15	40	−1	−10	−6	1	45	28*	9*	1.1*	5	15	110	84A	
★	〃206	〃	〃	〃	−30	−20	−200	200	85	−6	−20	55	−1	−10	−6	1	60	28*	10*	0.8*	7	15	120	84A	
★	〃207	〃	〃	〃	−30	−20	−200	200	85	−6	−15	65	−1	−10	−6	1	70	28	11*	0.8*	12	15	130	84A	
	〃208	日立	SW	〃	−20	−12	−400	120	85	−5	−12	>15	−0.3	−200	−6	1					>3	<25	<120	84A	
	〃209	〃	SW	〃	−20	−12	−400	120	85	−5	−12	>30	−0.3	−200	−6	1					>5	<25	<150	84A	
	〃210	〃	〃	〃	−20	−12	−400	120	85	−5	−12	>45	−0.3	−200	−6	1					>10	<25	<200	84A	
	〃211	〃	〃	〃	−18	−10	−100	120	85	−10	−12	>30	−0.3	−100	−6	1					>4	<20	<150	84A	
	〃212	〃	〃	〃	−25	−12	−100	120	85	−5	−12	>30	−0.3	−100	−6	1					>4	<20	<150	84A	
★	〃213	日電	RF. Mix	Ge. GD	−15	−0.5	−2	15	65	−5	−9				−6	1	25	PG = 7 dB (f = 100Mc)			140	1		19A	
★	〃214	〃	Conv. Osc	〃	−15	−0.5	−2	15	65	−5	−9				−6	1	25	PG = 29.5dB (f = 10 Mc)			140	1		19A	
★	〃215	〃	RF	〃	−15	−0.5	−2	15	65	−5	−9				−6	1	40	PG = 24 dB (f = 10 Mc)			120	1		19A	
★	〃216	〃	〃	〃	−15	−0.5	−2	15	65	−5	−9				−6	1	40	PG = 27 dB (f = 10 Mc)			120	1		19A	
	〃218	三洋	RF. IF	Ge. D	−20	−0.5	−10	50	75	−12	−15				−6	1	90	CG = 30 dB (f = 4.5Mc)			55	3	65	13A	
	〃219	〃	RF	〃	−20	−1.5	−15	70	75	−15	−15				−6	1	70	PG = 20 dB (f = 10.7 Mc)			55	3.5	35	12A	
	〃220	〃	RF. Conv	〃	−20	−0.5	−15	50	75	−15	−15				−6	1	150				60	3.5	35	12A	
	〃221	〃	〃	〃	−20	−1.5	−15	70	75	−15	−15				−6	1	80	CG = 23 dB (f = 12 Mc)			55	3.5	35	12A	
	〃222	〃	〃	〃	−20	−1.5	−15	70	75	−15	−15				−6	1	90	CG = 13 dB (f = 27 Mc)			60	3.5	35	12A	
	〃223	〃	Osc	〃	−20	−1.5	−15	70	75	−15	−15				−6	1	120				65	3.5	30	12A	
	〃224	〃	RF	〃	−20	−0.5	−10	50	75	−12	−15				−6	1	170	PG = 20 dB (f = 25 Mc)			90	2.5	65	13A	
	〃225	〃	〃	〃	−20	−1.5	−15	70	75	−15	−15				−6	1	80				55	3.5	35	12A	
	〃226	〃	RF. Mix	〃	−15	−0.5	−10	50	75	−12	−15				−6	1	70	PG = 20 dB (f = 20 Mc)			95	3	70	13A	
	〃227	〃	RF	〃	−20	−0.5	−10	50	75	−12	−15				−6	1					90	2	250	13A	
	〃228	〃	〃	〃	−80	−0.5	−50	170	75	−50	−40				−6	1	50				35	3	40	13A	
★	〃229	東芝	〃	Ge. Me	−20	−0.2	−5	75	85	−10	−12				−6	2	−0.9*	PG = 9.5dB (f = 200Mc)			400*	1	60	48C	
★	〃230	〃	〃	〃	−20	−0.2	−5	75	85	−10	−12				−6	2	−0.9*	PG = 11.5dB (f = 200Mc)			400*	1	50	48C	
	〃231	日立	RF	Ge. A	−40	−12	−400	3 W (T_c=25°C)	70	−50	−40				−6	70	60	85	3.5	1	2.5	70	60	83	
	〃232	〃	〃	〃	−30	−12	−400	3 W (T_c=25°C)	70	−50	−30				−6	70	90	130	4.5	1	4	70	60	83	
★	〃233	〃	IF	Ge. Me	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	1	70	PG = 38 dB (f = 455kc)			100	2.1	60*	13A	
	〃234	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	1	70	PG = 38 dB (f = 455kc)			120	2.1	55*	13A	
	〃235	〃	RF. Conv	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	1	90	CG = 13 dB (f = 100Mc)			135	2.7	50*	13A	
	2SA236	東芝	IF	Ge. D	−18	−0.5	−5	55	75	−12	−18				−6	1	−0.98*	h_{fe} = 16 (f = 1.5Mc)			35	1.7	35	13A	
	〃237	〃	〃	〃	−18	−0.5	−5	55	75	−12	−12				−6	1	−0.98*	h_{fe} = 17 (f = 1.5Mc)			35	2.5	35	13A	
★	〃238	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	−25		−30	200	85	−8	−15				−6	5	30	NF < 6 dB (f = 70 Mc)			700	2.5	35	84C	
★	〃239	東芝	RF	〃	−20	−0.2	−5	75	85	−10	−12				−6	1	−0.91*	PG = 14 dB (f = 100Mc)			200*	1.5	30	48C	
★	〃240	〃	RF. Conv Mix. Osc	Ge. EMe	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	20*	PG = 19dB (f = 70Mc)			200*	1	25	48C	
★	〃241	松下	〃	Ge. AD	−20	−0.4	−5	50	75	−13	−10				−6	1	25				200*	1.5	70	72B	
★	〃242	〃	〃	〃	−20	−0.4	−5	50	75	−13	−10				−6	1		g_{ie} 16 m℧	y_{fe} 15 m℧	g_{oe} 300 μ℧	250*	1.5	70	72B	
★	〃243	〃	〃	〃	−20	−0.4	−5	50	75	−13	−10				−6	1					300*	1.5	100	72B	
	〃243A	〃	〃	〃	−20		−5	80 ([illegible])	75	−13	−10				−6	1	25				300*	1.5	100	72B	
★	〃244	日電	RF. Conv. Mix Osc. PA	Ge. Me	−25	−0.5	−30	200	85	−8	−15				−6	5	30	PG = 12.5dB (f = 100Mc)			600	3		84C	
★	〃244A	〃	〃	〃	−25	−0.5	−30	200	85	−4	−15				−6	5	30	PG = 16 dB (f = 70 Mc)			400*			84C	
★	〃245	〃	〃	〃	−25	−0.5	−30	200	85	−8	−15				−6	5	30	PG = 14.5dB (f = 100Mc)			700	2.5		84C	
★	〃246	日立	PA	〃	−30	−0.5	−30	100	85	−30	−30				−6	5	70				160	3	70*	13A	
★	〃247	〃	SW	〃	−10	−1.2	−30	100	85	−5	−10	125	−3	−20	−3	20					200	4	65	13A	
	〃248	東芝	〃	Ge. D	−40	−2	−200	125	75	−8	−12	60	−1	−200	−6	1		t_r = 30 nS, t_f = 50nS t_s = 200 nS			40		<120	13A	
	〃249	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−40		−10	110	75	−16	−10				−6	1	60				50	1.7	50	12A	
★	〃250	〃	〃	〃	−100	−0.7	−10	110	75	−16	−10				−6	1	100				50	1.7	50	12A	
★	〃251	富士通	SW	Ge. MA	−15	−15	−50	50	80	−5	−6	50	−1	−15	−6	1					50	2.5	150	60	
★	〃252	〃	〃	〃	−15	−15	−50	50	80	−5	−6	150	−1	−15	−6	1					80	2.5	150	60	
★	〃253	〃	RF	Ge. Me	−20		−30	200	85	−8	−15				−5	10	30				450	2.5	50	84C	
	〃254	〃	Conv	Ge. A	−12	−0.5	−10	55	85	−10	−12				−6	1	80	PG = 30 dB (f = 1.5Mc)			10	10	120	4	
	〃255	〃	IF	〃	−12	−0.5	−10	55	85	−10	−12				−6	1	50	PG = 37 dB (f = 455kc)			5	10	100	4	
	〃256	〃	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. D	−20	−0.5	−10	55	85	−10	−12				−6	1	75	PG = 17 dB (f = 20 Mc)			60	2.2	30	4	
	〃257	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	55	85	−10	−12				−6	1	60	PG = 20 dB (f = 12 Mc)			50	2.2	50	4	
	〃258	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	55	85	−10	−12				−6	1	45	V_{osc} = 0.4 V (f = 12 Mc)			40	2.2	70	4	
	〃259	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	55	85	−10	−12				−6	1	45	PG = 15 dB (f = 12 Mc)			30	2.2	70	4	
	〃260	三洋	RF	Ge. Me	−20	−0.4	−10	100	85	−15	−15				−6	2	12	CG = 17 dB (f = 100Mc)			300*	1.5	50	48C	
	〃261	〃	〃	〃	−20	−0.4	−10	100	85	−15	−15				−6	2	15	PG = 15 dB (f = 100Mc)			300*	1.5	60	48C	
	〃262	〃	〃	〃	−20	−0.4	−10	100	85	−15	−15				−6	2	15	CG = 12 dB (f = 200Mc)			450*	1.5	65	48C	
	〃263	〃	〃	〃	−20	−0.4	−5	60	85	−15	−15				−6	2	15	PG = 10 dB (f = 200Mc)			500*	1.5	65	48C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測定情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SA264	三洋	RF	Ge.Me	−20	−0.4	−10	100	85	−15	−15				−6	2	15	PG = 10 dB (f = 200Mc)			450	1.5		48C	
	〃 265	〃	〃	〃	−20	−0.4	−10	100	85	−15	−15				−6	2	15	CG = 28 dB (f = 25 Mc)			300	1.5		48C	
★	〃 266	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge.D	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−6	1	75	PG = 17 dB (f = 30 Mc)			60	2.2	30	12A	
★	〃 267	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−6	1	60	CG = 20 dB (f = 12 Mc)			50	2.2	50	12A	
★	〃 268	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−6	1	45	Vosc = 0.4 V (f = 12.455 Mc)			40	2.2	70	12A	
★	〃 269	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−6	1	45	CG = 35 dB (f = 1 Mc)			30	2.2	70	12A	
	〃 270	〃	Conv	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−10	−6				−3	1	75	CG = 20 dB (f = 12 Mc)			50	3	50	12A	
	〃 271	〃	〃	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−10	−6				−3	1	60	CG = 28 dB (f = 1.5 Mc)			30	3	50	12A	
	〃 272	〃	IF	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−10	−6				−3	1	45	PG = 40 dB (f = 455 kc)			20	3	50	12A	
	〃 273	〃	Conv	〃	−34	−1	−10	80	85	−7	−12				−12	1	45	CG = 40 dB (f = 1 Mc)			40	2	50	12A	
	〃 274	〃	IF	〃	−34	−1	−10	80	85	−7	−12				−12	1	40	PG = 40 dB (f = 455 kc)			30	2	50	12A	
	〃 275	〃	RF	〃	−34	−1	−10	80	85	−5	−12				−12	1	60	PG = 28 dB (f = 1.5 Mc)			45	2	50	12A	
★	〃 276	東芝	SW	Ge.Me	−15	−2	−20	75	75	−5	−12	60	−0.5	−10	−6	2					210*	3.5		48C	
★	〃 277	〃	〃	Ge.A	−18	−12	−40	65	75	−3	−12	50	−1	−24	−6	1					3.5 ~13			84A	
★	〃 278	〃	〃	〃	−18	−12	−40	65	75	−3	−12	100	−1	−24	−6	1					>11			84A	
★	〃 279	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge.AD	−30		−30	120	75	−6	−6				−2	10	200				150*	4	50	72A	
	〃 280	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	−30		−30	120	75	−6	−6				−2	10	200				70	2	50	72A	
★	〃 281	〃	〃	〃	−50		−30	120	75	−6	−6				−2	10	200				100	2	50	72A	
★	〃 282	東芝	SW	Ge.A	−18	−12	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r = 0.6 μS, t_f = 0.35 μS, t_s = 0.32 μS			6			84A	
★	〃 283	〃	〃	〃	−18	−12	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r = 0.4 μS, t_f = 0.2 μS, t_s = 0.3 μS			10			84A	
★	〃 284	〃	〃	〃	−18	−12	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r = 0.3 μS, t_f = 0.2 μS, t_s = 0.25 μS			14			84A	
★	〃 285	日電	Conv	Ge.D	−18	−0.5	−5	50	75	−15	−18				−6	1	70	CG = 40 dB (f = 1.6 Mc)			40	2	40	13A	
★	〃 286	〃	Conv. Mix	〃	−18	−0.5	−5	50	75	−15	−18				−6	1	70	CG = 30 dB (f = 12 Mc)			50	2	40	13A	
★	〃 287	〃	RF	〃	−18	−0.5	−5	50	75	−15	−18				−6	1	70	PG = 29 dB (f = 10 Mc)			60	2	40	13A	
	〃 288	日立	〃	Ge.Me	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	3	20	PG = 18 dB (f = 100Mc)			330*	0.88	65	72C	
	〃 289	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	3	20	PG = 20 dB (f = 100Mc)			350*	0.82	65	72C	
	〃 290	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	3	20	PG = 21 dB (f = 100Mc)			370*	0.78	65	72C	
★	〃 291	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge.MD	−20		−50	50	85	−5	−6				−6	4	40				100	1.5	40	60	
	〃 293	〃	RF	〃	−15		−50	50	85	−5	−6				−6	4	40				300*	1.5	50	60	
	〃 296	八欧	IF	Ge.A	−15		−15	80	85	−5	−12				−6	1	45				5	13	80	12B	
	2SA297	八欧	RF	Ge.A	−18		−15	80	85	−5	−12				−6	1	65				10	13	80	12B	
	〃 298	〃	Conv. Mix Osc	Ge.D	−40		−10	80	85	−8	−12				−6	1	55				35	2.5	40	13B	
	〃 299	三洋	RF. IF	Ge.A	−15		−10	50	75	−11	−6				−6	1	60	PG = 31 dB (f = 455 kc)						6	
	〃 300	〃	〃	〃	−15		−10	50	75	−11	−6				−6	1	60	PG = 31 dB (f = 455 kc)						12B	
	〃 301	松下	SW	Ge.AD	−30	−0.5	−30	120	75	−6	−6	125	−1	−10										72B	
	〃 302	〃	〃	Ge.A	−20	−15	−100	83	75	−3	−5	20	−0.7	−100										20	
	〃 303	〃	〃	〃	−20	−15	−100	83	75	−3	−5	50	−0.7	−100										20	
★	〃 304	東芝	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−18	−12	−40	65	75	−4	−12				−6	1	70	PG = 38 dB (f = 455 kc)			4.5	11	80	84A	
★	〃 305	〃	〃	〃	−18	−12	−40	65	75	−4	−12				−6	1	70	PG = 36 dB (f = 1 Mc)			10	11	80	84A	
	〃 306	八欧	〃	Ge.D	−40		−10	80	85	−8	−12				−6	1	65				55	2.3	50	13B	
	〃 307	〃	〃	〃	−40		−10	80	85	−8	−12				−6	1	70				75	2.2	50	13B	
★	〃 308	松下	〃	Ge.AD	−20	−0.3	−5	83	75	−13	−12	>20	−12	−1	−12	1	250				450*	0.5	35	72A	
★	〃 309	〃	〃	〃	−20	−0.3	−5	83	75	−13	−12	>20	−12	−1	−12	1	250				600*	0.5	20	72A	
★	〃 310	〃	〃	〃	−32	−0.3	−25	166	75	−13	−12	>20	−12	−1	−12	1	250				650*	0.7	60	72A	
★	〃 311	東芝	SW	Ge.D	−40	−2	−400	150	75	−6	−12	65	−1	−400	−6	1		t_r = 0.34 μS, t_f = 0.15 μS, t_s = 0.10 μS			50	3	40	84A	
★	〃 312	〃	〃	〃	−40	−2	−400	150	75	−6	−12	40	−1	−200	−6	1		t_r = 0.4 μS, t_f = 0.14 μS, t_s = 0.16 μS			50	3	40	84A	
★	〃 313	〃	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−18	−0.5	−20	60	75	−6	−12				−6	1	60	h_{fe} = 15 (f = 1.5 Mc)			40	2	40	84A	
★	〃 314	〃	〃	〃	−18	−0.5	−20	60	75	−6	−12				−6	1	100	h_{fe} = 15 (f = 1.5 Mc)			40	2	40	84A	
★	〃 315	〃	〃	〃	−18	−0.5	−20	60	75	−6	−12				−6	1	110	h_{fe} = 32 (f = 1.5 Mc)			55	2	40	84A	
★	〃 316	〃	〃	〃	−18	−0.5	−20	60	75	−6	−12				−6	1	110	h_{fe} = 28 (f = 455 kc)			75	2	40	84A	
	〃 321	三洋	IF	〃	−20	−1.5	−15	70	75	−15	−15				−6	1	70				30	2.5~4.5	30	12A	
	〃 322	〃	〃	〃	−20	−1.5	−15	70	75	−15	−15				−6	1	70	CG = 36 dB (f = 1 Mc)			35	2~5	30	12A	
	〃 323	〃	Conv	〃	−20	−1.5	−15	70	75	−15	−15				−6	1	80				40	1.5~5.5	30	12A	
	〃 324	〃	RF. IF	〃	−20	−1.5	−15	70	75	−15	−15				−6	1	70				55	3.5	35	12A	
	〃 325	八欧	SW	Ge.A	−20	−15	−80	80	85	−5	−12	60	−1	−80										12B	
	〃 326	〃	〃	〃	−20	−15	−80	80	85	−5	−12	60	−1	−80										12B	
	〃 327	〃	〃	Ge.D	−40	−2	−80	80	85	−5	−12	30	−1	−80										13B	
	〃 328	三洋	IF	〃	−20	−0.5	−10	50	75	−20	−9				−6	1	60					3		13B	
	〃 329	〃	〃	〃	−20	−1.5	−10	50	75	−15	−12				−6	1	13~550				5~6	1.5~6.5	<90	12A	
	〃 330	〃	RF. IF	〃	−20	−1.5	−10	50	75	−15	−12				−6	1	13~550					1.5~6.5		12A	

	型	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測定情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SA331	三洋	Conv	Ge. D	−40	−1.5	−50	120	75	−15	−15				−6	1	30~300				>40	2~5	50	12A	
	〃 332	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	50	75	−20	−9				−6	1	110				60	3	150	13B	
	〃 333	〃	Osc	〃	−20	−0.5	−10	50	75	−20	−9				−6	1	30				55	3	150	13B	
	〃 334	〃	Mix	〃	−20	−0.5	−10	50	75	−20	−9				−6	1	30				65	3	150	13B	
	〃 336	日立	IF	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−15	−9				−3	1	70	PG = 38 dB (f = 455 kc)			30	2.6	40	13A	
	〃 337	〃	Conv	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−15	−9				−3	1	70	CG = 36 dB (f = 1.5Mc)			35	2.6	40	13A	
★	〃 338	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−20	−0.5	−5	50	75	−16	−10				−6	1	30				15	2.5	15	4	
★	〃 339	〃	〃	〃	−20	−0.5	−5	50	75	−16	−10				−6	1	50				30	2.5	20	4	
★	〃 340	〃	RF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	−20	−0.5	−10	63	75	−13	−6				−6	1	100				70	2	50	50C	
★	〃 341	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	63	75	−13	−6				−6	1	100				70	2	50	50C	
	〃 342	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	63	75	−13	−6				−6	1	100				100	2	40	50C	
★	〃 343	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	−20	−0.4	−5	86	75	−12	−10				−6	1	100	PG = 18 dB (f = 100Mc)			100*	1.5	50	72B	
★	〃 344	〃	〃	〃	−30	−0.5	−30	120	75	−6	−6				−2	10	200				100	4	35	13B	
★	〃 345	三菱	RF	Ge. Me	−20	−0.5	−10	60	85	−30					−6	1	30	PG = 16dB (f = 200Mc)			>250*	1.2	<100	48C	
★	〃 346	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30					−6	1	30	PG = 20dB (f = 200Mc)			>250*	1.2	<100	48C	
★	〃 347	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30					−6	1	30	PG = 21dB (f = 200Mc)			>250*	1.2	<100	48C	
★	〃 348	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30					−6	1	10	PG = 15dB (f = 100Mc)			>200*	1.5	<120	48C	
★	〃 349	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30					−6	1	10	PG = 15dB (f = 50Mc)			>100*	1.5	<120	48C	
	〃 350	日立	RF. Conv Mix. Osc	Ge. D	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	90	PG = 14 dB (f = 20 Mc)			40	2.5	30*	12A	
	〃 351	〃	RF. Osc	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	PG = 11dB (f = 12Mc)			40	2.5	30*	12A	
	〃 352	〃	RF. Conv Mix	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	75	CG = 22.5dB (f = 12MC)			40	2.5	30*	12A	
	〃 353	〃	RF	〃	−25	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	PG = 39 dB (f = 455 kc)			30	2.5	30*	12A	
	〃 354	〃	Conv. Mix	〃	−25	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	CG = 40 dB (f = 1 Mc)			30	2.5	30*	12A	
	〃 355	〃	RF	〃	−25	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	PG = 33 dB (f = 1.5Mc)			30	2.5	30*	12A	
★	〃 356	〃	〃	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−15	−9				−3	1	80	PG = 40 dB (f = 455 kc)			25	2.8	30	12A	
★	〃 357	〃	Conv. Mix	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−15	−9				−3	1	70	CG = 40 dB (f = 1.5Mc)			30	1.8	30	12A	
	〃 358	〃	RF	〃	−75	−1	−50	225 [illegible]	85	−12	−12				−9	1	90				40	2.5	35*	64	
	〃 359	三洋	〃	Ge. Me	−20	−0.4	−20	270	85	−15	−20				−6	5	30				300*	3.5	75	84B	
★	〃 360	三菱	〃	Ge. DB	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	1	70				110	2.3	85	13A	
★	〃 361	〃	RF. Conv Mix. Osc	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	1	70				125	2.3	80	13A	
★	2SA362	三菱	PA	Ge. DB	−30	−0.5	−30	100	85	−30	−30				−6	5	70				150*	3	70	13A	
★	〃 363	〃	SW	〃	−10	−1.2	−30	100	85	−5	−10				−3	20	80							13A	
★	〃 364	〃	RF	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−30	−9				−3	1	60				45	6	100	13A	
★	〃 365	〃	Mix. Osc	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−30	−9				−3	1	60				50	6	70	13A	
★	〃 366	〃	RF. Conv	〃	−9	−0.5	−10	80	85	−30	−9				−3	1	60				75	6	50	13A	
★	〃 367	〃	RF	Ge. D	−20	−0.5	−10	80	85	−15	−12				−9	1	70				30	2.5	40	12A	
★	〃 368	〃	Conv. Mix Osc	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−15	−12				−9	1	70				40	2.5	30	12A	
★	〃 369	〃	RF	〃	−20	−0.5	−10	80	85	−15	−12				−9	1	80				50	2.5	30	12A	
★	〃 370	〃	〃	〃	−75	−1	−50	120	85	−12	−12				−9	1	70				40	2.5	40	65	
★	〃 371	〃	SW	Ge. A	−20	−12	−15	80	85	−6	−12	70	−1.5	−10							10.5*	10	110	12A	
★	〃 372	東芝	〃	Ge. EMa	−15	−2	−200	100	75	−10	−12	25	−1	−10	−3	5		t_d+t_r = 6nS, t_f = 15nS t_s = 30nS			450*	2	120	49C	
	〃 373	日立	RF	〃	−25	−0.5	−150	250	85	−15	−10				−10	5	40				400*	3.2	100	84A	
	〃 373A	〃	〃	〃	−25	−0.5	−150	250	85	−15	−10				−10	5	40				400*	3.2	100	84A	
★	〃 374	松下	RF. Conv. Mix Osc. PA	Ge. AD	−34	−0.5	−300	1.5W (T_c=25°C)	90	−12	−10				−2	150	100				300*	13	10	84A	
★	〃 375	三菱	RF. Conv. Mix Osc. SW	Ge. D	−30	−1.5	−100	80	85	−6	−12	40	−1	−50	−9	1	80				40	2.5	30	12A	
	〃 376	SON	RF. Conv Mix.	Ge. DB	−22		−10	60	85	−6	−10	48	−3	−1	−6	2	0.96*	h_{fe} = 18dB (f = 100Mc)				0.4	70*	52	
★	〃 377	松下	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	−20	−0.4	−5	50	75	−13	−10				−6	1	100				200*	1.5	60	50C	
★	〃 378	〃	〃	〃	−20	−0.4	−5	50	75	−13	−10				−6	1	100				250*	1.5	30	50C	
★	〃 379	〃	〃	〃	−20	−0.4	−5	50	75	−13	−10				−6	1	100				300*	1.5	30	50C	
	〃 380	八欧	RF. Conv	Ge. D	−25	−0.5	−10	80	85	−12	−12				−6	1	70				60	2.2	40	12A	
	〃 381	〃	Osc	〃	−25	−0.5	−10	80	85	−12	−12				−6	1	50				35	2.5	40	12A	
	〃 382	〃	Mix	〃	−25	−0.5	−10	80	85	−12	−12				−6	1	55				30	2.2	40	12A	
	〃 383	〃	RF	〃	−25	−0.5	−10	80	85	−12	−12				−6	1	40				25	2.5	40	12A	
	〃 384	〃	Conv	〃	−25	−0.5	−10	80	85	−12	−12				−6	1	60				40	2.5	40	12A	
★	〃 385	松下	RF	Ge. A	−16	−10	−10	80	75	−12	−10				−6	1	120				10	8	120	12A	
	〃 386	〃	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	−32	−0.5	−300	1.85W (T_c=25°C)	90	−12	−10				−2	100	80				350*	12	8	84B	
	〃 387	三洋	〃	Ge. A	−10		−15	100	85	−50	−10				−6	1	30	h_{fe} = 9 (f = 455kc)				10	50	12A	
	〃 388																								
★	〃 389	日立	RF	Ge. Me	−20	−0.3	−10	50	85	−30	−20				−10	2	30	PG = 8.5dB (f = 800Mc)			600*	0.4	$C_c r_{bb}$ 10 pS	50C	
	〃 390	〃	〃	〃	−20	−0.3	−10	50	85	−30	−20				−10	2	30	PG = 9.5dB (f = 800Mc)			700*	0.4	$C_c r_{bb}$ 9.5pS	50C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{re} / h_{ib}* (Ω)	h_{ie} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SA391	沖	RF	Ge. A	−18	−12	−200	150	85	−6	−6				−5	1	70				7	10	150	84B	
	〃 392	〃	〃	〃	−18	−12	−200	150	85	−6	−6				−5	1	100				11	9.5	175	84B	
	〃 393	〃	〃	〃	−18	−12	−200	150	85	−6	−6				−5	1	150				16	9.2	200	84B	
	〃 393A	〃	〃	〃	−30	−12	−200	150	85	−6	−6				−5	1	150				16	9.2	230	84B	
	〃 394	〃	〃	〃	−18	−12	−200	150	85	−6	−6				−5	1	200				22	8.7	230	84B	
	〃 395	〃	〃	〃	−18	−12	−200	150	85	−6	−6				−5	1	300				29	8.5	260	84B	
★	〃 396	〃	〃	〃	−15	−15	−200	200	85	−10	−12				−5	1	85				6	20	150	84B	
★	〃 397	〃	〃	〃	−23	−15	−200	200	85	−10	−12				−5	1	100				8	20	150	84B	
★	〃 398	〃	〃	〃	−30	−20	−200	200	85	−10	−12				−5	1	120				10	19	160	84B	
★	〃 399	〃	〃	〃	−30	−20	−200	200	85	−10	−12				−5	1	70				12	17	160	84B	
★	〃 400	富士通	RF. Conv. Mix Osc	Ge. D	−20	−0.5	−10	80	85	−10	−12				−6	1	70				70	2.3	50	13A	
★	〃 401	日立	RF	Ge. Me	−30	−0.5	−40	130	85	−30	−30				−6	5	70				30	3	70	13A	
★	〃 402	東芝	〃	Si. EP	−35		−100	250	175	−1	−15	200	−6	−2	−6	1					200*	6	30	49C	
★	〃 403	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	−20	−0.2	−5	75	85	−10	−12				−6	2	10	PG = 16 dB (f = 70 Mc)			280*	1.5	40	19B	
★	〃 404	〃	〃	〃	−20	−0.2	−5	75	85	−10	−12				−6	2	10	PG = 12 dB (f = 200Mc)			400*	1.5	40	59	
★	〃 405	〃	SW	〃	−15	−3.5	−50	150	100	−3	−5	40	−0.5	−10	−3	10		t_d = 22 nS, t_r = 65 nS t_s = 28 nS, t_f = 45 nS			300*	5		49C	
★	〃 406	〃	〃	Ge. A	−30	−20	−200	200	85	−7	−15	50	−1	−10	−6	1	60	28*	10*	0.8*	9	15	120	84A	
★	〃 407	〃	〃	〃	−30	−20	−200	200	85	−7	−12	60	−1	−10	−6	1	70	28*	11*	0.8*	14	15	130	84A	
★	〃 408	富士通	〃	Ge. MA	−15	−15	−50	50	80	−5	−6	100	−1	−15	−6	1					50	3		60	
★	〃 409	〃	〃	〃	−15	−15	−50	50	80	−5	−6	100	−1	−15	−6	1					80	3		60	
★	〃 410	日電	〃	Ge. EMe	−12	−1	−150	150	100	−5	−5	40	−0.3	−10	−3	10		t_d = 10 nS, t_r = 50 nS t_s = 15 nS, t_f = 40 nS			300	1.5		49C	
★	〃 411	〃	〃	〃	−15	−2.5	−150	150	100	−5	−5	40	−0.3	−10	−3	10		t_d = 10 nS, t_r = 40 nS t_s = 16 nS, t_f = 35 nS			300	1.5		49C	
★	〃 412	日立	〃	Ge. Me	−13	−1	−100	150	85	−3	−6	50	−0.5	−30	−3	10					40*	7		12A	
★	〃 413	松下	〃	Ge. AD	−20	−2.5	−30	100	75	−5	−5	90	−1	−30	−2	30					>300*	4		49C	
★	〃 414	〃	〃	Ge. A	−30	−20	−200	150	85	−3	−5	40	−0.5	−100	−5	3					7*	9		84A	
★	〃 415	〃	〃	〃	−25	−20	−200	150	85	−3	−5	60	−0.5	−100	−5	3					10*	9		84A	
	〃 416	〃	〃	Ge. AD	−70	−1.5	−700	6 W (T_c = 25°C)	75	−1mA	−60	100	−10	−600	−10	300					120*	35		103	
★	〃 417	日電	〃	Ge. EMe	−15	−2.5	−200	150	100	−5	−10	70	−0.3	−10				t_d + t_r < 70nS, t_s + t_f < 100nS t_s < 50nS						46C	
	〃 419	三洋	〃	Ge. Me	−20		−5	50	85	−10	−12				−6	2	20	PG = 12 dB (f = 200Mc)						48C	
	〃 420	〃	〃	〃	−20		−5	50	85	−10	−12				−6	2	25	PG = 17 dB (f = 200Mc)			550	2		48C	
	2SA421	三洋	SW	Ge. Me	−20		−5	50	85	−10	−12				−12	2	25	PG = 8.5dB (f = 800 Mc)						48C	
	〃 422	〃	RF	〃	−20	−0.3	−5	50	85	−10	−12				−12	2	25	PG = 10 dB (f = 800Mc)			800	0.8		48C	
	〃 423	〃	〃	Ge.EMe	−20		−5	50	85	−10	−12				−12	2	25	PG = 8.5 dB (f = 800Mc)						48C	
	〃 424	〃	〃	〃	−20		−5	50	85	−10	−12				−12	2	25	PG = 10 dB (f = 800Mc)						48C	
	〃 425	八欧	〃	Ge. Me	−30		−30	200	85	−10	−15				−6	2	25				350*	3.3	60*	84B	
	〃 426	〃	〃	〃	−30		−30	200	85	−10	−15				−6	2	30				500*	2.5	60*	84B	
	〃 427	三洋	〃	Ge. D	−20	−0.5	−15	100	75	−15	−15				−6	1	60				45	3.5	40	13B	
	〃 428	〃	〃	〃	−20	−0.5	−15	100	75	−15	−15				−6	1	80				50	3.5	30	13B	
	〃 429	東芝	〃	Si. TP	−150	−3	−30	150	125	−1	−50	60	−2	−2	−10	2					100*	4	50	33	
	〃 430	〃	〃	Ge. Me	−20		−5	70	85	−10	−12				6	1	−0.95*	PG = 10 dB (f = 800Mc)			>450*	<0.8	<60	50C	
★	〃 431	〃	〃	〃	−20		−5	70	85	−10	−12				−6	1	−0.94*	PG = 16 dB (f = 200Mc)						50C	
	〃 432	〃	〃	〃	−20		−5	70	85	−10	−12				−6	1	−0.94*	PG = 14 dB (f = 200Mc)						50C	
★	〃 433	〃	〃	Ge. D	−18		−5	55	75	−8	−12				−6	1	50	PG = 21 dB (f = 10.7Mc)				<3.5		13A	
★	〃 434	日立	RF. Conv. Mix Osc	Ge. Me	−20	−0.5	−10	80	85	−30	−20				−6	8	80	PG = 16.5dB (f = 100Mc)			880*	0.9	80	72A	
★	〃 435	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 16.5 dB (f = 100Mc)			330*	0.9	80	9	
★	〃 436	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 18.5dB (f = 100Mc)			400*	0.98	65	9	
★	〃 437	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 19.3dB (f = 100Mc)			400*	0.92	65	9	
★	〃 438	〃	〃	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 20 dB (f = 100Mc)			520*	0.88	65	9	
	〃 439																								
	〃 440	三洋	RF. Conv. Mix Osc	Ge. Me	−20	−0.4	−5	60	85	−30	−20				−6	2	50	PG = 14dB (f = 100Mc)			350*	1.5	70*	48C	
	〃 441	〃	〃	〃	−20		−10	150	85	−30	−20				−6	2	40				500*	3.5	70	84B	
	〃 442																								
	〃 443	日立	Ch	Ge. A	−21	−12	−15	60	85	−6	−12	200	−6	−2	−6	1		h_{FE1}/h_{FE2} = 0.8−1.0			25	10	70	15	複合管
	〃 444	〃		〃	−16	−12	−12	60	85	−6	−12	80	−6	−1	−6	1	80	内装有熱納二極管			12	7	70	14	
	〃 445	〃	差動放大	〃	−16	−12	−15	60	85	−6	−12	75	−6	−1	−6	1		h_{FE1}/h_{FE2} = 0.8−1.0			10	10	70	15	複合管
★	〃 446	東芝	SW	Ge.EMe	−15	−2	−200	200	85	−10	−12	70	−1	−100				t_d + t_r < 35nS, t_s + t_f < 170nS t_s < 140 nS						84B	
★	〃 447	松下	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	−25		−15	90	75	−3.5	−10				−10	2	80				650*	1.6	20	57	
	〃 448	SONY	RF. Conv	Ge. Me	−15	−0.5	−5	40	75	−10	−10	20	−3	−3	−3	3	30	PG = 8 dB (f = 1000Mc)			1700*	0.15		52	
★	〃 449	日立	SW	Ge.EMe	−10	−1.25	−100	150	100	−5	−6	30	−1	−50	−1	20		t_d + t_r < 60nS, t_s + t_f < 120nS t_s < 100nS			300*	4		49C	
★	〃 450	〃	〃	〃	−12	−1.5	−100	150	100	−3	−6	40	−1	−50	−1	20		t_d + t_r < 60nS, t_s + t_f < 95nS t_s < 80nS			500*	2.5		49C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA451	日立	SW	Ge.EMe	−12	−1.5	−100	150	100	−3	−6	70	−1	−50	−1	20		$t_d+t_r<60$nS, t_s+t_f $t_s<90$nS <110nS			500*	2.5		49C	
★	〃 452	〃	〃	〃	−12	−1.5	−100	150	100	−3	−6	150	−1	−50	−1	20		$t_d+t_r<60$nS, t_s+t_f $t_s<100$nS <120nS			500*	2.5		49C	
★	〃 453	SON	RF.Conv.Mix Osc	Ge.DB	−22		−10	60	85	−5	−15	6	−3	−1	−6	2	−0.93*	PG = 25dB (f = 100Mc)			630*	0.45	70*	52	
★	〃 454	〃	〃	〃	−22		−10	60	85	−5	−15	12	−3	−1	−6	2	−0.96*	PG = 25dB (f = 100Mc)			630*	0.45	70*	52	
★	〃 455	〃	〃	〃	−22		−10	60	85	−5	−15	24	−3	−1	−6	2	−0.978*	PG = 25dB (f = 100Mc)			630*	0.45	70*	52	
★	〃 456	〃	〃	〃	−22		−10	60	85	−5	−15	48	−3	−1	−6	2	−0.988*	PG = 25dB (f = 100Mc)			630*	0.45	70*	52	
	〃 457	東芝	RF	Ge.D	−18	−0.5	−20	55	75	−10	−12				−6	1	200	$h_{fe}>10$ (f = 1.5Mc)			45	3	150	13A	
★	〃 458	三菱	SW	Ge.A	−25	−15	−200	150	85	−5	−12	60	−1	−10				$t_d+t_r<1$μS, t_s+t_f $t_s<0.7$μS <0.7μS						68	
★	〃 459	〃	〃	〃	−25	−15	−200	150	85	−5	−12	120	−1	−10				$t_d+t_r<1$μS, t_s+t_f $t_s<0.7$μS <0.7μS						68	
★	〃 460	〃	RF.Osc	Ge.Me	−20	−0.5	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 17dB (f = 100Mc)			400*	0.9	80*	11A	
★	〃 461	〃	RF.Mix.Osc	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 18dB (f = 100Mc)			400*	0.9	65*	11A	
★	〃 462	〃	RF	〃	−20	−0.5	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 20dB (f = 100Mc)			400*	0.9	65*	11A	
★	〃 463	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	−20	−0.5	−10	75	85	−30	−20				−6	3	10	PG = 16.5dB (f = 100Mc)			300*	1	80*	11A	
★	〃 464	〃	〃	〃	15	0.3	−10	60	85	−10	−15				−6	3	30				850*	0.8	C_c r_{bb} 13 pS	11A	
★	〃 465	松下	RF.Conv.Mix Osc	Ge.AD	−20		−5	50	75	−13	−10				−10	1	250	PG = 8 dB (f = 800Mc)			600*	0.5	20	57	
★	〃 466	東芝	RF.Conv.Mix Osc	Ge.D	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	40				15*	3	50	12A	
	〃 467	〃	RF	Si.EP	−40	−5	−400	300	125	−0.5	−20	100	−1	−100	−10	10	80				200*	10	30	33	2SC367之[illegible]
★	〃 468	〃	RF.Conv.Mix Osc	Ge.D	−18	−0.5	−10	55	85	−12	−18				−6	1	70				30*	3	40	12A	
★	〃 469	〃	〃	〃	−18	−0.5	−10	55	85	−12	−18				−6	1	50				30*	3	40	12A	
★	〃 470	〃	〃	〃	−18	−0.5	−10	55	85	−12	−18				−6	1	75				30*	3	40	12A	
★	〃 471	〃	〃	〃	−18	−0.5	−10	55	85	−12	−18				−6	1	50	PG = 21dB (f = 10.7Mc)				<3.5		12A	
★	〃 472	〃	〃	〃	−18	−0.5	−10	55	85	−12	−18				−6	1	80				30*	3	40	12A	
	〃 473	〃	RF.PA	Si.DJ	−30	−5	−3A	10W (T_c 25°C)	150	−11	−20	40~400	−2	−500	−12	500					100*	40	15	119	
★	〃 474	〃	RF.Conv.Mix Osc	Ge.D	−50	−0.5	−50	120	85	−12	−12				−6	1	50				70	4	30	12A	
★	〃 475	〃	〃	〃	−20	−0.5	−50	120	85	−12	−12				−6	1	50				30	4	30	12A	
★	〃 476	〃	〃	〃	−18	−0.5	−10	55	85	−12	−18				−6	1	60				65	1.5	40	12A	
★	〃 477	〃	RF	〃	−18	−0.5	−10	55	85	−12	−18				−6	1	60	PG = 27dB (f = 10.7Mc)				1.5		12A	
★	〃 478	〃	SW	〃	−40	−2	−400	125	85	−8	−12	60	−1	−400	−6	1		$t_r<85$nS, $t_f<250$nS $t_s<85$nS			>25	<6	<120	12A	
★	〃 479	〃	〃	〃	−40	−2	−200	125	85	−8	−12	50	−1	−200	−6	1		$t_r<50$nS, $t_f<70$nS $t_s<300$nS			>25	3	<120	12A	
★	〃 480	SON	RF	Si.E	−30	−5	−100	150	150	−3	−25	60	−3	−3	−6	1	120	h_{fe} = 3.0dB (f = 100Mc)				3	C_c r_{bb} 100pS	60	
	2SA481																								
★	〃 482	東芝	PA	Si.EP	−40	−5	−600	600	150	−1	−30	50	−2	−150	−10	10	50				70*	20	10	84B	
	〃 483	〃	RF.AF.PA	Si.TMe	−150	−5	−1A	20W (T_c=25°C)	150	−100	−150	30~240	−10	−100	−10	100					10*	50	25	99	
	〃 484	〃	PA	Si.EP	−110	−5	−1.5A	800	175	−10	−30	80	−2	−200	−10	30					20*	60	10	84B	2SC484之[illegible]
	〃 485	〃	〃	〃	−80	−5	−1.5A	800	175	−10	−30	80	−2	−200	−10	30					20*	60	10	84B	
	〃 486	〃	〃	〃	−50	−5	−1.5A	800	175	−10	−30	80	−2	−200	−10	30					20*	60	10	84B	2SC486之[illegible]
	〃 487																								
	〃 488																								
	〃 489	東芝	RF.PA	Si.EMe	−70	−5	−4A	30W (T_c=25°C)	150	−30	−50	40~240	−5	−500	−5	500					>3*	230	15	119	
	〃 490	〃	PA	〃	−50	−5	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−20	−30	40~240	−2	−500	−2	500					>3*	150	15	119	
	〃 491																								
	〃 492																								
	〃 493	東芝	RF.LN	Si.EP	−50	−5	−50	200	125	−0.1	−30	70~400	−6	−2	−6	1		3500	0.6	19.2	200*	5	30	33	
	〃 494	〃	LN	〃	−35	−5	−30	200	125	−0.5	−15	70~400	−6	−0.1	−6	0.1	NF = 2dB (f=120°.)	10kΩ	1	3	200*	4	30*	33	
	〃 495	〃	RF	〃	−35	−5	−100	200	125	−0.5	−15	70~240	−1	−10	−10	10					200*	4	30	33	2SC390之[illegible]
	〃 496	〃	PA	〃	−40	−5	−800	550	125	−1	−30	40~240	−2	−50	−10	10					100*	20	10	164	2SC496之[illegible]
	〃 497	〃	〃	〃	−80	−5	−800	600	150	−1	−30	40~240	−2	−200	−10	10					70*	33	15	84B	
	〃 498	〃	〃	〃	−50	−5	−800	600	150	−1	−30	40~240	−2	−200	−10	10					70*	33	15	84B	
	〃 499	〃	〃	〃	−40	−5	−100	200	150	−0.5	−15	60~200	−1	−10	−10	10					250*	5	30	49C	
	〃 500	〃	RF	〃	−30	−5	−100	250	175	−0.5	−15	60~200	−1	−10	−10	10					250*	5	30	49C	
★	〃 501	〃	〃	〃	−40	−5	−200	750	175	−1	−30	70	−1	−10	−10	10					200*	10	30	84B	2SC501之[illegible]
	〃 502	〃	〃	〃	−90	−5	−40	300	125	−0.5	−50	40~240	−1	−20	−10	10					750	8	50	33	
	〃 503	〃	RF	〃	−60	−5	−600	800	150	−0.5	−30	30~300	−2	−150	−10	10					130*	18	10	84B	2SC503之[illegible]
	〃 504	〃	〃	〃	−40	−5	−600	800	150	−0.5	−30	30~300	−2	−150	−10	10					130*	18	10	84B	2SC504之[illegible]
	〃 505	〃	PA	〃	−60	−5	−800	600	125	−1	−30	40~240	−2	−50	−10	10					100*	20	10	164	2SC495之[illegible]
	〃 506	〃	RF.Conv.Mix Osc	Ge.EMe	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	20				300*	1	25	10	
	〃 507	〃	〃	〃	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	20				250*	1	25	10	
	〃 508	〃	〃	〃	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	8				200*	1	25	10	
	〃 509	〃	RF.PA	Si.EP	−35	−5	−500	600	150	−0.1	−20	100	−2	−50	−10	10					140*	22	10	131	2SC509之[illegible]
	〃 510	〃	PA	〃	−120	−5	−1.5A	800	150	−1	−30	30~150	−2	−200	−10	30					60*	43	10		2SC510之[illegible]

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★ 2SA511	東芝	PA	Si. TP	−90	−5	−1A	800	150	−1	−30				−10	50	50				50*	43	10	84B	2SC511 之對稱
〃 512	〃	〃	Si. EP	−80	−5	−1.5A	800	150	−1	−30	30~150	−2	−200	−10	30					60*	43	10	84B	2SC512 之對稱
★ 〃 513	〃	〃	〃	−50	−5	−1A	800	150	−1	−30				−10	50	50				50*	43	10	84B	2SC513 之對稱
〃 514																								
〃 515																								
〃 516	東芝	RF. PA	Si. DB	−80	−5	−1.5A	800	175	−0.5	−30	60	−2	−200	−5	200	60				50*	43	10	84B	
〃 516A	〃	〃	〃	−120	−5	−1.5A	800	175	−0.5	−30	60	−2	−200	−5	200	60				50*	43	10	84B	
★ 〃 517	〃	RF	Ge. D	−18	−0.5	−10	55	85	−12	−18				−6	1	60				60	1.8	45	12A	
★ 〃 518	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	−18	−0.5	−10	55	85	−12	−18				−6	1	60				45	1.8	45	12A	
〃 519																								
〃 520																								
〃 521																								
〃 522	東芝 富士通	RF	Si. EP	−25	−5	−100	250	175	−0.1	−15	30~120	−1	−10	−10	10	50				200*	4	25	49C	
〃 522A	〃	〃	〃	−50	−5	−100	250	175	−0.1	−15	30~120	−1	−10	−10	10	50				200*	4	25	49C	
〃 523	富士通	RF. PA	〃	−40	−5	−300	650	175	−0.1	−10	30~120	−10	−10	−10	10	60				200*	4.5	50*	84B	
〃 523A	〃	〃	〃	−60	−5	−300	650	175	−0.1	−10	30~120	−10	−10	−10	10	60				200*	4.5	50*	84B	
〃 524	〃	〃	〃	−25	−3	−100	350	175	−0.1	−10				−10	10	50				250*	4.5	50*	49C	
★ 〃 525	東芝	RF. Conv. Mix Osc	Ge. EMe	−20		−5	75	35	−10	−12				−6	1	20	PG = 21dB (f = 10Mc)			250*	1	25	48C	
★ 〃 526	SON	PA	Si. E	−50	−5	−1A	500	150	−5	−50	70	−2	−100	−6	1	50	h_{fe} = 5dB (f = 50Mc)				18	$C_c r_{bb'}$ 100pS	84C	
★ 〃 527	〃	〃	〃	−50	−5	−2A	5W (T_c=25°C)	150	−5	−50	50	−2	−200	−6	1	50	h_{fe} = 6dB (f = 50Mc)				18	$C_c r_{bb'}$ 100pS	97C	
★ 〃 528	〃	〃	〃	−50	−5	−2A	5W (T_c=25°C)	150	−5	−50	70	−2	−100	−6	1	50	h_{fe} = 5dB (f = 50Mc)				18	$C_c r_{bb'}$ 100pS	97C	
★ 〃 529	〃	RF. PA	Si. EMe	−50	−5	−1A	5W (T_c=25°C)	150	−5	−50	80	−2	−100	−10	50		h_{fe} = 5dB (f = 50MHz)				18	$C_c r_{bb'}$ 100pS	181	
〃 530	日立	SW	Si. EP	−50	−5	−100	200	175	−1	−20				−1	−10	65	t_{on} < 200nS, t_{off} < 300nS, t_{stg} < 300nS			300*	5		49C	
〃 531																								
〃 532	三洋	RF. PA	Si. TP	−50	−5	−200	500	150	−10	−40	80	−6		−6	10					90*	7	$C_c r_{bb'}$ 45pS	84B	[illegible] 之對稱
〃 533																								
〃 534																								
〃 535	三洋			−75	−4	−700	500	150			60	−6	−50							80*				[illegible] 之對稱
〃 536	〃			−50	−4	−700	500	150			60	−6	−50							80				〃
〃 537	日立	RF	Si. EP	−60	−4	−700	750	200	−10	−30				−4	50	50				200*	15	30	84A	2SC706 之對稱
2SA537A	日立	RF	Si. EP	−90	−4	−700	750	200	−10	−30				−4	50	50				200*	15	30	84A	2SC706A 之對稱
★ 〃 538	東芝	〃	Ge. A	−25	−12	−50	120	75	−50	−25				−6	1	70				8	10	100	12A	
〃 539	日電	RF. PA	Si. EP	60	−5	−200	250	125	−0.2	−30	80	−10	−10	−10	10	80				200*	8.5	20	43	2SC815 之對稱
〃 540																								
〃 541																								
★ 〃 542	日電	RF. AF	Si. EP	−30	−5	−50	150	150	−0.05	−25	160	−10	−0.5	−5	1	180	5000	2	28	100*	5	20*	23	
★ 〃 543	〃	RF. LN	〃	−30	−5	−50	150	150	−0.05	−25	160	−10	−0.5	−5	1	180	5000	2	28	100*	5	20*	23	
〃 544	〃	RF	〃	−60	−5	−200	750	175	−0.2	−45				−10	10	100				160*	8	30	84A	2SC[illegible] 之對稱
〃 545	〃	RF. PA	〃	−70		−200	400	125	−0.1	−60	70	−2	−150	−10	10	110				200*	8.5	20	44	2SC653 之對稱
〃 546	松下	PA	〃	−70	−5	−1A	750	175	−3	−30	80	−3	−100	−10	50					80*	50	20	84B	2SC696 之對稱
〃 546A	〃	〃	〃	−90	−5	−1A	750	175	−3	−30	80	−3	−100	−10	50					80*	50	20	84B	2SC696A 之對稱
〃 547	〃	〃	〃	−70	−5	−1A	10W (T_c=25°C)	175	−3	−30	80	−3	−100	−10	50					80*	50	20	97B	2SC697 之對稱
〃 547A	〃	〃	〃	−90	−5	−1A	10W (T_c=25°C)	175	−3	−30	80	−3	−100	−10	50					80*	50	20	97B	2SC697A 之對稱
〃 548	日立	RF. SW	〃	−50	−5	−100	200	175	−1	−20	100	−12	−1	−10	20		t_{on} = 90nS, t_{off} = 160nS, t_{stg} = 150nS			400*	4	$C_c r_{bb'}$ 30pS	8C	
〃 549	〃	RF	Si. T	−70	−5	−100	200	175	−1	−20	80	−1	−10	−10	10					200*	2.5	80*	182C	
〃 550	松下	RF. AF	〃	−25	−5	−100	300	175	−1	−10	250	−5	−2	−5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	49C	2SC538 之對稱
〃 550A	〃	〃	〃	−45	−5	−100	300	175	−1	−10	250	−5	−2	−5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	49C	2SC538A 之對稱
〃 551																								
〃 552	日電	RF. SW	Si. EP	−60	−5	−200	750	175	−0.1	−45	100	−10	−10	−10	10	100	t_{on} < 100nS, t_{off} < 300nS, t_{stg} < 270nS			150*	8	10*	84C	
〃 553	富士通	RF	〃	−40		−300	250	175	−0.1	−10				−10	10	60				200*	4.5	50*	49C	
〃 554	〃	〃	〃	−25		−300	250	175	−1	−10				−10	10	60				200*	4.5	50*	49C	
〃 555	〃	〃	〃	−40		−200	200	125	−1	−10				−10	10	60				200*	5	50*	30	
〃 556	〃	〃	〃	−20		−200	200	125	−1	−10				−10	10	60				200*	5	50*	30	
〃 557	〃	〃	〃	−20		−250	300	125	−1	−10				−10	10	60				200*	5	50*	32	
〃 558	〃	SW	〃	−40	−5	−200	350	175	−0.1	−10	50	−1	−10				t_r = 10nS, t_f = 25nS, t_s = 90nS			200*	4.5	50*	49C	
〃 559	〃	〃	〃	−20	−5	−200	350	175	−0.5	−10	50	−1	−10				t_r = 10nS, t_f = 25nS, t_s = 90nS			200*	4.5	50*	49C	
〃 560	東芝 富士通	RF	Si. TP	−80	−5	−800	800	175	−0.5	−30	30~120	−2	−150	−10	50	70				150*	11	15	84B	2SC560 之對稱
〃 561	東芝	〃	Si. EP	−50	−5	−150	300	125	−0.1	−18	70~400	−1	−20	−6	1					70*	13	10	33	2SC734 之對稱
〃 562	〃	〃	〃	−30	−5	−400	300	125	−0.1	−18	70~400	−1	−100	−6	2						13	10	33	2SC735 之對稱
〃 563																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流電流增幅率下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測定條件 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA564	松下	RF. AF	Si. EP	−25	−5	−100	250	125	−1	−10	150	−5	−2	−5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	42	2SC[illegible] 之對稱
〃 564A	〃	〃	〃	−45	−5	−100	250	125	−1	−10	150	−5	−2	−5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	42	2SC[illegible]A 之對稱
〃 565	日立	RF	〃	−50	−4	−500	300	175	−0.5	−20	80	−3	−10	−6	1					60*	5	30*	12C	2SC[illegible] 之對稱
〃 566	〃	PA	〃	−100	−4	−700	10 W (Tc=25°C)	175	−10	−30	35～200	−4	−50	−6	30					100*	30	20*	99	2SC680 之對稱
〃 567	〃	RF	〃	−30	−4	−100	200	175	−0.5	−15	400	−6	−0.1	−6	1	300	10K	4	25	70*	5	25*	12A	
〃 568	三菱	PA	〃	−35	−4	−250	200	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	41	
〃 569	〃	PA	〃	−50	−4	−250	200	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	41	
〃 570	〃	〃	〃	−65	−4	−250	200	125	−1	−25	80	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	41	
〃 571	日電	SW	〃	−60	−5	−1A	800	175	−0.1	−45	80	−10	−50	−10	50	t_{on} < 40nS, t_{off} < 160nS, t_{stg} < 130nS				300*	16	30	84C	
〃 572	新日無																							
〃 573	〃	RF. AF	Si. EP	−30		−100	300	125	−0.1	−20	100	−6	−1	−6	1		5000	1.5	20	130*	4	$C_c r_{bb}$ 50pS	138	再登録
〃 574	〃	RF	〃	−60		−100	300	125	−0.1	−20	130	−1	−50	−10	2					150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50pS	138	再登録
〃 575	〃	〃	〃	−90		−100	300	125	−0.1	−20	100	−1	−50	−10	2					150*	4	$C_c r_{bb}$ 50pS	138	再登録
〃 576	〃	RF. PA	〃	−30		−200	600	125	−0.5	−20	80	−1	−100	−10	5					200*	5	$C_c r_{bb}$ 50pS	31	
〃 577	〃	〃	〃	−60		−400	600	125	−0.5	−20	100	−1	−100	−10	5					200*	5	$C_c r_{bb}$ 50pS	31	
〃 578	日電	RF. AF. LN	〃	−50	−5	−30	300	150	−0.05	−30	370	−3	−1	−3	1		12K	2.5	40	120*	7	20*	49C	
〃 579	〃	RF. AF	〃	−50	−5	−30	300	150	−0.05	−30	370	−3	−1	−3	1		12K	2.5	40	120*	7	20*	49C	
〃 580	富士通	RF. AF. PA	〃	−60	−6	−600	800	175	−1	−30	120	−2	−200	−6	1		4000	0.5	15	100*	18	20*	84B	
〃 581	〃	〃	〃	−100	−6	−600	800	175	−1	−30	120	−2	−200	−6	1		4000	0.5	15	100*	18	20*	84B	
〃 582																								
〃 583																								
〃 584																								
〃 585																								
〃 586																								
〃 587																								
〃 588																								
〃 589																								
〃 590																								
〃 591																								
〃 592																								
2SA593																								
〃 594	東芝	RF	Si. EP	−60	−5	−200	750	175	−0.1	−30	40～240	−1	−10	−10	10					400*	3	<128*	84B	2SC594 之對稱
〃 595																								
〃 596																								
〃 597	東芝	RF. PA	Si. EP	−50	−4	−1A	6 W (Tc=25°C)	175	−1	−30	50	−3	−150	−10	100					400*	10	10*	84B	
〃 598																								
〃 599																								
〃 600																								
〃 601																								
〃 602																								
〃 603	日電	RF	Si. EP	−60	−8	−200	300	150	−0.5	−40	150	−1	−10	−10	10					220*	6.5	70	124	
〃 604	〃	〃	〃	−120	−5	−30	300	150	−0.5	−100	80	−3	−1	−10	10					170*	3	20	49C	
〃 605	〃	RF. SW	〃	−180	−5	−50	300	150	−1	−100	100	−6	−15	−10	10					100*	4	40	49C	
〃 606	〃	PA	〃	−100	−5	−700	0.7	150	−3	−80	100	−5	−200	−5	150					115*	20	45*	84B	2SC960 之對稱
〃 607	〃	〃	〃	−100	−5	−700	1 W	150	−3	−80	80	−5	−300	−10	100					100*	30	45*	97B	2SC960 之對稱
〃 608	[illegible]洋	RF. AF. SW	〃	−30	−5	−100	100	125	−1	−25	150	−1	−10	−6	10					180*	7	$C_c r_{bb}$ 100pS	166	
〃 609	〃	RF. AF	〃	−30	−5	−100	100	125	−1	−25	85	−6	−1	−6	1					80*	7	$C_c r_{bb'}$ 100pS	166	
〃 610	新日無	〃	〃	−30	−5	−100	150	125	−1	−20	100	−6	−1	−6			5000	1.5	20	170*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 50pS	29	
〃 611	〃	〃	〃	−60	−5	−100	150	125	−1	−20	100	−6	−1	−6	1		5000	1.5	20	170*	3.3	$C_c r_{bb}$ 50pS	29	
〃 612	〃	RF. SW	〃	−90	−5	−50	150	125	−0.1	−20	100	−6	−1	−10	2					100*	4	$C_c r_{bb}$ 50pS	29	
〃 613	日立	PA	〃	−60	−7	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−1mA	−40	80	−5	−500	−10	200					30*	60	140*	134	2SD150 之對稱
〃 614	〃	〃	〃	−80	−7	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	80	−5	−500	−10	200					30*	60	140*	134	
〃 615																								
〃 616	日立	PA	Si. EMe	−80	−5	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	70	−5	−1A	−10	200					15*	100	60*	134	2SD155 之對稱
〃 617	日立	RF	Si. T	−150	−5	−50	200	175	−1	−100	80	−3	−15	−10	10					60*	3.5	$C_c r_{bb}$ 40pS	244	
〃 618	〃	〃	〃	−180	−5	−50	200	175	−1	−150	80	−3	−15	−10	10					60*	3.5	$C_c r_{bb}$ 40pS	244	
〃 619																								
〃 620	新日無	RF. AF. LN	Si. EP	−30	−5	−50	200	175	−50nA	−20	250	−6	−1	−6	0.3		50k	4	10	120*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 55pS	169	
〃 621	〃	RF. AF	〃	−60		−200	400	175	−0.5	−20	80	−1	−50	−6	1		5000	1.5	20	200*	6	$C_c r_{bb}$ 50pS	84B	
〃 622	〃	SW	Si. EP [illegible]	−30	−10	−300	150	125	−0.1	−20	40,000	−6	−100			t_{on} < 600nS, t_{off} < 1.2μS, t_{stg} < 600nS							194	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SA623	三菱	SW.PA	Si.EP	−35	−5	−1.5A	7 W (Tc=25°C)	150	−1	−25	100	−4	−500				$t_{on}<0.3\mu S$, $t_{off}<0.8\mu S$, $t_f<0.6\mu S$						132	2SC1013之对偶
	〃 624	〃	〃	〃	−50	−5	−1.2A	7 W (Tc=25°C)	150	−1	−25	100	−4	−500				〃						132	2SC1014之对偶
	〃 625	富士通	RF	〃	−100	−6	−500	700	175	−1	−30	120	−2	−200	−10	10					100*	18	20	84B	
	〃 626	日電	PA	Si.EMe	−80	−5	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−2mA	−60	50	−5	−2A	−10	200					15*	140	60*	102	2SD180之对偶
	〃 627	〃	〃	〃	−100	−5	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−2mA	−80	50	−5	−2A	−10	200					15*	140	60*	102	2SD181之对偶
	〃 628	三菱	RF.AF.SW	Si.EP	−30	−5	−100	150	125	−0.1	−25	200	−6	−1	−6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	再登録
★	〃 629	〃	RF.AF.LN	〃	−30	−5	−30	150	125	−0.1	−25	200	−6	−1	−6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 60pS	138B	
	〃 630																								
	〃 631																								
	〃 632																								
★	〃 633	日電	PA	Si.E	−30	−5	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−30	80	−5	−1A	−5	150					60*	60	10*	167	
	〃 634	〃	〃	〃	−40	−5	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−100	−30	80	−5	−1A	−5	150					60*			167	2SC1066之对偶
★	〃 635	日電	PA	〃	−60	−5	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−40	80	−5	−500	−5	150					50*	60	10*	167	
	〃 636	〃	〃	〃	−90	−5	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−100	−40	80	−5	−500	−5	150					40*			167	2SC1068之对偶
★	〃 637	松下	RF.AF	Si.TP	−150	−5	−50	300	175	−1	−100	150	−3	−15	−10	3	67	540	0.4	7.7	150*	4	$C_c r_{bb'}$ 150pS	49C	
	〃 638	日電	〃	Si.E	−150	−5	−50	250	125	−1	−100	100	−6	−15	−3	1		4000	0.9	6.5	100*	4	40	138	
	〃 639	〃	〃	〃	−180	−5	−50	250	125	−1	−100	100	−6	−15	−3	1		4000	0.9	6.5	100*	4	40	138	
	〃 640	〃	RF.LN	〃	−50	−5	−30	250	125	−0.1	−40	300	−3	−0.5	−3	1		9200	2.7	3.3	100*	8	20*	138	2SC1222之对偶
	〃 641	〃	RF.AF	〃	−50	−5	−30	250	125	−0.1	−40	300	−3	−0.5	−3	1		9200	2.7	3.3	100*	8	20*	138	2SC923之对偶
	〃 642	〃	RF.PA	〃	−30	−5	−300	250	125	−0.1	−15	120	−1	−50	−3	50					200*	15	12	138	2SD227之对偶
	〃 643	〃	〃	〃	−40	−5	−500	500	125	−0.2	−25	120	−1	−100	−6	50					180*	24	10	44	2SD261之对偶
	〃 644																								
★	〃 645	三菱	PA.SW	Si.EP	−70	−5	−800	7 W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300				$t_{on}<200nS$, $t_{off}<800nS$, $t_{stg}<600nS$						132	
★	〃 646	〃	〃	〃	−90	−5	−800	7 W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300				〃						132	
★	〃 647	〃	〃	〃	−110	−5	−800	7 W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300				〃						132	
★	〃 648	日電	PA	Si.EMe	−120	−5	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−2mA	−80	50	−5	−3A	−10	200					10*	200	30*	102	2SD217之对偶
★	〃 649	〃	〃	〃	−150	−5	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−2mA	−80	50	−5	−3A	−10	200					10*	200	30*	102	2SD218之对偶
★	〃 650	〃	〃	〃	−150	−5	−10A	100 W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	70	−5	−2A	−10	200					10*	500	20*	102	
★	〃 651	〃	〃	〃	−150	−5	−10A	100 W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	70	−5	−2A	−10	200					10*	500	20*	102	
★	〃 652	〃	〃	〃	−150	−6	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	80	−5	−200	−10	200					15*	100	30*	134	
	2SA653	日電	PA	Si.EMe	−150	−6	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	80	−5	−200	−10	200					15*	100	30*	134	
	〃 654																								
	〃 655																								
	〃 656	東芝	PA	Si.EMe	−130	−5	−7A	50W (Tc=25°C)	150	100	100~300	60	−5	−1A	−10	1A					5*	250	20	102	2SC519A之对偶
	〃 657	〃	〃	〃	−100	−5	−7A	50W (Tc=25°C)	150	100	100~300	60	−5	−1A	−10	1A					5*	250	20	102	2SC520A之对偶
	〃 658	〃	〃	〃	−70	−5	−7A	50W (Tc=25°C)	150	100	100~300	60	−5	−1A	−10	1A					5*	250	20	102	2SC521A之对偶
	〃 659																								
	〃 660																								
	〃 661	東芝	RF, AF, PA	Si.EP	−70	−5	−200	600	150	−0.1	−20	100	−2	−50	−10	10					100*	9	10	131	
	〃 662																								
	〃 663	東芝	RF.AF.PA	Si.TMe	−100	−5	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−50	80	−5	−1A	−5	1A					6*	600	15	102	2SC793之对偶
	〃 664																								
	〃 665																								
	〃 666	松下	RF.AF.LN	Si.EP	−25	−5	−50	150	125	−1	−10	250	−5	−2	−5	−2	200	5000	0.7	10	130*	2.8	$C_c r_{bb'}$ 160pS	138	
	〃 667																								
	〃 668	三菱	RF.SW	Si.EP	−100	−5	−100	150	125	−0.1	−25	100	−6	1	−6	1	$t_{on}<120nS$, $t_{off}<290nS$, $t_{stg}<100nS$				100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	
	〃 669	〃	SW	〃	−160	−5	−100	150	125	−0.1	−25	70	−6	1										138B	
	〃 670	日立	PA	Si.T	−50	−4	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−20	100	−4	−1A	−4	500					11*	200	6*	158	2SC1060之对偶
	〃 671	〃	〃	〃	−50	−4	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−20	100	−4	−1A	−4	500					11*	200	6*	159	2SC1061之对偶
	〃 672	〃	RF.LN	〃	−50	−4	−200	200	125	−0.5	−18	110	−12	−2	−12	2					80*	16	12*	170	
	〃 673	日立	RF	Si.EP	−35	−4	−500	400	125	−0.5	−20	130	−3	−10	−6	1					50*	7	12*	170	2SC1213之对偶
	〃 674																								
	〃 675	日電	AF.RF	Si.E	−80	−5	−100	250	125	−1	−60	120	−3	−20	−3	1		3200	0.9	11	100*	5	30	138	
	〃 676																								
	〃 677	SON	RF.SW	Si.E	−25	−5	−200	250	100	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	2		h_{fe}=3dB (f=100MHz)				6	$C_c r_{bb'}$ 60pS	168	
	〃 678	〃	〃	〃	−50	−5	−200	320	120	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	2		h_{fe}=3dB (f=100MHz)				6	$C_c r_{bb'}$ 60pS	168	
	〃 679	東芝	PA	Si.EMe	−120		−12A	100 W (Tc=25°C)	150	−100	−50	40~140	−5	−2A	−5	2A					6*	900	20	102	2SC1079之对偶
	〃 680	〃	〃	〃	−80		−12A	100 W (Tc=25°C)	150	−100	−50	40~140	−5	−2A	−5	2A					6*	900	20	102	2SC1080之对偶
	〃 681	〃	RF.PA	Si.EP	−100	−5	−1A	800	150	−1	−30	120	−2	−150	−2	150					50*	40	10	164	
	〃 682	〃	〃	〃	−80	−5	−750	800	150	−0.5	−30	70~240	−2	−150	−2	150					100*	15	15	164	2SC1382之对偶

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CE}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA683	松下	PA	Si.EP	−30	−5	−1A	750	135	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	165	
〃 684	〃	〃	〃	−60	−5	−1A	750	125	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	165	
〃 685	〃	AF	Si.TP	−150	−5	−50	300	125	−1	−100	150	−3	−15	−10	3	67	540	0.4	77	100*	5	35	138	
〃 686																								
〃 687																								
〃 688																								
〃 689																								
〃 690																								
〃 691																								
〃 692																								
〃 693																								
〃 694																								
〃 695	三菱	RF.PA	Si.EP	−25	−4	−700	500	125	−1	−25	100	−1	−500	−6	10					150*	20	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	2SC1209之對偶
〃 696	〃	〃	〃	−45	−4	−500	500	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	2SC1210之對偶
〃 697	〃	〃	〃	−65	−4	−500	500	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	2SC1211之對偶
〃 698	〃	PA.SW	〃	−130	−5	−800	7W (T_c=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300			t_{on}<200nS, t_{off}<800nS t_{stg}<600nS							132	
〃 699	松下	PA	〃	−40	−5	−2A	10W (T_c=25°C)	150	−1	−20	120	−5	−1A	−5	500					150*	50	3.3*	161	2SC1226之對偶
〃 700	日立	〃	Si.E	−35		−1.5A	8W (T_c=25°C)	150	−10	−35	100	−2	−200	−4	500					11*	200	6*	159	
〃 701	三洋	RF.LN	Si.EP	−30	−5	−50	100	125	−1	−25	200	−6	−1	−6	1		2200	0.5	7	80*	12	$C_c r_{bb}$ 100pS	166	
〃 702	〃	〃	〃	−50	−5	−50	100	125	−1	−45	200	−6	−1	−6	1		2200	0.5	7	80*	12	$C_c r_{bb}$ 100pS	166	
〃 703	三菱	SW.PA	〃	−25	−5	−1.5A	7W (T_c=25°C)	150	−1	−16	100	−4	−500				t_{on}<0.2μS, t_{off}<0.8μS t_{stg}<0.6μS						132	2SC1243之對偶
〃 704	SON	RF.AF.LN SW	Si.EMe	−25	−5	−200	250	100	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	1		6600	0.76	16.2	h_{fe}=3dB (100MHz)		$C_c r_{bb'}$ 60pS	168	
〃 705	〃	〃	Si.E	−50	−5	−200	320	120	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	1		h_{fe}=3dB (f=100MHz)				6	$C_c r_{bb}$ 60pS	168	
〃 706	〃	RF	Si.DB	−60	−6	−1A	950	120	−1	−50	150	−2	−100	−10	10					120*	10	$C_c r_{bb}$ 150pS	174	
〃 707	日電	RF.PA	Si.E	−40	−5	−500	750	135	−0.2	−25	120	−1	−100	−3	50					180*	24	10	177	
〃 708	〃	RF	〃	−80	−8	−700	800	150	−0.1	−60	150	−2	−50	−10	50					50*	25	25*	84B	
〃 709																								
〃 710	日電	RF.SW	Si.E	−50	−5	−100	300	150	−0.1	−30	120	−1	−10	−10	10	t_{on}<80nS, t_{off}<180nS t_{stg}<140nS				600*	2.5	34*	49C	
〃 711	〃	〃	〃	−50	−5	−100	300	150	−0.1	−30	120	−1	−10	−10	10	t_{on}<70nS, t_{off}<170nS t_{stg}<130nS				1000*	2.5	34*	49C	
〃 712	〃	〃	〃	−150	−5	−500	750	175	−0.1	−100	110	−10	−50	−10	50					350*	5.5	11*	84B	
2SA713	日電	RF	Si.E [illegible]	−15	−10	−300	250	125	−0.1	−10	20,000	−5	−100	−10	10					180*	6	200*	138	
〃 714																								
〃 715	日立	RF.PA	Si.EP	−35	−5	−1.5A	10W (T_c=25°C)	150	−20	−35	130	−2	−500	−2	200					160*	35	9*	160	
〃 716																								
〃 717	日電	RF.SW	Si.EP	−60	−5	−1A	800	175	−0.1	−40	80	−10	−50	−10	50					260*	18	10*	84B	
〃 718	〃	〃	〃	−60	−8	−200	300	150	−0.1	−40	140	−1	−10	−10	10					220*	6	30*	49C	
〃 719	松下	PA	〃	−30	−5	−500	400	125	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5*	138	2SC1317之對偶
〃 720	〃	〃	〃	−50	−5	−500	400	125	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5*	138	2SC1318之對偶
〃 721	〃	RF.LN	〃	−35	−5	−50	150	125	−0.1	−10	540	−5	−2	−5	2		3500	3	60	250*	5	100	138	
〃 722	〃	〃	〃	−55	−5	−50	150	125	−0.1	−10	540	−5	−2	−5	2		3500	3	60	250*	5	100	138	
〃 723	日電	RF.PA	Si.E	−40	−5	−500	250	125	−0.2	−25	120	−1	−100	−3	50					180*	24	10	138	2SD327之對偶
〃 724	〃	RF	〃	−35	−5	−50	250	125	−0.1	−25	150	−10	−0.5	−1	10					300*	3.5	20*	138	
〃 725	三菱	RF.AF.LN	Si.EP	−35	−5	−100	150	125	−0.1	−25	500	−6	−1	−6	1		15k	1.2	28	100*	3	$C_c r_{bb}$ 140pS	138B	
〃 726	〃	〃	〃	−50	−5	−100	150	125	−10	−50	500	−6	−1	−6	1		15k	1.2	28	100*	3	$C_c r_{bb}$ 60pS	138B	
〃 727																								
〃 728	三菱	RF.AF	Si.EP	−30	−5	−100	100	125	−0.1	−25	200	−6	−10	−6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_c r_{bb}$ 100pS	175	
〃 729																								
〃 730	松下	PA	Si.EP	−30	−5	−500	600	125	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5*	171	
〃 731	〃	〃	〃	−60	−5	−500	600	125	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5*	171	
〃 732	富士通	RF	〃	−40	−4	−300	650	175	−0.1	−10	60	−10	−10	−10	10					200*	4.5	50*	84B	
〃 733	日電	RF.AF	Si.E	−50	−5	−100	250	125	−0.1	−40	200	−6	−1	−6	1		5500	7.5	28	180*	8	12	138	2SC945之對偶
〃 734																								
〃 735																								
〃 736																								
〃 737																								
〃 738	日立	RF.PA	Si.E	−25	−5	−1.5A	8W (T_c=25°C)	150	−20	−25	130	−2	−500	−2	200					160*	35	9*	160	2SC1368之對偶
〃 739	東芝	SW	Si.TMe	−400	−5	−3A	50W (T_c=25°C)	150	−100	−300	20~300	−5	−500	−50							100		102	
〃 740	〃	RF.PA	〃	−150	−5	−1.5A	25W (T_c=25°C)	150	−20	−100	75	−10	−500	−10	500					5*	100	25	119	
〃 741	日立	SW	Si.EP	−20	−4	−100	360	175	−0.2	−16	70	−0.5	−30	−10	10		t_{on}<70nS, t_{off}<120nS t_{stg}<100nS			350*			49C	
〃 742	〃	〃	〃	−55	−5	−500	700	175	−0.5	−20	130	−1.6	−100				t_{on}<40nS, t_{off}<100nS t_{stg}<80nS						84B	

型 名	社 名	用 途	構 造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備 考
2SA743	日 立	RF. PA	Si. E	−50	−4	−1A	8W (Tc=25°C)	150	−1mA	−50	120	−4	−50	−4	30					120*	30	4*	160	2SC[illegible]之對偶
〃 744	SAK	PA	Si. EMe	−80	−6	−8A	70W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	60	−4	−3A	−12	500					10*	220	10*	102	
〃 745	〃	〃	〃	−100	−6	−8A	70W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60	−4	−3A	−12	500					10*	220	10*	102	
〃 746	〃	〃	〃	−80	−6	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	60	−4	−3A	−12	500					10*	255	10*	102	
〃 747	〃	〃	〃	−120	−6	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−120	60	−4	−3A	−12	500					10*	255	10*	102	
〃 748	松 下	RF. PA	Si. EP	−70	−5	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−40	130	−5	−1A	−5	500					150*	50	3*	172	
〃 749	〃	SW	〃	−100	−5	−50	250	125	−0.1	−50	80	−1	−20	−10	10		t_r<350nS, t_f<150nS, t_{stg}<200nS			>40*			138	
〃 750	日 電	RF. AF	Si. E	−50	−5	−30	250	125	−0.1	−40	300	−3	−0.5	−6	1		4200	2.7	33	100*	8	20*	138	
〃 751	松 下	PA	Si. EP	−30	−5	−1A	1 W	135	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	173	
〃 752	〃	〃	〃	−60	−5	−1A	1 W	135	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	173	
〃 753	日 立	〃	Si. T	−140	−5	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−30	100	−5	−1A	−5	1 A					20*	220	7*	102	2SC[illegible]之對偶
〃 754	〃	〃	〃	V_{CEO} −50	−4	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	35~120	−4	−1A										158	2SC1418之對偶
〃 755	〃	〃	〃	V_{CEO} −50	−4	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	35~120	−4	−1A										159	2SC1419之對偶
〃 756	〃	〃	〃	−100	−6	−6A	50W (Tc=25°C)	150	−1mA	−30	80	−5	−1A	−5	1A					20*	240	12*	102	2SC1030之對偶
〃 757	〃	〃	〃	−120	−6	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−30	100	−5	−1A	−5	1A					20*	250	10*	102	2SC[illegible]之對偶
〃 758	〃	〃	〃	−130	−5	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−30	100	−5	−1A	−5	1A					20*	250	10*	102	2SC[illegible]之對偶
〃 759	日 電	RF. PA	Si. E	−60	−5	−200	150	125	−0.1	−45	180	−1	−50	−10	10					200*	8.5	20	176	
〃 760	〃	〃	〃	−50	−5	−30	150	125	−0.1	−40	350	−3	−0.5	−3	1					100*	8	20*	176	
〃 761	SON	〃	Si. EP	−110	−5	−2A	6.3W (Tc=25°C)	120	−10	−50	100	−2	−400	−2	200					80*	50	$C_c r_{bb'}$ 98pS	181	
〃 762	〃	〃	〃	−110	−5	−2A	1.5W	150	−10	−50	100	−2	−400	−2	200					80*	50	$C_c r_{bb'}$ 95pS	99	
〃 763	新日無	RF. AF. LN	〃	−30	−5	−50	200	125	−50nA	−20	250	−6	−1	−6	0.3		50k	4	10	120*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 55pS	138	
〃 764	SAK	PA	Si.TMe	−60	−6	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	80	−4	−1A	−10	500					10*	90	8*	99	
〃 765	〃	〃	〃	−80	−6	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	80	−4	−1A	−10	500					10*	90	8*	99	
〃 766	松 下	〃	Si. Me	−150	−5	−400	30W (Tc=25°C)	150	−30	−60	60	−5	−100	−10	100					20*	100	25	99	
〃 767	東 芝	RF	Si. EP	−55	−5	−100	200	150	−0.1	−30	120	−1	−10	−10	1					150*	5	20	195	
〃 768																								
〃 769																								
〃 770																								
〃 771																								
〃 772	SON	RF. PA	Si.EP	−16	−6	−2A	750	120	−0.2	−16	350	−2	−100	−2	−10					60*	50	$C_c r_{bb'}$ 600pS	259	
2SA773	SON	RF. PA	Si. EP	−50	−6	−1A	750	120	−0.2	−25	250	−2	−100	−2	10					65*	25			
〃 774	松 下	RF. LN	Si. EP	−35	−5	−50	150	175	−0.1	−10	540	−5	−2	−5	2		3500	3	60	120*	5	100	54	
〃 775																								
〃 776	東 芝	RF. LN	Si. EP	−55	−5	−50	200	150	−0.1	−30	300	−6	−2	−6	1	285	7300	1	21	180*	3	35	195	
〃 777	松 下	PA	〃	−80	−5	−500	750	135	−0.1	−20	160	−10	150	−10	50					120*	20	2k*	165	
〃 778	日 立	RF	Si. T	−150		−50	200	125	−1	−100	80	−3	−15	−10	10					60*	4	$C_c r_{bb'}$ 40pS	170	
〃 779	〃	RF. PA	Si. EP	−35	−5	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−20	−30	150	−2	−50	−2	200					110*	50	9*	234	
〃 780	〃	RF	Si. P	−50	−4	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−30	120	−4	−50	−4	50					120*	8	50*	234	
〃 781	〃	SW	Si. EP	−20	−4	−200	200	125	−0.2	−16	80	−0.5	−30	−1	10	t_{on}<80nS, t_{off}<100nS, t_{stg}<100nS				650*	25	$C_c r_{bb'}$ 32pS	170	
〃 782	東洋電具	RF. Conv. Mix Osc. PA. AF	〃	−80	−5	−30	150	125	−1	−50	150	−6	−1	−6	1		7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160pS	235	
〃 783	〃	〃	〃	−50	−5	−30	150	125	−1	−30	150	−6	−1	−6	1		7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160pS	235	
〃 784	〃	〃	〃	−25	−5	−30	150	125	−1	−15	130	−6	−1	−6	1		7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160pS	235	
〃 785	〃	〃	〃	−80	−5	−50	150	125	−1	−50	150	−3	−10	−6	1		6.7k	0.8	10	180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 160pS	235	
〃 786	〃	〃	〃	−50	−5	−50	150	125	−1	−30	150	−3	−10	−6	1		6.7k	0.8	10	180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150pS	235	
〃 787	〃	〃	〃	−20	−5	−50	150	125	−1	−15	150	−3	−10	−6	1		6.7k	0.8	10	180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150pS	235	
〃 788	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA. AF. LN	〃	−50	−5	−30	150	125	−1	−30	150	−3	−10	−6	1	NF=2dB (f=1kHz)	7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160pS	235	
〃 789	〃	〃	〃	−25	−5	−30	150	125	−1	−15	150	−3	−10	−6	1	NF=2dB (f=1kHz)	7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160pS	235	
〃 790	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	−40	−6	−300	300	125	−1	−24	10,000	−5	−100	−5	10					200*	5.5	$C_c r_{bb'}$ 100pS	235	
〃 791	〃	〃	〃	−25	−6	−300	300	125	−1	−15	10,000	−5	−100	−5	10					200*	5.5	$C_c r_{bb'}$ 100pS	235	
〃 792																								
〃 793																								
〃 794	松 下	PA	Si. EP	−100	−5	−500	1.2 W	150	−1	−100	160	−10	−150	−10	50					120*	20	3.5k*	222	
〃 795	〃	〃	〃	−150	−5	−250	10W (Tc=25°C)	150	−30	−60	120	−10	−100	−10	50					120*	15	15	236	
〃 796	新日無	SW	〃	−30	−10	−300	300	125	−0.1	−20	40,000	−6	−100			t_{on}<600nS, t_{off}<1.3μS, t_{stg}<600nS							138	
〃 797																								
〃 798	三 菱	Diff. LN	Si.EP	−50	−5	−100	200 unit	125	−0.1	−35	250~1200	−6	1	−6	1		ΔV_{BE}=10mVmax, h_{FE}小/h_{FE}大=0.8			100*	3.0		276	
〃 799																								
〃 800																								
〃 801																								
〃 802																								

製名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)														外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測置情況 V_{CE}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* $(\times 10^{-4})$	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)		
2SA803																								
〃 804																								
〃 805																								
〃 806																								
〃 807																								
〃 808																								
〃 809	富士通	RF	Si.EP	-150	-5	-50	700	175	-1	-140	150	-5	-10	-5	10	t_{on}<1μS t_{off}<10μS t_{stg}<9.5μS				100*	3	70*	248	
〃 810	〃	〃	〃	-150	-5	-50	700	175	-1	-140	150	-5	-10	-5	10	t_{on}<1μS t_{off}<10μS t_{stg}<9.5μS				100*	3	70*	248	
〃 811	日 電	RF. AF	Si.PaE	-50	-5	-30	150	125	-0.05	-40	400	-3	-0.5	-3	1		9200	2.7	33	100*	8	20*	176	
〃 812		〃	Si.E	-50	-5	-100	150	125	-0.1	-40	200	-6	-1	-6	10		5500	7.5	28	180*	8	$C_c r_{bb'}$ 35pS	176	
〃 813	〃	RF. PA	〃	-60	-5	-200	150	125	-0.1	-45	80	-1	-50	-10	10					200*	8.5	20	176	
〃 814	東 芝	〃	Si.Eb	-120		-750	1.5W	150	-0.5	-50	130	-2	-150	-2	150					25*	30	5	119	
〃 815	〃	〃	〃	-100		-750	1.5W	150	-0.5	-50	130	-2	-150	-2	150					25*	30	5	119	
〃 816	〃	〃	Si.EP	-80		-750	1.5W	150	-0.5	-30	130	-2	-150	-2	150					100*	20	5	119	
〃 817	〃	〃	〃	-70		-750	600	150	-0.1	-20	130	-2	-50	-2	50					150*	9	5	131	
〃 818	〃	〃	Si.TP	-180		-50	1 W	150	-1	-100	130	-5	-10	-10	10					120*	4.5	10	249	
〃 819																								
〃 820																								
〃 821																								
〃 822																								
〃 823																								
〃 824																								
〃 825																								
〃 826																								
〃 827																								
〃 828																								
〃 829																								
〃 830																								
〃 831																								
〃 832																								
2SA833																								
〃 834																								
〃 835																								
〃 836																								
〃 837	松 下	RF.PA	Si.EMe	-80	-5	-4A	50W (Tc=25°C)	150	-1mA	-50	100	-4	-1A	-10	500					10*	200	10	102	
〃 838																								
〃 839	東 芝	RF.PA	Si.TMe	-150	-5	-1.5A	25W (Tc=25°C)	150	-20	-100	100	-10	-500	-10	500					5*	100	25	268	
〃 840																								
〃 841																								
〃 842																								
〃 843	松 下	RF.PA	Si.EMe	-200	-5	-500	20W (Tc=25°C)	150	-500	-200	120	-10	-400	-10	200					35*	80	25	268	
〃 844																								
〃 845																								
〃 846																								
〃 847	三 菱	AF,LN,RF	Si.EP	-90	-5	-50	200	125	-0.1	-50	250~1200	-6	1	-6	1					100	2.5		138B	2SC1708之對稱
〃 848																								
〃 849																								
〃 850	三 菱	AF.Drive	Si.EP	-100	-5	-300	800	135	-1	-50	55~300	-6	-10	-6	10					130*			242	
〃 851																								
〃 852																								
〃 853																								
〃 854																								
〃 855																								
〃 856																								
〃 857																								
〃 858																								
〃 859	ALP	RF	Si.E	-300	-5	-500	625	150	-0.25	-200	·125	-10	-10	-20	10					120*	3	$C_c r_{bb}$ 300pS	138D	MPSA92
〃 860	〃	〃	〃	-200	-5	-500	625	150	-0.25	-160	125	10	-10	-20	10					120*	3	$C_c r_{bb}$ 300pS	138D	MPSA93
〃 861																								
〃 862																								

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈沖下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測定情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fb} h_{fe}*	h_{ib} h_{ie}* (Ω)	h_{rb} h_{re}* (×10⁻⁴)	h_{ob} h_{oe}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ (Ω)	外形	備考
★	2SB 12	富士通	AF	Ge. A	−30		−50	50	70	−15	−30				−6	1	−0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8			61	2S113
★	〃 13	〃	〃	〃	−30		−50	100	70	−15	−30				−6	1	−0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8			61	2S114
	〃 14	〃	LN	〃	−30		−50	100	70	−15	−30				−6	1	−0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8	NF = 5dB (f = 1kc)		61	2S115
	〃 15	〃	AF	〃	−60		−50	100	70	−15	−60				−6	1	−0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8			61	2S116
	〃 16	〃	PA	〃	−16		−600	1.8W (Tc=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	2S119
	〃 16A	〃	〃	〃	−20		−600	1.8W (Tc=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	
	〃 17	〃	〃	〃	−32		−600	1.8W (Tc=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	2S120
	〃 17A	〃	〃	〃	−40		−600	1.8W (Tc=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	
	〃 18	〃	〃	〃	−60		−600	1.8W (Tc=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	2S121
	〃 18A	〃	〃	〃	−80		−600	1.8W (Tc=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	
	〃 19	〃	〃	〃	−16		−2.5A	5.5W (Tc=25°C)	70	−100	−5	50	−2	−50										94	2S122
	〃 20	〃	〃	〃	−32		−2.5A	5.5W (Tc=25°C)	70	−100	−5	50	−2	−50										94	2S123
	〃 21	〃	〃	〃	−60		−2.5A	5.5W (Tc=25°C)	70	−100	−5	50	−2	−50										94	2S124
	〃 22	三洋	〃	〃	−25	−12	−200	300	85	−15	−20	100	−1.5	−100	−6	100						1		63	2SD30之對稱
	〃 23	〃	AF	〃	−15	−5	−10	40	75	−10	−15				−6	1	70	3000	6	30	1.5			12A	
	〃 24	〃	〃	〃	−15	−10	−15	100	75	−15	−15				−6	1	70	3000	6	30	1.5	12		6	
	〃 25	東芝	PA	〃	−60	−12	−1.5A	20 W (Tc=25°C)	75	−160	−12	60	−1.5	−1A	−1.5	500					0.25			102	2S26A
	〃 26	〃	〃	〃	−32	−12	−1.5A	20 W (Tc=25°C)	75	−160	−12	60	−1.5	−1A	−1.5	500					0.25			102	2S 26
★	〃 26A	〃	〃	〃	−60	−12	−1.5A	20 W (Tc=25°C)	75	−160	−12	60	−1.5	−1A	−1.5	500					0.25			102	
	〃 27	SON	〃	〃	−15	−10	−0.5A	5 W (Tc=25°C)	85	−800	−15	29	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kc	200		103	2T305
	〃 28	〃	〃	〃	−15	−10	−0.5A	5 W (Tc=25°C)	85	−800	−15	68	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kc	200		103	2T305
	〃 29	〃	〃	〃	−15	−10	−0.5A	5 W (Tc=25°C)	85	−800	−15	115	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kc	200		103	2T305
	〃 30	〃	〃	〃	−15	−10	−0.5A	5 W (Tc=25°C)	85	−800	−15	68	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kc	200		103	2T306
	〃 31	〃	〃	〃	−15	−10	−0.5A	5 W (Tc=25°C)	85	−800	−15	115	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kc	200		103	2T306
	〃 32	富士通	AF	〃	−20	−2.5	−50	150	85	14	12				−9		40	1500	4.2	16.5	0.8			12A	2S 32
	〃 33	〃	PA	〃	−20	−2.5	−50	150	85	−14	−12	70	−1	−50	−6	1	80	2600	5.5	20.8	1			12A	2SD33之對稱
	〃 34	〃	〃	〃	−20	−2.5	−150	250	85	−14	−12	70	−1	−150	−6	1	85	2450	4.9	22.5	0.8			71A	2SD34之對稱
	〃 37	〃	〃	〃	−30	−12	−50	150	85	−14	−30	70	−1	−50	−6	1	80	2600	5.5	20.8	1			12A	2SD37之對稱
	〃 38	〃	〃	〃	−30	−12	−150	250	85	−16	−30	70	−1	−150	−6	1	85	2450	4.9	22.5	0.8			71A	2SD38之對稱
	〃 39	〃	LN	〃	−10	−10	−2	50	85	−10	−10				−4	0.5	65	3570	9.44	25	NF = 4dB (f = 1kc)			12A	2S 39
★	2SB 40	東芝	SW	Ge. A	−40	−12	−100	80	75	−10	−12	100	−1	−100	−6	1		t_r=0.35μS, t_f=0.35μS, t_s=0.6μS			>0.7	<50	<180	12A	
	〃 41	富士通	PA	〃	−40	−12	−1.2A	44 W (Tc=25°C)	91	−2mA	−30	65	−1.5	−1A	−14.4	50		PG = 30dB, Po = 10W (B級PP, Z_L = 24Ω)						102	2S 41
	〃 42	〃	〃	〃	−60	−12	−1.2A	44 W (Tc=25°C)	91	−2mA	−30	65	−1.5	−1A	−14.4	50		PG = 30dB, Po = 10W (B級PP, Z_L = 24Ω)						102	2S 42
★	〃 43	東芝	〃	〃	−25	−12	−50	150	75	−10	−12	70	−1	−50	−6	1					1	35		12A	
★	〃 43A	〃	〃	〃																				12A	
★	〃 44	〃	AF	〃	−30	−12	−50	80	75	−10	−12				−6	1	85	2500	5	30	>0.5	30		12A	2S 44
	〃 46	〃	〃	〃	−25	−12	−50	80	75	−5	−12				−6	1	140	4200	6	30		35		12A	2S 46
	〃 47	〃	LN	〃	−25	−12	−50	80	75	−14	−25				−6	1	140	4200	6	30	NF < 5dB (f = 1kc)			12A	2S 47
★	〃 48	SON	AF. PA	〃	−16		−100	140	65	−16	−16	43	−1	−20	−6	1	−0.973*	28*	8*	0.6	2.5	25		84A	2T 31
★	〃 49	〃	〃	〃	−16		−100	140	65	−16	−16	83	−1	−20	−6	1	−0.985*	28*	8*	0.6	3.0	25		84A	2T 31
★	〃 50	〃	〃	〃	−16		−100	140	65	−16	−16	131	−1	−20	−6	1	−0.990*	28*	8*	0.6	3.5	25		84A	2T 31
★	〃 51	〃	PA	〃	−30	−3	−200	200	85	−16	−25	43	−1	−20	−6	1	−0.973*	28*	8*	0.6	2.0	25		84A	2T 32
★	〃 52	〃	〃	〃	−30	−3	−200	200	85	−16	−25	83	−1	−20	−6	1	−0.985*	28*	8*	0.6	3.0	25		84A	2T 32
★	〃 53	〃	〃	〃	−30	−15	−250	200	85	−10	−30	70	−1	−20	−6	1	−0.982*	28*	7*	0.6	3.0	25		84A	2T 38
	〃 54	東芝	AF	〃	−30	−12	−150	150	75	−14	−30				−6	1	140	4200	6	30	1*	35	120	12A	2S 54
★	〃 55	〃	PA	〃	−60	−12	−50	150	75	−14	−25	80	−1	−50	−6	1					1	35		12A	2S56A
	〃 56	〃	〃	〃	−30	−12	−150	150	75	−14	−30	80	−1	−50	−6	1					1	35	120	12A	2S 56
★	〃 56A	〃	〃	〃	−45	−12	−150	150	75	−14	−25	80	−1	−50	−6	1					1	35		12A	
	〃 57	富士通	AF	〃	−30	−10	−100	100	70	−15	−30				−6	1	70	30*	3*	0.3*				78	
	〃 58	〃	〃	〃	−12	−2.5	−50	100	70	−15	−12				−6	1	−0.98	30*	3*	0.3*				78	
	〃 59	〃	SW	〃	−30	−10	−100	150	85	−15	−30	70	−1	−50										12A	
★	〃 60	〃	AF	〃	−20	−2.5	−50	150	85	−14	−12				−6	1	70	30*	3*	0.3*				12A	
★	〃 60A	〃	〃	〃	−20	−2.5	−50	150	85	−14	−12	70	−1	−50*										12A	
	〃 61	〃	〃	〃	−30	−12	−50	150	85	−10	−30				−6	1	85	3000	7	30	1	40		12A	2S 61
★	〃 62	東芝	PA	〃	−60	−12	−500	2 W (Tc=55°C)	75	−70	−12	60	−1	−500	−1	100					0.4			101	
	〃 63	〃	〃	〃	−32	−12	−500	2 W (Tc=55°C)	75	−70	−12	60	−1	−500	−1	100					0.4			101	
	〃 64	〃	〃	Ge. D	−100	−1	−6A	25 W (Tc=25°C)	75	−330	−12	70	−1.5	−1A	−1.5	500					1			102	
	〃 65	富士通	SW	Ge. A	−30	−12	−100	150	85	−15	−30				−6	1	65	t_r = 3μS, t_f = 4μS, t_s = 2μS			1	40		12A	2S 65
	〃 66	日立	AF	〃	−30	−12	−50	100	85	−15	−30				−6	1	−0.984*	30*	< 8*	0.38*	PG > 24dB (f = 1kc)			12A	2S 11 2N215C
	〃 67	〃	PA	〃	−55	−12	−150	350 [illegible]	70	−10	−12	63	−1	−150	−6	1	45	1360	2.1	21	1	45	70	66	2S193 HJ 43

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie}(real)$* (Ω)	外形	備考
★	2SB 68	日立	SW	Ge. A	−105	−50	−100	50	85	−14	−2.5	60	−0.35	−5										84 A	2N398
	〃 69	東芝	PA	Ge. D	−60	−1	−6A	25 W (Tc=25°C)	75	−330	−12	70	−1.5	−1A	−1.5	500					1			102	
	〃 70	松下	AF	Ge. A	−30	−10	−10	125	75	−12	−10				−2	0.5	30	2200	9	23	$f_{\alpha e}$= 15kc			20	OC 70
	〃 71	〃	〃	〃	−30	−10	−10	125	75	−12	−10				−2	3	50	800	5.4	80	$f_{\alpha e}$= 15kc			20	OC 71
	〃 73	日立	LN	〃	−10	−10	−2	20	85	−7	−10				−4	0.5	65	3900	3.8	11.8	NF < 6 dB (f = 1 kc)			12 A	2N220
	〃 74	〃	AF	〃	−16	−0.5	−15	80	85	−6	−12				−6	1	48							12 A	2S148 HJ 62
	〃 75	〃	〃	〃	−25	−12	−100	150	85	−14	−30	65	−1.5	−50	−6	1	55	1750	3	17.5	2			12 A	2SD75之對稱
	〃 75A	〃	〃	〃	−45	−12	−100	150	85	−25	−45	65	−1.5	−50	−6	1	55	1750	3	17.5	2			12 A	
	〃 76	〃	〃	〃	−12	−2.5	−100	150	85	−14	−12	65	−1.5	−50	−6	1	55	1750	3	17.5	2			12 A	2N406
	〃 77	〃	PA	〃	−25	−12	−100	150	85	−14	−25	85	−1	−50	−6	1	70	1900	3.8	26	2			12 C	2SD77之對稱
	〃 77A	〃	〃	〃	−45	−12	−100	150	85	−25	−45	85	−1	−50	−6	1	70	1900	3.8	26	2			12 C	2SD77A之對稱
	〃 78	〃	〃	〃	−12	−2.5	−100	150	85	−14	−12	85	−1.5	−50	−6	1	70							12 A	2N408 HJ 51
★	〃 79	〃	〃	〃	−25	−12	−150	250	85	−16	−30	70	−1	−150										70	2S 91 HJ34A
	〃 80	〃	〃	〃	−25	−10	−1A	4 W (Tc=…)	85	−100	−12	70	−1.5	−0.5A										101	2S177 HJ 36
	〃 81	〃	〃	〃	−80	−12	−0.5A	2 W (Tc=25°C)	85	−50	−50	45	−2	−100	−6	100	40	40	6	1200	0.5	40		101	2S177 HJ 47
	〃 82	〃	〃	〃	−100	−12	−0.5A	2 W (Tc=25°C)	85	−35	−50	40	−2	−100	−6	100	40	40	6	1200	0.5	40		101	2S177 HJ 47
	〃 83	〃	〃	〃	−40	−10	−3A	11 W (Tc=…)	91	−3mA	−40	70	−1.5	−0.7A										103	2N301
	〃 84	〃	〃	〃	−60	−10	−3A	11 W (Tc=…)	91	−3mA	−60	70	−1.5	−0.7A										103	2N301A
★	〃 85	〃	〃	〃	−40	−20	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−3mA	−40	30	−1.5	−4A										103	HS102
★	〃 86	〃	〃	〃	−60	−20	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−3mA	−60	30	−1.5	−4A										103	HS102
★	〃 87	〃	〃	〃	−80	−60	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−3mA	−80	30	−1.5	−4A										103	HS102
★	〃 88	〃	〃	〃	−100	−60	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−3mA	−100	30	−1.5	−4A										103	HS102
	〃 89	〃	〃	〃	−25	−12	−150	250	85	−16	−25	70	−1	−150	−6	1	55	1800	3.3	20				71 A	
	〃 89A	〃	〃	〃	−45	−12	−150	250	85	−50	−45	70	−1	−150	−6	1	55	1800	3.3	20				71 A	
	〃 90	東芝	AF	〃	−18	−12	−5	40	75	−14	−18				−6	1	70	30*	3.5*	0.4*	>1	12		5	
	〃 91	〃	PA	〃	−18	−12	−30	40	75	−14	−18	70	−1	−30	−6	1					>1			5	
	〃 92	松下	〃	〃	−32	−10	−125	125	75	−12	−10	50	−1	I_B= −2mA	−6	10					0.35			16	OC 72
	〃 93	〃	AF	〃	−30		−10	125	75	−12	−20				−2	3	90							20	MC 75
★	〃 94	東芝	PA	〃	−25	−12	−50	150	75	−14	−25	80	−1	−50	−6	1					1	35		12 A	2S 56
	〃 95	〃	〃	〃	−25	−12	−50	150	75	−14	−30	60	−1	−50										12 A	
	2SB 96	松下	PA	Ge. A	−32	−10	−125	125	75	−12	−10	80	−1	I_B= −2mA										16	OC 76
	〃 97	東芝	LN	〃	−18	−12	−5	40	75	−14	−30				−6	1	70	NF = 4 dB (V_{CE}= −3V, I_E= 0.5mA, f = 1 kc)						5	
★	〃 98	日電	AF	〃	−30		−50	125	75	−20	−6	35	−1	−50	−6	1	40	30*	3.5*	0.3*	1	35		84 A	ST340
★	〃 99	〃	AF	〃	−30		−50	125	75	−20	−6	130	−1	−50	−6	1	120	30*	3.5*	0.25*	1.5	35		84 A	ST340
★	〃 100	〃	LN	〃	−30	−10	−50	100	75	−10	−30				−6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	NF = 3.5dB (f = 1 kc)		84 A	2S100 ST34H
★	〃 101	〃	AF. PA	〃	−30	−10	−50	125	75	−10	−30				−6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	35		84 A	2S101 ST34F
★	〃 102	〃	〃	〃	−30	−10	−50	180	75	−10	−30				−6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	35		91	2S102 ST34FR
★	〃 103	〃	〃	〃	−30	−10	−100	125	75	−10	−30	70	−1	−50	−6	1		P_o = 400mW (B級 PP) PG = 25dB (Z_i = 300Ω)			1.2			84 A	2S103 ST34G
★	〃 104	〃	〃	〃	−30	−10	−100	180	75	−10	−30	70	−1	−50	−6	1		P_o = 400mW (B級 PP) PG = 25dB (Z_i = 300Ω)			1.2			91	2S104 ST34GR
★	〃 105	〃	〃	〃	−30	−10	−500	500	75	−100	−30	70	−2	−200	−2	200					0.5			81	2S105 ST35
★	〃 106	〃	〃	〃	−30	−10	−500	3 W ([illegible])	75	−100	−30	70	−2	−200	−2	200					0.5			95	2S106 ST35R
★	〃 107	〃	〃	〃	−30		−2A	10 W (Tc=25°C)	75	−500	−30	70	−2	−1A	−2	200		P_o = 7 W (B級 PP) PG = 30dB (Z_i = 25Ω)			0.4			104	2S107 ST36
★	〃 107A	〃	〃	〃	−60		−3A	20 W (Tc=25°C)	75	−500	−60	70	−2	−1A	−2	200		P_o = 7 W (B級 PP) PG = 30dB (Z_i = 25Ω)			0.4			104	2S107 ST36A
★	〃 108	〃	PA	〃	−40	−10	−500	500	75	−100	−40	70	−2	−200	−2	200					0.5			81	
★	〃 108A	〃	〃	〃	−60	−10	−500	500	75	−100	−60	70	−2	−200	−2	200					0.5			81	
★	〃 108B	〃	〃	〃	−80	−10	−500	500	75	−100	−80	70	−2	−200	−2	200					0.5			81	
★	〃 109	〃	〃	〃	−40	−10	−500	3 W ([illegible])	75	−100	−40	70	−2	−200	−2	200					0.5			95	
★	〃 109A	〃	〃	〃	−60	−10	−500	3 W ([illegible])	75	−100	−60	70	−2	−200	−2	200					0.5			95	
★	〃 109B	〃	〃	〃	−80	−10	−500	3 W ([illegible])	75	−100	−80	70	−2	−200	−2	200					0.5			95	
★	〃 110	〃	AF	〃	−25	−10	−50	100	85	−10	−6				−6	1	30	30*	2.5*	0.5*	1			19 A	ST330
★	〃 111	〃	〃	〃	−25	−10	−50	100	85	−10	−6				−6	1	45	30*	2.5*	0.5*	1			19 A	ST331
★	〃 112	〃	〃	〃	−25	−10	−50	100	85	−10	−6				−6	1	60	30*	2.5*	0.5*	1			19 A	ST332
★	〃 113	〃	〃	〃	−25	−10	−50	100	85	−10	−6				−6	1	80	30*	2.5*	0.5*	1			19 A	ST333
★	〃 114	〃	PA	〃	−25	−10	−50	100	85	−10	−6	65	−1	−20	−6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5			19 A	ST381
★	〃 115	〃	〃	〃	−25	−10	−50	100	85	−10	−6	85	−1	−20	−6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5			19 A	ST382
★	〃 116	〃	〃	〃	−25	−10	−50	100	85	−10	−6	110	−1	−20	−6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5			19 A	ST383
★	〃 117	〃	〃	〃	−25	−10	−50	100	85	−10	−6	140	−1	−20	−6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5			19 A	
	〃 118	松下	〃	〃	−15	−10	−1.5A	50 W (Tc=25°C)	75	−100	−14	60	−7	−0.3A	−7	300					0.2			102	
	〃 119	〃	〃	〃	−32	−10	−1.5A	50 W (Tc=25°C)	75	−100	−14	60	−7	−0.3A	−7	300					0.2			102	OC 19
	〃 120	富士通	AF	〃	−32	−2.5	−20	150	85	−6.5	−12				−12	2	70	PG = 41 dB P_o = 5 mW (A級S)						12 A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)														外形	備考
					V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	形	
	2SB121	富士通	SW	Ge. A	−105	− 50	−100	50	85	− 14	−2.5	60	−0.35	− 5	− 6	1					0.5			12A	
	〃 122	東芝	〃	〃	− 80	− 40	−1.5A	20 W (Tc=25°C)	75	−160	−12	60	−1.5	−1 A	−1.5	500					0.25			102	
	〃 123	〃	〃	〃	− 40	− 30	− 5 A	20 W (Tc=25°C)	75	−1mA	−40										0.25	<300	<40	102	
	〃 124	〃	〃	〃	− 60	− 25	15A	40 W (Tc=25°C)	75	-1.2mA	−12	70	−1.5	−15A	− 6	500					0 3			107	
	〃 125	〃	〃	〃	− 36	− 25	−15A	40 W (Tc=25°C)	75	-1.2mA	−12	70	−1.5	−15A	− 6	500					0.3			107	
	〃 126	松下	PA	〃	− 32	− 10	−3.5A	30W (Tc≤45°C)	90	− 220	−14	35	−1	−1 A	− 6	1 A					f_{ae}= 6 kc			102	OC 26
	〃 127	〃	〃	〃	− 32	− 10	−3.5A	30W (Tc≤45°C)	90	− 220	−14	75	−1	−1 A	− 6	1 A					f_{ae}= 6 kc			102	OC 27
	〃 128	〃	〃	〃	− 80	− 40	− 6 A	30W (Tc≤45°C)	90	− 220	−14	40	− 1	− 1 A										102	OC 28
	〃 128A	〃	〃	〃	−120	− 60	− 6 A	54 W (Tc=25°C)	90	− 200	− 14	50	− 1	−1 A										102	
	〃 129	〃	〃	〃	− 80	− 40	− 6 A	54 W (Tc=25°C)	90	− 200	− 14	85	− 1	−1 A										102	OC 29
★	〃 129A	〃	〃	〃	−120	− 60	− 6 A	54 W (Tc=25°C)	90	− 200	− 14	85	− 1	−1 A										102	
★	〃 130	〃	〃	〃	− 32	− 10	−1.5A	6.5 W (Tc=25°C)	75	− 200	− 14	60	− 7	−0.3	− 7	300					0.2			100	OC 30
	〃 131	富士通	〃	〃	− 40	− 12	−1.5A	65 W (Tc=25°C)	90	−2mA	−30	65	−1.5	− 1A	−14.4	50		PG = 30dB (B級PP Z_l = 24Ω) P_o = 12W			f_{ae}= 5 kc			102	2S131
	〃 131A	〃	〃	〃	− 40	− 12	−1.5A	65 W (Tc=25°C)	90	−2mA	−30	65	−1.5	− 1A							f_{ae}= 5 kc			102	
	〃 132	〃	〃	〃	− 60	− 12	−1.5A	65 W (Tc=25°C)	90	−2mA	−30	65	−1.5	− 1A	−14.4	50		PG = 30dB (B級PP Z_l = 24Ω) P_o = 12W			f_{ae}= 5 kc			102	
	〃 134	三菱	AF. LN	〃	− 30	− 15	−100	100	85	− 10	−25				− 6	1	70	2100	3.2	21	NF = 4 dB (f = 1kHz, I_C = 0.5mA)			12B	
	〃 135	〃	AF	〃	− 30	− 15	−100	100	85	− 10	−25				− 6	1	70	2100	3.2	21				12B	
	〃 136	〃	PA	〃	− 25	− 12	−150	150	85	− 10	−25	120	−1.5	− 50										12B	
★	〃 137	〃	〃	〃	− 30	− 15	−5 A	30 W (Tc=25°C)	85	−500	−20	80	−1.5	− 1 A										103	
★	〃 138	〃	〃	〃	− 60	− 30	−5 A	30 W (Tc=25°C)	85	−500	−30	80	−1.5	− 1 A										103	
	〃 140	SON	〃	〃	− 40	− 12	−1.5A	12 W (Tc=25°C)	85	−600	−40	74	−1.5	− 1 A							f_{ae}= 7 kc	200		103	2T301
	〃 141	〃	〃	〃	− 60	− 12	−1.5A	12 W (Tc=25°C)	85	−600	− 60	74	−1.5	− 1 A							f_{ae}= 7 kc	200		103	2T302
	〃 142	〃	〃	〃	− 30	−12	− 1 A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	− 30	24	−1.5	− 1 A							f_{ae}= 7 kc	200		103	2T303
	〃 143	〃	〃	〃	− 30	−12	− 1 A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	− 30	37	−1.5	− 1 A							f_{ae}= 7 kc	200		103	2T303
	〃 144	〃	〃	〃	− 30	−12	− 1 A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	− 30	75	−1.5	− 1 A							f_{ae}= 7 kc	200		103	2T303
	〃 145	〃	〃	〃	− 30	−12	− 1 A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	− 30	37	−1.5	− 1 A							f_{ae}= 7 kc	200		103	2T304
	〃 146	〃	〃	〃	− 30	−12	− 1 A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	− 30	75	−1.5	− 1 A							f_{ae}= 7 kc	200		103	2T304
	〃 147	〃	〃	〃	− 60	−12	−1.5A	12 W (Tc=25°C)	85	−600	− 50	60	−1.5	−200							f_{ae}= 7 kc	200		103	
	〃 148	東芝	SW	〃	− 80	−25	−15A	40 W (Tc=25°C)	75	−1.2mA	− 12	70	−1.5	−15A	− 6	0.5A					0.3			107	
★	〃 149	〃	〃	〃	− 40	−30	− 8 A	25 W (Tc=25°C)	75	−230	− 12	60	−1.5	− 8 A	−1.5	0.5A					0.25	<400	< 30	102	
★	2SB150	東芝	SW	Ge. A	−105	−50	− 40	50	75	− 50	−105	35	−0.35	− 5	− 6	1					0.5	< 20	<370	12A	2S150
	〃 151	富士通	〃	〃	− 80	−60	− 5 A	50 W (Tc=25°C)	100	−500	− 30	40	−1.5	− 3 A	−1.5	1 A					f_{ae}= 5kc			102	
	〃 152	〃	〃	〃	−100	−60	− 5 A	50 W (Tc=25°C)	100	−500	− 30	40	−1.5	− 3 A	−1.5	1 A					f_{ae}= 5kc			102	
★	152A	〃	〃	〃	−100	−60	− 5 A	50 W (Tc=25°C)	100	−3mA	−100	70	− 1	− 1 A							f_{ae}> 4.5kc			102	
★	〃 153	日立	AF	〃	− 12	−2.5	− 70	150	85	− 14	− 12				− 3	1	70	2200	5	35				12A	
★	〃 154	〃	PA	〃	− 12	−2.5	− 70	150	85	− 14	− 12	70	−1.5	− 50										12A	
	〃 155	〃	AF	〃	− 16	−2.5	−300	150	85	− 14	− 12				− 4	1	30	875	1.66	10.7	1.4			12A	
	〃 156	〃	PA	〃	− 16	−2.5	−300	150	85	− 14	− 12	70	− 1	−150	− 4	1	45	P_o = 600mW PG = 27dB (B級PP Z_l = 66Ω)						12A	
	156A	〃	〃	〃	− 20	− 6	−300	150	85	− 14	− 20	70	− 1	−150	− 4	1	45							12A	
★	〃 157	松下	AF	〃	− 7	− 7	− 5	10	55	− 10	− 2				−0.5	0.25	35				f_{ae}> 10 kc			2 A	OC 57
★	〃 158	〃	〃	〃	− 7	− 7	− 5	10	55	− 10	− 2				−0.5	0.25	55				f_{ae}> 10 kc			2 A	OC 58
★	〃 159	〃	AF	〃	− 7	− 7	− 5	10	55	− 10	− 2				−0.5	0.25	80				f_{ae}> 10 kc			2 A	OC 59
★	〃 160	〃	PA	〃	− 7	− 7	− 5	10	55	− 10	− 2	75	− 2	−0.5										2 A	OC 60
★	〃 161	日電	〃	〃	− 30		−100	125	75	− 10	− 6	50	− 1	− 50	− 6	1					0.65			84 A	2S161 ST341
★	〃 162	〃	〃	〃	− 30		−100	180	75	− 10	− 6	50	− 1	− 50	− 6	1					0.65			91	2S162 ST341R
★	〃 163	〃	〃	〃	− 30		−100	125	75	− 10	− 6	70	− 1	− 50	− 6	1					0.8			84 A	2S163 ST342
★	〃 164	〃	〃	〃	− 30		−100	180	75	− 10	− 6	70	− 1	− 50	− 6	1					0.8			91	2S164 ST342R
★	〃 165	〃	〃	〃	− 30		−100	125	75	− 10	− 6	100	− 1	− 50	− 6	1					1			84 A	2S165 ST343
★	〃 166	〃	〃	〃	− 30		−100	180	75	− 10	− 6	100	− 1	− 50	− 6	1					1			91	2S166 ST343R
	〃 168	富士通	AF	〃	− 9	−2.5	−100	150	85	− 14	− 9				− 3	1	60	1300	4.9	20	0.8			12A	
	〃 169	〃	PA	〃	− 9	−2.5	−100	150	85	− 14	− 9	80	− 1	− 50	− 3	1		PG = 22dB P_o = 100mW (B級PP Z_l = 100Ω)						12A	
★	〃 170	松下	AF	〃	− 30	− 10	−100	125	85	− 12	− 10				− 2	0.5	30	2200	9	23	f_{ae}= 15 kc			12B	OC 70
	〃 171	〃	〃	〃	− 30	− 10	−100	125	85	− 12	− 10				− 2	3	50	800	5.4	80	f_{ae}= 15 kc			12B	OC 71
	〃 172	〃	PA	〃	− 32	− 10	−125	125	85	− 12	− 10	50	− 1	I_B= −2mA	− 6	10					0.35			12B	2SD31之對稱アリ
	〃 173	〃	LN	〃	− 20	− 10	−100	125	85	− 12	− 10				− 2	3	50	800	5.4	80	NF = 3 dB (V_{CE}= −2V, I_E=0.5mA)			4	2S 74
	〃 174	〃	PA	〃	− 20	− 6	−300	225	75	− 20	− 12	65	−0.5	−300	− 6	50					1.5			12B	OC 74
	〃 175	〃	AF	〃	− 30	− 10	−100	125	85	− 12	− 10				− 2	3	100	1300	8	125				12B	OC 75
	〃 176	〃	PA	〃	− 32	− 10	−125	125	85	− 12	− 10	90	− 1	I_B= −2mA										12B	2SD32之對稱アリ
★	〃 177	〃	〃	〃	− 60	− 10	−125	125	85	− 12	− 10	90	− 1	I_B= −2mA										12B	OC 77
	〃 178	〃	〃	〃	− 20	− 6	−300	225	85	− 20	− 12	56	V_{CB}=0V	−300										17	2SD178之對稱アリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μΩ)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ (Ω)	外形	備考
2SB178A	松下	PA	Ge. A	−40	−6	−320	225	85	−20	−12	56	V_{CB}=0V	−300										17	
〃179	東芝	AF	〃	−25	−12	−50	80	75	−14	−30				−6	1	50							12A	2S179
〃180	富士通	PA	〃	−40	−12	−0.5A	5.5 W (T_c=25°C)	92	−1mA	−40	70	−1.5	−500	−12	15		PG = 26dB (B級PP, P_o = 4W, Z_l = 60Ω)						83	
★ 〃180A	〃	〃	〃	−40	−12	−0.5A	12 W (T_c=25°C)	90	−500	−30	70	−1.5	−500							f_{ae} = 13kc			83	
〃181	〃	〃	〃	−60	−12	−0.5A	5.5 W (T_c=25°C)	92	−1mA	−60	70	−1.5	−500	−12	15		PG = 28dB (B級PP, P_o = 4W, Z_l = 60Ω)						83	
★ 〃181A	〃	〃	〃	−60	−12	−0.5A	12 W (T_c=25°C)	90	−200	−30	70	−1.5	−500							f_{ae} = 13kc			83	
〃183	日立	AF	〃	−12	−2.5	−20	50	85	−12	−12				−0.5	0.25	55							3	
〃184	〃	PA	〃	−12	−2.5	−20	50	85	−12	−12	100	−2	−5										3	
〃185	三洋	〃	〃	−25	−12	−150	200	85	−15	−20				−6	1	45	2000	5	20	1			12A	
〃186	〃	〃	〃	−25	−12	−150	200	85	−15	−20				−6	1	120	6000	13	40	1	25		12A	
〃187	〃	〃	〃	−25	−12	−150	200	85	−15	−20				−6	1					1			12A	2SD187之對稱
〃188	〃	〃	〃	−25	−12	−150	200	85	−15	−20				−6	1	20				1			12A	2S188
〃189	東芝	〃	〃	−25	−12	−250	250	75	−14	−25	75	−1	−100	−6	1					1			62	2S189
〃190	沖	AF	〃	−25	−12	−50	90	80	−15	−25				−6	1	150	PG = 45 dB (f = 1 kc)						12A	
〃191	〃	〃	〃	−25	−12	−50	90	80	−15	−25				−6	1	70	PG = 43 dB (f = 1 kc)						12A	
〃192	〃	〃	〃	−25	−12	−50	90	80	−15	−25				−6	1	35	PG = 41 dB (f = 1 kc)						12A	
〃193	〃	〃	〃	−25	−12	−100	200	80	−15	−25				−6	1	150	PG = 45 dB (f = 1 kc)						75	
〃194	〃	〃	〃	−25	−12	−100	200	80	−15	−25				−6	1	70	PG = 43 dB (f = 1 kc)						75	
〃195	〃	〃	〃	−25	−12	−100	200	80	−15	−25				−6	1	35	PG = 41 dB (f = 1 kc)						75	
〃196	〃	〃	〃	−30	−12	−500	500	80	−100	−30	50	−2	−200										82	
〃197	〃	〃	〃	−50	−12	−500	500	80	−100	−50	50	−2	−200										82	
〃198	沖	〃	〃	−70	−12	−500	500	80	−100	−70	50	−2	−200										82	
〃199	富士通	PA	〃	−12	−2.5	−300	250	85	−14	−12	80	−1	−150	−3	1		PG = 22dB (B級PP, P_o = 250mW, Z_l = 50Ω)						71A	
★ 〃200	東芝	〃	〃	−32	−12	−400	225	75	−40	−12	75	−1	−150	−1	100					0.5			77	
★ 〃201	〃	SW	〃	−35	−12	−400	300	75	−30	−12	150	−1	−150	−1	100		t_r = 0.6μS, t_f = 0.7μS, t_s = 5μS			0.5			84A	
★ 〃202	〃	PA	〃	−32	−12	−400	225	75	−40	−12	140	−1	−150	−1	100					0.5			77	
〃203	新電元	〃	〃	−40	−40	−20A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−40	40	−1.5	−15A										105	L10
〃204	〃	〃	〃	−40	−40	−30A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−40	100	−1.5	−15A										105	
〃205	〃	〃	〃	−80	−40	−20A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−80	40	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} = 2.5kc			105	H10
〃206	〃	〃	〃	−80	−40	−30A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−80	100	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} = 2.5kc			105	
2SB207	新電元	PA	Ge. A	−100	−40	−20A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−100	40	−1.5	−15A										105	
〃208	〃	〃	〃	−100	−40	−30A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−100	100	−1.5	−15A										105	
〃209	〃	〃	〃	−40	−40	−20A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−40	40	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} = 2.5kc			105	L15A
〃210	〃	SW	〃	−40	−40	−30A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−40	100	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} = 2.5kc			105	L15B
〃211	〃	〃	〃	−80	−40	−20A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−80	40	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} = 2.5kc			105	H15A
〃212	〃	〃	〃	−80	−40	−30A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−80	100	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} = 2.5kc			105	H15B
〃213	〃	〃	〃	−100	−40	−20A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−100	40	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} = 2.5kc			105	U15A
〃214	〃	〃	〃	−100	−40	−30A	80 W (T_c=25°C)	85	−5mA	−100	100	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} = 2.5kc			105	U15B
〃215	三洋	〃	〃	−100	−20	−3A	24 W (T_c=25°C)	85	−500	−12	100	−1.5	−1A	−3	100					<0.15	<400	<50	102	
〃216	〃	PA	〃	−60	−10	−3A	24 W (T_c=25°C)	85	−500	−12	80	−1.5	−200	−1.5	200					0.25			102	
〃217	〃	PA	〃	−25	−10	−3A	24 W (T_c=25°C)	85	−500	−12	80	−1.5	−1A	−1.5	200					0.5			102	
★ 〃218	日電	SW	〃	−80	−20	−100	225	85	−10	−50	50	−1	−100	−5	1					2.5	<30	<200	84A	
★ 〃219	〃	PA	〃	−30	−10	−200	225	85	−16	−25	31	−1	−20	−6	1		30*			1.5	25		84A	2SD19之對稱
★ 〃219A	〃	〃	〃	−30	−10	−500	225	85	−16	−25	31	−1	−20	−5	1					1.5			84A	2SD20之對稱
★ 〃220	〃	〃	〃	−30	−10	−200	225	85	−16	−25	50	−1	−20	−6	1		30*			2	25		84A	2SD21之對稱
★ 〃220A	〃	〃	〃	−30	−10	−500	225	85	−16	−25	50	−1	−20	−5	1					2			84A	2SD22之對稱
★ 〃221	〃	〃	〃	−30	−10	−200	225	85	−16	−25	72	−1	−20	−6	1		30*			2	25		84A	2SD23之對稱
★ 〃221A	〃	〃	〃	−30	−10	−500	225	85	−16	−25	72	−1	−20	−5	1					2.5			84A	
★ 〃222	〃	〃	〃	−30	−10	−200	225	85	−16	−25	97	−1	−20	−6	1		30*			2.5	25		84A	
★ 〃222A	〃	〃	〃	−30	−10	−500	225	85	−16	−25	97	−1	−20	−5	1					2.8			84A	
★ 〃223	〃	〃	〃	−30	−10	−200	225	85	−16	−25	150	−1	−20	−6	1		30*			3.0	25		84A	
★ 〃223A	〃	PA	Ge. A	−30	−10	−500	225	85	−16	−25	150	−1	−20	−5	1					3			84A	
★ 〃224	〃	〃	〃	−45	−15	−500	225	85	−10	−30	35	−1	−20	−5	1	30	31*	4*	0.65*	2	25		84A	2N524
★ 〃225	〃	〃	〃	−45	−15	−500	225	85	−10	−30	52	−1	−20	−5	1	44	31*	5*	0.6*	2.5	25		84A	2N525
★ 〃226	〃	〃	〃	−45	−15	−500	225	85	−10	−30	73	−1	−20	−5	1	64	30*	6.5*	0.42*	3	25		84A	2N526
★ 〃227	〃	〃	〃	−45	−15	−500	225	85	−10	−30	91	−1	−20	−5	1	81	29*	8*	0.37*	3.3	25		84A	2N527
〃228	日立	〃	〃	−80	−50	−5A	50 W (T_c=25°C)	91	−5mA	−80	28	−1.5	−4A										103	
★ 〃229	〃	〃	〃	−100	−50	−5A	50 W (T_c=25°C)	91	−5mA	−100	28	−1.5	−4A										103	
〃230	〃	〃	〃	−120	−50	−5A	50 W (T_c=25°C)	91	−5mA	−120	28	−1.5	−4A										103	
〃231	東芝	SW	Ge. D	−120	−1	−6A	25 W (T_c=25°C)	75	−5mA	−120	50	−1.5	−5A										102	

2SB

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB232	松下	PA	Ge. D	−130	−0.5	−6A	54 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	60	−1	−200										102	
★	〃 233	〃	〃	〃	−130	−0.5	−6A	54 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	150	−1	−200										102	
★	〃 234	〃	SW	〃	−180	−1.3	−6A	54 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	25	−1	−6A										102	
★	〃 235	東芝	〃	Ge. A	−80	−25	−15A	60 W (Tc=25°C)	85	−1.2mA	−12	60	−2	−5A	−6	0.5A					0.3			109	
★	〃 236	〃	〃	〃	−60	−25	−15A	60 W (Tc=25°C)	85	−1.2mA	−12	60	−2	−5A	−6	0.5A					0.3			109	
★	〃 237	〃	〃	〃	−36	−25	−15A	60 W (Tc=25°C)	85	−1.2mA	−12	60	−2	−5A	−6	0.5A					0.3			109	
★	〃 238	日電	PA	〃	−40	−15	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−100	−40	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 239	〃	SW	〃	−80	−30	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−100	−80	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 239A	〃	〃	〃	−100	−30	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−100	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 240	〃	PA	〃	−40	−15	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−40	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 240A	〃	〃	〃	−60	−30	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−60	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 241	〃	SW	〃	−80	−30	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−80	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 241A	〃	〃	〃	−100	−30	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−100	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 242	〃	PA	〃	−30	−15	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−30	40	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 242A	〃	〃	〃	−60	−20	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−60	40	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 243	〃	〃	〃	−30	−15	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−30	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 243A	〃	〃	〃	−60	−20	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−60	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 244	〃	SW	〃	−80	−30	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−80	40	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 245	〃	〃	〃	−80	−30	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−80	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 246	〃	PA	〃	−40	−20	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−500	−40	60	−1.5	−2A	−1.5	200					>0.2			102	
★	〃 247	〃	SW	〃	−60	−20	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−500	−60	60	−1.5	−2A	−1.5	200					>0.2			104	
★	〃 248	〃	PA	〃	−40	−20	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−40	60	−1.5	−2A	−1.5	200					>0.2			102	
★	〃 248A	〃	〃	〃	−60	−20	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−60	60	−1.5	−2A	−1.5	200					>0.2			102	
★	〃 249	〃	SW	〃	−80	−40	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−80	60	−1.5	−2A	−2	200					>0.2			102	
★	〃 250	〃	PA	〃	−30	−20	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−30	40	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 250A	〃	〃	〃	−60	−20	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−60	40	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 251	〃	〃	〃	−30	−20	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−30	60	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 251A	〃	〃	〃	−60	−20	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−60	60	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 252	〃	SW	〃	−80	−40	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−80	40	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 252A	〃	〃	〃	−120	−40	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−120	40	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	2SB253	日電	SW	Ge. A	−80	−40	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−80	60	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 253A	〃	〃	〃	−120	−40	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−120	60	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
	〃 254	三洋	PA	〃	−35	−12	−1A	12 W (Tc=25°C)	85	−200	−25	100	−1.5	−200	−1.5	200					0.7			10'	
	〃 255	〃	〃	〃	−35	−12	−1A	4.8 W (Tc=25°C)	85	−500	−25	50	−1.5	−200	−1.5	200					0.4			101	
	〃 256	〃	〃	〃	−25	−12	−1A	12 W (Tc=25°C)	85	−200	−25	100	−1.5	−200	−1.5	200					0.7			101	
★	〃 257	東芝	LN	〃	−18	−12	−5	60	75	−3	−12				−6	1	125	2500	5	4.5	NF = 5 dB (V_{CE} = −3V, I_E = 0.5mA)			12 A	
	〃 258	〃	PA	Ge. D	−120	−1	−15A	60 W (Tc=25°C)	75	−3.5mA	−12	60	−1.5	−15A	−6	500					1.5			109	
	〃 259	〃	〃	〃	−80	−1	−15A	60 W (Tc=25°C)	75	−3.5mA	−12	60	−1.5	−15A	−6	500					1.5			109	
	〃 260	〃	〃	〃	−50	−1	−15A	60 W (Tc=25°C)	75	−3.5mA	−12	60	−1.5	−15A	−6	500					1.5			109	
	〃 261	富士通	AF	Ge. A	−20	−2.5	−30	65	85	−12	−12				−6	1	45	2000	6	20	2.5			4	
	〃 262	〃	PA	〃	−20	−2.5	−30	65	85	−12	−12	60	−1.5	−30	−6	115	90	3000	6	30	3			4	2SD162之対称
	〃 263	〃	〃	〃	−20	−2.5	−150	200	85	−14	−12	65	−1	−150	−6	1	60	1650	4.3	19	1.5			12 A	
★	〃 264	日電	LN	〃	−30	−10	−50	100	75	−5	−6				−1.5	0.5	70	57*	4*	1.5*	NF = 3 dB (V_{CE} = −1.5V, I_E = 0.5mA)			19 A	
★	〃 265	東芝	SW	〃	−40	−12	−100	170	75	−10	−12	62	−1	−100	−6	1		t_r=2.5μS, t_f=1.4μS, t_s=1.4μS			1.3	30	140	84 A	
	〃 266	八欧	AF	〃	−25		−150	150	85	−10	−12				−6	1	67	1800	3.7	23				12 A	
	〃 267	〃	PA	〃	−25		−150	150	85	−10	−12	70	−1	−150										12 A	
★	〃 268	三菱	〃	〃	−30		−150	250	85	−14	−25	75	−1	−150										71 A	
	〃 269	八欧	LN	〃	−25		−150	150	85	−10	−15				−6	1	67	2000	4	23	NF = 4 dB (V_{CE} = −2V, I_E = 0.5mA)			12 A	
	〃 270	三洋	AF	〃	−12	−5		150	85	−15	−6				−6	1	80	3000	8	35				12 A	
	〃 271	〃	PA	〃	−25	−10	−500	720 (Tc=25°C)	85	−60	−12	80	−1.5	−0.1A	−1.5	100					0.5			12 A	
	〃 272	〃	〃	〃	−25	−10	−500	720 (Tc=25°C)	85	−60	−12	100	−6	−0.1A	−1.5	100					0.8			12 A	
	〃 273	〃	〃	〃	−35	−10	−500	720 (Tc=25°C)	85	−60	−12	100	−6	−0.1A	−1.5	100					0.8			12 A	
★	〃 274	日立	〃	Ge. D	−80	−1.5	−6A	50 W (Tc=25°C)	91	−5mA	−80	30	−1.5	−4A	−1.5	500					1		3.5	103	
★	〃 275	〃	SW	〃	−120	−1.5	−6A	50 W (Tc=25°C)	91	−5mA	−120	40	−1.5	−4A	−1.5	500					1		3.5	103	
★	〃 276	〃	〃	〃	−120	−1.5	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−5mA	−120	35	−1.2	−10A	−1.5	500					1		3.5	103	
	〃 277	松下	LN	〃	−15		−5	80	75	−12	−2				−6	1	100	2800	3.8	35	NF = 5 dB			20	
★	〃 278	〃	AF	Si. A	−25	−20	−50	250	150	−0.1	−10				−6	1	28	1300	1.8	13	1			16	
★	〃 279	〃	〃	〃	−25	−20	−50	250	150	−0.1	−10				−6	1	50	2100	2.4	17	1			16	
★	〃 280	〃	〃	〃	−32	−12	−250	300	150	−0.1	−10	24	−2	−30	−6	1	25	800	1.1	10	1.5*			16	
★	〃 281	〃	〃	〃	−60	−12	−250	300	150	−0.1	−10	24	−2	−30	−6	1	40	1400	1.7	18	1.5*			16	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB282	松下	SW	Ge. A	−80	−40	−6A	30 W (Tc=25°C)	90	−100	−0.5	21	−1	−6A	−6	1 A					0.25	160		103	
★	〃 283	〃	〃	〃	−60	−20	−6A	30 W (Tc=25°C)	90	−100	−0.5	53	−1	−6A	−6	1 A					0.25	160		103	
★	〃 284	〃	〃	〃	−60	−20	−6A	30 W (Tc=25°C)	90	−100	−0.5	30	−1	−6A	−6	1 A					0.25	160		103	
★	〃 285	〃	〃	〃	−80	−40	−6A	30 W (Tc=25°C)	90	−100	−0.5	36	−1	−6A	−6	1 A					0.25	160		103	
★	〃 286	〃	〃	Ge. D	−80	−0.5	−6A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	17	−1	−6A										103	
★	〃 287	〃	〃	〃	−80	−1.3	−6A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	36	−1	−6A										103	
★	〃 288	〃	〃	Ge. A	−32	−10	−125	125	75	−10	−10	50	−0.7	−125										12 A	
★	〃 289	〃	〃	〃	−60	−10	−125	125	75	−10	−10	50	−0.7	−125										12 A	
★	〃 290	東芝	LN	〃	−18	−12	−40	65	75	−4	−12				−3	0.5	110	3500	6	20	5	9.5		84 A	
★	〃 291	〃	AF	〃	−30	−12	−150	150	75	−10	−12	70	−1	−50	−6	1	100	4200	6	30	1	35		84 A	
★	〃 292	〃	PA	〃	−30	−12	−150	150	75	−10	−12	80	−1	−50	−6	1	100	4200	6	30	1	35		84 A	
★	〃 292A	〃	〃	〃	−60	−12	−150	150	75	−10	−12	80	−1	−50										84 A	
	〃 293	八欧	〃	〃	−18		−250	150	85	−10	−12	70	−1	−150										12 B	
	〃 294	〃	AF	〃	−18		−250	150	85	−10	−12				−4	1	36	1000	2.9	18				12 B	
	〃 295	富士通	SW	〃	−100	−40	−5A	40 W (Tc=25°C)	85	−3mA	−100	70	−1	−1A	−1	1 A					f_{ae}= 4.5 kc			102	
★	〃 296	東芝	〃	Ge. D	−130	−3	−10A	35 W (Tc=25°C)	75	−1mA	−50	35	−1.5	−10A										102	
	〃 297																								
	〃 298																								
	〃 299	八欧	SW	Ge. A	−30	−25	−150	150	85	−10	−12	65	−1	−150										12 B	
	〃 300	東芝	PA	Ge. D	−100	−1	−10A	35 W (Tc=25°C)	75	−330	−12	60	−1.5	−5A										102	
	〃 301	〃	〃	〃	−60	−1	−10A	35 W (Tc=25°C)	75	−330	−12	60	−1.5	−5A										102	
	〃 302	日立	LN	Ge. A	−10	−5	−2	40	85	−6	−10				−4	0.5	80	4500	4	26	NF = 4 dB (f = 1 kc)			12 B	
	〃 303	三洋	LN AF	〃	−25	−12	−20	100	75	−15	−15				−2	0.5	180	12KΩ	30	50	NF = 3.5dB (V_{CE} = −6V, I_E = 1mA)			12 B	
	〃 304	富士通	SW	〃	−30	−10	−500	225	70	−15	−30	70	−1	−50										84 C	
	〃 304A	〃	〃	〃	−45	−15	−500	225	70	−10	−35	70	−1	−50										84 B	
★	〃 305																								
★	〃 306	東芝	SW	Ge. A	−100	−50	−20	75	75	−10	−105	60	−0.35	−2										84 A	
	〃 307																								
	〃 308																								
★	〃 309	松下	PA	Ge. DB	−75	−1	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−200	−0.5	62	V_{CB}= 0V	I_E= 1 A	−4	1 A					f_{ae}= 17 kc			102	
★	2SB310	松下	SW	Ge. DB	−140	−1	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−0.5	62	V_{CB}= 0V	I_E= 1 A	−4	1 A					f_{ae}= 17 kc			103	
★	〃 311	〃	〃	〃	−180	−1	−10A	50 W (Tc=25°C)	90	−220	−0.5	62	V_{CB}= 0V	I_E= 1 A	−4	1 A					f_{ae}= 17 kc			103	
★	〃 312	〃	〃	〃	−140	−1	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−0.5	27	V_{CB}= 0V	−8A										103	
	〃 313	〃	〃	〃	−180	−1	−10A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−0.5	27	V_{CB}= 0V	−8A										103	
	〃 314	沖	PA	Ge. A	−30		−500	3 W	80	−100	−30	45	−2	−200										96	
★	〃 315	三菱	AF	〃	−16		−300	150	85	−14	−12				−3	1	50	1100	1.5	20				12 A	
★	〃 316	〃	PA	〃	−16		−300	150	85	−14	−12	60	−1	−150										12 A	
★	〃 317	〃	〃	〃	−16		−300	250	85	−14	−12	60	−1	−150										71 A	
	〃 318	富士通	〃	Ge. D	−60	−1	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−1mA	−40	100	−2	−1A	−5	500					2*			102	
	〃 319	〃	SW	〃	−100	−1	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−1mA	−40	100	−2	−1A	−5	500					3*			102	
	〃 320	〃	〃	〃	−100	−2	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−1mA	−40	100	−2	−1A	−5	500	t_r = 1.6μS, t_f = 1 μS, t_s = 1.3 μS				2*			102	
	〃 321	東芝	LN	Ge. A	−12	−12	−50	40	75	−4	−12				−1.5	0.5	100	4000	6	20	NF = 3 dB (V_{CE} = −3V, I_E = 0.5mA)			1	
	〃 322	〃	AF	〃	−12	−12	−50	40	75	−4	−12				−1.5	0.5	50	3000	5	19				1	
	〃 323	〃	〃	〃	−12	−12	−50	40	75	−4	−12				−1.5	0.5	100	4000	6	20				1	
	〃 324	松下	PA	〃	−32	−10	−1A	200	90	−10	−10	53	V_{CB}= 0V	−0.3A	−2	10					f_{ae} > 10 kc			12 A	
	〃 325	富士通	SW	〃	−120	−50	−0.6A	1.8 W (Tc=25°C)	85	−20	−5	50	−2	−50										93	
★	〃 326	日電	PA	〃	−30	−15	−500	225	85	−10	−30	65	−1	−20	−5	1					3			84 A	
★	〃 327	〃	〃	〃	−30	−15	−500	225	85	−10	−30	110	−1	−20	−5	1					3.3			84 A	
★	〃 328	〃	〃	〃	−25	−10	−200	150	85	−10	−15	70	−1	−20	−6	1					2			19 A	
★	〃 329	〃	〃	〃	−25	−10	−200	150	85	−10	−15	100	−1	−20	−6	1					2			19 A	
★	〃 330	〃	SW	〃	−110	−50	−150	225	85	−20	−50	35	−1	−20	−5	1					0.5			84 A	
	2SB331	日立	〃	〃	−40	−20	−15A	80 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−40	70	−2	−5A										109	
	〃 332	〃	〃	〃	−60	−40	−15A	80 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−60	60	−2	−5A										109	
	〃 333	〃	〃	〃	−80	−40	−15A	80 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−80	60	−2	−5A										109	
	〃 334	〃	〃	〃	−100	−60	−15A	80 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−100	40	−2	−5A										109	
★	〃 335	松下	AF	〃	−20	−10	−60	83	75	−10	−10	36~110	−1	I_B= −250μA	−6	1	70	2800	2.6	10				4	
★	〃 336	〃	PA	〃	−20	−10	−60	83	75	−10	−10	80	−1	−60										4	
	〃 337	日立	〃	〃	−40	−10	−7A	30 W (Tc=25°C)	100	−1mA	−30	90	−2	−1A	−2	1 A					0.3			103	
	〃 338	〃	〃	〃	−60	−10	−7A	50 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−30	75	−4	−1A										103	
	〃 339	〃	〃	〃	−80	−50	−10A	50 W (Tc=25°C)	90	−250	−30	75	−4	−1A	−4	1 A					0.25			103	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測量情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SB340	日立	PA. SW	Ge. A	−100	−50	−10A	50 W (Tc=25°C)	90	−250	−30	35	−1	−8A	−4	1 A					0.25			103	
	〃 341	〃	〃	〃	−120	−50	−10A	50 W (Tc=25°C)	90	−250	−30	35	−1	−8A										103	
	〃 342	三洋	〃	Ge. D	−120	−1	−6A	30 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−120	50	−1.5	−5A	−1.5	500					1.5			103	
	〃 343	〃	〃	〃	−150	−1	−6A	30 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−150	50	−1.5	−5A	−1.5	500					1.5			103	
	〃 344																								
	〃 345	松下	AF	Ge. A	−32	−10	−100	165	85	−10	−10				−5	2	90	1700	6.5	80	f_{ae} = 17 kc			12A	
	〃 346	〃	〃	〃	−32	−10	−100	165	85	−10	−10				−5	2	120	2400	8	100	f_{ae} = 17 kc			12A	
	〃 347	〃	LN	〃	−32	−10	−100	165	85	−10	−10				−5	2	90	1700	6.5	80	f_{ae} = 17 kc	NF = 3dB (I_E = 0.5mA)		12A	
	〃 348	〃	〃	〃	−32	−10	−100	165	75	−10	−10				−5	2	120	2400	8	100	f_{ae} = 17 kc	NF = 3dB (I_E = 0.5mA)		12A	
	〃 349	三洋	AF	〃	−20		−10	50	75	−20	−10	150	−1.5	−10										12A	
	〃 350	〃	PA	〃	−25		−50	50	75	−20	−10	100	−1.5	−30										12A	
	〃 351	富士通	SW	〃	−40	−20	−15A	70 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−40	70	−2	−5A										109	
	〃 352	〃	〃	〃	−60	−40	−15A	70 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−60	70	−2	−5A										109	
	〃 353	〃	〃	〃	−80	−40	−15A	70 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−80	70	−2	−5A										109	
	〃 354	〃	〃	〃	−100	−60	−15A	70 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−100	70	−2	−5A										109	
	〃 355	三菱	PA	〃	−25	−12	−1A	4 W (Tc=25°C)	85	−100	−12	60	−1.5	−0.5A										101	
★	〃 356	〃	〃	〃	−80	−12	−1A	4 W (Tc=25°C)	85	−50	−50	50	−1.5	−0.5A										101	
★	〃 357	〃	〃	〃	−100	−12	−1A	3 W (Tc=25°C)	85	−50	−50	40	−1.5	−0.5A										101	
★	〃 358	〃	〃	Ge. D	−80	−1.5	−6A	50 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	30	−1.5	−4A	1.5	200					2			103	
★	〃 359	〃	SW	〃	−120	−1.5	−10A	50 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	25	−1.5	−4A	1.5	200								103	
★	〃 360	〃	〃	〃	−180	−1.5	−10A	50 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	30	−1.5	−4A	1.5	200					2			103	
★	〃 361	日立	PA	Ge. DB	−80	−1	−5A	40 W (Tc=25°C)	100	−500	−40	110	−2	−1A	−5	0.7A					f_{ae} = 50 kc			103	
★	〃 362	〃	〃	〃	−100	−1	−7A	50 W (Tc=25°C)	90	−500	−30	75	−2	−5A	−5	0.7A					f_{ae} = 50 kc			103	
★	〃 363	日電	SW	Ge. D	−140	−1	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−10mA	−140	50	−1.5	−5A										102	
	〃 364	東芝	PA	Ge. A	−20	−12	−400	150	75	−14	−20	60~150	−0.5	−100	−6	1					1			12A	
	〃 365	〃	〃	〃	−20	−12	−400	150	75	−14	−20	35~190	−0.5	−100	−6	1					1			12A	
	〃 366	〃	SW	Ge. D	−140	−1	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−330	−12	50	−1.5	−5A										102	
	〃 367	日立	PA	Ge. A	−25	−12	−1A	6.6W (Tc=25°C)	85	−100	−12	90	−1.5	−0.5A										100	
	〃 368	〃	〃	〃	−45	−12	−1A	6.8W (Tc=25°C)	85	−100	−12	90	−1.5	−0.5A										100	
	〃 369																								
	2SB370	日立	PA	Ge. A	−25	−12	−500	200	85	−20	−12	150	−1	−150	−6	1	110							12A	
	〃 370A	〃	〃	〃	−32	−12	−500	200	85	−20	−12	150	−1	−150	−6	1	110							12A	
★	〃 371	松下	〃	〃	−32	−10	−200	165	75	−15	−10	790	V_{CB} = 0V	−1A	−2	10					f_{ae} > 10 kc			12A	
	〃 372	三洋	〃	〃	−25	−10	−1A	1.5 W (Tc=25°C)	85	−50	−20													84B	
	〃 373	〃	〃	〃	−25	−10	−1A	1.5 W (Tc=25°C)	85	−50	−20	150	−1.5	−200	−1.5	200						0.7		84B	
	〃 374	〃	〃	〃	−60	−10	−1A	1.5 W (Tc=25°C)	85	−50	−20	150	−1.5	−200										84B	
	〃 375	〃	SW	Ge. D	−135	−3	−9A	30 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−150	50	−1.5	−8A	−1.5	500						1 5		103	
★	〃 376	松下	PA	Ge. A	−20	−6	−300	225	75	−20	−12	50	−0.5	−300										17	
	〃 377	SON	LN	〃	−32		−150	270	85	−10	−32				−6	0.5	134	53*	5*	0.3*	NF = 2dB (f = 1kc)			84A	
	〃 378	〃	AF. PA	〃	−18		−150	180	65	−10	−18	42	−1	−20	−6	1	34	27*	3.5*	0.5*	2.5	25		84A	
	〃 378A	〃	〃	〃	−23		−300	270	85	−10	−23	42	−1	−20	−6	1	34	27*	3.5*	0.5*	2.5	25		84A	
	〃 378B	〃	〃	〃	−23		−500	270	85	−10	−23	42	−1	−20	−6	1	34	27*	3.5*	0.5*	2.5	25		84A	
	〃 379	〃	〃	〃	−18		−150	180	65	−10	−18	84	−1	−20	−6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25		84A	
	〃 379A	〃	〃	〃	−23		−300	270	85	−10	−23	84	−1	−20	−6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25		84A	
	〃 379B	〃	〃	〃	−23		−500	270	85	−10	−23	84	−1	−20	−6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25		84A	
	〃 380	〃	〃	〃	−18		−150	180	65	−10	−18	169	−1	−20	−6	1	136	27*	5*	0.3*	3.5	25		84A	
	〃 380A	〃	〃	〃	−23		−300	270	85	−10	−23	169	−1	−20	−6	1	136	27*	5*	0.3*	3.5	25		84A	
	〃 381	〃	〃	〃	−32		−300	270	85	−10	−32	42	−1	−20	−6	1	34	27*	3.6*	0.5*	2.5	25		84A	
	〃 382	〃	〃	〃	−32		−300	270	85	−10	−32	84	−1	−20	−6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25		84A	
	〃 383	〃	PA	〃	−32		−500	270	85	−10	−32	84	−1	−20	−6	1					3	25		84A	
	〃 384	八欧	AF	〃	−20		−30	80	85	−10	−12				−6	1	60	1600	3.5	2.3				12A	
	〃 385	〃	PA	〃	−20		−30	80	85	−10	−12	50	−1	−50										12A	
★	〃 386	三菱	SW	〃	−30	−15	−300	150	85	−10		80	−0.5	−50										12A	
	〃 387	日立	AF	〃	−12	−2.5	−20	30	85	−10	−12				−0.5	0.25	55	6000	4.5	21	4			2B	
	〃 388																								
	〃 389	富士通	LN	Ge. A	−12	−0.5	−10	80	85	−6	−12				−4	0.5	100	8000	15	25	NF = 3dB (f = 1kc)			12A	
	〃 390	三洋	PA. SW	Ge. D	−80	−1	−6A	30 W (Tc=25°C)	85	−200	−15	50	−1.5	−3A	−1.5	−500						1.5		103	
	〃 391	〃	〃	〃	−50	−1	−6A	30 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−50	75	−1.5	−3A	−1.5	−500						1.5		103	
	〃 392	沖	AF. SW	Ge. A	−20	−13	−200	200	85	−7	−12	75	−0.5	−10	−5	1	90	30*	8*	0.3*				84B	
	〃 393	〃	〃	〃	−28	−13	−200	200	85	−7	−12	38	−0.5	−10	−5	1	45	30*	8*	0.3*				84B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB} (V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE} (V)	I_C (mA)	偏置情況 V_{CB} (V)	I_E (mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SB394	沖	AF. SW	Ge. A	−28	−13	−200	200	85	−7	−12	75	−0.5	−10	−5	1	90	30*	8*	0.3*				84B	
	〃 395	〃	〃	〃	−28	−13	−200	200	85	−7	−12	150	−0.5	−10	−5	1	180	30*	8*	0.3*				84B	
	〃 396	〃	〃	〃	−40	−13	−200	150	85	−7	−12	75	−0.5	−10	−5	1	90	30*	8*	0.3*				84B	
★	〃 397	〃	SW	〃	−48	−15	−80	200	85	−10	−12	45	−0.5	−5										84B	
★	〃 398	〃	〃	〃	−110	−30	−80	200	85	−15	−100	45	−0.5	−5										84B	
★	〃 399	〃	〃	〃	−110	−30	−80	200	85	−15	−100	25	−0.5	−20										84B	
	〃 400	三洋	LN	〃	−20	−10	−40	100	85	−15	−10				−6	1	100	3000	8	35	1	25		12A	
★	〃 401	松下	SW	Ge. A	−40	−10	−300	240	85	−10	−10	60	−0.5	−300	−5	10					>0.3*			84A	
★	〃 402	〃	〃	〃	−60	−10	−300	240	85	−10	−10	60	−0.5	−300	−5	10					>0.3*			84A	
★	〃 403	〃	〃	〃	−40	−20	−300	240	85	−10	−10	100	−0.5	−300	−5	10					>0.7*			84A	
	〃 404	三洋	〃	〃	−100	−40	−100	100	85	−20	−100	100	−1.5	−30										84B	
	〃 405	〃	PA	〃	−25		−1A	720 (Tc=25°C)	85	−50	−20	100	−1.5	−200							0.7			12A	2SB172之對稱
	〃 406	〃	SW	Ge. D	−200	−2	−10A	37.5W (Tc=25°C)	100	−250	−30	35	−1.5	−8A	−2	500					0.7			102	
	〃 407	〃	PA	Ge. A	−30	−10	−7A	30 W (Tc=25°C)	85	−500	−30	80	−1.5	−1A	−1.5	500					0.35*			103	
	〃 408	〃	〃	〃	−25	−12	−200	300	85	−15	−20	175	−1.5	−100	−1.5	30							<150	12B	
	〃 409	〃	AF	〃	−12		−50	150	75	−15	−6				−6	1	80	3000	8	35				12B	
	〃 410	〃	PA. SW	Ge. DB	−135	−5	−15A	40 W (Tc=25°C)	85	−250	−30	50	−1.5	−8A	−1.5	−500					3*			103	
	〃 411	〃	〃	〃	−200	−5	−11A	40 W (Tc=25°C)	85	−250	−30	40	−1.5	−8A	−1.5	−500					2.5*			103	
	〃 412	〃	〃	〃	−300	−5	−11A	40 W (Tc=25°C)	85	−250	−30	50	−1.5	−8A										103	
	〃 413	東芝	PA	Ge. D	−60	−1	−1.5A	12.5W (Tc=25°C)	85	−100	−12	>30	−1	−0.5A										101	
	〃 414	〃	〃	〃	−32	−1	−1.5A	12.5W (Tc=25°C)	85	−100	−12	>30	−1	−0.5A										101	
	〃 415	〃	〃	Ge. A	−32	−6	−1A	200	85	−14	−12	70	V_{CB} 0	−0.3A	−1	100					1			12A	
★	〃 416	沖	AF	Ge. A	−25	−13	−80	150	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	120	45*	45*	0.4*				84B	
★	〃 417	〃	〃	〃	−45	−13	−80	150	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	120	45*	45*	0.4*				84B	
★	〃 418	〃	〃	〃	−70	−13	−80	150	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	120	45*	45*	0.4*				84B	
	〃 419	日立	PA	Ge. DB	−45	−1.2	−1.5A	6 W (Tc=25°C)	100	−250	−12	80	−1.5	−0.5A										100	
	〃 420	〃	〃	〃	−120	−1.5	−1.5A	6 W (Tc=25°C)	100	−250	−12	100	−1.5	−1A										100	
★	〃 421	東芝	〃	Ge. D	−80	−1	−600	300	85	−50	−12	70	−1	−150										77	
★	〃 422	〃	AF	Ge. A	−18	−2	−40	60	75	−12	−12				−6	1	50	1500	4	20				12A	
★	〃 423	〃	PA	〃	−30	−12	−150	150	75	−30	−30	70	−1.5	−50										12A	
★	2SB424	東芝	SW	Ge. A	−80	−40	−3A	30 W (Tc=25°C)	85	−160	−12	60	−1.5	−1A										102	
★	〃 425	〃	PA	〃	−60	−12	−3A	30 W (Tc=25°C)	85	−160	−12	60	−1.5	−1A										102	
★	〃 426	〃	〃	〃	−32	−12	−3A	30 W (Tc=25°C)	85	−160	−12	60	−1.5	−1A										102	
	〃 427	富士通	SW	〃	−45	−15	−500	225	70	−15	−45	60	−1	−100	−6	1					1			84B	
	〃 428	〃	PA	〃	−45	−15	−500	225	70	−15	−45	90	−1	−100	−6	1					1			84B	
★	〃 429	日電	〃	〃	−30		−50	100	85	−16	−30	150	−1	−20										19A	
	〃 430	松下	〃	Ge. DB	−70		−20A	80 W (Tc=25°C)	90	−20mA	−70	60	V_{CB}=0V	−4A										109	
	〃 431	富士通	〃	Ge. A	−32	−12	−500	200	85	−20	−12	120	−1	−150	−6	1	80	2400	8.9	38	1.2			12A	
	〃 432	〃	PA. SW	Ge. D	−150	−2	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−1mA	−40	70	−2	−5A	−5	500					3*			102	
	〃 433	〃	SW	Ge. A	−70	−40	−15A	56 W (Tc=25°C)	85	−4mA	−30	50	−2	−5A										102	
	〃 434	東芝	PA	Si.EMe	−50	−5	−3A	25 W (Tc=25°C)	150	−10	−30	80	−5	−0.5A	−5	500					3*	200		119	
	〃 435	〃	〃	〃	−35	−5	−3A	25 W (Tc=25°C)	150	−10	−30	80	5	−0.5A	−5	500					3*	200		119	
★	〃 436	沖	AF	Ge. A	−25		−120	120	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	80	33*	2.4*	0.4*				12A	
★	〃 437	〃	〃	〃	−45		−120	120	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	80	33*	2.4*	0.4*				12A	
★	〃 438	〃	〃	〃	−70		−120	120	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	80	33*	2.4*	0.4*				12A	
	〃 439	東芝	〃	〃	−30	−12	−150	150	75	−14	−12				−6	1	130	4000	8	45	2			12A	
	〃 440	〃	LN	〃	−30	−12	−150	150	75	−14	−12				−6	1	130	4000	8	45	NF = 3dB (f = 1kc)			12A	
★	〃 441	日立	PA	Ge. DB	−160	−1	−6A	40 W (Tc=25°C)	100	−250	−30	50	−1.5	−200										103	
	〃 442	〃	SW	〃	−160	−1.5	−6A	40 W (Tc=25°C)	100	−500	−30	50	−1.5	−4A										103	
★	〃 443	〃	AF. LN	Ge. A	−18	−12	−10	100	85	−10	−12				−6	1	150	3900	7.4	53	3			12A	
★	〃 444	〃	〃	〃	−18	−12	−10	100	85	−7	−12				−6	1	160	4300	7.7	59	3			12A	
	〃 445	富士通	PA	Ge. D	−40	−1	−1.5A	10 W (Tc=25°C)	85	−200	−12	100	−2	−1A	−5	0.5A					1.5*			101	
	〃 446	〃	〃	〃	−60	−1	−1.5A	10 W (Tc=25°C)	85	−100	−12	100	−2	−1A	−5	0.5A					1.5*			101	
	〃 447	〃	PA. SW	〃	−220	−3	−6A	45 W (Tc=25°C)	90	−500	−50	35	−1	−6A	−5	0.5A					1.5*			102	
★	〃 448	松下	PA	Ge. A	−32	−10	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−32	50	−0.5	−1A										100	
	〃 449	〃	〃	〃	−50	−20	−3.5A	22.5W (Tc≤25°C)	100	−3mA	−14	35	V_{CB}=0V	−3A	−2	0.5A					f_{ae} ≥7kHz			103	
	〃 450	八欧	PA	Ge. A	−25		−500	200	85	−20	−12	120	−1	−150										12A	
★	〃 451	三菱	〃	〃	−25	−6	−1A	300	85	−30	−12	80	−1	−150										69	
★	〃 452	〃	〃	〃	−25	−6	−1A	300	85	−30	−12	150	−1	−150										69	
★	〃 453	〃	PA. SW	〃	−30	−15	−300	250	85	−12	−25	120	−1	−100	−6	1					>1			68	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電氣的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★ 2SB454	三菱	PA.SW	Ge.A	−80	−40	−300	250	85	−30	−80	120	−1	−100	−6	1					>1			68	
★ 〃 455	〃	〃	〃	−105	−50	−150	250	85	−30	−105	120	−1	−100	−6	1					>1			68	
〃 456	富士通	〃	〃	−80	−30	−1A	13W (T_c=25°C)	85	−100	−80	80	−1	−300										83	
〃 457	三菱	PA	〃	−20	−2.5	−500	150	85	−15	−12	110	−1	−150										12B	
〃 457A	〃	〃	〃	−32	−6	−500	150	85	−15	−12	110	−1	−150										12B	
★ 〃 458	〃	〃	〃	−25	−12	−1A	800	85	−100	−12	65	−1.5	−500										100	
★ 〃 458A	〃	〃	〃	−45	−12	−1A	800	85	−100	−12	65	−1.5	−500										100	
★ 〃 458B	〃	〃	〃	−100	−12	−1A	800	85	−50	−50	65	−1.5	−500										100	
〃 459	日立	AF.LN	〃	−30	−2.5	−50	120	100	−12	−20	130	−6	−1	−6	1	180	5200	11	78	NF = 4.5dB (−6V, 1mA, 1kc)			12A	
★ 〃 460	〃	〃	〃	−40	−2.5	−50	120	100	−6	−20	130	−6	−1	−6	1	180	5200	11	78	NF = 4.5dB (−6V, 1mA, 1kc)			12A	
〃 461	東芝	PA	〃	−35	−12	−1A	250	85	−12	−14	50~180	−0.5	−500	−1	100					1.2			84A	
★ 〃 462	〃	〃	〃	−60	−12	−2A	6W (T_c=25°C)	85	−70	−12	80	−1	−0.5A										99	
〃 463	〃	〃	〃	−32	−12	−2A	6W (T_c=25°C)	85	−70	−12	80	−1	−0.5A										99	
★ 〃 464	〃	〃	Ge.D	−100	−1	−6A	30W (T_c=25°C)	85	−330	−12	70	−1.5	−1A										102	
★ 〃 465	〃	〃	〃	−60	−1	−6A	30W (T_c=25°C)	85	−330	−12	70	−1.5	−1A										102	
〃 466	富士通	〃	Ge.A	−40	−12	−500	12W (T_c=25°C)	90	−500	−30	70	−1.5	−500	−1.5	500					f_{ae}= 13kc			101	
〃 467	〃	〃	〃	−60	−12	−500	12W (T_c=25°C)	90	−200	−30	70	−1.5	−500	−1.5	500					f_{ae}= 13kc			101	
〃 468	日立	SW	Ge.DB	−200	−1.5	−10A	32W (T_c=25°C)	85	−500	−30	28	−1.5	−4A					t_f=1.5μS					103	
〃 469																								
〃 470	富士通	AF	Ge.A	−25	−2.5	−50	80	85	−6	−20				−6	1	160	5000	15	40				12A	
〃 471	日立	PA	〃	−60	−10	−10A	30W (T_c≤55°C)	100	−500	−30	90	−2	−1A	−2	1					0.3			103	
〃 472	〃	〃	〃	−80	−10	−10A	30W (T_c≤55°C)	100	−500	−30	90	−2	−1A	−2	1					0.3			103	
〃 473	松下	〃	〃	−32	−10	−1A	4.3W (T_c=25°C)	90	−15	−10	80	V_{CB} = 0V	−0.5A							f_{ae}= 20kc			100	
〃 474	三洋	〃	〃	−35	−6	−2A	12W (T_c=25°C)	85	−200	−25	100	−1.5	−200	−1.5	200					0.7			101	
〃 475	松下	〃	〃	−20	−6	−300	150	85	−20	−12	60	−1	−150										12A	
〃 476	〃	〃	〃	−20	−6	−2A	6W (T_c=25°C)	85	−500	−20	80	−0.5	−2A										84B	
★ 〃 477	三菱	PA.SW	〃	−30	−15	−30A	80W (T_c=25°C)	85	−5mA	−30	40	−2	−15A										109	
★ 〃 478	〃	〃	〃	−60	−30	−30A	80W (T_c=25°C)	85	−5mA	−60	40	−2	−15A										109	
★ 〃 479	〃	〃	〃	−80	−40	−30A	80W (T_c=25°C)	85	−5mA	−80	40	−2	−15A										109	
★ 〃 480	〃	〃	〃	−100	−50	−30A	80W (T_c=25°C)	85	−5mA	−100	40	−2	−15A										109	
★ 2SB481	松下	PA	Ge.A	−32	−10	−1A	6W (T_c=25°C)	90	−1mA	−32	50	−0.5	−1A	−2	100					f_{ae}= 15kc			100	
★ 〃 482	東芝	AF	〃	−35	−12	−50	120	85	−6	−12				−6	1	200	6500	9	56				12A	
★ 〃 483	新電元	PA.SW	〃	−80	−40	−15A	60W (T_c=25°C)	85	−5mA	−80	100	−1.5	−10A										102	
★ 〃 484	〃	〃	〃	−100	−40	−15A	60W (T_c=25°C)	85	−5mA	−100	100	−1.5	−10A										102	
★ 〃 485	〃	〃	〃	−140	−40	−15A	60W (T_c=25°C)	85	−5mA	−140	100	−1.5	−10A										102	
★ 〃 486	東芝	AF.LN	〃	−25	−12	−50	120	85	−5	−12				−6	1	200	6500	9	56	NF = 3dB (f = 1kc)			12A	
〃 487	富士通	PA	〃	−30	−2.5	−500	5W (T_c=25°C)	85	−20	−12	60	−1	−300										98A	
〃 488	〃	〃	〃	−60	−12	−500	5W (T_c=25°C)	85	−20	−12	60	−1	−300										98A	
〃 489																								
〃 490																								
〃 491	三洋			−250	−5	−11A	40W (T_c=25°C)	85			35	−1.5	−8A							1.0*				
〃 492	〃	PA	Ge.A	−25	−6	−2A	6W (T_c=25°C)	85	−50	−20	110	−1.5	−200	−1.5	200					0.7			84B	
〃 493	松下	PA.SW	〃	−40	−14	−1A	9W (T_c=25°C)	90	−1mA	−40	70	V_{CB} = 0V	3A										83	
★ 〃 494	三菱	PA	〃	−25	−6	−1A	200	85	−20	−12	55	−1	−150										12A	
〃 495	〃	〃	〃	−25	−6	−1A	200	85	−20	−12	110	−1	−150										12A	
〃 496	日立	〃	〃	−25	−2.5	−250	300 (T_c≤55°C)	85	−14	−25	90	−1.5	−50	−6	1					2			12A	2SD96 之對稱
〃 497	富士通	LN	〃	−20		−30	65	85	−6	−12				−6	1	90	3000	6	30	NF = 3dB (I_E = 0.5mA, f = 1kc)			4	
★ 〃 498	日電	〃	〃	−25		−50	100	85	−5	−15				−6	1	170	31	5*	0.25*	NF = 3dB (−6V, 1mA)			19A	
〃 499																								
〃 500																								
〃 501																								
〃 502	東芝	PA	Si.EMe	−110	−8	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−10	−50	80	−5	−500	−10	500					1*	200		99	2SD102 之對稱
〃 503	〃	〃	〃	−70	−8	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−10	−50	80	−5	−500	−10	500					1*	200		99	2SD103 之對稱
〃 504	日電	PA.SW	Si.EP	−80	−10	−2A	1W	175	−1	−60	80	−2	−500										84C	
〃 505	〃	〃	〃	−80	−10	−2A	15W (T_c=25°C)	175	−1	−60	80	−2	−500										97C	
〃 506	〃	〃	Si.EMe	−150	−7	−5A	50W (T_c=25°C)	175	−2mA	−100	70	−5	−1A										102	
〃 507	三洋	PA	Si.E	−60	−5	−3A	30W (T_c=25°C)	150	−100	−20	90	−2	−1A										162	
〃 508	〃	〃	〃	−60	−5	−3A	30W (T_c=25°C)	150	−100	−20	90	−2	−1A										163	
〃 509	〃	〃	〃	−60	−5	−4A	35W (T_c=25°C)	150	−100	−20	80	−2	−1A										99	
〃 510	日電	PA.SW	Si.EP	−80	−7	−1.5A	800	150	−1	−60	100	−2	−200										84B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SB511	三洋	PA	Si.E	−35	−5	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−100	−20	90	−2	−1A										162	
〃 512	松下	〃	Si.EMe	−60	−8	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−30	−20	60	−3	−1A										178	
〃 513	〃	〃	〃	−60	−8	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−30	−20	60	−3	−1A										179	
〃 514	三洋	〃	Si.E	−50	−5	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	90	−2	−1A										162	
〃 515	〃	〃	〃	−50	−5	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	90	−2	−1A										163	
〃 516	日立	〃	Ge.A	−20		−100	150	85	−25	−12	110	−1.5	−50										12C	
〃 517																								
〃 518	SON	PA	Si.EMe	−90	−8	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−1A										103	
〃 519	〃	〃	〃	−110	−8	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−1A										102	
〃 520	〃	〃	〃	−140		−12A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−1A										102	
〃 521	〃	〃	〃	−60		−5A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−2.5A										240	
〃 522	〃	〃	〃	−60		−5A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−2.5A										241	
〃 523	三菱	〃	Si.EP	−40	−5	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−25	120	−4	−500										180	2SD360 之對偶
〃 524	〃	〃	〃	−60	−5	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−25	100	−4	−500										180	2SD361 之對偶
〃 525	〃	〃	〃	−30	−4	−1A	800	135	−1	−25	150	−1	−500							100*			242	2SD335 之對偶
〃 526	〃	〃	〃	−90	−5	−800	10W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300										180	2SD356 之對偶
〃 527	〃	〃	〃	−110	−5	−800	10W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300										180	2SD357 之對偶
〃 528	〃	〃	〃	−130	−5	−800	10W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300										180	2SD358 之對偶
〃 529	〃	〃	〃	−40	−5	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−25	120	−4	−500										180	2SD359 之對偶
〃 530	東芝	〃	Si.EMe	−110	−5	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−50	80	−5	−1A										102	
〃 531	〃	〃	〃	−90	−5	−8A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−50	80	−5	−1A										102	
〃 532	松下	〃	〃	−80	−5	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−50	100	−4	−1A	−10	500					10*			102	
〃 533	〃	〃	GeA	−20	−12	−2A	6W (Tc=25°C)	85	−200	−20	150	V_{CB} 0V	I_E 2A	−2	100					1.2*			84C	
〃 534	日立	〃	〃	−20	−6	−500	200	85	−25	−12	150	−1	−150										12A	
〃 535	〃	〃	〃	−35		−1A	5W (Tc=25°C)	85	−20	−12	100	−0.5	−500										84B	
〃 536	日電	PA	SiE	−140	−5	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−120	90	−5	−300										151	
〃 537	〃	〃	〃	−140	−5	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−120	90	−5	−300										152	
〃 538	日立	PA SW	GeA	−65	−30	−15A	75W (Tc=25°C)	100	−10mA	−65	100	−2	−10A										102	
〃 539	日電	PA	Si.TMe	−130	−6	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−120	75	−5	−2A										102	
〃 540	東芝	〃	GeA	−50		−3A	250	85	−100	−25	100	−2	−3A										245	
2SB541	日電	PA	Si.TMe	−110	−6	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−100	80	−5	−1A										102	
〃 542	三菱	〃	Si.EP	−20	−5	−300	300	125	−1	−20	150	−2	−150	−6	10					150*			138B	2SD392 之對偶
〃 543																								
〃 544																								
〃 545																								
〃 546																								
〃 547																								
〃 548	日電	PA	Si.E	−100	−5	−800	5W (Tc=25°C)	150	−1	−80	80	−5	−200										225	
〃 549	〃	〃	〃	−100	−5	−800	5W (Tc=25°C)	150	−1	−80	80	−5	−200										225	
〃 550																								
〃 551																								
〃 552																								
〃 553																								
〃 554	東芝	PA	Si.TMe	−160	−5	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−80	80	−5	−2A										102	
〃 555	〃	〃	〃	−140	−5	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−60	80	−5	−2A										102	
〃 556	〃	〃	〃	−120	−5	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−60	80	−5	−2A										102	
〃 557	〃	〃	〃	−120	−5	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−60	80	−5	−1A										102	
〃 558	〃	〃	〃	−100	−5	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−50	80	−5	−1A										102	
〃 559																								
〃 560																								
〃 561	日立	PA	Si.EP	−25	−5	−700	500	150	−1	−20	130	−1	−150										138	
〃 562	〃	〃	〃	−25	−5	−1A	900	150	−1	−20	140	−2	−500										251	
〃 563																								
〃 564																								
〃 565																								
〃 566																								
〃 567																								
〃 568																								
〃 569	ALP	PA	Si.E	−40	−5	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−500	−40	6000	−3	−2A										252	2SD479 之對偶
〃 570	〃	〃	〃	−60	−5	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−500	−60	6000	−3	−2A										252	2SD480 之對偶

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測量情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SB571	ALP	PA	Si.E	−80	−5	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−500	−80	6000	−3	−2A										252	2SD481 之對偶
〃 572	〃	〃	〃	−40	−5	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	50	−1	−500										252	[illegible] 之對偶
〃 573	〃	〃	〃	−60	−5	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−60	50	−1	−500										252	2SD489 之對偶
〃 574	〃	〃	〃	−80	−5	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−80	50	−1	−500										252	2SD490 之對偶
〃 575	〃	〃	〃	−40	−5	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	50	−2	−1.5A										252	[illegible] 之對偶
〃 576	〃	〃	〃	−60	−5	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−60	50	−2	−1.5A										252	2SD484 之對偶
〃 577	〃	〃	〃	−80	−5	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	50	−2	−1.5A										252	2SD487 之對偶
〃 578	〃	〃	〃	−70	−5	−10A	90W (Tc=25°C)	150	−1mA	−70	40	−4	−4A										253	2SD491 之對偶
〃 579	〃	〃	〃	−60	−5	−5A	75W (Tc=25°C)	150	−100	−60	40	−2	−2.5A										253	[illegible] 之對偶
〃 580	〃	〃	〃	−80	−5	−5A	75W (Tc=25°C)	150	−100	−80	40	−2	−2.5A										253	2SD494 之對偶
〃 581	〃	〃	〃	−100	−5	−5A	75W (Tc=25°C)	150	−100	−100	40	−2	−2.5A										253	2SD495 之對偶
〃 582	〃	〃	〃	−60	−5	−8A	75W (Tc=25°C)	150	−500	−60	3000	−4	−4A										253	[illegible] 之對偶
〃 583	〃	〃	〃	−80	−5	−8A	75W (Tc=25°C)	150	−500	−80	3000	−4	−4A										253	2SD497 之對偶
〃 584	〃	〃	〃	−100	−5	−8A	75W (Tc=25°C)	150	−500	−100	3000	−4	−3A										253	2SD499 之對偶
〃 585	〃	〃	〃	−60	−5	−8A	100W (Tc=25°C)	200	−500	−60	3000	−3	−4A										102	2SD502 之對偶
〃 586	〃	〃	〃	−80	−5	−8A	100W (Tc=25°C)	200	−500	−80	3000	−4	−8A										102	2SD503 之對偶
〃 587	〃	〃	〃	−60	−5	−12A	150W (Tc=25°C)	200	−500	−50	3000	−3	−6A										102	2SD504 之對偶
〃 588	〃	〃	〃	−80	−5	−12A	150W (Tc=25°C)	200	−500	−80	3000	−3	−6A										102	2SD505 之對偶
〃 589	〃	〃	〃	−100	−5	−12A	150W (Tc=25°C)	200	−500	−100	3000	−3	−6A										102	2SD506 之對偶
〃 590																								
〃 591																								
〃 592																								
〃 593																								
〃 594																								
〃 595																								
〃 596																								
〃 597																								
〃 598																								
〃 599																								
〃 600																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測量情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC 11	東芝	SW	Ge.A	18	12	24	55	75	9	12	44	1	24	6	−1		t_r=0.08μS, t_f=0.07μS, t_s=0.07μS			6	<20	<200	12A	
〃 12	〃	〃	Si.Me	60	8	250	180	150	10	30	20	10	200				t_d+t_r=0.6μS, t_f=0.6μS, t_s=1μS						84A	
★ 〃 13	〃	〃	Ge.A	18	12	40	65	75	9	12	48	1	24	6	−1		t_r=0.33μS, t_f=0.19μS, t_s=0.21μS			9			84A	
★ 〃 14	〃	〃	〃	18	12	40	65	75	9	12	48	1	24	6	−1		t_r=0.24μS, t_f=0.11μS, t_s=0.19μS			15			84A	
〃 15	SON	RF	Si.Me	30	5	50	750	175	1	30	30	5	10	20	−10	21		5	0.36	150*	2	100*	84C	
〃 16	東芝	SW	Si.P	25	5	30	250	175	2.5	15	25	1	10				t_r=20nS, t_f=45nS, t_s=250nS				<7		49C	
〃 16A	〃	〃	〃	25	5	50	250	175	1	15	30	1	10										49C	
〃 17	〃	RF	〃	20		50	250	175	2.5	12				6	−2	30				150*	4	90	49C	
〃 17A	〃	〃	〃	25		30	250	175	1	15				10	−10	30				150*	4	30	49C	
〃 18	〃	〃	〃	25	2	30	250	175	0.1	6	12	0.3	0.1	6	−1	20				50	6	40	49C	
※ 〃 19	〃	SW	〃	40	5	400	600	150	1	30	50	2	150				t_r=40nS, t_f=120nS, t_s=650nS			>70*	30		84A	
★ 〃 20	〃	RF	〃	40	3	400	600	150	1	30				10	−10	−0.98*				90	30	25	84A	
〃 21	〃	SW	〃	60	5.5	2A	50W (T_C=25°C)	150	1mA	30	25	10	1A	30	−300					6*	450		102	
〃 22	日電	RF	Si.EP	75	5	600	13W (T_C=25°C)	175	2	50	50	10	150	10	−50	50				110*	20		83	
〃 23	〃	〃	〃	75	5	500	13W (T_C=25°C)	175	5	50	50	10	150	10	−50	50				110*	20		83	
〃 24	〃	〃	〃	100	5	500	13W (T_C=25°C)	175	5	70	50	10	150	10	−50	50				110*	20		83	
〃 25	松下	RF.IF.Conv Mix.Osc	Si.Me	60		60	500	150	10	12				12	−10	50				70	10	70	84B	
★ 〃 26	富士通	RF	〃	60		100	500	150	1	30				10	−10	50				150	4	70	79	
〃 27	〃	〃	Si.P	60		100	650	175	1	30				6	−1	80				350*	4	50*	84C	
〃 28	〃	〃	〃	40	5	50	225	150	1	10				10	−10	30				100*	4	50	84C	
〃 29	〃	〃	〃	40	5	25	115	150	1	10				10	−10	30				100*	4	50	84C	
〃 30	日電	〃	Si.EP	60	5	80	500	150	0.1	30				10	−10	45	h_{fe} = 23dB (f = 20Mc)			280*	4	35	84A	
〃 31	〃	RF.PA	〃	60	5	200	750	175	0.1	30				10	−10	35				200*	4	35	84A	
〃 32	〃	〃	〃	60	5	200	750	175	0.1	30				10	−10	60				250*	4	40	84A	2SA544之対偶
★ 〃 32A	〃	〃	〃	60	5	200	750	175	1	30				10	−10	60				250*	4	40	84A	
〃 33	〃	RF	〃	45	3	150	150	150	0.1	20				10	−5	55	h_{fe} = 22dB (f = 20Mc)			250*	3.5	40	48C	
★ 〃 34	松下	SW	Ge.A	20	20	250	140	75	3	5	30	0.5	200	5	−3					6*	20		20	
★ 〃 35	〃	〃	〃	20	20	400	140	75	3	5	65	0.5	200	5	−3					12*	20		20	
★ 〃 36	〃	〃	〃	20	20	400	140	75	3	5	100	0.5	200	5	−3					20*	20		20	
★ 〃 37	日電	RF.IF.Conv Mix.PA	Si.EP	40	3	200	200	175	0.1	20				10	−10	50				200*	4	50	84A	
2SC 38	日電	RF.IF.Conv Mix.Osc	Si.EP	40	3	200	750	175	0.1	30				10	−10	50				200*	4	50	84C	
〃 39	富士通	RF	Si.Me	25	3	50	250	150	0.1	10				6	−1	50				500*	2.3	80*	49C	
〃 39A	〃	〃	〃	25	3	50	250	150	0.1	10				6	−3	120	NF < 6dB (f = 1Mc)			350*	3	65*	49C	
〃 40	〃	〃	〃	25	3	50	250	150	0.1	10				6	−1	50				750*	2.3	80*	49C	
〃 41	SON	〃	〃	150		5A	50W (T_C=25°C)	150	60mA	150	28	10	1A	10	−0.5A					20	250	5	103	
〃 42	〃	〃	〃	150	6	5A	50W (T_C=25°C)	150	60mA	150	28	10	1A	10	−0.5A					20	250	5	103	
〃 42A	〃	〃	〃	200	6	5A	50W (T_C=25°C)	150	30	50	40	10	1A	10	−0.5A					20*	250		103	
〃 43	〃	〃	〃	100	6	5A	50W (T_C=25°C)	150	60mA	100	28	10	1A	10	−0.5A					20	250	5	103	
〃 44	〃	〃	〃	50	6	5A	50W (T_C=25°C)	150	60mA	50	28	10	1A	10	−0.5A					20	25	5	103	
〃 45	日電	RF.IF.Conv Mix.Osc	Si.P	45		100	500	150	1	30	50	2	10	10	−10	50				160*	4	130*	84A	
〃 46	富士通	RF.IF.Conv Mix.Osc.SW	Si.Me	60	5	300	600	150	0.1	10	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35*	84C	
〃 47	〃	〃	〃	40	5	300	600	150	1	6	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35*	84C	
〃 48	〃	〃	〃	120	5	300	600	150	0.1	10	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35*	84C	
〃 49	日電	RF.IF.Conv Mix.Osc	Si.EP	120	6	300	800	175	0.5	60	60	10	150	10	−50	60				175*	9		84A	
〃 50	松下	RF.Conv Mix.Osc	Ge.A	20	20	200	100	75	3	5				6	−1	45				12	20	100	20	
〃 51	富士通	RF.IF.Conv Mix.Osc.PA	Si.Me	60	5	300	1W	150	0.1	10	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35	80	
〃 52	〃	〃	Si.P	40	5	100	500	150	0.03	10	50	1	10	6	−1	50	28*	1.5*	0.1*	350*	4	40*	84C	
〃 53	〃	RF.IF.Conv Mix.Osc.PA	〃	25	3	100	600	150	0.5	10	50	1	10	6	−1	50				300*	4	40*	84C	
〃 54	〃	RF.IF.Conv Mix.Osc.SW	〃	40	5	100	300	150	0.03	10	50	1	10	6	−1	50	28*	1.5*	0.1*	350*	4	40*	49C	
〃 55	〃	RF.IF.Conv Mix.Osc.PA	〃	25	3	100	360	150	0.5	10	50	1	10	6	−1	50				300*	4	40*	49C	
〃 56	〃	RF.Conv Mix.Osc	〃	20	3	25	200	120	2	12				6	−2	60				180*	2.3	80*	30	
〃 57	日電	PA	Si.Me	75	4	500	13W (T_C=25°C)	175	30	30	30	10	150							110*	22		83	
〃 58	松下	RF.IF.Conv Mix.Osc.PA	〃	60	1.5	60	600	175	2	12	50	12	10	12	−10	50				250*	2.5	170	84A	
〃 58A	〃	〃	〃	140	1.5	60	600	175	2	12	50	12	10	12	−10	50				250*	2.5	170	84A	
〃 59	日電	RF.IF.Conv Mix.Osc	Si.EP	120	6	300	800	175	0.5	60	35	10	150	10	−50	35				140*	9		84A	
〃 60	三洋	RF	Ge.A	20	10	20	100	85	15	20				6	−1	50				5	15	80	12A	
〃 61	富士通	RF.IF.Conv Mix.Osc.SW	Si.Me	30	5	300	1.2W	175	1	10	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35	80	
〃 62	日立	SW	Si.P	40	5	50	360	175	0.025	15	100	1	10	10	−10					300*	5.5		49C	
〃 63	日電	〃	Si.Me	25	3	50	300	150	1	15	40	1	10	10	−10					400*	4.5		49C	
〃 64	三洋	RF	〃	80	2	50	600	175	1.5	20				20	−5	50				100*	5	80	84B	

	製名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測量情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SC 65	三洋	RF	Si. Me	150	4	50	600	175	15	150	30	20	5	20	− 5	20				200*	<10	<200	84B	
	〃 66	〃	〃	〃	150	2	50	600	175	1.5	20				20	− 5	70				130*	5	100	84B	
	〃 67	日電	SW	Si. EP	40	5	200	360	175	0.1	15	80	1	10				t_{on}<20nS, t_{off}<40nS, t_{stg}<20nS						49C	
	〃 68	〃	SW	〃	25	5	200	300	150	1	15	40	1	10	10	− 10		t_r<60nS, t_f<60nS, t_s<80nS			400*	4.5	50	49C	
	〃 69	〃	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	120	6	300	800	175	0.5	60	50	1	150	10	− 50	50				160*	9		84A	
★	〃 70	東芝	RF	Si. TMe	180		20	800	150	1	30				30	− 2	45				125*	1.8	100	84A	
★	〃 71	〃	SW	Ge. A	18	12	200	150	85	7	12	100	0.5	100										84A	
★	〃 72	〃	〃	〃	18	12	200	150	85	7	12	100	0.5	100										84A	
	〃 73	SON	RF. Conv. Mix Osc	Ge, G	15		5	30	75	8	15				6	− 1	−0.976*	PG = 27 dB (f = 2 Mc)			20	2		18	2S132 2T 73
★	〃 74	東芝	RF	Si. P	30	5	100	360	175	4	15				6	− 2	50				100	2.5	100	84A	
	〃 75	SON	IF	Ge. G	15		5	30	75	8	15				6	− 1	−0.96*	PG = 41dB (f = 455kc)			10	2.1		18	2S133 2T 75
	〃 76	〃	〃	〃	15		5	30	75	8	15				6	− 1	−0.96*	PG = 37 dB (f = 455kc)			10	2.1		18	2S134 2T 76
	〃 77	〃	〃	〃	15		5	30	75	8	15				6	− 1	−0.96*	PG = 32 dB (f = 455kc)			10	2.1		18	2S136 2T 77
	〃 78	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	15		5	30	75	2	15				6	− 1	−0.98*	33*	2*	0.2*	20	1.5		18	2S136 2T 78
	〃 79	富士通	〃	Si. Me	15	3	50	300	175	1	10				6	− 1	50				500*	2.3	80*	49C	
★	〃 80	日電	〃	Si. EP	30	3	80	200	175	0.1	20				10	− 5	55				200*	3.5	40	48C	
★	〃 81	三菱	PA	Si. Me	50		5 A	125 W (T_c=25°C)	150	10 mA	50	30	10	1 A	10	−1 A	30				5	300	5	108	
★	〃 82	〃	〃	〃	100		5 A	125 W (T_c=25°C)	150	10 mA	100	30	10	1 A	10	−1 A	30				5	300	5	108	
★	〃 83	〃	〃	〃	150		5 A	125 W (T_c=25°C)	150	10 mA	150	30	10	1 A	10	−1 A	30				5	300	5	108	
★	〃 84	〃	SW	Ge. A	25	20	200	120	85	25	25	40	0.5	20										12A	
★	〃 85	〃	〃	〃	25	20	400	120	85	25	25	30	0.3	200										12A	
★	〃 86	〃	〃	〃	25	20	400	120	85	25	25	60	0.3	200										12A	
	〃 87	富士通	RF. Conv. Mix Osc. SW. PA	Si. Me	30	3	100	600	175	1	10	50	1	10	10	− 10	50				250*	4	90*	84C	
	〃 88	〃	〃	〃	120	3	100	600	175	1	10	50	1	10	10	− 10	50				250*	3	70*	84C	
	〃 92	日電	PA	Si. EP	100	5	2 A	20 W (T_c=25°C)	175	0.1	50	35	10	350	10	−350		P_o = 9 W (f = 100Mc)			190*	35	25*	83	
	〃 93	〃	〃	〃	80	5	2 A	20 W (T_c=25°C)	175	0.1	50	35	10	350	10	−350		P_o = 9 W (f = 100Mc)			190*	35	25*	83	
	〃 94	〃	〃	〃	100	5	2 A	20 W (T_c=25°C)	175	0.1	50	35	10	350	10	−350		P_o = 9 W (f = 100Mc)			190*	35	25*	83	
	〃 95	東芝	RF. PA	Si. Me	140		100	800	150	1	30				10	− 10					140*	10	80	84A	
	〃 96	〃	chopper	Si. EP	25	5	150	500	175	0.01	15	60			10	− 10					150*	17	50	88A	複合管
★	〃 97	日電	RF. SW	〃	60	5	1 A	800	175	1	40	60	10	150	10	− 50	90	t_{on} = 25nS, t_{off} = 75nS, t_s = 50nS			250*	10	17*	84A	
	2SC 98	松下	SW	Si. EP	20	5	100	300	175	10	20	45	0.35	10	2	− 10					350*	< 5		49C	
	〃 99	〃	〃	〃	20	5	100	300	175	10	20	80	0.35	10	2	− 10					350*	< 5		49C	
★	〃 100	日電	RF. SW	〃	40	5	200	150	200	0.025	20	60	1	10	10	− 10	80	t_d + t_r <40nS, t_s + t_f <70nS			400*	35	40*	23	
★	〃 101	東芝	RF	Si. Me	60	5.5	2 A	60 W (T_c=25°C)	150	10 mA	20				10	−0.5A	30	h_{fe} = 16 (f = 1 Mc)				350	$C_c r_{bb'}$ 18 nS	101	
★	〃 102	〃	〃	〃	50		7 A	100 W (T_c=25°C)	150	45 mA	50				10	−0.5A	25	h_{fe} = 10 (f = 1 Mc)				850	$C_c r_{bb'}$ 10 nS	109	
	〃 103	〃	SW	Si. P	25	5	50	250	175	1	15	35	1	10				t_d + t_r <40nS, t_s <500nS, t_f <60nS						49C	
	〃 103A	〃	〃	〃	30	5	80	250	175	0.2	15	100	1	10										49C	
	〃 104	〃	RF	〃	25		50	250	175	1	15				10	− 10	32				250*	4	30	49C	
	〃 104A	〃	〃	〃	30	5	80	250	175	0.2	15	60	1	10										49C	
	〃 105	〃	〃	〃	30	5	80	250	175	0.005	15	35	1	0.1	10	− 10	60				250*	4	30	49C	
★	〃 106	〃	SW. PA	Si. E	60	5	1.5 A	15 W (T_c=25°C)	150	3 mA	30	20	5	0.5A	12	−200	30				100*	50	7	83	
★	〃 107	〃	〃	〃	60	5	1 A	15 W (T_c=25°C)	150	3 mA	30	20	5	0.5A	12	−200	30				100*	50	7	83	
★	〃 108	〃	RF. SW	Si. EMe	90	5	600	600	150	1	30	35	2	150	10	− 10					90*	20	55	84A	
★	〃 109	〃	SW	〃	50	5	600	600	150	1	30	35	2	150										84A	
★	〃 110	日立	RF. PA	Si. Me	40	5	200	750	175	1	20				6	− 10	80				160*	7	55	84A	
★	〃 111	〃	〃	〃	50	5	200	750	175	1	20				6	− 10	50				160*	10	60	84A	
★	〃 112	〃	SW	〃	40	5	200	750	175	1	20	50	2	200										84A	
★	〃 113	〃	〃	〃	50	5	200	750	175	1	20	50	2	200										84A	
★	〃 114	〃	〃	〃	50	5	200	750	175	1	20	50						t_d = 20 nS, t_s = 110nS, t_r = 50nS, t_f = 20nS						84A	
	〃 115	SON	RF	Si. EMe	30	5	50	750	175	3	30	50	5	3	20	− 10	50				200*	3	100*	84A	
	〃 116	日立	RF. PA	〃	50	5	200	750	175	1	20	40	2	200	6	− 10	40				120*	14	70	84A	
	〃 117	〃	SW. PA	Si. TP	75	5	600	13 W (T_c=25°C)	175	5	40	40	15	30	15	− 30	45				112*	15	20	83	
★	〃 118	〃	PA	〃	80	5	600	13 W (T_c=25°C)	175	5	40				15	− 30	45				120*	15	20	83	
★	〃 119	〃	〃	〃	75	5	600	13 W (T_c=25°C)	175	5	40				15	− 30	45				130*	15	20	83	
★	〃 120	日電	RF	Si. P	40	1	25	250	150	0.1	10	40	10	0.05	10	− 1	90	27	2	0.1	200*	4	40	84A	
★	〃 121	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	40	1	25	250	175	1	30				10	− 1	40	35*	2*	0.15*	130*	4	30*	84A	
★	〃 122	〃	〃	〃	40	1	25	250	175	1	30				10	− 1	90	35*	2*	0.15*	160*	4	40*	84A	
★	〃 123	〃	〃	〃	40	1	25	250	175	1	30				10	− 1	140	35*	2*	0.1*	180*	4	40*	84A	
★	〃 124	〃	〃	〃	40	1	25	250	175	0.2	30	40	10	0.05	10	− 1	90	35*	2*	0.1*	200*	4	40*	84A	
	〃 125	SON	RF. SW	Si. EMe	100	5	50	750	175	3	30	50	5	3	20	− 10	50				200*	3	$C_c r_{bb'}$ 100 pS	84C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC126	SON	RF.SW	Si.EMe	140	5	50	750	175	3	30	50	5	3	20	−10	50				200*	3	Cc rbb' 100 pS	84C	
★ 〃 127	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	20		25	200	175	2	15				10	−1	160				200*	4	40*	84A	
〃 128	松下	SW	Ge.A	30	20	200	150	85	3	5	40	0.5	100	5	−3					7*	9		84A	
〃 129	〃	〃	〃	25	20	200	150	85	3	5	60	0.5	100	5	−3					10*	9		84A	
〃 130	富士通	RF.Conv.Mix Osc.PA	Si.EP	60		1A	1.8W	175	0.1	10	40	10	20	10	−20	40				160*	15	35*	83	
〃 131	〃	SW	〃	40	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10				t_r = 8nS, t_f = 20nS, t_s = 20nS						49C	
〃 132	〃	〃	〃	20	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10				t_r = 8nS, t_f = 20nS, t_s = 20nS						49C	
〃 133	〃	〃	〃	20	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10				t_r = 8nS, t_f = 20nS, t_s = 20nS						49C	
〃 134	〃	〃	〃	40	5	300	350	175	0.02	10	60	1	10				t_r = 10nS, t_f = 25nS, t_s = 100nS						49C	
〃 135	〃	〃	〃	20	5	300	350	175	0.02	10	60	1	10				t_r = 10nS, t_f = 25nS, t_s = 100nS						49C	
〃 136	〃	〃	〃	80	5	300	350	175	0.02	10	60	1	10				t_r = 10nS, t_f = 25nS, t_s = 100nS						49C	
〃 137	〃	〃	〃	25	5	300	350	175	0.05	10	50	1	10										49C	
〃 138	日電	RF.Conv.Mix Osc	〃	60	5	500	800	175	1	40				10	−30	50				400*	4	40*	85A	
〃 138A	〃	〃	〃	60	5	500	800	175						10	−30	50				400*	4	40*	85A	
〃 139	〃	〃	〃	60	5	500	800	175	2	40				10	−30	50				400*	4	40*	85A	
〃 140	SON	RF	Si.EMe	60		1A	1.7W	175	12	30				10	−50	−0.97*				150*	13	20*	74	
〃 141	沖	〃	Si.EP	20	5	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95				450*	4	70*	49C	
〃 142	〃	RF.SW	〃	30	5	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95	t_d = 12nS, t_{on} = 10nS, t_r = 16nS, t_{off} = 32nS			450*	4	70*	49C	
〃 143	〃	〃	〃	40	5	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95	t_d = 12nS, t_{on} = 10nS, t_r = 16nS, t_{off} = 32nS			450*	4	70*	49C	
〃 144	〃	〃	〃	50	5	200	360	175	0.1	15	65	1	10	10	−10	85	t_d = 15nS, t_{on} = 15nS, t_r = 10nS, t_{off} = 32nS			450*	3	70*	49C	
〃 144A	〃	〃	〃	60	5	200	360	175	0.1	15	65	1	10	10	−10	85	t_d = 12nS, t_{on} = 15nS, t_r = 16nS, t_{off} = 32nS			450*	3	70*	49C	
★ 〃 145	〃	RF	〃	30	5	200	360	175	0.1	15				10	−10	70				500*	3	70*	49C	
★ 〃 146	〃	〃	〃	50	5	200	360	175	0.1	15				10	−10	80				500*	3	70*	49C	
★ 〃 146A	〃	〃	〃	60	5	200	360	175	0.1	15				10	−10	80				500*	3	70*	49C	
〃 147	SON	〃	Si.EMe	30	5	1A	750	175	5	30	50	4	100	10	−50	−0.96*				120*	12	20*	74	
★ 〃 149	日電	RF.IF.Conv Osc	Si.DB	120	6	300	800	175	10	60	45	10	150	10	−50	45				160*	14	45*	84A	
〃 150	日立	RF	Si.Me	20	1	100	750	175	10	20				6	−10					80*	7	70	84A	
〃 151	〃	〃	〃	40	4	100	750	175	10	40				6	−10					100*	7	70	84A	
〃 152	〃	〃	〃	60	4	100	750	175	10	60				6	−10					120*	7	70	84A	
〃 153	〃	〃	〃	120	4	100	750	175	10	120	65	5	50	5	−10	40				140*	6	80	84A	
2SC154	日立	RF	Si.EMe	120	5	100	750	175	10	120				10	−10	60				150*	2.5	20	84A	
★ 〃 154A	〃	〃	〃	150	5	100	750	175	10	150				10	−10	60				150*	2.5	20	84A	
〃 155	富士通	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	20	2	25	100	125	2	12				6	−2	35				200*	2	60*	35	
〃 156	〃	〃	〃	20	2	25	100	125	2	12				6	−2	50				200*	2	80*	35	
〃 157	日立	RF	Si.GD	20	1	20	125	150	1	12				6	−2	30				25	3.5	80	84A	
〃 158	〃	〃	〃	20	1	20	125	150	1	12				6	−2	40				40	3.5	80	84A	
〃 159	〃	〃	〃	20	1	20	125	150	1	12				6	−2	50				60	3.5	80	84A	
〃 160	〃	〃	〃	20	1	20	125	150	1	12				6	−2	60				100	3.5	80	84A	
〃 161	東芝	SW.PA	Si.Me	60	5.5	4A	50W (T_c=25°C)	150	2mA	30	25	5	3A	10	−200					30*	350	50	102	
〃 162	沖	RF	Si.EP	30	5	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	−20	90				500*	3.5	90*	84A	
〃 163	〃	〃	〃	50	5	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	−20	90				500*	3.3	90*	84A	
〃 164	〃	〃	〃	60	5	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	−20	90				500*	3.2	90*	84A	
〃 165	〃	〃	〃	60	5	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	−20	90				500*	3.3	90*	84A	
★ 〃 166	日立	RF.SW	Si.GD	30	5	30	200	175	0.1	20	80	12	3	12	−3					16	13	90*	49C	
★ 〃 167	〃	〃	〃	55	5	30	200	175	0.1	20	80	12	3	12	−3					16	13	90*	49C	
〃 170	富士通	RF.PA	Si.P	25	3	50	110	175	0.5	20	40	1	10	6	−10	60				250*	5	50	49C	
〃 171	〃	〃	〃	25	3	50	200	175	0.5	20	30	6	0.1	6	−10	60				250*	5	50	49C	
〃 172	〃	〃	〃	25	5	50	300	175	0.1	20	30	6	0.1	6	−10	60				350*	5	50	49C	
〃 172A	〃	〃	〃	40	5	50	360	200	0.025	20				6	−10	60				350*	5	50	49C	
〃 173	SON	RF.Conv.Mix Osc	Ge.G	15		5	30	75	8	15				6	−1	0.976				20	2		7	
〃 174	富士通	〃	Si.P	30	5	25	200	175	1	12				6	−2	45				170*	1.5	65*	50C	
〃 174A	〃	〃	〃	60	5	25	200	175	1	30				6	−2	45				200*	1.5	65*	50C	
〃 175	SON	IF	Ge.G	15		5	30	75	8	15				6	−1	−0.96*				10	2.1		7	
〃 176	〃	〃	〃	15		5	30	75	8	15				6	−1	−0.96*				10	2.1		7	
〃 177	〃	〃	〃	15		5	30	75	8	15				6	−1	−0.96*				10	2.1		7	
〃 178	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	15		5	30	75	2	15				6	−1	−0.98*	33*	2*	0.2*	20	1.5		7	
★ 〃 179	日立	SW	Ge.A	25	20	400	120	85	8	12	40	0.2	20	6	−1		t_r = 0.4μS, t_f = 0.3μS, t_s = 0.25μS			3	25	300	12A	
〃 180	〃	〃	〃	25	20	400	120	85	8	12	35	0.3	200	6	−1		t_r = 0.3μS, t_f = 0.16μS, t_s = 0.25μS			5	25	250	12A	
〃 181	〃	〃	〃	25	20	400	120	85	8	12	60	0.3	200	6	−1		t_r = 0.25μS, t_f = 0.13μS, t_s = 0.25μS			10	25	250	12A	
★ 〃 182	日電	RF.AF.PA	Si.EP	25	5	150	150	150	1	20	80	1	20	6	−1	55				90*	6.5	25	23	V81A

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測定情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^-4)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★ 2SC183	日 電	RF.Conv.Mix Osc. AF	Si. EP	20	5	30	100	125	0.1	15	75	3	0.5	6	−1	80	2000	0.55	10	150*	1.6	50*	23	V81 B
★ 〃 184	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	5	30	100	125	0.1	15				6	−1	80				200*	1.6	50*	23	V81 C
★ 〃 185	〃	〃	〃	20	5	30	100	125	0.1	15				6	−1	80				250*	1.6	50*	23	V81 D
〃 186	富士通	〃	Si. P	20	2	25	85	120	2	12				6	−2.5	40				200*	4	35	12 A	
〃 187	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	2	25	85	120	2	12				6	−2.5	50				200*	4	50	12 A	
〃 188	〃	RF. PA	〃	40	3	500	600	175	1	30	40	10	150	6	−10	50				150*	9	35	84 B	
〃 189	〃	RF. SW. PA	〃	60	5	500	600	175	1	30	40	10	150	6	−10	50				150*	9	35	84 B	
〃 190	〃	〃	〃	60	5	500	600	175	1	30	75	10	150	6	−10	80				180*	9	35	84 B	
〃 191	SON	RF	Si. GD	60	1	10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84 A	
〃 192	〃	〃	〃	60	1	10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	10	3	200	84 A	
〃 193	〃	〃	〃	60	1	10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	30	3	200	84 A	
〃 194	〃	〃	〃	60	1	10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84 A	
〃 195	〃	〃	〃	30	1	10	250	150	1	30				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	10	3	200	84 A	
〃 196	〃	〃	〃	30	1	10	250	150	1	30				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	30	3	200	84 A	
〃 197	〃	〃	〃	30	1	10	250	150	1	30				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84 A	
〃 198	富士通	RF. PA	Si. EP	50	5	500	800	175	1	10				10	−20	40				350*	6	50*	85 B	
★ 〃 199	東 芝	SW	Si. Me	80	15	50	600	175	0.1	15	70	12	3	12	−3	70	h_{fe} = 2 (f = 50 MHz)				2	100	84 B	
〃 200	富士通	RF.Conv.Mix Osc. PA	Si. EP	40		300	650	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	84 C	
〃 201	〃	〃	〃	20		300	650	175	0.1	10				6	−1	60				350*	4	50*	84 C	
〃 202	〃	〃	〃	80		300	650	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	84 C	
〃 203	〃	〃	〃	40		200	350	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	49 C	
〃 204	〃	RF. SW	〃	30	5	200	350	175	0.05	10	60	1	10	6	−2	70	t_r < 20nS, t_f < 60nS t_s < 250nS			250*	4	80*	49 C	
〃 205	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	80		200	350	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	49 C	
〃 206	〃	〃	Si. P	20	2	25	200	175	2	12				6	−2	35				200*	2	80*	50 C	
〃 207	〃	〃	〃	20	3	25	200	175	0.1	12				6	−2	80				800*	1.0	80*	50 C	
〃 208	〃	〃	〃	20	3	25	200	175	1	12				6	−2	60				550*	1.2	80*	50 C	
〃 209	〃	〃	〃	20	3	25	200	175	1	12				6	−2	40				450*	1.2	80*	50 C	
〃 210	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	50		500	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	84 B	
〃 211	〃	RF	〃	25		500	650	175	1	10				10	−20	50				150*	15	35*	84 B	
〃 212	〃	〃	〃	80		500	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	84 B	
2SC213	富士通	RF. PA	Si. P	50		600	1.5 W	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	83	
〃 214	〃	〃	〃	25		600	1.5 W	175	1	10				10	−20	50				150*	15	35*	83	
〃 215	〃	〃	〃	80		600	1.5 W	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	83	
〃 216	〃	SW	〃	50	5	300	650	175	0.1	10	50	1	50										84 B	
〃 217	〃	〃	〃	25	5	300	650	175	1	10	50	1	50										84 B	
〃 218	〃	〃	〃	80	5	300	650	175	0.1	10	50	1	50										84 B	
〃 220	〃	RF	Si. EP	50		700	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	25*	84 B	
〃 221	〃	〃	〃	25		700	650	175	1	10				10	−20	50				150*	15	25*	84 B	
〃 222	〃	〃	〃	80		700	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	25*	84 B	
〃 223	〃	RF. PA	〃	50		1 A	1.5 W	175	0.1	10				10	−20	20				150*	15	25*	83	
〃 224	〃	〃	〃	25		1 A	1.5 W	175	1	10				10	−20	20				150*	15	25*	83	
〃 225	〃	〃	〃	80		1 A	1.5 W	175	0.1	10				10	−20	20				150*	15	25*	83	
〃 226	〃	SW	〃	50	5	700	650	175	0.1	10	50	1	100										84 B	
〃 227	〃	〃	〃	25	5	700	650	175	1	10	50	1	100										84 B	
〃 228	〃	〃	〃	80	5	700	650	175	0.1	10	50	1	100										84 B	
〃 229	〃	〃	〃	80	5	1 A	1.5 W	175	0.1	10	50	1	100										83	
〃 230	〃	RF.Conv.Mix Osc. PA	〃	80	3	200	350	175	0.02	10				6	−2	60				350*	4	50*	49 C	
〃 231	〃	SW	Si.EMe	50	5	700	650	175	1	10	40	1	150										84 B	
〃 232	〃	〃	〃	25	5	700	650	175	1	10	40	1	150										84 B	
〃 233	〃	〃	〃	80	5	700	650	175	1	10	40	1	150										84 B	
〃 234	〃	RF. PA	〃	100		1.5 A	1.8 W	175	1 mA	30				10	−150	20				140*	35	25*	83	
〃 235	〃	〃	〃	100		1.5 A	1.5 W	175	1 mA	30				10	−150	20				120*	35	25*	83	
〃 236	〃	〃	〃	90		500	1.8 W	175	0.1	10				10	−20	17				100*	15	25*	83	
〃 237	〃	RF	Si. EP	25		300	350	175	0.05	10				6	−1	80				450*	5	50*	49 C	
〃 238	〃	RF. AF	〃	40	5	100	650	175	0.1	10				6	−1	80	30*	3*	0.1*	350*	4	50*	84 B	
〃 239	〃	SW	〃	50	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10				t_r < 20nS, t_f < 50nS t_s < 100nS						49 C	
★ 〃 240	日 電	SW	Si.EMe	100	5	5 A	75 W (Tc = 25°C)	175	5 mA	100	35	10	1 A	2	−1A					35			104	
★ 〃 241	〃	〃	〃	60	5	5 A	75 W (Tc = 25°C)	175	10mA	60	35	10	1 A	10	−1A		t_d = 0.03μS, t_s = 1μS t_r = 0.47μS, t_f = 0.5μS			35			102	
★ 〃 242	〃	〃	〃	100	5	5 A	75 W (Tc = 25°C)	175	10mA	100	35	10	1 A	10	−1A		t_d = 0.03μS, t_s = 1μS t_r = 0.47μS, t_f = 0.5μS			35			102	
★ 〃 243	〃	〃	〃	140	5	5 A	75 W (Tc = 25°C)	175	10mA	140	35	10	1 A	10	−1A		t_d = 0.03μS, t_s = 1μS t_r = 0.47μS, t_f = 0.5μS			35			102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a=25°C$) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 ($T_a=25°C$) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	测試情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC244	日電	SW	Si.EMs	60	5	5 A	75 W (Tc=25°C)	175	50mA	60	35	10	1 A	10	−1A		t_d=0.03μS, t_r=1μS, t_s=0.47μS, t_f=0.5μS			35			102	
★	〃 245	〃	〃	〃	120	5	5 A	75 W (Tc=25°C)	175	20mA	120	35	10	1 A	10	−1A		t_d=0.03μS, t_r=1μS, t_s=0.47μS, t_f=0.5μS			35			102	
★	〃 246	〃	〃	〃	180	5	5 A	75 W (Tc=25°C)	175	20mA	180	35	10	1 A	10	−1A		t_d=0.03μS, t_r=1μS, t_s=0.47μS, t_f=0.5μS			35			102	
	〃 247	富士通	RF.PA	Si.P	100	3	100	600	175	1	30				6	−2	60				150*	3	70*	84B	
	〃 248	〃	〃	〃	70	5	50	300	175	1	30				6	−2.5	60				170*	2.5	50	49C	
	〃 249	〃	〃	〃	70	5	70	500	175	1	30				6	−2.5	60				170*	2.7	50	84B	
	〃 250	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	2	25	60	150	2	12				6	−2	45				170*	2	65	13A	
★	〃 251	日電	〃	Si.EP	30	3	30	200	150	1	15				6	−5	50	NF < 6 dB (f = 1 Mc)			900*	1	70*	50C	
★	〃 251A	〃	〃	〃	30		30	200	150	1	15				6	−5	50	NF < 6 dB (f = 1 Mc)			900*	1	70*	50C	
★	〃 252	〃	〃	〃	30	3	30	200	150	1	15				6	−5	50				900*	1	70*	50C	
★	〃 253	〃	〃	〃	30	3	30	200	150	1	15				6	−5	50	NF < 6 dB (f = 70Mc)			900*	1	70*	50C	
	〃 254	沖	RF.PA	〃	50	5	800	650	175	2	40	50	1	150	10	−50	55				250*	13	20*	84A	
	〃 255	〃	〃	〃	80	5	800	650	175	1	40	45	1	150	10	−50	50				250*	13	20*	84A	
	〃 256	〃	〃	〃	90	5	800	650	175	1	40	45	1	150	10	−50	50				250*	13	20*	84A	
	〃 257	〃	〃	〃	50	5	800	800	175	2	40	50	1	150	10	−50	55				250*	13	20*	91	
	〃 258	〃	〃	〃	80	5	800	800	175	1	40	45	1	150	10	−50	50				250*	13	20*	91	
	〃 259	〃	〃	〃	90	5	800	800	175	1	40	45	1	150	10	−50	50				250*	13	20*	91	
	〃 260	〃	PA	〃	30	5	1 A	1.6W	175	2	20	60	10	150	10	−50	65				280*	15	23*	83	
	〃 261	〃	〃	〃	60	5	1 A	1.6W	175	1	20	60	10	150	10	−50	65				280*	14	23*	83	
	〃 262	〃	〃	〃	80	5	1 A	1.6W	175	1	20	60	10	150	10	−50	65				280*	13	23*	83	
	〃 263	〃	RF	〃	15		120	100	100	0.4	9				5	−1	60				200*	3	70*	21	
	〃 264	〃	RF.SW	〃	30	5	120	100	100	0.1	9	75	1	10	5	−5	85	t_d=12nS, t_{stg}=10nS, t_r=15nS, t_{off}=30nS			400*	3	70*	21	
	〃 265	〃	〃	〃	40	5	120	100	100	0.1	9	75	1	10	5	−5	85				400*	3	70*	21	
★	〃 266	日電	RF.AF	〃	30	5	30	100	150	0.1	25	75	3	0.5	6	−1	80	2000	0.55	10	250*	1.6	45	23	
★	〃 267	〃	RF.PA	〃	35	5	200	150	150	1	35	70	1	20	6	−1	45				90*	6.5	25	23	
★	〃 268	〃	RF.PA.SW	〃	60	5	30	150	150	5	50	40	1	1	6	−1	55				150*	1.6	50	23	
★	〃 269	〃	SW	〃	25	5	200	150	150	1	15	85	0.5	1				t_{on}<20nS, t_{off}<40nS, t_{stg}<20nS						139	
	〃 270	SON	PA	Si.Me	270	6	5A	50 W (Tc=25°C)	150	1 mA	50	40	3	2 A	10	−500	56				22*	250	5	103	
★	〃 271	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	25	3	20	100	150	1	12				6	−2	70	NF < 8 dB (f = 70Mc)			1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10 pS	23	
★	〃 272	〃	〃	〃	25	3	20	100	150	1	12				6	−2	70	NF = 8 dB (f = 900 Mc)			1200*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 3 pS	23	
★	2SC273	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	120	5	50	500	150	1	60				30	−3	50				150*	2.5	25	84A	
	〃 274																								
	〃 275																								
	〃 276																								
	〃 277																								
	〃 278																								
	〃 279																								
	〃 280	日立	Diff	Si.E	30	5	10	80	125	0.01	20	80	−6	0.1										15	
	〃 281	〃	RF	Si.EPs	30	5	100	200	175	0.1	20	170	6	10	6	−0.1	50	h_{fe}=8 (6V, 10mA, 20Mc)				7	70	12C	
	〃 282	〃	SW	〃	30	5	100	350	175	1	20	100	6	10	6	−10					180*	7	60	12A	
	〃 283	〃	PA	〃	50	5	100	350	175	0.1	20	65	6	10	6	−10	100				180*	7	60	12A	
	〃 284	〃	SW	〃	70	5	100	350	175	1	20	60	6	10	6	−10					160*	7	60	12A	
	〃 285	富士通	PA	Si.EP	50		200	500	150	0.1	10				10	−10	60				320*	3.5	80*	84B	
	〃 285A	〃	RF.PA	〃	50		300	500	150	0.1	10				10	−10	60	KF₂>30dB, KF₃>85dB (15V, 50mA, 1Mc)			500*	3.5	60*	84B	
★	〃 286	日電	RF.Conv.Mix Osc	〃	20		10	100	150	1	12				6	−2	70	PG = 24 dB (f = 100Mc)			900*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 15 pS	23	
★	〃 287	〃	〃	〃	20	2	10	100	150	1	12				6	−2	70	PG = 20 dB (f = 200Mc)			900*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 12 pS	23	
★	〃 288	〃	〃	〃	30	2	20	100	150	1	12				6	−2	70	P_o = 23mW (f = 900Mc)			1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10 pS	23	
★	〃 289	〃	〃	〃	25	2	20	100	150	1	12				6	−2	70	NF = 9 dB (f = 900Mc)			1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 4 pS	23	
★	〃 290	〃	PA	Si.EP	70	5	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	3 mA	30	35	10	350	10	−350		P_o ≒ 6 W (f ≒ 100Mc)			160*	35	25*	83	
	〃 291	SON	〃	Si.E	70	5	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 pS	84C	
	〃 292	〃	〃	〃	100	5	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 pS	84C	
	〃 293	〃	〃	〃	130	5	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 pS	84C	
	〃 294	日電	Diff	Si.EP 複合	25	5	50	300	175	0.1	10	80	1	1	6	−2		h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0			200*	4.5	40	87B	複合管
★	〃 295	〃	Ch	〃	15	5	50	300	175	1	10	50	1	0.2	6	−2					200*	4.5	40	86B	複合管
	〃 296	富士通	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	20	3	25	200	175	1	12				6	−2	80				180*	2.5	100*	50C	
	〃 297	SON	PA	Si.E	70	5	3 A	10 W (Tc=25°C)	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 pS	97C	
	〃 298	〃	〃	〃	100	5	3 A	10 W (Tc=25°C)	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 pS	97C	
	〃 299	〃	〃	〃	130	5	3 A	10 W (Tc=25°C)	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 pS	97C	
	〃 300	三菱	RF	Si.EP	25	5	100	260	150	0.5	15	85	10	0.1	15	−10					400*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 250pS	49A	再登録
	〃 301	〃	〃	〃	25	5	100	260	150	0.01	15	85	10	0.1	15	−10					400*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 250pS	49A	再登録

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	側試情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fe}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC302	三菱	RF.Conv. Mix. Osc	Si.EP	50	5	100	360	200	0.01	15	50	10	0.1	15	−10					420*	3.5	65*	49C	
★ 〃 303	〃	RF.PA	〃	50	3	500	800	200	50	28	20	28	100	20	−50					200*	10		84B	
★ 〃 304	〃	〃	〃	60	4	500	800	200	10	28	25	28	100	20	−50					220*	10		84B	
★ 〃 305	〃	〃	〃	80	5	500	800	200	0.05	28	30	28	100	20	−50					220*	10		84B	
〃 306	〃	RF.SW	〃	50	5	500	800	200	0.1	30	85	10	150	10	−30					240*	10	30*	84B	再登録
〃 307	〃	〃	〃	80	5	500	800	200	10nA	30	85	10	150	10	−30					240*	10	30*	84B	再登録
★ 〃 308	〃	〃	〃	100	5	500	800	200	1	90	65	10	150	10	−30					90*	10	30*	84B	
〃 309	〃	〃	〃	120	5	500	800	200	1	90	65	10	150	10	−30					120*	6	30*	84B	再登録
〃 310	〃	〃	〃	140	5	500	800	200	10nA	90	65	10	150	10	−30					120*	6	30*	84B	再登録
〃 311																								
〃 312																								
〃 313	日立	RF.Conv. Mix Osc	Si.EP	30	2	50	200	200	0.5	10	40	10	10	10	−10	50				1000*	1	$C_c r_{bb'}$ 10pS	9	
★ 〃 314	〃	PA	Si.TMe	75	4	1.2A	2W	175	10	40				4	−100	25				70*	20	27	83	
〃 315	〃	〃	〃	75	4	1.2A	2W	175	10	40				4	−100	25				80*	20	25	83	
〃 316	松下	RF.Conv. Mix Osc. PA	Si.P	45	5	30	300	175	0.01	10				5	−2	300	6500	1.4	32	80*	4.5	80	49C	
〃 317	日立	SW	Si.Me	70	5	100	350	175	0.1	20	100	6	10	6	−10		t_d+t_r<0.09μS, t_s<0.7μS, t_f+t_s<0.7μS			240*	4.5	75	12A	
〃 318	SON	RF	Si.E	50	5	100	300	175	0.2	25	90	3	1	6	−2		h_{fe} = 4.5dB (f = 100Mc)				3	$C_c r_{bb'}$ 100pS	49C	
〃 319	日電	RF.Conv. Mix Osc. PA	Si.EP	40	4	300	1.75W (T_c=25°C)	175	1	20				10	−30	40	P_o = 1.2W (f = 200Mc)			500*	6.5	40*	84A	
〃 320	〃	〃	〃	40	4	500	2.5W (T_c=25°C)	175	1	20				10	−30	40	P_o = 2.4W (f = 200Mc)			600*	6.5	40*	84A	
〃 321	日立	SW	〃	40	5	200	360	175	1	20	40	1	10	10	−20					450*	4		49C	
〃 322	〃	〃	〃	40	5	200	360	175	0.25	20	40	1	10	10	−20					450*	4		49C	
〃 323	東芝	〃	〃	40	5	100	250	175	1	30	50	1	10										49C	
〃 324	富士通	RF.Conv. Mix Osc	Si.P	20	3	25	200	175	2	12				6	−2	70				180*	4.5	60*	49C	
〃 325	沖	RF	Si.EP	12	3	50	250	175	0.02	6				5	−5	110				1000*	1.7	90*	50C	
〃 326	〃	〃	〃	20	3	50	250	175	0.02	6				5	−5	110				1000*	1.7	90*	50C	
〃 327	〃	〃	〃	30	3	50	250	175	0.02	6				5	−5	110				1000*	1.7	90*	50C	
〃 328	〃	〃	〃	30	3	20	200	175	0.2	15				6	−5	60	NF = 3db (f = 70Mc)			1500	0.65	$C_c r_{bb'}$ 5pF	50C	
〃 329	〃	〃	〃	30	3	20	200	175	0.2	15				6	−5	60	NF = 1.5dB (f = 70Mc)			1500*	0.65	$C_c r_{bb'}$ 5pS	50C	
〃 330	〃	RF. LN	〃	20	3	20	200	175	0.5	15	60	10	10	10	−10	NF = 2.5dB (6V, −3mA, 450MHz)				3500*	0.75	$C_c r_{bb'}$ 2.5pS	128	
〃 331	〃	〃	〃	20	3	20	200	175	0.5	15	60	10	10	10	−10	NF = 2.0dB (6V, −3mA, 450MHz)				3500*	0.75	$C_c r_{bb'}$ 1.5pS	128	
2SC332	沖	RF.SW	Si.EP	30	5	200	150	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95	t_{on}<40nS, t_{off}<44nS t_s<26nS			450*	3	70*	48C	
〃 333	〃	〃	〃	40	5	200	150	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95	t_{on}<40nS, t_{off}<44nS t_s<26nS			450*	3	70*	48C	
〃 334	〃	〃	〃	60	5	200	150	175	0.1	15	65	1	10	10	−10	85	t_{on}<40nS, t_{off}<44nS t_s<26nS			450*	2	70*	48C	
★ 〃 335	〃	〃	〃	50	5	200	250	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	100	t_{on}<40nS, t_{off}<44nS t_s<26nS			450*	3	70*	49C	
★ 〃 336	〃	〃	〃	60	5	200	250	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	100	t_{on}<40nS, t_{off}<44nS t_s<26nS			450*	3	70*	49C	
★ 〃 337	〃	RF	Si.P	20	5	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				100*	3	50*	49C	
★ 〃 338	〃	〃	〃	70	5	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				100*	3	50*	49C	
★ 〃 339	〃	〃	〃	110	5	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				100*	3	50*	49C	
〃 340	〃	〃	〃	20	5	20	100	100	0.1	15	170	1	2	5	−1	2200				130*	1.4	60*	21	
〃 341	〃	〃	〃	70	5	20	100	100	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				120*	1.4	60*	21	
〃 342	〃	〃	〃	110	5	20	100	100	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				120*	1.4	60*	21	
〃 343	〃	RF.SW	Si.EP	35	5	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	−30	70				430*	6.5	45*	84A	
〃 344	〃	〃	〃	60	5	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	−30	70				430*	6	45*	84A	
〃 345	〃	〃	〃	80	5	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	−30	70				430*	5	45*	84A	
〃 346	〃	RF.SW	〃	45	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	−30	75	t_{on}<80nS, t_{off}<70nS t_{stg}<35nS			320*	10	40*	84A	
〃 347	〃	〃	〃	60	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	−30	75	t_{on}<80nS, t_{off}<70nS t_{stg}<35nS			320*	10	40*	84A	
〃 348	〃	〃	〃	60	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	−30	75	t_{on}<80nS, t_{off}<70nS t_{stg}<35nS			320*	7.5	40*	84A	
〃 349	〃	〃	〃	90	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	−30	75	t_{on}<80nS, t_{off}<70nS t_{stg}<35nS			320*	7.5	40*	84A	
〃 350	日立	RF.AF.LN	Si.Me	30	5	100	200	175	0.01	20	120	6	0.1	6	−1	160	7000	2	25	180*	7	60	12A	
★ 〃 351	東芝	RF	Si.P	40	2	20	200	150	0.5	18				10	−4	50				600*	1.4	15	33	
〃 352	SON	〃	Si.EP	50	5	100	750	175	0.2	25	90	3	1	6	−2		h_{fe} = 4.5dB (f = 100Mc)						84C	
〃 353	〃	〃	〃	100	5	100	750	175	0.2	25	90	3	1	6	−2		h_{fe} = 4.5dB (f = 100Mc)						84C	
〃 354	富士通	RF.PA	Si.TP	40	4	1.5A	7W (T_c=25°C)	200	1	30	100	4	500	4	−100	50				180*	20	10*	84B	
〃 355	〃	PA	〃	75	4	2.5A	15W (T_c=25°C)	200	1	30	100	4	500	4	−100	50	P_o = 3W (f = 150Mc)			180*	20	10*	111	
〃 356	日電	SW	Si.EP	30	5	200	300	175	1	20	60	1	10				t_d+t_r<20nS, t_s+t_f<40nS, t_r<20nS						46C	
〃 357																								
〃 358																								
〃 359																								
〃 360	東芝	RF	Si.P	30	5	100	250	175	1	15				10	−10	100				150*	5	50	49C	
〃 361	〃	RF.Conv. Mix Osc	〃	25	5	100	200	125	0.5	18	40~160	12	2	6	−2	80				150*	4	90	33	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流電流増幅率 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SC362	東芝	RF. Conv. Mix Osc	Si. P	25	5	100	200	125	0.5	18	70~280	12	2	6	−2	140				150*	4	90	33	
	〃 363	〃	〃	〃	25	5	100	200	125	0.5	18	150~500	12	2	6	−2	250				150*	4	90	33	
	〃 364	〃	RF. Conv Mix. Osc	〃	25	5	40	200	125	0.5	18				6	−2	400				150*	4	100	33	
	〃 365																								
	〃 366	東芝	RF. Conv Mix. Osc	Si. P	50	5	400	300	125	0.5	18				10	−10	60				120*	10	70	33	
★	〃 367	〃	〃	Si. EP	40	5	800	300	125	0.5	18				10	−10	70				120*	10	60	33	2SA467之對稱
★	〃 368	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	25	5	100	250	175	0.1	18				10	−1	250				150*	1.5	120	49C	
★	〃 369	〃	〃	〃	18	5	100	200	125	0.1	18				10	−1	250				150*	1.5	120	33	
★	〃 370	〃	〃	〃	30	4	100	200	125	1	18				6	−1	40				150*	2.5	80	33	
★	〃 371	〃	〃	〃	30	4	100	200	125	1	18				6	−1	80				150*	2.5	80	33	
	〃 372	〃	〃	〃	35	4	100	200	125	0.5	18	70~400	12	2	10	−1					200*	2	50	33	2SA495之對稱
	〃 373	〃	〃	〃	35	4	100	200	125	0.5	18	70~400	12	2	10	−1					200*	2	50	33	
★	〃 374	〃	〃	〃	30	4	100	200	125	1	18				6	−1	400				150*	2.5	80	33	
★	〃 375	〃	RF	〃	20	2	50	200	125	0.5	15				10	−8	100				600*	1.5	20	33	
★	〃 376	〃	〃	〃	70	4	100	200	125	1	18				6	−1	60				150*	2.5	40	33	
★	〃 377	〃	〃	〃	35	4	30	200	125	0.5	18				12	−2	70				150*	2	$C_c r_{bb'}$ 40pS	33	
	〃 378	〃	RF. Conv. Mix	〃	35	4	30	200	125	0.5	18	40~240	12	2	10	−1					150*	2	$C_c r_{bb'}$ 40pS	33	
★	〃 379	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	30	4	100	200	125	0.5	18				10	−2	70				300*	2	40	33	
	〃 380	〃	IF	Si. P	35	4	30	200	125	0.5	18	40~240	12	2	10	−1					250*	2	20	33	
	〃 381	〃	〃	Si. EP	40	4	20	100	125	0.5	18	25~140	6	1	16	−1					>250*	2	$C_c r_{bb'}$ 10pS	33	
	〃 382	〃	〃	〃	40	2	50	200	125	0.5	18	>30	10	4	10	−4		PG > 32 dB (f = 45Mc)			600*	Cre 1.0	18	33	正向AGC
	〃 383	〃	〃	〃	75	3	50	300	125	0.025	10	20~100	12.5	12.5	12	−12.5					>300*	0.8~2.0		33	
★	〃 384	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	20	2	50	200	125	0.5	15				6	−1	50				500*	1.4	25	33	
★	〃 385	〃	〃	〃	20	2	20	200	125	0.5	15				3	−8	80				600*	1.6	20	33	
★	〃 386	〃	RF. Conv. Mix	〃	20	2	20	200	125	0.5	15				3	−8	80				500*	1.6	18	33	
★	〃 387	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	20	2	50	200	125	0.5	15				10	−8	100	P_o = 8 mW (f = 930Mc)			900*	1.4	15	33	
★	〃 388	〃	RF. Conv. Mix	〃	20	2	20	200	125	0.5	15				3	−8	80				450*	1.6	18	33	
★	〃 389	〃	RF	Si. P	20	3	20	150	150	0.1	10				5	−4	50				500*	0.8	10	50C	
	〃 390	〃	〃	Si. EP	30	3	20	150	150	0.1	20	40~200	10	2	10	−2		NF = 2 dB (f = 100Mc, 10V, 2mA)			1000*	0.5	$C_c r_{bb'}$ < 6 pS	50C	
★	〃 391	〃	〃	〃	20	2	20	150	150	1	10				10	−2	70				1200*	1	$C_c r_{bb'}$ 5 pS	50C	
	2SC392	東芝	RF	Si. P	30	3	20	150	150	0.5	15	40~300	10	2	10	−2		NF = 4.5dB (f = 800Mc)			800*	Cre 0.3	$C_c r_{bb'}$ 3 pS	50C	正向AGC
	〃 393	〃	〃	〃	20	2	20	200	150	50	10				5	−4	100	PG = 35dB (f = 45Mc)						50C	
	〃 394	〃	RF. Conv. Mix	Si. EP	25	4	100	200	125	0.5	18	40~300	12	12	10	−1					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 45pS	33	
★	〃 395	〃	SW	〃	20	3	200	250	175	1	15	50	1	1										49C	
★	〃 396	〃	RF	〃	30	3	200	250	175	1	15				10	−10	40				450*	3	60	49C	
★	〃 397	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	20	2	50	200	175	0.5	15				10	−8	80				800*	1.9	30	50C	
	〃 398	〃	RF	Si. P	20	2	20	200	150	0.05	10	20~200	5	4	5	−4					>250*	0.25~0.5	<25	50C	正向AGC
	〃 399	〃	RF. Conv	〃	20	2	20	200	150	0.05	10	20~200	5	4	5	−4					>250*	0.25~0.5	<25	50C	正向AGC
	〃 400	〃	RF. SW	Si. EP	30	5	100	250	175	0.5	15	30~350	1	10	10	−10					300*	4	40	49C	
	〃 401	SON	RF. Conv. Mix Osc, SW	〃	50	5	100	100	120	0.2	25	90	3	1	6	−1	110	t_r < 0.06μS, t_f < 0.15μS t_s < 0.5μS			140*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 80pS	38	
★	〃 402	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	50		100	100	120	0.2	25	90	3	1	6	−1	110				140*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 80pS	38	
★	〃 403	〃	〃	〃	50		100	100	120	0.2	25	60	3	1	6	−1	75				140*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 50pS	38	
★	〃 404	〃	RF	Si. E	50	3	50	100	120	0.2	25	90	3	1	6	−1	120				140*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 80pS	38	
★	〃 405	三菱	SW	Ge. A	25	15	200	150	100	10	25	60	1	100										68	
★	〃 406	〃	〃	〃	25	15	200	150	100	10	25	120	1	100										68	
	〃 407	新電元	〃	Si. DB	150	4	10 A	100 W (T_C = 25°C)	150	50mA	150	20	5	5 A	10	2 A		t_r < 1 μS, t_f < 1 μS t_s < 4 μS			f = 0.4			102	
	〃 408	〃	〃	〃	150	4	10 A	100 W (T_C = 25°C)	150	50mA	150	40	5	5 A	10	2 A		t_r < 1 μS, t_f < 1 μS t_s < 4 μS			f = 0.4			102	
	〃 409	〃	〃	〃	200	4	10 A	100 W (T_C = 25°C)	150	20mA	200	20	5	5 A	10	2 A		t_r < 1 μS, t_f < 1 μS t_s < 4 μS			f = 0.4			102	
	〃 410	〃	〃	〃	200	4	10 A	100 W (T_C = 25°C)	150	20mA	200	40	5	5 A	10	2 A		t_r < 1 μS, t_f < 1 μS t_s < 4 μS			f = 0.4			102	
	〃 411	〃	〃	〃	300	4	10 A	100 W (T_C = 25°C)	150	5 mA	300	20	5	5 A	10	2 A		t_r < 1 μS, t_f < 1 μS t_s < 4 μS			f = 0.4			102	
	〃 412	〃	〃	〃	300	4	10 A	100 W (T_C = 25°C)	150	5 mA	300	40	5	5 A	10	2 A		t_r < 1 μS, t_f < 1 μS t_s < 4 μS			f = 0.4			102	
	〃 413	沖	PA. SW	Si. EP	60	5	1.5 A	20 W (T_C = 25°C)	175	10	50	50	10	150	10	−100	60				180*	20	10*	83	
	〃 414	〃	〃	〃	90	5	1.5 A	20 W (T_C = 25°C)	175	2	50	50	10	150	10	−100	60				180*	17	10*	83	
	〃 415	〃	〃	〃	120	5	1.5 A	20 W (T_C = 25°C)	175	2	50	50	10	150	10	−100	60				180*	14	10*	83	
	〃 416	〃	SW	〃	90	5	1.5 A	2 W	175	5	80	60	1	400				t_{on} < 100nS, t_{off} < 250nS t_{stg} < 190nS						83	
	〃 417																								
	〃 418																								
	〃 419																								
	〃 420	沖	SW	Si. EP	25	5	80	150	175	0.1	15	130	3	2			t_{on} < 15nS, t_{off} < 30nS t_{stg} < 20nS				h_{FE1}/h_{FE2} > 0.13 (5V, 2mA)			87C	複合管
	〃 421																								

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測量情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SC422																								
	〃 423	三洋	RF.Conv.Mix Osc.PA	Si.EP	40	4	300	500	175	1	35	80	10	20	10	−20					500*	5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	84B	
	〃 424	〃	〃	〃	40	4	300	200	175	1	35	80	10	20	10	−20					500*	5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	84B	
	〃 425	〃	〃	〃	20	4	300	500	175	1	15	80	10	20	10	−20					500*	5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	84B	
	〃 426	〃	〃	〃	20	4	300	200	175	1	15	80	10	20	10	−20					500*	5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	84B	
	〃 427	〃	RF.Conv.Mix Osc.PA.SW	〃	40	5	100	300	175	1	35	80	6	1	10	−20	50				180*	5	60	49C	
	〃 428	〃	〃	〃	20	5	100	300	175	1	15	80	6	1	10	−20	50				180*	5	60	49C	
★	〃 429	日電	RF.Conv.Mix Osc	〃	25	2	10	100	150	1	12				6	−1	27	NF < 7 dB (f = 70Mc)			380*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 19 pS	23	
★	〃 430	〃	〃	〃	25	2	10	100	150	1	12				6	−1	46	NF < 7 dB (f = 70Mc)			420*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 19 pS	23	
	〃 431	新電元	SW	Si.DB	150	4	30A	200W (T_c=25°C)	150	50mA	150	20	5	10A	10	−2.5A					$f_{\alpha e}$ = 0.4			105	
	〃 432	〃	〃	〃	150	4	30A	200W (T_c=25°C)	150	50mA	150	40	5	10A	10	−2.5A					$f_{\alpha e}$ = 0.4			105	
	〃 433	〃	〃	〃	200	4	30A	200W (T_c=25°C)	150	20mA	200	20	5	10A	10	−2.5A					$f_{\alpha e}$ = 0.4			105	
	〃 434	〃	〃	〃	200	4	30A	200W (T_c=25°C)	150	20mA	200	40	5	10A	10	−2.5A					$f_{\alpha e}$ = 0.4			105	
	〃 435	〃	〃	〃	300	4	30A	200W (T_c=25°C)	150	5mA	300	20	5	10A	10	−2.5A					$f_{\alpha e}$ = 0.4			105	
	〃 436	〃	〃	〃	300	4	30A	200W (T_c=25°C)	150	5mA	300	40	5	10A	10	−2.5A					$f_{\alpha e}$ = 0.4			105	
★	〃 437	三菱	PA	Si.TP	100	5	2A	13W (T_c=25°C)	175	10	28	20	28	350	28	−300	30				210*	45	8*	83	MT-301
★	〃 438	〃	〃	〃	75	5	2A	13W (T_c=25°C)	175	100	28	20	28	350	28	−300	30				210*	45	8*	83	MT-302
★	〃 439	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	25	5	100	500	200	0.5	15	50	10	0.1	10	−1	100				420*	3.5	65*	84B	
	〃 440	〃	〃	〃	25	5	100	500	200	0.5	15	50	10	0.1	10	−1	100				420*	3.5	65*	84B	MTF-156
★	〃 441	〃	〃	〃	25	5	100	500	200	0.01	15	50	10	0.1	10	−1	100				420*	3.5	65*	84B	MTF-157
★	〃 442	〃	〃	〃	50	5	100	500	200	0.01	15	50	10	0.1	10	−1	100				420*	3.5	65*	84B	MTF-158
★	〃 443	〃	PA	〃	50	3	500	800	200	0.05	28	20	28	100	28	−5	15	PG = 10 dB (f = 70Mc)			200*	10		84B	MTF-206
	〃 444	〃	〃	〃	60	4	500	800	200	0.01	28	25	28	100	28	−5	20	PG = 12 dB (f = 70Mc)			220*	10		84B	MTF-207
★	〃 445	〃	〃	〃	80	5	500	800	200	0.05	28	30	28	100	28	−5	25	PG = 13 dB (f = 70Mc)			220*	10		84B	MTF-208
★	〃 446	〃	〃	〃	60	4	500	800	200	0.01	28	25	28	100	28	−5	20	PG = 12 dB (f = 70Mc)			220*	10		84B	
★	〃 447	〃	〃	〃	75	4	2A	5W	175	50	28	20	28	350	28	−100	30				210*	29	8*	112	
★	〃 448	〃	〃	〃	100	5	2A	5W	175	10	30	20	28	350	28	−100	30				190*	29	8*	112	MTD-306
★	〃 449	〃	〃	〃	75	5	2A	5W	175	100	30	20	28	350	28	−100	30				190*	29	8*	112	MTD-307
★	〃 450	〃	〃	〃	60	4	2A	5W	175	100	30	20	28	350	28	−100	30				210*	29	8*	112	MTD-308
★	〃 451	〃	〃	〃	100	4	1.2A	25W (T_c=25°C)	200	100	28	>15	28	350	28	−100	30				180*	20	15*	112	
★	2SC452	三菱	PA	Si.TP	100	4	1.2A	25W (T_c=25°C)	200	500	28	>15	28	350	28	−100	30				180*	20	15*	112	
★	〃 453	〃	〃	〃	90	4	1.2A	25W (T_c=25°C)	200	500	28	>10	28	350	28	−100	30				170*	20	15*	112	
	〃 454	日立	RF.Conv.Mix Osc	Si.EPs	30	5	100	200	125	0.5	18				12	−2	150				230*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 100pS	37	
	〃 455	〃	〃	〃	30	5	100	200	125	1	18				12	−2	40				230*	1.8	40	37	
	〃 456	松下	PA	Si.EP	50	1.5	600	750	175	1	12	12	6	80	6	−80	20				200*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	84A	
★	〃 457	日電	Diff	〃	25	5	50	300	175	0.1	10	80	1	1	6	−2		h_{FE1}/h_{FE2} = 0.8~1.0			200*	4.5	40*	87B	複合管
	〃 458	日立	RF	Si.EPs	30	5	100	200	125	0.5	18	140	6	2	5	−0.1	130	16.5k	0.7	11	230*	1.8	100	37	
★	〃 459	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	5	100	200	125	1	18	160	12	2	12	−2	110	2800	1.6	20	230*	1.8	100	37	
	〃 460	〃	〃	Si.P	30	5	100	200	125	0.5	18				12	−2	85				230*	1.8	40	37	
	〃 461	〃	〃	〃	30	5	100	200	125	0.5	18				12	−2	85				230*	1.8	40	37	
★	〃 462	〃	RF	〃	40	4	50	200	200	0.5	20				10	−4	90	PG = 26dB (f = 45Mc)			600*	0.9		9	
	〃 463	〃	〃	〃	40	4	50	200	200	0.5	20				10	−4	90	PG = 16dB (f = 200Mc)			600*	0.8		9	正(順) AGC
	〃 464	〃	RF.Conv Mix.Osc	〃	30	2	50	200	200	0.5	10				6	−1	40	PG = 28dB (f = 45Mc)			1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10pS	9	
	〃 465	〃	〃	〃	30	2	50	200	200	0.5	10				6	−1	40				1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10pS	9	
	〃 466	〃	〃	〃	30	2	50	200	200	0.5	10				6	−1	40	PG = 14dB (f = 200Mc)			1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10pS	9	
	〃 467	富士通	SW	Si.EP	20	4	50	300	175	0.5	10	40	1	10										49C	
★	〃 468	日立	〃	〃	40	5	200	200	175	1	20	60	1	10	10	−20					450*	4-		8A	
★	〃 469	日電	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	5	30	100	125	0.1	15	90	3	0.5	6	−1	100				250*	1.6	50*	23	
★	〃 470	SONY	RF	〃	90	5	100	750	175	1	25	60	5	3	6	−5					150*	2	$C_c r_{bb'}$ 20pS	84C	
★	〃 471	日立	AF	Si.Me	30	5	100	200	175	0.1	20				6	−0.1	50				160*	7	70	8A	
★	〃 472	〃	SW	〃	V_{CBX} 30	5	100	200	175	0.1	20	100	6	10				t_{on} < 0.1μS, t_{off} < 0.8μS, t_s < 1μS			180*	7	60	8A	
★	〃 473	〃	〃	Si.TMe	70	5	100	200	175	0.1	20	80	6	10				t_{on} < 80 nS, t_{off} < 200nS, t_s < 700nS			180*	4.5	75	8A	
	〃 474	〃	〃	Si.Me	V_{CBX} 70	5	100	200	175	0.1	20	60	6	10				t_{on} < 0.1μS, t_{off} < 0.8μS, t_s < 1μS			160*	7		8A	
★	〃 475	日電	RF.AF LN	Si.EP	20	5	100	150	150	0.1	15	300	3	0.5	3	−0.5	350	15kΩ	18	3.5	100*			23	
★	〃 476	〃	RF.AF	〃	20	5	100	150	150	0.1	15	350	3	0.5	3	−0.5	400	15kΩ	20	3.8	100*			23	
★	〃 477	松下	RF	〃	50	5	30	140	175	1	10	170	10	1							230*	Cre 0.5pS		49C	
	〃 478	〃	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	50	1.5	120	300	175	1	15	20	12	20	12	−1	15				180*	4	$C_c r_{bb'}$ 75pS	49C	
	〃 479	日立	SW	〃	60	5	600	650	175	1	40	80	1	100				t_{on} < 80nS, t_s < 70nS, t_{off} < 100nS						84A	
★	〃 480	〃	〃	〃	60	5	600	800	175	1	30	80	1	150				t_{on} < 30nS, t_s < 30nS, t_{off} < 40nS						84A	
	〃 481	東芝	PA	〃	60	5	1A	600	150	10	30	35	2	150	2	−150		P_o > 1 W (f = 30MHz, V_{cc} = 24V, P_i = 0.1W)			>100*	<30	<25	84B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電氣的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏值情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC482	東芝	RF.PA	Si.EP	40	5	600	600	175	1	30	30~300	2	150	2	−150					>50*	15	7	84B	
★ 〃 483	〃	PA	Si.TMe	100	5	1 A	15 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	120	2	150	2	−30	100				25*	80	5	99	
★ 〃 484	〃	〃	〃	150	5	1.5A	800	175	10	30	30~300	2	200	10	−30					20*	50	10	84B	2SA484 之對稱
〃 485	〃	〃	〃	100	5	1.5A	800	175	10	30	30~300	2	200	10	−30					20*	50	10	84B	2SA485 之對稱
〃 486	〃	〃	〃	70	5	1.5A	800	175	10	30	30~300	2	200	10	−200					20*	50	10	84B	2SA486 之對稱
〃 487	〃	〃	〃	110	5	1.5A	15 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	120	2	200	2	−200	100				20*	85	5	99	
〃 488	〃	〃	〃	140	5	3 A	15 W (Tc=25°C)	150	3mA	50				5	−0.5A	80				10*	130	5	99	
★ 〃 489	〃	〃	〃	100	5	3 A	15 W (Tc=25°C)	150	3mA	50				5	−0.5A	80				10*	130	5	99	
★ 〃 490	〃	〃	〃	60	5	3 A	15 W (Tc=25°C)	150	3mA	50				5	−0.5A	80				10*	130	5	99	
★ 〃 491	〃	〃	〃	50	5	1.5A	15 W (Tc=25°C)	150	10	30	70	2	0.5A	2	−0.5A	70				40*	40	25	99	
★ 〃 492	〃	〃	〃	110	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50				5	−1A	60				20*	80	15	102	
★ 〃 493	〃	〃	〃	80	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50				5	−1A	60				20*	80	15	102	
★ 〃 494	〃	〃	〃	50	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50				5	−1A	60				20*	80	15	102	
〃 495	〃	〃	Si.EP	70	5	600	550	125	1	30	40~240	2	50	10	−10					100*	10	10	164	2SA495 之對稱
〃 496	〃	〃	〃	40	5	600	550	125	1	30	40~240	2	50	10	−10					100*	10	10	164	2SA496 之對稱
〃 497	〃	〃	〃	100	5	800	600	150	1	30	40~240	2	200	10	−10					80*	15	10	84B	2SA497 之對稱
〃 498	〃	〃	〃	80	5	800	600	150	1	30	40~240	2	200	10	−10					80*	15	10	84B	2SA498 之對稱
〃 499	〃	〃	〃	100	2	20	300	125	1	18				12	−2	80				150*	2	40	33	
〃 500	〃	RF	Si.TMe	120	5	20	600	150	1	30				30	−3	140				175*	2	40	84A	
★ 〃 501	〃	〃	Si.EP	60	5	300	750	175	0.1	30				10	−10	80				200*	4	40	84B	2SA501 之對稱
★ 〃 502	〃	PA	〃	60	5	1 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	30	30	5	200	5	−200	30	PG = 12dB (f = 60Mc, P_{in} = 0.1W)						84C	
〃 503	〃	RF.SW	〃	60	5	600	800	175	0.5	30	30~300	2	150	10	−10					150*	13	8	84B	2SA503 之對稱
〃 504	〃	〃	〃	40	5	600	800	175	0.5	30	30~300	2	150	10	−10					150*	13	8	84B	2SA504 之對稱
〃 505	〃	〃	Si.TP	300	3	100	600	150	1	100	40~140	2	50	10	−10					60*	< 20	< 20	84B	
〃 506	〃	〃	〃	200	3	100	600	150	1	100	40~140	2	50	10	−10					60*	< 20	< 20	84B	
〃 507	〃	〃	〃	170	5	80	750	175	0.5	100	70	5	10	20	−10					250*	2.8	50*	84B	
〃 508	東芝	PA	Si.TMe	180	5	4 A	20 W (Tc=25°C)	150	120	50	40	5	4 A	5	−4A					60*	50	12	99	
〃 509	〃	RF. PA	Si.EP	35	5	500	600	150	0.1	20	100	2	50	10	−10					100*	11	10	131	2SC109 之對稱
〃 510	東芝	PA	Si.TP	140	5	1.5A	800	175	1	30	30~150	2	200	10	−30					60*	25	10	84B	2SA510 之對稱
★ 〃 511	〃	〃	〃	120	5	1 A	800	150	3	30				10	−50					50*	30	10	84B	2SA511 之對稱
2SC512	東芝	PA	Si.TP	100	5	1.5A	600	175	1	30	30~150	2	200	10	−30					60*	25	10	84B	2SA512 之對稱
★ 〃 513	〃	〃	〃	70	5	1 A	800	150	3	30				10	−50	50				50*	30	10	84A	2SA513 之對稱
★ 〃 514	〃	〃	Si.TMe	300	3	100	4 W (Tc=25°C)	150	0.1	300				10	−50	60				20*	7	30	98	
★ 〃 515	〃	〃	〃	300	3	100	6 W (Tc=25°C)	150	100	300				10	−50	60				20*	7	30	99	
〃 516	〃	RF.PA	Si.DB	100	5	1.5A	800	175	0.5	30	60	2	200	5	−200	60				50*	25	10	84B	
〃 516A	〃	〃	〃	140	5	1.5A	800	175	0.5	30	60	2	200	5	−200	60				50*	25	10	84B	
〃 517	〃	PA	Si.EP	60	4	2 A	10 W (Tc=25°C)	175	10	30	30	5	500	10	−200					300*	25	10	97B	
★ 〃 518	〃	〃	Si.TMe	140	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50	40	5	5 A	5	−5A	40	h_{fe} = 2 (f = 20Mc)				70	10	102	
★ 〃 518A	〃	〃	〃	180	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	1 mA	50	40	5	5 A	5	−5A	40	h_{fe} = 2 (f = 20Mc)				70	10	102	
〃 519	〃	〃	〃	110	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50	50	5	1 A	5	−0.5A	50				20*	150	15	102	
〃 519A	〃	〃	〃	130	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	50	30~300	5	1 A	10	−1A					20*	150	15	102	
★ 〃 520	〃	〃	〃	80	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50	50	5	1 A	5	−0.5A	50				20*	150	15	102	
〃 520A	〃	〃	〃	100	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	50	30~300	5	1 A	10	−1A					20*	150	15	102	
★ 〃 521	〃	〃	〃	50	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50	50	5	1 A	5	−0.5A	50				20*	150	15	102	
〃 521A	〃	〃	〃	70	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	50	30~300	5	1 A	10	−1A					20*	150	15	102	
〃 522	〃	〃	Si.TP	140	5	1.5A	10 W (Tc=25°C)	175	1	30	30~150	2	200	10	−30					60*	25	10	97B	2SA510 之對稱
★ 〃 523	〃	〃	〃	120	5	1.5A	10 W (Tc=25°C)	175	3	30				10	−50	50				50*	25	10	97B	
〃 524	〃	〃	〃	100	5	1.5A	10 W (Tc=25°C)	175	1	30	30~150	2	200	10	−30					60*	25	10	97B	2SA512 之對稱
★ 〃 525	〃	〃	〃	70	5	1.5A	10 W (Tc=25°C)	150	3	30				10	−50	50				50*	35	10	97B	
★ 〃 526	松下	〃	Si.TMe	165	5	55	2.3W (Tc=25°C)	175	2	12				20	−45	20				250*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 25pS	84A	
〃 527	〃	RF	Si.P	35	3	10	130	175	1	10				10	−2.5	50				340*	1	20	50C	
〃 528	日立	RF.PA	Si.EP	20	5	150	200	125	0.5	20	100	1	150	6	−1	70				100*	12	35	37	
〃 529	〃	RF.AF	Si.P	30	5	100	100	125	0.5	18	160	12	2	12	−2	160	2800	0.7	20	230*	1.8	100	36	
〃 530	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	5	100	100	125	0.5	18				12	−2	150				230*	1.8	100	36	
〃 531	〃	〃	〃	30	5	100	100	125	0.5	18				12	−2	40				230*	1.8	40	36	
〃 532	〃	〃	〃	30	5	100	100	125	0.5	18				12	−2	110	PG = 28dB (f = 10.7Mc)			230*	1.8	100	36	
〃 533	〃	〃	〃	30	5	100	100	125	0.5	18				12	−2	85	PG = 29dB (f = 10.7Mc)			230*	1.8	40	36	
〃 534	〃	〃	〃	30	5	100	100	125	0.5	18				12	−2	85	PG = 17dB (f = 100Mc)			230*	1.8	40	36	
〃 535	〃	〃	Si.EP	30	4	20	100	125	0.5	10	80	6	1	6	−1	70				700*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 5 pS	37	
〃 536	三洋	〃	Si.P	40	5	100	200	125	1	35	120	6	1	6	−1					180*	3	$C_c r_{bb'}$ 250pS	27	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測定情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SC537	三洋	RF. Conv. Mix Osc.	Si. P	20	5	100	200	125	1	15	120	6	1	6	−1	80				180*	3	$C_c r_{bb'}$ 280pS	27	
	〃 538	松下	RF. AF	Si. EP	25	5	50	300	175	1	10	250	5	2	5	−2	250	3500	2.5	35	80*	4.5	70	49C	2SA550之対偶
	〃 538A	〃	〃	〃	45	5	50	300	175	1	10	250	5	2	5	−2	250	3500	2.5	35	80*	4.5	70	49C	2SA550A之対偶
★	〃 539	〃	RF	〃	25	5	50	300	175	1	10	250	5	2	5	−2	250	3500	2.5	35	80*	4.5	70	49C	
★	〃 540	日電	RF. AF. LN	〃	30	5	100	150	150	0.1	25	270	3	0.5	3	−0.5	300	15kΩ	16		100	8	30	23	
	〃 541	富士通	PA	〃	50	4	1 A	7 W (Tc=25°C)	200	5	30	30	4	100	4	−100	30				400*	7	12*	84B	
	〃 542	〃	〃	〃	65	4	1.5A	11.6W (Tc=25°C)	200	5	30	25	4	500	4	−150	30				400*	7	10*	111	
	〃 543	〃	〃	〃	65	4	3 A	23 W (Tc=25°C)	200	12	30	20	4	1 A	4	−200	30				300*	14	7*	111	
	〃 544	三洋	RF. Conv. Mix Osc.	〃	40	4	30	120	125	1	30	60	6	1	6	−1					350*	1.4	$C_c r_{bb}$ 40pS	27	
	〃 545	〃	〃	〃	20	4	30	120	125	1	15	60	6	1	6	−1					350*	1.4	$C_c r_{bb}$ 40pS	27	
	〃 546	〃	〃	〃	30		30	150	125	1	30				10	−2	80				600*	1	$C_c r_{bb'}$ 9pS	27	
	〃 547	東芝	PA	〃	65	4	1 A	6 W (Tc=25°C)	175	100	30				28	−150					500*	<10	12	84B	
★	〃 548	〃	RF. PA	〃	36	4	500	6 W (Tc=25°C)	175	100	15				13.5	−100	30				550*	13	10*	84B	
	〃 549	〃	PA	〃	65	4	1.5A	10 W (Tc=25°C)	175	100	30				28	−150	30				500*	<10	7	111	
★	〃 550	〃	〃	〃	36	4	1.5A	10 W (Tc=25°C)	175	100	15				13.5	−150	30				400*	18	7*	111	
	〃 551	〃	〃	〃	65	4	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	250	30				28	−150					400*	<20	6.5*	111	
★	〃 552	〃	〃	〃	36	4	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	250	15				13.5	−300	30				350*	40	5*	111	
	〃 553	〃	〃	〃	55	4	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	250	30				28	−200	30				400*	15	6.5*	111	
★	〃 554	〃	〃	〃	36	4	500	6 W (Tc=25°C)	175	100	15				13.5	−100	30				400*	17	10*	84B	
	〃 555	〃	〃	〃	55	3.5	400	4.2 W (Tc=25°C)	175	20	28				28	−25					800*	3	25*	84B	
★	〃 556	〃	RF. PA	〃	40	2	400	750	150	25	20				15	−50	45				850*	2.8	100*	84B	
	〃 557	〃	PA	〃	40	3.5	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	20	15	50	2	400	10	−200					350*	25	10*	111	
	〃 558	〃	〃	Si. TMe	250	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	1mA	50	40	5	5 A	5	−5A					20	70	10	102	
★	〃 559	〃	〃	Si. EP	60	5	300	600	175	10	30	80	1	100	10	−10		h_{fe} = 2.3 (100MHz)				3.2	10	84B	
	〃 560	東芝 富士通	RF	Si. EP	80	5	800	800	175	0.5	30	30~120	2	150	10	−50	70				150*	11	15	84B	2SA560之対偶
	〃 561	富士通	RF. Conv. Mix Osc	Si. P	20	2	25	200	125	2	12				6	−2	35				200*	2	60*	30	
	〃 562	松下	RF	〃	40	4	25	130	175	1	10	>26	10	4	10	−4	80				330*	Cre 0.15pF	$C_c r_{bb}$ 45pS	117C	正向AGC
	〃 563	〃	〃	Si. EP	40	4	25	200	175	1	10	>38	10	7	10	−5	130				550*	Cre 0.23pF	$C_c r_{bb}$ 80pS	117C	
	〃 564	富士通	SW	〃	50	5	500	650	175	1	10	50	1	150				t_r = 45nS, t_f = 35nS, t_s = 50nS						84B	
	〃 565	〃	〃	〃	50	5	200	350	175	1	10	45	1	10				t_r = 10nS, t_f = 26nS, t_s = 100nS						49C	
	2SC566	日電	RF. PA	Si. EP	50	4	300	800	175	0.2	35	70	10	100	10	−30					700*	4		85A	
	〃 567	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	30	3	20	200	150	0.5	15				6	−2	80				1300*	0.65	$C_c r_{bb'}$ 3pS	50C	
	〃 568	〃	〃	〃	30	3	20	200	150	0.1	15				6	−2	80	NF = 1.5dB (f = 70Mc)			1000*	0.65	$C_c r_{bb'}$ 3pS	50C	
	〃 569	協同	SW	〃	40	4.5	150	150	150	0.5	20	60	1	10				t_r < 15nS, t_f < 15nS, t_s < 20nS						22	KT 200
	〃 570	〃	〃	〃	40	4.5	200	300	150	0.5	20	60	1	10				t_r < 15nS, t_f < 15nS, t_s < 20nS						28	KT 210
★	〃 571	松下	PA	〃	36	4	500	6 W (Tc=25°C)	175	5	20	70	13.5	100	13.5	−100	70				320*	27	5*	84B	
★	〃 572	〃	〃	〃	36	4	1 A	10 W (Tc=25°C)	175	5	20	80	13.5	200	13.5	−200	80				330*	27	5*	111	
★	〃 573	〃	〃	〃	36	4	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	10	20	80	13.5	400	13.5	−400	80				350*	27	4.5*	111	
	〃 574	〃	RF. PA	〃	80	4	1 A	7.5W (Tc=25°C)	175	0.5	80	>5	10	500	10	−100	15				280*	15	$C_c r_{bb'}$ 20pS	110	
	〃 575	〃	〃	〃	80	4	1 A	5 W (Tc=25°C)	175	0.5	40	20	5	500	10	−100	20				210*	7	$C_c r_{bb'}$ 18pS	84C	
	〃 576	〃	RF. SW	〃	40	5	500	360	200	0.1	20	40	1	10	6	−2	60	t_d+t_r < 12nS, t_s+t_f < 15nS, t_s < 10nS			650*	2.5	20	49C	
	〃 577	〃	〃	〃	40	5	500	360	200	0.1	20	80	1	10	6	−2	80	t_d+t_r < 12nS, t_s+t_f < 16nS, t_s < 13nS			600*	2.5	20	49C	
★	〃 578	日電	SW	〃	60	5	500	600	175	1	30	60	1.5	150				t_d < 25nS, t_r < 100nS, t_s < 100nS, t_f < 50nS						84A	
	〃 579	〃	〃	〃	30	5	200	360	175	0.1	15	80	0.4	50				t_d < 35nS, t_r < 15nS, t_s < 40nS, t_f < 35nS						49C	
★	〃 580	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	60	5	1 A	800	175	1	40	60	10	150	10	−50	80				250*	10	20*	84A	
★	〃 581	松下	RF. Conv Mix. Osc	〃	30	5	30	140	175	1	10				10	−1	85				230*	1.5	20	50C	
	〃 582	〃	PA	Si. Me	300	3	100	6.5W (Tc=25°C)	150	100	300	65	10	50	10	−50	60				35*	8	30	99	
	〃 583	〃	RF. Conv Mix. Osc	〃	30	2.5	20	200	200	0.01	15				5	−2	80				1300*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 8pS	50C	
	〃 584	〃	RF. PA	〃	80	4	2 A	17.5W (Tc=25°C)	200	1 mA	80	10	10	500	10	−500	15				200*	30	$C_c r_{bb'}$ 20pS	111	
★	〃 585	〃	PA	Si. EP	65	4	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	12	30	80	28	200	28	−200	30				350*	14	6.5*	111	
★	〃 586	〃	〃	Si. EMe	150	6	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	15mA	150	30	4	5 A	4	−5A	20				55*	130	8	102	
	〃 587	松下 東芝	RF	Si. P	45	5	30	300	175	0.01	10				10	−2	300				80*	3	80	49C	
	〃 587A	〃	〃	〃	45	5	30	300	175	0.01	10				10	−2	300	NF < 2.5dB (f = 1kc)			80*	3	80	49C	
	〃 588	富士通 日立	〃	Si. DB	30	5	100	600	175	1	15				10	−10	100				200*	2.5	50	84B	
	〃 589	松下	〃	〃	165	5	80	750	175	2	25	40	5	3	20	−3	40				200*	2	$C_c r_{bb'}$ 35pS	84B	
	〃 590	日電 三菱	〃	〃	120	5	300	800	175	1	60	70	10	150	10	−50	70				150*	12	30*	84B	
	〃 591	富士通, 沖 日電, 日立	RF. PA	〃	100	4	1.5 A	20 W (Tc=25°C)	175	1 mA	30	10~40	10	150	10	−150	20				150*	35	25*	83	
	〃 592	富士通	PA	Si. TP	75	4	2.5 A	13 W (Tc=25°C)	175	1	30	60	4	0.5 A	28	−100	60				180*	20	10*	111	
	〃 593	松下	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	50	5	30	165	175	1	10	40~160	10	1	10	−1	100				230*	1.5	18	50C	
★	〃 594	[illegible]	RF. PA	〃	60	5	200	750	175	0.1	45	40~240	1	10	10	−10					400*	3	<120*	84B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μΩ)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC595	日立,沖,東芝,富士通,日電	SW	Si.EP	30	5	200	300	150	1	15	60	1	10	10	−10	60	t_{on}<100nS, t_{off}<100nS, t_s<60nS			450*	4	40*	49C	
〃596	日電 富士通	RF.PA	〃	60	5	500	800	175	0.5	20	25~100	10	30	10	−30	50				400*	6	40*	85B	
〃597	富士通,東芝,松下	PA	〃	65	4	1 A	6 W (T_c=25°C)	175	5	30				28	−100	30				400*	7	12*	84B	
〃598	日電,東芝,沖,日立,松下,富士通	〃	〃	65	4	1.5A	10 W (T_c=25°C)	175	5	30				28	−100	30				400*	7	12*	111	
〃599	三菱	〃	〃	60	4	1.5A	20 W (T_c=25°C)	200	500	28	30	28	50	28	−50	50	PG = 5 dB (f=120Mc, P_i=1.9W)			500*	25	7*	114	
〃600	東芝,富士通,日電,松下	〃	〃	65	4	3 A	20 W (T_c=25°C)	175	12	30				28	−200	30				400*	14	7.5*	111	
〃601	松下 富士通	RF.SW	〃	40	5	100	300	175	0.1	20	60	1	10	10	−10	80	t_d+t_r<12nS, t_s<13nS, t_s+t_f<18nS			580*	2.4	20	49C	
〃602	東芝,沖,富士通,日立	RF	〃	30	3	30	200	150	1	15				6	−5	60	NF = 6dB (f = 70Mc)			800*	1.3	70*	50C	
〃603	日電	Ch	〃	7	7	50	200	150	1	6	100	0.5	0.1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.1~1.0, ΔV_{pi}<100μV, $\gamma\Delta V_{pi}$<5μV/°C, ΔI_{pi}<2nA						70*	5.5	$C_c r_{bb'}$ 2nS	47	複合管 (双方向性)
〃604																								
〃605	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	30	4	20	150	150	0.2	20				10	−2	70				480*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 2pS	23	正向 AGC
〃606	〃	〃	〃	30	4	20	150	150	0.2	20				10	−2	70				530*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 1.6pS	23	正向 AGC
〃607	日立	PA	Si.T	75	4	600	1 W	175	5	40				10	−50	50				70*	25	20*	84A	
〃608	〃	〃	〃	75	4	1.5A	10 W (T_c=25°C)	175	5	40				10	−50	60				70*	25	20*	97B	
〃609	〃	〃	〃	75	4	1.5A	10 W (T_c=25°C)	175	5	40				10	−50	60				80*	25	25*	97B	
〃610	松下	〃	Si.TP	100	4	10 A	100 W (T_c=25°C)	175	10mA	40	50	1	1 A			P_o=32W (f=40MHz, V_{CE}=40V, P_i=7.5W)							109	
〃611	日電,沖,富士通,東芝,松下	RF.Conv Mix.Osc	Si.EP	20	3	20	200	150	1	10				10	−2	80	NF = 2.5dB (f = 70Mc)			1000*	1	$C_c r_{bb'}$ 3pS	50C	
〃612	東芝,日電,日立,松下	RF	〃	35	2	20	180	175	1	10				10	−2	80	NF = 2.5dB (f = 70Mc)			1300*	1	Z_{rb} 30Ω	50C	
★ 〃613	日電	SW	〃	40	5	200	360	200	0.1	20	80	1	10				t_{on}<20nS, t_{off}<25nS, t_s<20nS						49C	
〃614	三洋	Osc.PA	Si.P	80	4	1.5 A	7.5 W (T_c=25°C)	175	1	40	80	10	250	10	−250					200*	12.5	8	84B	
〃615	〃	〃	〃	30	4	1.5 A	7.5 W (T_c=25°C)	175	1	10	80	10	250	10	−250					200*	12.5	8	84B	
〃616	〃	〃	〃	80		1.5 A	13 W (T_c=25°C)	175	1	40				10	−250	80				200*	12.5	8	83	
〃617	〃	〃	〃	30		1.5 A	13 W (T_c=25°C)	175	1	10				10	−250	80				200*	12.5	8	83	
〃618	富士通	RF	〃	25	3	20	150	150	0.1	12				6	−2	50	NF = 4.5dB (f = 70Mc)			600*	1.2	60*	50C	
〃618A	〃	〃	〃	25	3	20	150	150	0.1	12				6	−2	50	NF = 3 dB (f = 70Mc)			600*	1.2	60*	50C	
〃619	三菱	SW.PA	Si.EP	30	5	200	250	125	1	25	110	6	10				t_{on}<40nS, t_{off}<250nS, t_{stg}<150nS						40	
〃620	〃	RF.PA	〃	50	5	200	250	125	1	25	90	6	10	6	−1	80				250*	7	$C_c r_{bb'}$ 100pS	40	
★ 〃621	〃	RF.Conv.Mix Osc.SW	〃	25	4	100	150	150	1	25	75	6	10	6	−1	80	2500	0.4	15	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100pS	8 A	
★ 〃622	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	25	4	100	150	150	1	25	75	6	10	6	−1	80	2500	0.4	15	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100pS	11A	
〃623	協同	SW	〃	40	4.5	150	150	150	0.5	20	60	1	10				t_r<30nS, t_f<30nS, t_s<60nS						22	KT-2003
2SC624	協同	SW	Si.EP	40	4.5	200	300	150	0.5	20	60	1	10				t_r<30nS, t_f<30nS, t_s<60nS						28	KT-2103
〃625																								
★ 〃626	日電	RF.Conv.Mix Osc.PA	Si.EP	50	5	200	750	175	0.1	20				10	−10	130				350*	4	45*	84A	
〃627	富士通	RF.AF.SW	Si.T	200	4	100	700	175	5	100	80	10	50	6	−2	50	1000	0.8	10	20*	6	25	84B	
〃628	日電	RF.PA	Si.EP	40	4	500	2.5 W (T_c=25°C)	175	0.4	20	40	10	100	10	−30	40	P_o=2 W (f=200Mc, V_{cc}=15V)			700*	5.5	40*	84A	
〃629	SON	RF.Conv Mix.Osc	Si.DB	18		30	150	120	0.2	15	30	3	1	6	−1	36				800*	1.3	$C_c r_{bb'}$ 16pS	38	
〃630																								
★ 〃631	SON	RF.LN	Si.E	25		100	180	120	0.2	25	350	3	1	6	−0.1	170	36kΩ	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	38	
★ 〃632	〃	〃	〃	40		100	180	120	0.2	25	350	3	1	6	−0.1	170	36kΩ	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	38	
★ 〃633	〃	RF.Conv.Mix Osc.SW	〃	25	6	100	180	120	0.2	25	90	3	1	6	−1	110	t_r<0.06μS, t_f<0.15μS, t_{stg}<0.50μS			140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	38	
★ 〃634	〃	〃	〃	40	6	100	180	120	0.2	25	90	3	1	6	−1	110	t_r<0.06μS, t_f<0.15μS, t_{stg}<0.50μS			140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	38	
〃635	日電	PA	Si.EP	65		1.5A	10 W (T_c=25°C)	175	3	18				10	−150	50	P_o>4 W (f=175Mc, V_{cc}=18V)			450*	10	10*	111	
〃636	〃	〃	〃	65	4	3 A	20 W (T_c=25°C)	175	10	18				18	−150	50	P_o>7 W (f = 260Mc)			350*	16	8*	111	
〃637	〃	〃	〃	40	4	1 A	10 W (T_c=25°C)	175	10	20				10	−100	50				450*	16	10*	111	
〃638	〃	〃	〃	40	4	2 A	20 W (T_c=25°C)	175	20	20				13.5	−200	50				300*	28	8*	111	
〃639	〃	SW	〃	40	5	200	360	200	0.1	20	100	1	10				t_{on}<12nS, t_{off}<18nS, t_s<3nS						49C	
★ 〃640	〃	RF	〃	30	5	100	150	150	0.1	25	270	3	0.5	3	−0.5	300	15kΩ	16	3	100*	8	30*	23	
〃641	日立	SW	〃	40	5	100	100	125	0.25	20	85	1	10				t_{on}=20nS, t_{off}=20nS, t_s=10nS						36	
〃642	東芝	PA	Si.TMe	1100	5	1 A	50 W (T_c=25°C)	150	10	500	30~160	15	150	15	−200					70.5	70	10	102	
〃643	〃	〃	〃	1100	5	2.5A	50 W (T_c=25°C)	150	10	500	>7	15	2 A	15	−2A	15				>2	80	10	102	
〃644	松下	RF.AF.LN	Si.EP	30	5	50	150	125	1	10	250	5	2	5	−2	200	5000	0.7	10	160*	2.3	$C_c r_{bb'}$ 110pS	138	
〃645	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	5	30	140	175	1	10				10	−1	100				200*	Cre 0.65	22	54	
★ 〃646	〃	PA	Si.TMe	60	5	4 A	25 W (T_c=25°C)	150	10mA	60	55	4	2.5A	4	−100	70				50*	110	12	102	
〃647	〃	〃	〃	80	5	5 A	50 W (T_c=25°C)	150	10mA	80	40	4	4 A	4	−4A	30				43*	160	7	102	
〃648	日立	RF	Si.E	30		30	100	150	0.1	20	280	6	0.1	5	−0.1	320	17kΩ	1.9	12	350*	1.7	80*	182C	
〃649	〃	RF.AF.LN	Si.E	30	6	30	200	175	0.1	20	120	6	0.1	5	−0.1	150	36kΩ	9.4	3.1	220*	2.7	85	12A	
〃650	〃	〃	〃	30	6	30	200	175	0.1	20	250	6	0.1	5	−0.1	300	86kΩ	2.8	8.5	220*	2.7	75	12A	
〃651	日電	PA	Si.EP	45	4	300	750	150	0.1	20				10	−30	80				1100*	2.4	27*	84A	
〃652	〃	〃	〃	40	3	300	750	150	0.2	20				10	−30	80				1100*	2.4	27*	84A	
〃653	〃	RF	〃	25	3	20	200	150	0.1	12				6	−2	120	NF < 4 dB (1 Mc), NF < 22dB (1 kc)			1400*	0.6	60*	50C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a=25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a=25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC654	日電	RF	Si. EP	40	3	300	800	150	1	35				15	−50	80				650	2.9	21*	85 A	
〃 655	松下	RF. AF. PA	〃	10	2	10	75	125	1	10	400	5	2	5	−2	250	3500	2.5	35	80*	4.5	70	34	
〃 656	〃	RF	〃	10	2	5	50	125	1	10				10	−5	130				550*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 80pS	34	
〃 657	SON	RF. Conv. Mix Osc	Si. DB	18		30	150	120	0.2	15	50	10	4	6	−1	50				500*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 15pS	38	
★ 〃 658	三菱	〃	〃	25	4	20	150	150	1	12	60	6	1	6	−1	60				550*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 30pS	8 A	
★ 〃 659	〃	〃	〃	25	4	20	150	150	1	12	60	6	1	6	−1	60				400*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 40pS	8 A	
〃 660	〃	RF. Conv Mix	Si. P	25	4	20	150	150	0.5	20	60	10	3	10	−3	60				600*	1	$C_c r_{bb'}$ 3 pS	11 A	正向 AGC
〃 661	〃	〃	〃	25	4	20	150	150	0.5	20	60	10	3	10	−3	60				600*	1	$C_c r_{bb'}$ 4 pS	11 A	正向 AGC
〃 662	〃	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	25	2	20	150	150	0.5	10				6	−2	40				800*	1	$C_c r_{bb'}$ 4 pS	9	
〃 663	〃	〃	〃	25	2	20	150	150			10~300	10	10							900*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 5 pS	11A	
〃 664	日立	PA	Si. T	100	5	5 A	50 W (T_c=25°C)	150	1mA	30	60	5	1 A	5	−1A	60				15*	300	10	103	
〃 665	〃	〃	〃	125	5	5 A	50 W (T_c=25°C)	150	1mA	30	60	5	1 A	5	−1A	60				15*	300	10	103	
〃 666																								
〃 667																								
〃 668	三洋	RF. Conv. Mix.	Si. TP	15	3	30	120	125	1	10	60	6	1	6	−1					560*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 20pS	27	
〃 669																								
〃 669A	SON	PA	Si. EMe	30	5	4 A	1 W	175	5	25	70	2	100	10	−50	70				70*	18	$C_c r_{bb'}$ 50pS	84 A	
〃 670																								
〃 671																								
〃 672																								
〃 673																								
〃 674	三洋	RF. Conv. Mix.	Si. TP	15	4	30	120	125	1	10	60	6	1	6	−1					560*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 15pS	27	
〃 675	芝電	SW	Si. Me	250	6	7 A	50 W (T_c=25°C)	180	10	30	30	10	0.5A				t_r<0.5μS, t_f<0.5μS t_s<2.5μS						102	
〃 676	〃	〃	〃	200	6	7 A	50 W (T_c=25°C)	180	10	30	30	10	0.5A				t_r<0.5μS, t_f<0.5μS t_s<2.5μS						102	
〃 677	〃	〃	〃	150	6	7 A	50 W (T_c=25°C)	180	30	30	40	10	0.5A				t_r< 1 μS, t_f< 1 μS t_s<3.5μS						102	
〃 678	〃	〃	〃	100	6	7 A	50 W (T_c=25°C)	180	100	30	40	10	0.5A				t_r< 1 μS, t_f< 1 μS t_s<3.5μS						102	
〃 679	日立	PA	Si. T	300	6	2 A	30 W (T_c=25°C)	175	1	30	60	10	20	10	−200	190				20*	75	20	153	
〃 680	〃	〃	〃	200	6	2 A	12.5W (T_c=25°C)	150	1	30	180	10	200	10	−200	190				20*	75	20	153	
〃 681	〃	SW	〃	200	5	6 A	50 W (T_c=25°C)	150	I_{CES} 15mA	30	30	4	4 A				t_r< 4 μS, t_f< 1 μS t_s< 3 μS						102	
〃 682	〃	RF	Si. P	20	3	20	180	175	0.1	10	60	10	2	10	−2	75	PG=18dB (f=45Mc)			550*	0.37		9	正向 AGC
2SC683	日立	RF	Si. P	20	3	20	180	175	0.1	10	60	10	2	10	−2	75	PG=21dB (f=200Mc)			550*	0.37		9	正向 AGC
〃 684	〃	RF. Conv. Mix Osc	Si. EP	30	2	50	200	125	0.5	10	740	10	10	10	−10	50	P_{out}=8mW (f=930Mc)			1100*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 10pS	37	
〃 685	〃	PA	Si. T	300	3	100	6.25W (T_c=25°C)	150	100	300				10	−50	60				25*	5	20	153	
★ 〃 686	日電	RF	Si. EP	150	6	50	800	175	0.01	100	90	10	25	10	−25	100				180*	2.6	10*	84 A	
★ 〃 687	松下	SW	〃	150	6	5 A	50 W (T_c=25°C)	150	15mA	150	30	4	5 A				t_r< 2 μS, t_f< 1 μS t_s< 2 μS						102	
★ 〃 688	三菱	PA	〃	60	4	1.5A	20 W (T_c=25°C)	200	500	25				10	−100	30	PG=6.5dB (f=150Mc, P_i=1.9W)				20		114	
〃 689	日立	SW	Si. T	40	5	100	300	175	0.25	20	50	1	100				t_{on}<13nS, t_{off}<15nS t_s<10nS						49C	
〃 690	三菱	PA	Si. EP	60	5	3 A	35 W (T_c=25°C)	200	500	30	50	10	100				P_o=25W (f=150Mc, Vcc=25V, P_i=5W)						113	再登録
〃 691	〃	〃	〃	60	4	500	10 W (T_c=25°C)	200	200	30	50	10	100				P_o=3.5W (f=150Mc, Vcc=24V, P_i=0.3W)						113	再登録
〃 692	〃	〃	〃	60	5	1 A	17.5W (T_c=25°C)	200	200	30	50	10	100				P_o=0 W (f=400Mc, Vcc=28V, P_i=3W)						113	再登録
〃 693	三洋	RF. LN	Si. P	40		50	100	125	1	35	230	6	1	6	−1	NF=[illegible]	3000	0.7	9	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 250pS	27	
〃 694	〃	〃	〃	40		50	100	125	1	35	230	6	1	6	−1	NF=[illegible]	3000	0.7	9	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 250pS	27	
★ 〃 695	日電	AF. RF	Si. EP	20	5	30	100	150	0.1	15	150	3	0.1	6	−1	200	6000	0.9	20	150*	2	50*	23	
〃 696	松下	PA	〃	100	5	3 A	750	175	3	30	55	V_{CB}=2 V	100	2	−100	80				100*	20	$C_c r_{bb'}$ 40pS	84 A	2SA546之対偶
〃 696A	〃	〃	〃	130	5	3 A	750	175	3	30	55	V_{CB}=2 V	100	2	−100	80				100*	20	$C_c r_{bb'}$ 40pS	84 A	2SA546A之対偶
〃 697	〃	〃	〃	100	5	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	30	55	V_{CB}=2 V	100	2	−100	80				100*	22	$C_c r_{bb'}$ 40pS	97 B	2SA547之対偶
〃 697A	〃	〃	〃	130	5	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	30	55	V_{CB}=2 V	100	2	−100	80				100*	22	$C_c r_{bb'}$ 40pS	97 B	2SA547A之対偶
★ 〃 698	日電	RF. PA	〃	100	5	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	1	60	80	2	0.5A	10	−50	65				90*	35	15*	97 A	
★ 〃 699	三菱	PA	Si. TP	50	4	1 A	10 W (T_c=25°C)	200	50	12				12	−100	30	PG=9dB (f=27Mc, P_i=0.5W)				20		97 A	
★ 〃 700	〃	〃	Si. EP	60	3	500	5 W (T_c=25°C)	200	100	20				20	−50	30	PG=11dB (f=150Mc, P_i=0.2W)				6		84C	
★ 〃 701	〃	〃	〃		3	750	5 W (T_c=25°C)	200	100	15				15	−50	30	PG=10dB (f=150Mc, P_i=0.2W)				7		84C	
〃 702	〃	〃	〃	40	4	750	10 W (T_c=25°C)	200	100	15	50	10	100				P_o=3 W (f=150Mc, Vcc=15V, P_i=0.25W)						113	再登録
〃 703	〃	〃	〃	40	5	2 A	25 W (T_c=25°C)	200	1mA	15	50	10	100				P_o=12W (f=175Mc, Vcc=13.5V, P_i=3.5W)						113	再登録
〃 704	〃	〃	〃	40	5	4 A	40 W (T_c=25°C)	200	2mA	15	50	10	100				P_o=17W (f=175Mc, Vcc=13.5V, P_i=5.5W)						113	再登録
〃 705	三洋	RF. Conv. Mix. Osc.	〃	15	3	30	120	125	1	10	70	6	1	6	−1					700*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 14pS	27	
〃 706	〃	RF	〃	15	3	30	120	125	1	10	80	6	1	6	−1					800*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 17pS	166	
〃 707	日立	RF	Si. P	20	3	20	150	175	0.1	10	50	10	2	10	−2	75	PG=13dB (f=200Mc)			650*	0.4		9	
〃 708	〃	〃	Si. T	60	4	1 A	750	150	10	30	40	4	400	4	−50	50				15*	25	100	84 A	2SA537之対偶
〃 708A	〃	〃	〃	90	4	1 A	750	150	10	30	40	4	400	4	−50	50				15*	25	100	84 A	2SA537A之対偶
★ 〃 709	三菱	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	25	4	100	200	125	1	25	75	6	10	6	−1	60				180*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 180pS	41	

	製名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電氣的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $A_{b'c}$(small)* (Ω)	外形	備考
	2SC710	三菱	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	30	4	30	200	125	1	25	90	6	1	6	−1					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 20pS	138B	再登錄
	〃 711	〃	RF.	〃	30	4	50	200	125	0.1	25	250	6	1	6	−1		8500	0.6	40	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 200pS	138B	再登錄
	〃 712	〃	〃	〃	30	4	100	200	125	1	25	90	6	10	6	−1		2500	0.4	15	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 150pS	138B	再登錄
★	〃 712A	〃	〃	〃	30	4	100	200	125	1	25	75	6	10	6	−1	80	2500	0.4	15	180*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 150pS	41	
	〃 713	〃	SW	〃	30	4	100	200	125	0.1	25	90	6	10				t_{on}<60nS, t_{off}<150nS, t_{stg}<120nS			>100	2.5		138B	再登錄
	〃 714	〃	〃	〃	70	5	200	250	125	0.1	25	60	6	10	6	−10		t_{on}<40nS, t_{off}<250nS, t_{stg}<150nS			200*	7		41	
	〃 715	〃	RF. V	〃	40	5	100	120	125	1	35	180	6	1	6	−1		3500	0.8		140*	4	$C_c r_{bb'}$ 250pS	27	
	〃 716	〃	〃	〃	20	5	100	100	125	1	15	180	6	1	6	−1		3500	0.8	13	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 250pS	27	
	〃 717	日立	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	2	50	200	125	0.5	10	>40	10	10	6	−1	40	PG = 16dB (f = 200Mc)			1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10pS	37	
	〃 718	富士通	SW	〃	20	4	200	300	175	0.4	15	60	1	10	10	−10	t_r = 4nS, t_f = 9nS, t_s = 6nS				800*	2		49C	
	〃 719	〃	〃	〃	20	4	200	200	175	0.4	15	60	1	10	10	−10	t_r = 4nS, t_f = 9nS, t_s = 6nS				800*	2		46C	
	〃 720	〃	RF	Si.P	25	3	20	200	175	0.05	6				6	−2	100	PG = 30dB (f = 45Mc)			500*	1.2	80*	50C	正向 AGC
	〃 721	〃	〃	〃	25	3	20	200	120	0.05	6				6	−2	100	PG = 30dB (f = 45Mc)			500*	1.4	80*	30	正向 AGC
★	〃 722	〃	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	20		25	200	126	0.5	12				6	−2	80				700*	1.5	80*	30	
★	〃 723	〃	〃	Si.P	20		25	200	125	1	12				6	−2	60				500*	1.5	80*	30	
	〃 724	〃	RF.SW	Si.EP	30	5	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	−2	70	t_r<20nS, t_f<50nS, t_s<250nS			250*	4	80*	30	
	〃 725	〃	〃	〃	60	5	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	−2	70	t_r<20nS, t_f<50nS, t_s<250nS			250*	4	80*	30	
	〃 726	〃	SW	〃	20	4	200	200	125	1	15	60	1	10		−2		t_r = 4nS, t_f = 9nS, t_s = 6nS						30	
	〃 727	〃	RF.AF.SW	Si.T	100	3	100	350	175	1	30	90	4	10	6	−2	60	1200	1	12	20*	9	40	49C	
	〃 728	〃	〃	〃	200	6	100	350	175	1	30	90	4	10	6	−2	60	1200	1	12	20*	9	40	49C	
★	〃 729	日電	RF	Si.EP	50	5	200	600	175	0.5	30				10	−10	60				250*	4	40	84A	
	〃 730	三菱	PA	〃	40	4	400	1 W	175	10	15	50	10	100				P_o = 1.5W (f = 150Mc, V_{CC} = 13.5V, P_i = 0.1W)						84B	再登錄
	〃 731	松下	〃	〃	40	4	500	2.5W (T_c=25°C)	175	1	20	70	13.5	100				P_o = 1.2W (f = 500MHz, V_{CE} = 13.5V, P_i = 0.3W)						84B	
	〃 732	東芝	RF	Si.EP	35	5	100	300	125	0.1	18	200~700	6	2	6	−2					80*	6	100	33	
	〃 733	〃	〃	〃	35	5	100	300	125	0.1	18	70~700	6	2	6	−2	200				>80*	7	$C_c r_{bb'}$ 150pS	33	
	〃 734	〃	〃	〃	70	5	150	300	125	0.1	18	70~400	1	20	6	−10					150*	5	15	33	2SA561 之對偶
	〃 735	〃	〃	〃	35	5	400	300	125	0.1	18	70~400	1	100	5	−50					300*	7	$C_c r_{bb'}$ 150pS	33	2SA562 之對偶
★	〃 736	日電	SW	〃	135	5	5 A	50 W (T_c=25°C)	175	500	60	60	10	1 A				t_{on}<2μS, t_{off}<4μS, t_{stg} = 3μS						102	
	〃 737	三菱	PA	〃	60	5	1.5A	20 W (T_c=25°C)	200	500	30	50	10	100				P_o = 14W (f = 150Mc, V_{CC} = 25V, P_{in} = 1.9W)						113	再登錄
	〃 738	〃	RF	〃	25	4	20	150	125	1	12	20~300	6	1	6	−1	60				400*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 30pS	40	
	2SC739	三菱	RF.Conv Mix.Osc	Si.EP	25	4	20	150	125	1	12				6	−1	60				350*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 30pS	40	
★	〃 740	〃	〃	〃	25	2	20	150	150	0.5	10	40	10	10	10	−10	40				900*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 5pS	11A	
	〃 741	〃	PA	〃	40	4	300	680	175	1	15	50	10	100				P_o = 0.3W (f = 150Mc, V_{CC} = 13.5V, P_{in} = 10mW)						84B	再登錄
	〃 742	富士通	〃	〃	65	4	1.5A	12.5W (T_c=25°C)	175	5	30				10	−150	30				400*	8	10*	111	
	〃 743	〃	〃	〃	65	4	3 A	25 W (T_c=25°C)	176	10	30				10	−300	30				350*	16	7*	111	
	〃 744																								
	〃 745	富士通	PA	Si.EP	50	4	1.5A	12.5W (T_c=25°C)	175	10	10				10	−150	45				450*	7	8*	111	
	〃 746	〃	〃	〃	45	4	3 A	25 W (T_c=25°C)	175	20	10				10	−300	35				400*	20	6*	111	
	〃 747																								
	〃 748	富士通	PA	Si.EP	36	4	1 A	12.5W (T_c=25°C)	175	10	10				10	−150	25				400*	16	7*	111	
	〃 749	〃	〃	〃	36	4	2 A	25 W (T_c=25°C)	175	25	10				10	−300	25				350*	32	5*	111	
	〃 750																								
	〃 751	東芝	RF	Si.EP	20	2	20	100	150	1	10				10	−8	50				650*	1.9	30	46C	
	〃 752	〃	〃	〃	30	4	100	100	125	0.5	20				10	−10	60				300*	4	30	33	
	〃 753	日電	RF.Conv.Mix Osc	〃	25		20	100	150	1	12				6	−2	70				1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 12pS	23	
	〃 754	〃	RF.AF	〃	20		150	150	150	1	20	100	1	20	6	−1	60				90*	6.5	25	23	
	〃 755	〃	RF	〃	15		100	150	150	0.1	15	270	3	0.5	3	−0.5	300	15kΩ	16	3	100*	8	30*	23	
	〃 756	SON	PA	Si.E	100	6	4 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	50	80	2	100	10	−50	60				65*	35	$C_c r_{bb'}$ 60pS	84C	
	〃 757	日電	RF.Conv.Mix Osc	〃	30		20	100	150	1	12				6	−2	70				1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10pS	23	
	〃 758	芝電	PA	Si.TMe	280	5	8 A	60 W (T_c=25°C)	150	10	30				5	−0.5A	35				18*	275	10	102	
	〃 759	〃	〃	〃	180	5	8 A	60 W (T_c=25°C)	150	10	30				5	−0.5A	35				18*	275	10	102	
	〃 760	〃	〃	〃	100	5	8 A	60 W (T_c=25°C)	150	100	30				5	−0.5A	35				18*	275	10	102	
	〃 761	松下	RF.Conv Mix.Osc	Si.P	30	3	20	150	175	100	30				10	−2	40	PG = 6dB (f = 900 Mc)			675*	C_{re} 0.28	60	50C	正向 AGC
	〃 762	〃	〃	〃	30	3	20	150	175	100	30				10	−2	40				675*	1	60	50C	正向 AGC
	〃 763	三菱	〃	〃	25	3	20	100	125	0.5	12	70	6	1	6	−1					470*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 15pS	138B	
	〃 764	日電	SW	Si.EP	40	5	200	360	200	0.1	20	85	1	10	10	−10	80	t_{on}<12nS, t_{off}<18nS, t_{stg}<13nS			750*	2	$C_c r_{bb'}$ 25pS	49C	
★	〃 765	三菱	PA	Si.TMe	60		2 A	30 W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	60	4	1 A				P_o = 20W (f = 27MHz, V_{cc} = 25V, P_i = 3W)						102	
★	〃 766	〃	〃	〃	120		2 A	30 W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	60	4	1 A				P_o = 19W (f = 27MHz, V_{cc} = 38V, P_i = 2W)						102	
★	〃 767	〃	〃	〃	180		2 A	30 W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	60	4	1 A				P_o = 19W (f = 27MHz, V_{cc} = 38V, P_i = 2W)						102	
★	〃 768	〃	PA.SW	〃	60	5	10A	50W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	25	4	2 A				t_r<3μS, t_f<1μS, t_{stg}<2μS						102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μΩ)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC769	三菱	PA. SW	Si. TMe	120	5	10 A	50 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	25	4	2 A			t_r< 3 μS, t_f< 1 μS, t_{stg}< 2 μS							102	
★	〃 770	〃	〃	〃	200	5	10 A	50 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	25	4	2 A			t_r< 3 μS, t_f< 1 μS, t_{stg}< 2 μS							102	
★	〃 771	〃	〃	〃	250	5	10 A	50W (Tc=25°C)	150	1mA	30	25	4	2 A							t_r<3 μS, t_f<1 μS, t_{stg}<2 μS			102	
	〃 772	三洋	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. EP	15		30	120	125	1	10	60	6	1	6	−1					300*	1.5	Cc rbb' 30pS	27	
	〃 773	三菱	Osc	〃	50	5	200	500	125	1	25				6	−10	60	Posc = 40mW (f = 27MHz)						138B	
★	〃 774	〃	〃	〃	50	4	500	800	200	10	30	70	10	100				Posc = 70mW (f = 27Mc, VCE = 12V, Ic = 25mA)						84 B	再登録
★	〃 775	〃	PA	〃	75	4	1 A	800	200	10	30	70	10	100				Po = 0.7W (f = 27MHz, Vcc = 12V, Pi = 30mW)						84 B	再登録
★	〃 776	〃	〃	〃	75	4	1 A	1 W	200	10	30	70	10	100				Po = 1.8W (f = 27MHz, Vcc = 12V, Pi = 75mW)						84 B	再登録
★	〃 777	〃	〃	〃	75	4	1 A	2 W	200	10	30	50	10	100				Po = 3.5W (f = 27MHz, Vcc = 12V, Pi = 0.4W)						97 B	再登録
★	〃 778	〃	〃	〃	80	4	2 A	2.5W	200	10	30	50	10	100				Po = 4 W (f = 27MHz, Vcc = 12V, Pi = 0.4W)						97 B	再登録
	〃 779	東芝	SW	Si. TMe	300	6	2 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	200	30~200	10	100	10	−100		t_{on}< 2 μS, t_f< 3 μS, t_{stg}< 4 μS			20*	40		99	
★	〃 780	〃	RF	Si. EP	70	2	20	150	125	5	70				10	−2	60				100*	3	50	33	2SA[illegible] 之對稱
	〃 781	日電	RF. PA	〃	75	5	1 A	5 W (Tc=25°C)	175	1	40				10	−150	80				350*	11	13*	84 A	
	〃 782	東芝	PA	Si. TMe	300	5	1.5A	20 W (Tc=25°C)	150	100	200	30~240	10	100	10	−100	100				10*	50	25	99	
	〃 783	〃	〃	〃	200	5	1.5A	20 W (Tc=25°C)	150	100	200	30~240	10	100	10	−100					10*	50	25	99	
	〃 784	〃	RF	Si. EP	40	4	20	100	125	0.5	18	25~140	6	1	6	−1					500*	Cre 0.65	Cc rbb' 10pS	33	
	〃 785	〃	Conv. Mix Osc	〃	40	4	20	100	125	0.5	18	25~140	6	1	6	−1					500*	Cre 0.65	Cc rbb' 10pS	33	
	〃 786	〃	RF	〃	20	3	20	200	150	0.05	10	20~200	5	4	10	−4		NF = 3.5dB (f = 100MHz)			>250*	Cre 0.5~0.8	<25	50C	
	〃 787	〃	RF. LN	Si. P	25	3	20	150	150	0.025	10	>25	10	2	10	−2		NF = 5dB (f = 600MHz)			1000*	Cre 0.3		50C	
	〃 788	〃	RF. SW	Si. EP	250	5	50	800	150	0.1	30	100	5	10	30	−10					120*	4	25	84B	
	〃 789	〃	RF. PA	Si. TMe	70	5	4 A	30W (Tc=25°C)	150	30	50	40~240	5	500	5	−500					> 3*	150		119	
	〃 790	〃	PA	〃	50	5	3 A	25W (Tc=25°C)	150	10	30	40~240	2	500	2	−500					> 3*	70		119	
	〃 791	〃	〃	Si. TMe	90	5	1.5A	15 W (Tc=25°C)	150	120	30	40~250	2	200	5	−500					60*	40		99	
	〃 792	〃	〃	〃	300	5	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	50	300	90	10	300	10	−100					10*	80		102	
	〃 793	〃	〃	Si. TMe	100	5	7 A	60 W (Tc=25°C)	150	100	50	80	5	1 A	5	−500					9*	220		102	
	〃 794	〃	〃	〃	70	5	7 A	60 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	50	5	1 A	5	−500	50				9*	230	15	102	
	〃 795	SON	〃	Si. DB	250	6	100	9 W (Tc=25°C)	150	10	100	70	10	10	10	−10	70				180*	7	Cc rbb' 50pS	100	
	〃 796	富士通	RF. Osc	Si. EP	40		500	1 W (Tc=25°C)	175	5	12	50	4	150	20	−15					230*	5	20*	84 B	
	〃 797	〃	PA	〃	60		500	1 W (Tc=25°C)	175	5	12	30	4	150	20	−15	Po = 1.3W (f = 27Mc, Vcc = 12V, Pi = 75mW)				150*	5	12*	84 B	
	〃 798	〃	〃	Si. TP	60		1.5A	5 W (Tc=25°C)	175	5	12	70	4	400			Po = 3.5W (f = 27Mc, Vcc = 12V, Pi = 0.5W)							84 B	
	2SC799	日電	RF. PA	Si. EP	80	5	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	1	40	90	10	150	10	−150	Po = 3.5W (f = 27MHz, Vcc = 12V, Pi = 0.4W)				250*	15		97B	
	〃 800	〃	RF	Si. TMe	30	4	20	100	150	0.1	25	8	6	2	6	−2	85				800*	0.5	Cc rbb' 2 pS	23	
★	〃 801	〃	RF. PA	〃	75	5	500	13 W (Tc=25°C)	175	1	50	50	10	150	10	−50	45				100*	32	12*	83	
	〃 802	富士通	PA. SW	Si. EP	60	4	500	1 W (Tc=25°C)	175	5	12	30	4	150	20	−15	Po = 1.3W (f = 27M, Vcc = 12V, Pi = 75mW)				180*	5	12*	84 B	
	〃 803	〃	〃	Si. TP	60	4	1.5A	5 W (Tc=25°C)	175	1	12	70	4	400			Po = 3.5W (f = 27Mc, Vcc = 12V, Pi = 0.5W				90*	9	7*	84 B	
★	〃 804	SON	RF. Conv. Mix. Osc	Si. DB	15		20	150	100	0.5	15	50	3	1	6	−4		h_{fe} = 12 (f = 100Mc)				0.32	40*	24	
	〃 805	〃	RF. AF. SW	Si. DB	100	5	200	475	120	1	25	100	5	3	10	−2					160*	3	Cc rbb' 80pS	84B	
★	〃 806	〃	PA	Si. TMe	650	10	10 A	125 W (Tc=25°C)	150	5mA	500	30	3	2 A	10	−0.5A	50				5*	280	5	102	
★	〃 807	〃	〃	〃	500	10	10 A	125 W (Tc=25°C)	150	5mA	500	50	3	100	10	−0.5A	50				5*	300	5	102	
	〃 808	〃	〃	〃	300	8	5 A	80W (Tc=25°C)	150	30	50	100	3	2 A	10	−500					12*	310	Cc rbb' 700pS	102	
	〃 809	富士通	RF	Si. EP	25	3	20	200	155	0.1	12				6	−2	90				1200*	1.4	40*	50C	
	〃 810	〃	RF. PA	〃	40	3	300	500	150	1	35				15	−50	70				750*	3.8	25*	85 B	
	〃 811	〃	RF	〃		4	30	180	175	0.5	15	60	10	2	10	−2					800*	0.9	50	50C	
	〃 812	富士通	SW	Si. EP	20	4	100	250	150	0.5	10	50	1	10				t_r<10nS, t_f<15nS, t_{stg}<12nS				2.5		49C	
	〃 813																								
★	〃 814	日電	RF. PA	Si. EP	30	5	500	400	125	0.2	18	150	5	50	10	−10	140				180*	13	25	44	
	〃 815	〃	RF. Osc PA	〃	60	5	200	250	125	0.2	30	80	10	10	10	−10	80				200*	5.5	25	43	2SA[illegible] 之對稱
	〃 816	三菱	RF	〃	60		1 A	1 W	200	10	28	100	6	0.1	10	−30					140*	12	Cc rbb' 60pS	84 B	再登録
	〃 817	〃	〃	〃	30		20	120	150	0.1	12	80	10	1				Gpe = 13dB (f = 600MHz, Vce = 6V, Ic = 4mA)						50C	
★	〃 818	三菱		Si. TP	160	5	100	800	200			20−180	10	10							100*	4.5	Cc rbb' 14pS		
	〃 819	日立	PA	Si. EP	65	4	1 A	6 W (Tc=25°C)	175	100	65				28	−100	30				500*	7.5	12	84C	
	〃 820	〃	〃	〃	65	4	1.5A	10 W (Tc=25°C)	175	100	65				28	−100	30				500*	7.5	10	121	
	〃 821	松下	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	40	4	300	2.5W (Tc=25°C)	175	1	20				13.5	−100	70				450*	6.5	15*	84 B	
	〃 822	〃	〃	〃	40	4	500	2.5W (Tc=25°C)	175	1	20				13.5	−100	70				550*	6.5	15*	84 B	
	〃 823	日電	RF	〃	30	3	60	600	150	0.1	10				10	−15	130	NF < 3.5dB (f = 150Mc)			1500*	0.9	Cc rbb' 3 pS	85 A	
	〃 824	〃	〃	〃	50	3	120	650	150	0.1	10				10	−50	130	NF < 4.3dB (f = 150Mc)			1300*	2.2	Cc rbb' 4 pS	85 A	
	〃 825	富士通	SW	Si. T	300	6	2 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5A				t_r< 2 μS, t_f< 3 μS, t_{stg}< 6 μS						99	
	〃 826	〃	RF	Si. TMe	100	6	300	700	175	1	30	100	4	50	6	−10	100				20*	10	30	84 B	
	〃 827	〃	RF. SW	〃	100	6	500	700	175	1	30	100	4	50	6	−10	100	t_{on}<0.2 μS, t_f<0.2 μS, t_{stg}< 2 μS			20*	10	30	84 B	
	〃 828	松下	RF. AF	Si. EP	30	5	50	250	125	1	10				5	−2	220	3600	0.4	20	150*	2.2	70	42	2SA564 之對稱

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μʊ)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SC828A	松下	RF. AF	Si. EP	45	5	50	250	125	1	10				5	−2	220	3600	0.4	20	150*	2.2	70	42	2SC564A之对偶
	〃 829	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	30	5	30	250	125	1	10				10	−2	130				230*	1.3	35	42	
	〃 830	日立	PA	Si.TMe	50	4	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	20	80	4	1 A	4	−500					20*	75	15		
	〃 831	日電	PA	Si. EP	50	4	2 A	23 W (Tc=25°C)	175	5	20	15~200	10	1 A	10	−30	80	P_o=13 W (V_{cc}=18V, P_i=2W, f=260Mc)			500*	18		111	
	〃 832																								
	〃 833	[illegible]	SW	Si. TMe	450	6	2 A	26 W (Tc=25°C)	150	100	200	80	10	100	10	−100	100	t_{on}<3μS, t_{off}<3μS, t_{stg}<6μS				50		99	
	〃 834																								
	〃 835																								
★	〃 836	日電	RF	Si. P	30	4	20	200	125	0.2	20	70	10	4	10	−4	60				600*	0.9	$C_c r_{bb}$ 3 pS	43	正向AGC
★	〃 837	〃	〃	Si. EP	30	4	20	250	125	0.2	20	40	10	10	10	−10	30	PG=20dB (f=45Mc)			550*	1.6		43	
★	〃 838	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	50	5	30	250	125	0.1	15	80	3	0.5	6	−1	90				250*	1.8	$C_c r_{bb}$ 20 pS	43	
	〃 839	〃	〃	〃	50	5	30	250	125	0.1	15	80	3	0.5	6	−1	90	NF=2dB (f=1 Mc)			250*	1.8	$C_c r_{bb}$ 20 pS	43	
	〃 840	松下	PA	Si. TMe	100	5	2 A	20 W (Tc=25°C)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	−100	60				50*	90	25	99	
	〃 840A	〃	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	150	5	2 A	20 W (Tc=25°C)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	−100	60				50*	90	25	99	
★	〃 841	富士通	PA	〃	36		500	6 W (Tc=25°C)	175	5	12	50	4	500	12	−150					450*	12	12*	84 B	
★	〃 842	〃	〃	〃	36		1 A	10 W (Tc=25°C)	175	5	12	40	4	1 A	12	−150					450*	13	10*	111	
★	〃 843	〃	〃	〃	36		2 A	20 W (Tc=25°C)	175	12	12	50	4	2 A	12	−150					350*	25	7*	111	
	〃 844	〃	〃	〃	40	2	400	3.5 W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	15	−30	40	P_o=1.1W (f=175Mc, V_{CE}=12V)			800*	3	20*	84 B	
	〃 845	〃	〃	〃	55	3.5	400	3.5 W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	15	−30	40	P_o=1.4W (f=100Mc, V_{CE}=28V)			800*	3	20*	84 B	
	〃 846																								
	〃 847	富士通	RF	Si. EP	30	5	200	350	175	0.5	12	160	4	10	6	−1					70*	10	40	49 C	
	〃 848	〃	RF. LN	〃	30	5	200	350	175	0.1	12	160	4	10	6	−1		3500	0.1	5	60*	10	40	49 C	
	〃 849	〃	SW. AF	〃	30	5	300	350	175	0.5	12	160	4	10	6	−1		3500	0.1	5	t_r<0.08μS, t_f<0.15μS, t_{stg}<0.8μS			49 C	
	〃 850	〃	SW. PA	〃	50	7	500	350	175	0.5	12	160	4	10				t_r<0.08μS, t_f<0.15μS, t_{stg}<0.8μS						49 C	
★	〃 851	日電	PA	〃	50	5	8 A	75 W (Tc=25°C)	200	500	30	50	5	5 A				P_o=40W (f=80Mc, V_{cc}=13.5V, P_i=6 W)						118	
	〃 852	〃	RF	〃	45	3	80	500	150	0.5	15	100	6	20	6	−20					1100*	2	$C_c r_{bb}$ 3.7pS	85 B	
	〃 853	日電	RF. PA	Si. EP	70		200	400	125	0.1	60	70	2	150	10	−10	110				90*	7.5	40*	44	2SA545之对偶
	〃 854	富士通	PA	〃	40	2	300	2.5W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	15	−30	40	P_o=0.75 W (f=176Mc, V_{CE}=12V)			800*	2.5	20*	84 B	
	〃 855	〃	〃	〃	40	2	400	3 W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	15	−30	40	P_o=0.9W (f=175Mc, V_{CE}=12V)			800*	2.5	20*	84 B	
	〃 856	日立	RF	Si. TPa	150	5	50	300	175	1	20	50	6	10	6	−10					150*	2.5	25*	12 A	
	2SC857	日立	SW. RF	Si. TMe	200	5	50	200	175	0.1	20	80	6	10	6	−10					100*	3	40	12A	
	〃 858	三洋	RF. LN	Si. P	20		50	100	125	1	15	230	6	1	6	−1	NF [illegible] f 25	3000	0.7	9	140*	4	$C_c r_{bb}$ 250pS	27	
	〃 859	〃	〃	〃	20		50	100	125	1	15	230	6	1	6	−1	NF 15dB f 25	3000	0.7	9	140*	4	$C_c r_{bb}$ 250pS	27	
	〃 860	〃	RF	Si. EP	15	3	30	80	125	1	10	60	6	1	6	−1					700*	1.5	$C_c r_{bb}$ 50pS	205C	
	〃 861	日立	PA	Si. TMe	450	6	1 A	50 W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	50	5	200	15	−200					7*	140	10	102	
	〃 862	〃	〃	〃	650	6	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	9	2	3.5 A	15	−200					7*	140	10	102	
★	〃 863	東芝	RF	Si. EP	60	4	25	175	150	1	10				10	−5	100				600*	1.5	10	117C	
★	〃 864	〃	〃	〃	40	4	25	175	150	1	10				10	−5	100				600*	1.5	10	117C	
	〃 865	富士通	PA	Si. TP	60		2 A	20 W (Tc=25°C)	175	5	30	70	4	1 A			P_o 4.8W f 80Mc, V_{cc} 20V, P_i 1 W							83	
	〃 866	〃	〃	〃	60		1.5 A	5 W (Tc=25°C)	175	5	12	70	4	400			P_o 3.5W f 27Mc, V_{cc} 12V, P_i 0.5W							97 B	
	〃 867	SONY	PA. SW	Si. TMe	400	10	1 A	18 W (Tc=25°C)	150	100	50	80	3	100	10	−200					8*	120	12	100	
	〃 868	[illegible]	SW	Si. EP	130	5	30	200	125	0.1	25	90	6	1			t_{on}<80nS, t_{off}<90nS, t_{stg}<200nS							138B	[illegible]
	〃 869	〃	〃	〃	160	5	30	200	125	0.1	25	90	6	1			t_{on}<80nS, t_{off}<90nS, t_{stg}<200nS							138B	[illegible]
	〃 870	〃	RF. AF. LN	〃	30	4	30	200	125	0.1	25	160	6	0.1	6	−0.1	190	50 k	1.2	3.5	150*	2.5	$C_c r_{bb}$ 200pS	41	
	〃 871	〃	〃	〃	30	4	30	200	125	0.1	25	250	6	0.1	6	−0.1	270	70 k	1.4	3.5	150*	2.5	$C_c r_{bb}$ 200pS	41	
	〃 872	富士通	PA	〃	40		400	3.5 W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	13.5	−30	P_o 1.3W f 400Mc, V_{cc} 13.5V, P_i 0.4W				800*	3	20*	84C	
	〃 873	[illegible]			75	4	1 A	500	150	100	70	60	6	50							200*		$C_c r_{bb}$ 50pS		[illegible]之对偶
	〃 874	〃			50	4	1 A	500	150	100	45	60	6	50							200*		$C_c r_{bb}$ 50pS		[illegible]之对偶
	〃 875	〃	RF. PA	Si. TP	75	5	200	500	150	10	40	100	6	50	6	−10					170*	5		84B	
	〃 876	〃	〃	〃	50	5	200	500	150	10	40	100	6	50	6	−10					170*	5		84B	
	〃 877	協同	SW	Si. EP	40	4.5	200	300	175	0.1	20	60	1	10				t_{on}<20nS, t_{off}<35nS, t_{stg}<20nS						49C	
	〃 878	〃	〃	〃	40	4.5	200	300	175	0.1	20	70	1	10				t_{on}<12nS, t_{off}<22nS, t_{stg}<13nS						49C	
	〃 879	〃	〃	〃	60	5	1 A	800	175	1	40	80	1	100				t_{on}<70nS, t_{off}<100nS, t_{stg}<50nS						84A	
	〃 880	〃	〃	〃	60	5	1 A	800	175	1	40	80	1	100				t_{on}<70nS, t_{off}<100nS, t_{stg}<50nS						84A	
	〃 881	日電	RF. PA	〃	60		200	400	125	0.1	45	70	2	150	10	−10	110				200*	5.5	25	44	
	〃 882	[illegible]	RF. Conv Osc	〃	150	5	2 A	25 W (Tc=25°C)	150	50	30				5	−0.5A	50				30*	45	7	102	
	〃 883	〃	〃	〃	90	5	2 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	30				5	−0.5A	50				30*	45	7	102	
	〃 884	〃	PA	Si. TMe	80	5	2 A	15 W (Tc=25°C)	150	100	30	60	5	500	5	−200					30*	45	7	99	
	〃 885	〃	SW	〃	330	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	30	35	5	1 A				t_r<2μS, t_f<3μS, t_{stg}<6μS						102	
	〃 886	〃	〃	〃	270	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	30	35	5	1 A				t_r<2μS, t_f<3μS, t_{stg}<6μS						102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測量情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fe}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ (Ω)	外形	備考
	2SC887	芝電	SW	Si. TMe	210	5	7 A	50 W (T_c=25°C)	150	50	30	35	5	1 A				t_r< 2 μS, t_f< 3 μS t_{stg}< 6 μS						102	
	〃 888	〃	〃	〃	150	5	7 A	50 W (T_c=25°C)	150	100	30	35	5	1 A				t_r< 2 μS, t_f< 3 μS t_{stg}< 6 μS						102	
	〃 889	三菱	RF. AF. LN	Si. EP	90	5	7 A	50 W (T_c=25°C)	150	100	30	35	5	1 A				t_r< 2 μS, t_f< 3 μS t_{stg}< 6 μS						102	
	〃 890	日電	PA	〃	40	3	400	750	175	5	20				10	−50	40	P_o=1.3W (f=500Mc, P_i=0.3W, V_{cc}=13.5V)						84C	
	〃 891	〃	〃	〃	40	4	600	10.3W (T_c=25°C)	175	10	20				10	−100	40	P_o=3.7W (f=500Mc, P_i= 1 W, V_{cc}=13.5V)						115	
	〃 892	〃	〃	〃	40	4	1.2A	17.7W (T_c=25°C)	175	20	20				10	−300	40	P_o=7.5W (f=500Mc, P_i= 1 W, V_{cc}=13.5V)						115	
	〃 893	富士通	RF	Si. TMe	100	6	500	12 W (T_c=25°C)	175	1	30	100	4	50	6	−10	100				20*	10	30	97	
	〃 894	SON	RF. SW	Si. DB	25	6	100	100	120	0.2	25	100	3	1	6	−2					200*	2.4	Cc rbb' 120pS	38	
	〃 895	〃	PA. SW	Si. TMe	150	8	2.5 A	20W (T_c=25°C)	150	50	50	120	3	100	10	−200					20*	145	24	100	
	〃 896	日電	RF	Si. EP	55	5	200	300	175	1	20				10	−5	70				200*	3.5	35*	46C	
	〃 897	日立	PA	Si.TMe	150	6	7 A	60 W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	80	5	1 A	5	−1 A					15*	140	10*	102	2SA757 之對偶
	〃 898	〃	〃	〃	150	5	7 A	80 W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	50	5	1A	5	−1 A					15*	140	10*	102	2SA718 之對偶
★	〃 899	日電	RF. AF. LN	Si. EP	50	5	50	250	125	0.1	15	110	3	0.5	6	−1	140	4000	0.65	8.5	250*	1.8	Cc rbb' 70pS	43	
	〃 900	〃	RF. LN	Si. E	30	5	30	250	125	0.1	25	400	3	0.5	3	−1		14K	5.8	23	100*	3.5	50*	138	
	〃 901	松下	PA	Si. TMe	200	6	5 A	50 W (T_c=25°C)	150	15mA	150	25	4	5 A				t_r< 3 μS, t_f< 1 μS t_{stg}< 5 μS						102	
	〃 901A	〃	PA	Si. EP	250	6	5 A	50 W (T_c=25°C)	150	15mA	150	25	4	5 A				t_r< 3 μS, t_f< 1 μS t_{stg}< 3 μS						102	
	〃 902	富士通	SW	Si. TMe	150	6	10A	75 W (T_c=25°C)	175	15	30	50	4	5 A				t_r< 2 μS, t_f<1.5 μS t_{stg}<2.5 μS						102	
★	〃 903	三菱	PA	Si. EP	35	4	300	200	125	1	25	100	2	150	6	−10					150*	10	Cc rbb' 100pS	41	
★	〃 904	〃	〃	〃	50	4	300	200	125	1	25	100	2	150	6	−10					150*	10		41	
★	〃 905	〃	〃	〃	65	4	300	200	125	1	25	80	2	150	6	−10					150*	10		41	
	〃 906	富士通	PA. SW	〃	50	7	500	600	175	0.5	12	160	4	10				t_r<0.08 μS, t_f<0.15 μS t_{stg}<0.5 μS						89	
	〃 907	日立	RF. SW. AF	Si. DB	40	5	100	200	175	0.5	20	200	1	10	6	−1		4000	2	10	240*	1.7	150	12A	
	〃 907A	〃	〃	〃	60	5	100	200	175	0.5	20	120	1	10	6	−1		4000	2	10	240*	1.7	150	12A	
	〃 908	三菱	PA	Si. EP	40	4	500	860	175	50	15	50	10	100				P_o=1.2W (f=500Mc, V_{CC}=13.5V, P_i=0.4W)						84B	再登録
	〃 909	〃	〃	〃	40	4	600	7 W (T_c=25°C)	200	50	15	50	10	100				P_o=3.5W (f=500Mc, P_i= 1 W, V_{CC}=13.5V)						113	
★	〃 910	〃	〃	〃	40	3	1 A	10 W (T_c=25°C)	200	100	15				10	−100	50	PG = 5 dB (f=500Mc, P_i= 2 W, V_{CE}=13.5V)						113	
	〃 911	〃	〃	〃	40	4	500	1.7W	175	50	15	50	10	100				P_o=1.4W (f=500 MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.3W)						125	再登録
	〃 912	〃	RF. Conv. Mix Osc. SW	Si. EP	30	5	100	150	150	0.1	25	90	6	10	6	−1	80	2500	0.35	15	150*	2.5	Cc rbb' 100pS	8 A	
	〃 913	富士通, [illegible] 日電, 日立	SW	〃	40	5	300	300	175	0.2	20	70	1	30		t_{on}<45nS, t_{off}<42nS t_{stg}<27nS								49C	
	〃 914	〃	〃	〃	40	5	300	300	175	0.2	20	70	1	30		t_{on}<60nS, t_{off}<60nS t_{stg}<65nS								49C	
	2SC915	富士通, [illegible] 日電, 日立	SW	Si. EP	30	5	300	300	175	0.2	20	70	1	30			t_{on}<45nS, t_{off}<42nS t_{stg}<27nS							49C	
	〃 916	〃	〃	〃	100	5.5	1.5 A	2 W	175	10	80	70	1	400			t_{on}<60nS, t_{off}<210nS t_{stg}<190nS							83	
	〃 917	日立	RF	Si. P	40		50	300	175	10	40	40	10	10	10	−10					800*	1	Cc rbb' 5 pS	56C	
★	〃 918	SON	〃	Si. DB	20		30	188	100	0.2	15	80	10	4	10	−4	A_{fe}=12dB (f=100 MHz)					0.7	Cc rbb' 10pS	205C	
	〃 919																								
★	〃 920	日電	RF. Conv. Mix. Osc. LN	Si. EP	50	5	30	150	150	0.1	15	75	3	0.5	6	−1	NF = 2.5dB (f= 1 Mc)				250*	1.6	Cc rbb' 30pS	23	
★	〃 921	〃	RF. Conv. Mix. Osc.	〃	25	2	10	100	150	0.1	12	65	3	0.5	6	−1					650*	0.9	Cc rbb' 9 pS	23	
	〃 922	〃	〃	Si. E	30	5	20	250	125	0.1	20	80	6	1	6	−1					650*	1.1	Cc rbb' 15pS	138	
	〃 923	〃	RF. AF	〃	30	5	30	250	125	0.1	25	400	3	0.5	3	−1		14K	5.8	23	100*	3.5	50*	138	2SA641 之對偶
★	〃 924	〃	〃	Si. EP	30		50	250	125	0.1	15	100	3	0.5	6	−1	130	3800	0.6	8	250*	1.8	Cc rbb' 20pS	43	
★	〃 925	〃	RF. AF. SW	〃	30	5	50	250	125	0.1	30	130	12	2	12	−2	140	2300	3.5	45	250*	1.8	50	43	
★	〃 926	SON	RF. SW	Si. DB	115	3.5	100	100	120	0.2	115	50	3	1	10	−2					160*	2.5	Cc rbb' 40pS	38	
	〃 927	三洋	RF. LN	Si. TP	30	3	20	150	125	1	25	80	6	1	6	−3					500*	0.7	Cc rbb' 3.0 pS	205C	
	〃 928	〃	RF	〃	30	3	20	150	125	1	25	80	6	1	6	−3					500*	0.7	Cc rbb' 3 pS	205C	
	〃 929	〃	RF. Conv. LN	Si. EP	15	5	30	120	125	1	10	100	6	1	6	−1					300*	1.5	Cc rbb' 20pS	166	
	〃 930	〃	RF	〃	15	5	30	120	125	1	10	80	6	1	6	−1					300*	1.5	Cc rbb' 30pS	166	
	〃 931	〃	PA	Si. TMe	50		3 A	10 W (T_c=25°C)	125	1 mA	45	70	2	1 A	5	−0.5A					120*	100	35	120	
	〃 932	〃	〃	〃	30		3 A	10 W (T_c=25°C)	125	1 mA	25	70	2	1 A	5	−0.5A					120*	100	35	120	
	〃 933	〃	RF. AF	Si. EP	50	5	300	300	125	1	45	150	5	20	6	−5					300*	5	Cc rbb' 120pS	138	
	〃 934	〃	〃	〃	20	5	300	300	125	1	15	150	5	20	6	−5					300*	5	Cc rbb' 120pS	138	
	〃 935	日立	PA	Si. TMe	300	5	2.5 A	50 W (T_c=25°C)	150	I_{CEX} 1mA	300	14	10	300	15	−200					5*	75	20	102	
	〃 936	〃	〃	〃	1000	5	1 A	22 W	125	I_{CEX} 1mA	500	45	10	100	15	−200					7*	35	25	102	
	〃 937	〃	〃	〃	1200	6	2.5 A	22 W (T_c=25°C)	125	I_{CEX} 1mA	500	8	10	2.5A	15	−200	t_f<1.2μS				4*	100	15	102	
	〃 938	日電	RF	Si. E	60	5	200	250	125	0.1	60	80	1	50	10	−10					90*	7.5	40*	138	
★	〃 939	日電	PA. SW	Si.EMe	150	7	5 A	50W (T_c=25°C)	150	2mA	60	70	5	5A	10	−200					20*	150	20*	102	
	〃 940	〃	〃	SiEMe	200	7	5 A	50W (T_c=25°C)	150	2mA	90	70	5	5A	10	−200					20*	150	20*	102	
	〃 941	東芝	RF. LN	Si. EP	35	4	20	200	125	0.1	20	40~240	12	2	10	−2	NF = 2 dB (f= 1 Mc, I_E= −1mA)				120*	Cre 2.2	Cc rbb' 30pS	33	
	〃 942	富士通	RF	〃	20		20	300/unit	150	0.5	10				6	−2	70				700*	1.3	80*	122	複合管
	〃 943	日電	〃	〃	60	8	200	300	150	0.5	40	150	1	10	10	−10					220*	4	40	49B	
	〃 944	〃	RF. AF. SW	Si. E	60	8	100	250	125	0.1	40	120	10	2	10	−2		2300	3.5	45	250*	2.2	Cc rbb' 40pS	138	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO}最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μƱ)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ (Ω)	外形	備考
2SC945	日電	RF. AF	Si. E	50	5	100	250	125	0.1	40	150	6	1	6	−1		4500	4.5	17	250*	4.5	25*	138	2SA733 之對偶
〃 946																								
〃 947	松下	RF. Conv. Mix. Osc. PA	Si. P	25	3	15	150	175	100	25	50	10	2	10	−3					650*	Cre 0.33pF	20	50C	
〃 948	〃	RF	〃	25	3	15	150	175	100	25	60	10	3	10	−3					800*	Cre 0.33pF	30	50C	
〃 949	新日無	RF. AF. LN	Si. EP	30		50	200	125	0.05	20	150	6	1	6	−0.1		50k	5	15	40*	6	$C_c r_{bb'}$ 60pS	29	
〃 950	〃	RF. AF	〃	30		100	300	125	0.1	20	100	6	1	10	−2		5000	1	20	55*	5	$C_c r_{bb'}$ 40pS	29	
〃 951																								
〃 952	新日無	RF	Si. EP	90		200	300	125	0.1	20	90	1	50	10	−2					40*	5	$C_c r_{bb'}$ 50pS	29	
〃 953	〃	〃	〃	30		200	600	125	0.5	20	80	1	100	10	−5					90*	5	$C_c r_{bb'}$ 50pS	31	
〃 954	〃	RF. PA	〃	60		400	600	125	0.5	20	100	1	100	10	−5					90*	5	$C_c r_{bb'}$ 50pS	31	
〃 955	〃	RF	〃	20		50	150	125	1	10	100	6	1	6	−2					150*	2	$C_c r_{bb'}$ 250pS	29	
〃 956	〃	RF. AF	〃	50	5	50	150	125	0.1	20	250	6	1	6	−1		30kΩ	6	30	200*	2	$C_c r_{bb'}$ 200pS	29	
〃 957	SONY	RF	Si. DB	30		100	360	100	0.3	15	30	3	1	10	−10		h_{fe} = 16dB (f = 100MHz)				1.5	$C_c r_{bb'}$ 10pS	206C	
〃 958																								
〃 959	日電	PA	Si.EP	120	5	700	0.7	150	3	80	100	5	200	5	−150					80*	17	35	84B	2SA604 之對偶
〃 960	〃	〃	〃	120	5	700	1 W	150	3	80	80	5	300	10	−100					100*	30	35*	97B	2SA607 之對偶
〃 961	芝電	PA	Si.TMe	120	5	7 A	60W (T_c=25°C)	150	100	30	60	4	1 A	5	−500					13*	350	5	102	
〃 962	〃	〃	〃	100	5	7 A	60W (T_c=25°C)	150	100	30	60	4	1 A	5	−500								102	
〃 963	富士通	RF	Si. EP	35		50	250	175	2	12	70	6	1	6	−1					200*	2	50*	55C	
〃 964	〃	〃	〃	35		50	250	175	2	12	100	6	1	6	−1		4000	5	20	200*	2	50*	55C	
〃 965	〃	RF. SW	〃	45	4	100	250	175	0.5	12	130	6	1	6	−1	t_r < 60nS, t_f < 100nS t_{stg} < 200nS				200*	2	50*	55C	
〃 966	〃	RF. AF. LN	〃	30		200	500	175	0.5	12	160	4	10	6	−1		3500	0.1	5	60*	10	80	55C	
〃 967	〃	RF. AF. PA	〃	30		500	500	175	1	12	160	4	10	6	−1		3500	0.1	5	60*	10	70	55C	
〃 968	〃	RF. PA	〃	50		500	500	175	1	12	160	4	10	6	−1					60*	10	70	55C	
〃 969	〃	RF. AF. LN	〃	50		200	500	175	0.1	12	160	4	10	6	−1		3500	0.1	5	60*	10	80	55C	
〃 970	〃	RF. SW	〃	50	7	500	500	175	0.5	12	160	4	10	6	−1	t_r < 60nS, t_f < 150nS t_{stg} < 600nS				70*	10	70	55C	
〃 971	〃	RF. PA	〃	50		500	1 W	175	1	12	160	4	10	6	−1					60*	10	70	90	
〃 972																								
〃 973	三菱	PA	Si. EP	40	4	500	7 W (T_c=25°C)	200	50	15	50	10	100			P_o = 4 W (f = 500MHz, V_{cc} = 13.5V, P_i = 1W)							126	
★ 〃 974	〃	〃	〃	35		1 A	10 W (T_c=25°C)	200	100	15	50	10	100			P_o = 6 W (f = 500MHz, V_{cc} = 13.5V, P_i = 2W)							183	再登錄
2SC975	三菱	PA	Si. EP	35	5	1.5A	17 W (T_c=25°C)	175	200	15	50	10	100				P_o = 8 W (f = 500MHz, V_{cc} = 13.5V, P_i = 3W)						183	再登錄
〃 976	〃	〃	〃	55	4	400	5 W (T_c=25°C)	175	100	30	50	28	20				P_o = 1.1 W (f = 1 GHz, V_{cc} = 28 V, P_i = 0.3 W)						126	
〃 977	〃	〃	〃	55	4	600	10 W (T_c=25°C)	175	300	30	50	28	50				P_o = 3 W (f = 1 GHz, V_{cc} = 28 V, P_i = 0.75 W)						126	
〃 978	〃	〃	〃	55	4.5	1.2A	18 W (T_c=25°C)	175	500	30	50	28	50				P_o = 5.5 W (f = 1 GHz, V_{cc} = 28 V, P_i = 2 W)						126	
〃 979	東芝	RF	〃	70	5	100	300	175	0.1	50	40~240	1	10	10	−10					250*	3		49C	
〃 980	〃	〃	〃	70	5	100	200	125	1	50	70	1	10	10	−10					400*	3	30	33	
〃 981	〃	PA	〃	100	5	5 A	25W (T_c=25°C)	150	10	40	70	1.5	5 A	5	−500					10*	80	10	99	
〃 982	〃	AF.SW	〃	30	10	300	300	125	0.1	30	>5000	5	10	10	−10					100*	6	100	185	
〃 983	〃	〃	Si. TP	250	5	50	600	150	0.1	30	40~240	5	10	30	−10					120*	<5.5	25	131	
〃 984	日立	〃	Si.EPa	50	4	500	350	175	0.5	20	80	3	10	3	−10					230*	5	24*	12A	2SA565 之對偶
★ 〃 985	日電	RF. LN	〃	20	3	40	200	150	0.5	10	80	5	15	5	−15	NF = 5.3dB (f = 2 Gc, 5 V, −4 mA)				3200*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 1 pS	26	
★ 〃 986		RF	Si. E	35	3	200	3.5W (T_c=25°C)	200	1	20	100	15	70	15	−70					2500*	1	$C_c r_{bb'}$ 3 pS	187	
★ 〃 987	〃	〃	Si. EP	20	3	30	150	150	0.5	10	80	10	10	10	−10	NF = 6 dB (f = 4 Gc, 10V, −3 mA)				4500*	0.35	$C_c r_{bb'}$ 0.6pS	26	
〃 988	〃	〃	〃	20	3	30	200	200	0.1	10	80	10	10	10	−10	NF = 2 dB (f = 500Mc, 10V, −3 mA)				3000*	0.5	30*	50C	
★ 〃 989	〃	〃	〃	20	3	50	300	200	0.5	10	80	1	30	3	−15					3000*	0.9	30*	25	
★ 〃 990	〃	PA	〃	50	4	2 A	24 W (T_c=25°C)	175	10	20	40	10	1 A	10	−300	P_o = 15 W (f = 400Mc, V_{cc} = 18V, P_i = 4.3W)				400*	25		116	
★ 〃 991	東芝	〃	〃	36	4	400	600	175	1	15	30	3	100	10	−50	P_o = 1.3W (f = 175Mc, V_{cc} = 12V, P_i = 0.1W)				500*	5	10	84B	
★ 〃 992	〃	〃	〃	36	4	600	600	175	1	15	30	3	100	10	−50	P_o = 2.5W (f = 175Mc, V_{cc} = 12V, P_i = 0.5W)				500*	5	10	84B	
〃 993	富士通	RF	〃	25		200	200	175	0.05	10				6	−1	80				400*	3.5	50*	46C	
〃 994	東芝	RF. PA	〃	36	3	100	600	175	1	15	40	3	100	10	−10					500	3.8		84B	
〃 995	〃	RF. PA	Si. TP	300	5	100	800	150	0.1	100	100	10	50	10	−30					100*	4.2	10	84B	
〃 996	〃	〃	〃	300	5	100	1.2W	150	0.1	100	100	10	50	10	−30					100*	4.2	10	97B	
〃 997	〃	RF	Si. P	40		25	150	150	0.025	10	70	10	4	10	−4					600*	1.5		117C	
〃 998	〃	PA	Si. EP	40	4	400	600	175	1	15	>20	5	50	5	−50					550*	6.5		84B	
★ 〃 999	〃	RF. PA. SW	Si. TMe	1500	5	1.5A	50 W (T_c=25°C)	150	10	500	50	15	150	15	−200					1	70	10	102	
〃 1000	〃	RF. LN	Si. EP	55	5	100	200	125	0.1	18	200~700	6	2	6	−1	280	7500	0.62	6.4	80*	6	100	33	
〃 1001	〃	RF. PA	〃	40	4	500	5 W (T_c=25°C)	175	1	15	>20	5	100	10	−50	P_o = 1.2W (f = 470Mc, V_{cc} = 12.6V, P_i = 0.3W)				700*	6.5	25*	84B	
★ 〃 1002	〃	〃	〃	36	4	1 A	10 W (T_c=25°C)	175	20	15	60	2	200	12.6	−100	P_o = 3 W (f = 470Mc, V_{cc} = 12.6V, P_i = 1W)				700*	10	20*	84A	
★ 〃 1003	〃	〃	〃	36	4	2 A	20 W (T_c=25°C)	175	50	15	50	2	400	12.6	−200	P_o = 6 W (f = 470Mc, V_{cc} = 12.6V, P_i = 2.5W)				350*	20	10*	111	
〃 1004	〃	PA	Si. TMe	1100	5	500	50 W (T_c=25°C)	150	10	500	70	15	150	15	−200					5.5*	40		102	

型名		用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偶置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie}(real)$* (Ω)	外形	備考
2SC1004A	東芝	PA. SW	Si. TMe	1500	5	500	50 W (T_C=25°C)	150	10	500	70	15	150	15	−200					5.5*	40		102	
★ 〃 1005	〃	PA	〃	1100	5	5 A	50 W (T_C=25°C)	150	10	500	12	15	4 A	15	−500					3*	150	5	102	
〃 1006	日電	RF. AF	Si. E	50	5	30	300	150	0.05	30	600	3	1	3	−1		18K	2	45	200*	3	50*	49C	
〃 1007	〃	RF. SW	Si. EP	60	8	20	300	150	0.1	40	150	1	10	10	−10					220*	3	30*	49C	
〃 1008	〃	RF	Si. E	80	8	700	800	150	0.1	60	160	2	50	10	−50					*	17	25*	84B	
★ 〃 1009	〃	RF. Conv. Mix. Osc. LN	〃	50	5	50	150	125	0.1	25	80	3	0.5	6	−1		NF = 2 dB (f = 1MHz, 6V, 0.5mA)			250*		$C_c r_{bb'}$ 25pS	176	
〃 1010	〃	AF. LN	〃	50	5	30	300	150	0.05	30	550	3	1	3	−1		18K	2	45	120*	3	50*	49C	
〃 1011	三菱	PA	Si. EP	40	4	750	2.5 W	200	100	15	50	10	100			P_o = 3 W (f = 150 MHz, V_{cc} = 15 V, P_i = 250 mW)							125	
〃 1012	松下	RF. AF	Si. TP	165	5	60	2.5 W (T_C=25°C)	175	2	12	60	20	40	10	−3	35	300	0.4	2.7	*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 60pS	84B	
〃 1013	三菱	SW. P	Si. EP	35	5	1.5 A	7 W (T_C=25°C)	125	1	25	80	4	500				t_{on} < 0.2 μS, t_{off} < 1.2 μS, t_s < 1 μS						132	
〃 1014	〃	〃	〃	50	5	1.5 A	7 W (T_C=25°C)	125	1	25	70	4	500				t_{on} < 0.2 μS, t_{off} < 1.2 μS, t_s < 1 μS						132	
〃 1015	〃	PA	〃	40	4.5	3 A	33 W (T_C=25°C)	175	500	15	50	10	100			P_o = 14 W (f = 450 MHz, V_{cc} = 13.5 V, P_i = 6 W)							183	再登録
★ 〃 1016	〃	〃	〃	35		500	2 W	200	50	15	50	10	100			P_o = 1.3 W (f = 500 MHz, V_{cc} = 12 V, P_i = 0.3 mW)							186	
〃 1017	〃	〃	〃	75	4	1 A	4 W (T_C=25°C)	125	10	30	50	10	100			P_o = 60 mW (f = 27 MHz, I_C = 25 mA, V_{cc} = 12 V)							132	
〃 1018	〃	〃	〃	75	4	1 A	4 W (T_C=25°C)	125	10	30	50	10	100			P_o = 1.4 W (f = 27 MHz, P_i = 75 mW, V_{cc} = 12 V)							132	
★ 〃 1019	〃	〃	〃	60		4 A	40 W (T_C=25°C)	175	1mA	30	50	10	100			P_o = 28 W (f = 500 MHz, V_{cc} = 28 V, P_i = 20 W)							188	
★ 〃 1020	〃	〃	〃	60		8 A	70 W (T_C=25°C)	175	2mA	30	50	10	100			P_o = 45 W (f = 500 MHz, V_{cc} = 28 V, P_i = 20 W)							188	
〃 1021	〃	〃	〃	60	5	6 A	60 W (T_C=25°C)	175	2 mA	30	50	10	100			P_o = 45 W (f = 90 MHz, V_{cc} = 28 V, P_i = 5 W)							127	再登録
〃 1022	〃	〃	〃	60	5	6 A	60 W (T_C=25°C)	175	2 mA	30	50	10	100			P_o = 45 W (f = 150 MHz, V_{cc} = 28 V, P_i = 10 W)							127	再登録
〃 1023	富士通	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. P	25		25	150	125	2	12	40	6	1	6	−2					200*	1.8		138	
〃 1024																								
〃 1025																								
〃 1026	富士通	RF. Conv.	Si. P	25	3	25	150	125	2	12	100	6	1	6	−2	NF = 2.5 dB (f = 1 MHz, 6V, 1mA)				200*	1.8	70	138	
〃 1027																								
〃 1028																								
〃 1029																								
〃 1030	日立	PA	Si. TMe	150	6	6 A	50 W (T_C=25°C)	150	1 mA	30	80	5	1 A	5	−1A					10*	180	12*	102	2SA756之對偶
〃 1031	富士通	SW	〃	300	6	2 A	30 W (T_C=25°C)	175	5	150	220	10	500				t_{on} < 5 μS, t_{off} < 15 μS, t_{stg} < 5 μS						99	
〃 1032		RF	Si. P	25	3	25	150	125	2	12	100	6	1	6	−2					200*	1.8	70*	138	
〃 1033	松下	RF. AF	Si. TP	200	5	25	300	175	2	12	70	10		10	−3	38	300	0.4	2.9	135*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 60pS	49C	
2SC1034	SON	PA. SW	Si. TMe	1100	13	1 A	25 W (T_C=25°C)	150	5 mA	800	18	3	750	10	−200					5*	95	$C_c r_{bb'}$ 220pS	100	
〃 1035	三洋	LN	Si. TP	30	3	20	150	150	1	25	100	6	1	6	−3	NF = 6 dB (f = 800 MHz, 11 V, 2mA)				700*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 2.5pS	205C	
〃 1036	〃	RF	〃	30	3	20	150	150	1	25	100	6	1	6	−3					700*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 2.5pS	205C	
〃 1037	日電	PA	Si. EP	60	4	4 A	50 W (T_C=25°C)	175	1 mA	30	50	10	1 A			P_o = 33 W (f = 160 Mc, V_{cc} = 28 V, P_i = 10 W)							111	
〃 1038	〃	〃	〃	40	3	150	3.75 W (T_C=25°C)	175	50	20	50	10	70	10	−70	P_o = 800 mW (f = 2.3 GHz, V_{cc} = 18 V, P_i = 250 mW)				2000*	2.5		129	
〃 1039	〃	〃	〃	40	3	250	7.5 W (T_C=25°C)	175	100	20	50	10	100	10	−100	P_o = 1.4 W (f = 2.3 GHz, V_{cc} = 18 V, P_i = 630 mW)				2000*	4		129	
〃 1040	〃	〃	Si. E	45	4	1.2 A	15 W (T_C=25°C)	175	1 mA	30	50	10	1 A			P_o = 8 W (f = 500 MHz, V_{cc} = 18 V, P_i = 2 W)							184	
〃 1041	日電	PA	Si. EP	40	3	150	3.75 W (T_C=25°C)	175	50	20	50	10	70	10	−70	P_o = 900 mW (f = 2 GHz, V_{cc} = 18 V, P_i = 250 mW)				2000*	2.5		129	
〃 1042	〃	〃	〃	40	3	250	7.5 W (T_C=25°C)	175	100	20	50	10	100	10	−100	P_o = 1.6 W (f = 2 GHz, V_{cc} = 18 V, P_i = 630 mW)				2000*	4		129	
〃 1043	〃	RF. LN	Si. E	45	3	300	6 W (T_C=25°C)	175	0.1	30	80	10	100	15	−50	P_G = 15 dB (f = 500 MHz, 50 mA) NF = 3.5 dB (f = 200 MHz, 50 mA)				2200*	2.5		129	
〃 1044	〃	RF	〃	45	4	30	250	200	50 nA	30	100	6	6	6	−6	G_P = 22 dB (f = 200 MHz)				1000*	NF = 3 dB (f = 200 MHz)		50C	
〃 1045																								
〃 1046																								
〃 1047	松下	RF	Si. EP	30	3	15	150	125	10	30	120	6	1	6	−1					650*	Cre 0.88pF	30	138	
〃 1048	三洋	〃	Si. Me	200	6	50	600	150	10	100	90	10	25	10	−10					120*	3.5		84B	
〃 1049																								
〃 1050																								
〃 1051																								
〃 1052	富士通	SW	Si. EP	75	5	1 A	800	175	0.5	50	40	1	500			t_{on} < 50 nS, t_{off} < 70 nS, t_{stg} < 40 nS							84B	
★ 〃 1053	〃	〃	〃	75	5	700	800	175	0.2	40	50	1	500			t_{on} < 40 nS, t_{off} < 60 nS, t_{stg} < 45 nS							84B	
★ 〃 1054	〃	RF. LN	〃	35	3	50	180	175	0.5	12	60	6	1	6	−2	NF = 3 dB (f = 200 MHz, 6 V, 1mA)				700*	1	30*	205C	
〃 1055	日立	PA. SW	Si. TMe	130	6	7 A	25 W (T_C=25°C)	175	200	30	60	4	5 A	5	−1A					25*	200	12*	99	
〃 1056	SON	RF	Si. PaMe	260	5	100	750	175	1	100	150	5	3	10	−10				*	150*	10	$C_c r_{bb'}$ 50pS	84B	
★ 〃 1057	富士通	PA	Si. EP	50	3.5	1 A	12 W (T_C=25°C)	175	500	20	50	5	500			P_o = 6.5 W (V_{cc} = 24 V, f = 700 MHz, P_i = 2 W)							133	
★ 〃 1058	〃	〃	〃	50	3.5	2 A	20 W (T_C=25°C)	175	1 mA	20	50	5	1 A			P_o = 11.5 W (V_{cc} = 24 V, f = 700 MHz, P_i = 4 W)							133	
〃 1059	日立			300	4	150	8 W (T_C=25°C)	150			60	10	50										153	
〃 1060	〃	PA	Si. T	50	4	3 A	25 W (T_C=25°C)	150	100	20	100	4	1 A	4	−500					8*	100	6*	158	2SA670之對偶
〃 1061	〃	〃	〃	50	4	3 A	25 W (T_C=25°C)	150	100	20	100	4	1 A	4	−500					8*	100	6*	159	2SA671之對偶
〃 1062	富士通	SW	Si. TMe	200	4	100	700	175	2	100	60	2	50			t_{on} < 3.2 μS, t_{on} < 12 μS, t_{stg} < 8 μS							84B	
〃 1063	SON	SW	Si. DB	10	5	1 A	750	150	1	10	60	1	65			t_r < 60 nS, t_f < 100 nS, t_{stg} < 300 nS							84C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB} (V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE} (V)	I_C (mA)	偏置情况 V_{CB} (V)	I_E (mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{re(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC1064	協同	SW	Si. EP	60	5	1 A	800	175	0.5	40	45	1	500										84 A	
〃 1065	〃	〃	〃	90	5	1 A	800	175	0.5	40	40	3	500							400*			84 B	
〃 1066	富士通	RF	〃	20	3	25	200	175	0.1	12				6	−2	120				800*	1.4	80*	46 C	
〃 1067	〃	〃	〃	35	3	50	180	175	0.5	12	60	6	1	6	−2					500*	1	30*	205C	
〃 1068	〃	〃	〃	25	3	150	600	175	0.5	20	100	10	40	10	−40					2000*	2	40*	84 B	
〃 1069	〃	SW	〃	100	6	1 A	800	175	0.5	70	40	3	500	10	−10	t_{on}<60nS, t_{off}<100nS, t_{stg}<90nS				400*	<9		84 B	
〃 1070	日電	RF	〃	30	4	20	150	150	0.1	25	100	10	3	10	−3					900*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 3pS	210	
〃 1071	富士通. [illegible] 日電. 日立	SW	〃	30	5	200	300	175	0.2	20	80	1	30			t_{on}<45nS, t_{off}<42nS, t_{stg}<22nS							49 C	
〃 1072	〃	〃	〃	60	5	700	800	175	0.3	40	50	1	500			t_{on}<40nS, t_{off}<60nS, t_{stg}<50nS							123	
〃 1072A	〃	〃	〃	66	5	700	800	175	0.3	40	50	1	500			t_{on}<40nS, t_{off}<60nS, t_{stg}<50nS							123	
〃 1073	松下	PA	〃	36	4	500	2 W (T_c=25°C)	175	5	20	70	13.5	100			P_o=1.8W (f=500MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=0.4W)							142	
〃 1074	〃	〃	〃	36	4	1 A	10W (T_c=25°C)	175	5	20	50	13.5	200			P_o=4 W (f=500MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=1.0W)							142	
〃 1075	〃	〃	〃	36	4	2 A	20W (T_c=25°C)	175	10	20	60	13.5	400			P_o=8 W (f=500MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=3 W)							142	
〃 1076	〃	〃	〃	36	4	3 A	30W (T_c=25°C)	175	30	20	50	13.5	600			P_o=15W (f=500MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=6 W)							142	
〃 1077	東芝	〃	〃	65	4	5 A	50W (T_c=25°C)	175	10mA	20	>20	10	1 A	20	−200	P_o=42W (f=175MHz, V_{cc}=28V, P_i=1W)				150*	45		141	
〃 1078	〃	〃	Si TMe	700	5	500	20W (T_c=25°C)	150	10	500	70	15	150	15	−150					2*	40	10	99	
〃 1079	〃	〃	〃	150	5	12A	100 W (T_c=25°C)	150	100	50	40~140	5	2 A	5	−2A					4*	350		102	
〃 1080	〃	〃	〃	110	5	12A	100 W (T_c=25°C)	150	100	30	40~140	5	2 A	5	−2A					4*	350		102	
★ 〃 1081	日電	〃	〃	40	4	2.5A	30W (T_c=25°C)	175	1mA	30	70	10	1 A	10	−300	P_o=14W (f=500MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=5.5W)				400*			115	
〃 1082	富士通	〃	Si. EP	50	3.5	500	7 W (T_c=25°C)	175	100	20	50	5	200			P_o=3 W η=55% (f=700MHz, V_{cc}=24V, P_i=0.5W)							192	再登録
〃 1083	〃	〃	〃	40	3.5	500	3 W (T_c=25°C)	175	100	20	80	5	200	12	−100	P_o=1.2W (f=175MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.1W)				1600*	4		84 B	
〃 1084	〃	RF. AF	〃	35	4	50	250	175	0.5	12	300	6	1	6	−1		8000	1.7	7.8	300*	2	50*	55 C	
〃 1085	日立	RF. LN	Si. DB	30	5	100	200	125	0.1	30	160	6	2	6	−1		4000	0.3	145	230*	1.8	100*	137	
★ 〃 1086	SON	PA. SW	Si TMe	1000	14	4 A	125 W (T_c=25°C)	120	2mA	800	12	3	2 A	10	−500					5*	175	$C_c r_{bb'}$ 450pS	102	
〃 1087																								
★ 〃 1088	三菱	PA	Si. TP	300	5	100	12.5W (T_c=25°C)	150	3	300	70	10	50	50	−20					40*	5	$C_c r_{bb'}$ 20pS	180	
★ 〃 1089	〃	〃	〃	300	5	100	12.5W (T_c=25°C)	150	3	300	70	10	50	50	−20					50*	3	$C_c r_{bb'}$ 20pS	180	
〃 1090	日電	RF	Si. EP	20	3	50	300	200	0.5	10	80	1	30	3	−15					3000*	0.9	30*	130	
〃 1091																								
〃 1092																								
2SC1093																								
〃 1094																								
〃 1095																								
〃 1096	日電	PA	Si. E	40	5	2 A	10W (T_c=25°C)	150	100	30	80	5	1 A	5	−150					60*			167	2SA634 之對偶
〃 1097																								
〃 1098	日電	PA	Si. E	70	5	1 A	10W (T_c=25°C)	150	100	40	80	5	500	5	−150					40*			167	2SA636 之對偶
★ 〃 1099	日電	SW	Si. TMe	1200	7	4.5A	50W (T_c=25°C)	150	1 mA	1000	25	15	3 A			t_r<2.5μS, t_f<1μS, t_{stg}<1.5μS							102	
★ 〃 1100	〃	〃	〃	1100	7	4.5A	50W (T_c=25°C)	150	1 mA	1000	25	15	3 A			t_r<2.5μS, t_f<1μS, t_{stg}<1.5μS							102	
〃 1101	〃	〃	〃	1100	5	1.5A	50W (T_c=25°C)	150	1 mA	1000	60	15	500			t_r<10μS, t_f<2μS, t_{stg}<2μS							102	
★ 〃 1102	〃	PA. SW	〃	300	7	100	11W (T_c=25°C)	150	100	300	90	10	10	30	−10					80*	3.5	10	134	
★ 〃 1103	〃	PA	Si. TP	250	7	100	800	150	100	250	80	10	10	30	−10					80*	4.5	30	84B	再登録
〃 1104	〃	SW	〃	300	5	1.5A	20W (T_c=25°C)	150	100	200	80	10	400			t_r<2.5μS, t_f<2μS, t_{stg}<1.5μS							134	
★ 〃 1105	〃	PA	〃	300	5	100	15W (T_c=25°C)	150	100	200	80	10	50	50	−20					20*	5	30	134	
〃 1106	〃	SW	〃	350	5	3 A	80W (T_c=25°C)	150	1 mA	200	90	15	500			t_r<3μS, t_f<3μS, t_{stg}<2μS							102	
〃 1107	SAK	PA	Si. TMe	80		4 A	25W (T_c=25°C)	150	100	80	120	4	1 A	10	−200					10*	25	26*	211	
〃 1108	〃	〃	〃	100		4 A	25W (T_c=25°C)	150	100	100	120	4	1 A	10	−200					10*	25	26*	211	
〃 1109	〃	〃	〃	80		4 A	25W (T_c=25°C)	150	100	80	120	4	1 A	10	−200					10*	25	26*	212	
〃 1110	〃	〃	〃	100		4 A	25W (T_c=25°C)	150	100	100	120	4	1 A	10	−200					10*	25	26*	212	
〃 1111	〃	〃	〃	140	6	6 A	50W (T_c=25°C)	150	1 mA	140	60	4	3 A	12	−500					10*	115	12*	102	
〃 1112	〃	〃	〃	160	6	6 A	50W (T_c=25°C)	150	1 mA	160	60	4	3 A	12	−500					10*	115	12*	102	
〃 1113	〃	PA. SW	〃	120	10	6 A	40W (T_c=25°C)	150	10	120	60	4	5 A	12	−500	t_r<1.5μS, t_f<1μS, t_{stg}<4μS				10*			99	再登録
〃 1114	〃	PA	〃	300	7	4 A	100 W (T_c=25°C)	150	1 mA	300	60	4	1 A	12	−100					10*	50	26*	102	
〃 1115	〃	〃	〃	140	6	10 A	100 W (T_c=25°C)	150	1 mA	140	60	4	3 A	12	−500					10*	165	13*	102	
〃 1116	〃	〃	〃	180	6	10 A	100 W (T_c=25°C)	150	1 mA	180	60	4	3 A	12	−500					10*	165	13*	102	
〃 1117	日立	RF	Si. P	20	3	20	150	150	1	15	150	10	2			G_{pe}=13dB (11V, 2mA, f=800MHz)				850*	Cre 0.35		56 C	
〃 1118	日電	〃	Si. E	45	4	2 A	27W (T_c=25°C)	175	2	30	50	10	1 A			P_o=14.5W (f=500MHz, V_{cc}=18V, P_i=5W)							184	
〃 1119	日電	RF	Si. EP	20	3	30	250	175	0.1	10	100	10	10	10	−10					4500*	0.5	20*	130	
〃 1120	東芝	PA	〃	35	4	1.5A	10W (T_c=25°C)	175	5	15	40	5	500	10	−100	P_o=4 W (f=470MHz, P_i=1W, V_{cc}=12.6V)				700*	8	20*	135	
〃 1121	〃	〃	〃	35	4	3 A	20W (T_c=25°C)	175	25	15	40	5	1 A	10	−200	P_o=8.5W (f=470MHz, P_i=3W, V_{cc}=12.6V)				500*	20	10*	135	
★ 〃 1122	〃	〃	〃	35	4	4.5A	30W (T_c=25°C)	175	100	15	40	5	1.5A	10	−100	P_o=14W (f=470MHz, P_i=6W, V_{cc}=12.6V)				400	20		135	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC1123	SON	Mix	Si. DB	35	3	100	300	100	0.2	15	70	3	1	10	−5	h_{fe}=15dB (f=100MHz)					2.1	$C_c r_{bb'}$ 8 pS	208	
〃 1124	〃	PA	Si.PaMe	140	6	1 A	950	120	1	50	160	2	100	10	−10					120*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150pS	174	
〃 1125																								
〃 1126	SON	RF. Osc	Si. DB	30	3	50	250	100	0.2	15	50	3	1	10	−8	h_{fe}=15dB (f=100MHz)					1.5	$C_c r_{bb'}$ 16 pS	208	
〃 1127	〃	RF	Si.PaMe	180	8	100	950	120	1	100	60	5	3	10	−2					30*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 80pS	174	
〃 1128	〃	〃	〃	35	3	100	300	100	0.3	15	70	3	1	10	−10	h_{fe}=16dB (f=100MHz)					1.6	$C_c r_{bb'}$ 7 pS	208	
〃 1129	〃	〃	〃	35	3	30	300	100	0.2	15	70	10	4	10	−4	h_{fe}=12dB (f=100MHz)					1	$C_c r_{bb'}$ 12pS	208	
〃 1130	ORG	PA. SW	SiT	800	6	3.5A	80W (T_c=25°C)	150	2mA	800	15	5	2 A	10	−1A	t_{on}<1μS, t_{off}<2μS				4*	150	10	102	
〃 1131	〃	〃	〃	600	6	3.5A	80W (T_c=25°C)	150	2mA	600	15	5	2 A	10	−1A	t_{on}<1μS, t_{off}<2μS				4*	150	10	102	
〃 1132	〃	〃	〃	1200	6	2.5A	30W (T_c=25°C)	125	1mA	1200	15	5	0.5A	10	−1A	t_{on}<1μS, t_{off}<1.2μS				3.5*	110	10	102	
〃 1133																								
〃 1134																								
〃 1135																								
〃 1136	ORG	PA. SW	Si. T	200	6	30A	200W (T_c=25°C)	150	5mA	200	20	5	10A	10	−1A					9*	650	5	154	
〃 1137																								
〃 1138	ORG	PA. SW	Si. T	800	6	30 A	200 W (T_c=25°C)	150	5mA	800	20	15	10 A	10	−1A					9*	650	5	154	
〃 1139	〃	〃	〃	600	6	30 A	200 W (T_c=25°C)	150	5mA	600	20	5	10 A	10	−1A					9*	650	5	154	
〃 1140	〃	〃	〃	800	6	15 A	150W (T_c=25°C)	150	3mA	800	15	5	7.5A	10	−1A	t_{on}<1.5μS, t_{off}<5μS				10*	350	10	102	
〃 1141	〃	〃	〃	600	6	15 A	150W (T_c=25°C)	150	3mA	600	15	5	7.5A	10	−1A	t_{on}<1.5μS, t_{off}<5μS				10*	350	10	102	
〃 1142	〃	〃	〃	800	6	10A	125W (T_c=25°C)	150	3mA	800	15	5	5 A	10	−1A	t_{on}<1.5μS, t_{off}<3μS				4*	270	10	102	
〃 1143	〃	〃	〃	600	6	10A	125W (T_c=25°C)	150	3mA	600	15	5	5 A	10	−1A	t_{on}<1.5μS, t_{off}<3μS				4*	270	10	102	
〃 1144																								
〃 1145																								
〃 1146																								
〃 1147																								
〃 1148																								
〃 1149																								
〃 1150	富士通	SW	Si. EP	60	5	1 A	800	175	0.5	50	50	1	500				t_{on}<35nS, t_{off}<65nS t_{stg}<30nS						123	
〃 1151	三菱	RF. PA	Si. EMe	900	5	1 A	50W (T_c=25°C)	125	200	500	60	10	150	15	−200					5*	65	25	102	
〃 1152	〃	〃	〃	300	5	2.5A	50W (T_c=25°C)	125	200	300	60	10	500	15	−200					5*	65	25	102	
2SC1153	三菱	SW	Si. EMe	1200	6	2.5A	50W (T_c=25°C)	125	1mA	1200	20	10	2.5A			t_r<1.5μS, t_{stg}<2μS, t_f<3μS							102	
〃 1154	〃	〃	〃	1200	6	3.5A	50W (T_c=25°C)	125	1mA	1200	20	10	3.5A			〃							102	
★ 〃 1155	〃	SW. PA	Si. EP	70	5	800	7 W (T_c=25°C)	150	10	25	100	4	300			t_{on}<0.2μS, t_{stg}<1μS, t_{off}<1.2μS							132	
★ 〃 1156	〃	〃	〃	90	5	800	7 W (T_c=25°C)	150	10	25	100	4	300			〃							132	
★ 〃 1157	〃	〃	〃	110	5	800	7 W (T_c=25°C)	150	10	25	100	4	300			〃							132	
★ 〃 1158	日電	Osc	〃	35	4	20	150	150	1	15	80	10	5	10	−5					1100*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 6 pS	139	
★ 〃 1159	〃	〃	〃	35	4	20	150	150	1	15	80	10	5	10	−5					1100*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 6 pS	139	
〃 1160	〃	PA	〃	200	6	1 A	15W (T_c=25°C)	150	5	200	80	5	200	10	−200					20*	30	40*	134	
〃 1161	〃	〃	〃	200	6	1 A	15W (T_c=25°C)	150	5	200	80	5	200	10	−200					20*	30	40*	134	
〃 1162	日立	RF. PA	〃	35	5	1.5A	10W (T_c=25°C)	150	20	35	130	2	500	2	−200					180*	30	9.5*	160	
〃 1163	松下	PA	Si. P	300	3	100	20.8W (T_c=25°C)	150	100	300	70	10	50	10	−20					55*	8	30	133	
〃 1164	東芝	RF	Si. EP	40	3	300	600	150	0.3	20	25~90	10	50	20	−50					1400*	2.2	10	85B	
〃 1165	〃	PA	〃	40	4	500	700	175	1	15	>20	5	100	10	−50		P_o=1.0W, P_i=0.3W (f=470MHz, V_{CE}=12.6V)			600*	6.5	25*	84B	
〃 1166	〃	〃	Si. EP	70	5	200	600	150	0.1	20	100	1	50	10	−10					120*	6	10	131	1SA661之對稱
〃 1167	〃	〃	Si. TMe	1200	5	1.5A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	>10	10	500	15	−200					>2			102	
〃 1168	〃	〃	Si. TP	300	5	150	12.5W (T_c=25°C)	150	0.1	100	100	10	50	10	−30					100*	5	10	99	
〃 1169	〃	RF. Conv	Si. EP	40	4	1 A	800	175	1	15	>20	5	100	10	−50	P_o>2.5W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.25W)				600*	6.5	25	97B	
★ 〃 1170	〃	PA	Si. TMe	1200	5	3.5A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	12	10	3 A	10	−0.5A					4*	80	10	102	
〃 1170A	〃	〃	〃	1400	5	3.5A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	12	10	3 A	10	−0.5A					4*	80	10	102	
〃 1171	〃	〃	〃	1100	5	1 A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	30~160	15	150	15	−200					>0.5	70		102	
〃 1172	〃	〃	〃	1500	5	5 A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	20	10	2 A	10	−500					5*	80	10	102	
〃 1173	〃	RF. PA	Si. EP	30	5	3 A	10W (T_c=25°C)	150	1	20	40~400	2	500	2	−500					100*	35		119	
〃 1174	日立	PA	Si. TMe	1200	6	3.5A	50W (T_c=25°C)	150	I_{CBK} 1 mA	1200	8	10	3.5A	15	−200	t_f<1.2μS				4*	120	10	102	
〃 1175	三洋	RF	Si. TP	50	4	200	300	125	10	40	100	6	50	6	−10					170*	5		138	
〃 1176	三菱	PA	Si. EP	40	4.5	1 A	15W (T_c=25°C)	175	100	15	50	10	100				P_o=7.5W, η=70% (f=175MHz, P_i=1.5W, V_{cc}=13.5V)						113	
〃 1177	〃	〃	〃	40	4.5	2.5A	25W (T_c=25°C)	175	1mA	15	30	10	100				P_o=10W, η=80% (f=175MHz, P_i=3.5W, V_{cc}=13.5V)						113	
〃 1178																								
〃 1179																								
〃 1180																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} (μA)	最大值 V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC1181																								
〃 1182																								
〃 1183																								
〃 1184	日電	SW	Si.TMe	900	5	1 A	50W (Tc=25°C)	150	500	800	60	10	200			t_r<10μS, t_f<3.5μS, t_{stg}<1.5μS							102	
〃 1185	〃	〃	〃	300	5	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	90	10	400			t_r<2.5μS, t_f<2μS, t_{stg}<1.5μS							102	
〃 1186																								
〃 1187	日電	RF	Si.P	40	4	25	250	125	0.1	20	90	10	3	10	−3					600*	1	$C_c r_{bb'}$ 12pS	138C	正向AGC
〃 1188	〃	〃	Si.E	40	4	30	250	125	0.1	20	100	10	10	10	−10					850*	1.3	$C_c r_{bb'}$ 9pS	138C	
〃 1189	〃	〃	〃	50	4	30	250	125	0.1	20	100	10	10	10	−10					850*	1.3	$C_c r_{bb'}$ 9pS	138C	
〃 1190	松下	PA	Si.EP	36	4	2.5A	30W (Tc=25°C)	175	100	20	50	13.5	400			P_o=16W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=4W)				600*	17		142	
〃 1191	〃	〃	〃	36	4	3.5A	45W (Tc=25°C)	175	0.5mA	20	50	13.5	800			P_o=27W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=8W)					50		143	
〃 1192	〃	〃	〃	36	4	5 A	60W (Tc=25°C)	175	1mA	20	60	13.5	1 A			P_o=37W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=14W)				350*	100		143	
〃 1193	東芝	LN	〃	20	2	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	−10	NF=3.5dB (10V, 2mA, 2GHz) PG=11dB (10V, 10mA, 2GHz)				4500*	0.8	20*	140	
〃 1194																								
〃 1195	東芝	RF.PA	Si.TMe	200	5	2.5A	100W (Tc=25°C)	150	10	200	50	5	1 A	10	−100					10*	80	25	102	
〃 1196	〃	PA	Si.EP	60	4.5	750	10W (Tc=25°C)	175	5	15	50	10	1 A	10	−150	P_o>3W (f=700MHz, V_{CC}=28V, P_i=1W)				800*	5		135	再登録
〃 1197	〃	〃	〃	60	4.5	2 A	30W (Tc=25°C)	175	10	15	55	10	1 A	10	−150	P_o>9W (f=700MHz, V_{CC}=28V, P_i=3W)				700*	<25		135	再登録
〃 1198	〃	〃	〃	45	4	3.5A	30W (Tc=25°C)	175	50	15	>20	10	1 A	10	−150	P_o=20W (f=700MHz, V_{CC}=28V, P_i=9W)				800*	30		213	
〃 1199	〃	RF.LN	〃	50	3	300	600	150	0.1	20	80	10	20	10	−20	NF=2.5dB (10V, −10mA, 200MHz)				1400*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 5pS	85B	
〃 1200	〃	PA	〃	40	3.5	180	2.5W (Tc=25°C)	175	1	20	120	5	100	5	−100	P_o=1.05W (f=2GHz, P_i=0.4W, V_{CC}=18V)				1700*	2.3		136	
〃 1201																								
〃 1202																								
〃 1203																								
〃 1204	日立	RF.AF	Si.EP	30		100	310	125	0.5	18	250	12	2	12	−0.1	130	16.5k	0.7	11	230*	1.8	60*	207	
〃 1205	〃	RF Mix Conv.Osc	Si.P	30		100	310	125	0.5	18	120	12	2	12	−2					230*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 13pS	37	
〃 1206	三菱	RF.PA	Si.EP	45	4.5	1.7A	25W (Tc=25°C)	175	1mA	30	50	25	50			P_o=10W (f=770MHz, V_{cc}=25V, P_i=4W)							209	
〃 1207	〃	〃	〃	45	4.5	3 A	30W (Tc=25°C)	175	2mA	30	50	25	50			P_o=16W (f=770MHz, V_{cc}=25V, P_i=7W)							209	
〃 1208	〃	〃	〃	36	5	10 A	60W (Tc=25°C)	175	2mA	15	50	10	500			P_o=37W, η=70% (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=15W)							127	
〃 1209	〃	〃	〃	25	4	700	500	125	1	25	100	1	500	6	−10					150*	15	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	2SA695之對偶
〃 1210	〃	〃	〃	45	4	500	500	125	1	25	100	2	150	6	−10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	2SA696之對偶
2SC1211	三菱	RF.PA	Si.EP	65	4	500	500	125	1	25	100	2	150	6	−10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	2SA697之對偶
〃 1212	日立	RF	〃	50	4	1 A	750	150	5	50	180	4	50	4	−30					160*	30	4*	160	再登録
〃 1213	〃	〃	〃	35	4	500	400	125	0.5	20	180	3	10	6	−1					50*	5	9*	170	2SA673之對偶
〃 1214	〃	〃	〃	50	4	500	600	125	0.5	20	180	3	10	6	−1					50*	5	9*	170	
〃 1215	松下	〃	〃	30	3	50	200	125	100	30	100	10	2	10	−10					1200*	Cre 1pF	30	138	
〃 1216	日電	SW	Si.E	40	5	200	300	150	0.1	30	140	1	10	10	−10	t_{on}<20nS, t_{off}<40nS, t_{stg}<20nS				500*	3		49C	
〃 1217	〃	RF.SW	〃	150	5	300	750	175	0.1	100	70	10	50	10	−50					250*	3.7	13*	84B	
〃 1218	〃	〃	〃	80	5	500	750	175	0.1	50	80	10	50	10	−50					370*	3.5	20*	84B	
★ 〃 1219	富士通	RF	Si.EP	30	5	500	200	125	1	12	160	2	100	6	−1					60*	12	70*	138	
★ 〃 1220	〃																							
〃 1221																								
〃 1222	日電	RF.LN	Si.E	50	5	30	250	125	0.1	40	400	3	0.5	3	−1		14k	5.8	23	100*	3.5	50	138	2SA640之對偶
〃 1223	三菱	PA	Si.EP	30	4	500	800	175	50	15	70	15	30			Gpe=13.3dB(f=220MHz, I_C=30mA, V_{cc}=13.5V)							84B	再登録
★ 〃 1224	〃	SW.PA	〃	130	5	800	7W (Tc=25°C)	150	10	25	100	4	300			t_{on}<0.2μS, t_{off}<1.2μS, t_{stg}<1μS							132	
〃 1225																								
〃 1226	松下	PA	Si.EP	40	5	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	120	5	1 A	5	−500					150*	50	3.3*	161	2SA699之對偶
〃 1227	富士通	SW	Si.TMe	300	5	10A	100W (Tc=25°C)	175	20	150	50	5	5 A	5	−1A	t_{on}<1μS, t_{off}<1.5μS, t_{stg}<4μS				27*			102	
〃 1228	〃	〃	〃	500	5	10A	100W (Tc=25°C)	175	20	150	15	5	5 A	5	−1A	t_{on}<2.5μS, t_{off}<2.5μS, t_{stg}<4μS				15*			102	
〃 1229	〃	〃	〃	250	5	10A	100W (Tc=25°C)	175	100	150	50	5	5 A	5	−1A	t_{on}<1μS, t_{off}<1.5μS, t_{stg}<4μS				27*			102	
〃 1230	〃	〃	〃	450	5	10A	100W (Tc=25°C)	175	100	150	15	5	5 A	5	−1A	t_{on}<2.5μS, t_{off}<2.5μS, t_{stg}<4μS				15*			102	
〃 1231	〃	〃	Si.EP	20	4	200	300	175	0.4	15	60	1	10	10	−10	t_r<10nS, t_f<15nS, t_{stg}<12nS				800*	2		49C	
〃 1232	〃	PA	〃	45	3.5	1 A	12W (Tc=25°C)	175	500	20	50	5	500			P_o=6W (f=700MHz, V_{cc}=16V, P_i=2W)							133	
〃 1233	〃	〃	〃	45	3.5	2 A	20W (Tc=25°C)	175	1mA	20	50	5	1 A			P_o=11W (f=700MHz, V_{cc}=16V, P_i=4W)							133	
〃 1234																								
〃 1235																								
〃 1236	東芝	LN	Si.EP	20	2	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	−10	NF=5.0dB (10V, 5mA, 4GHz) PG=7.0dB (10V, 10mA, 4GHz)				6500*	0.8	20*	140	
〃 1237	〃	PA	Si.EMe	85	4	2 A	10W (Tc=25°C)	150	10	20	40	5	500	5	−100	P_o=3.6W (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.4W)				100*	30		119	
〃 1238	三菱	〃	Si.EP	35	4	150	5W (Tc=25°C)	175	50	25	50	15	40			PG=11dB(f=770MHz, I_C=40mA, V_{cc}=15V)							157	
〃 1239	〃	〃	〃	80	4.5	4 A	12.5W (Tc=25°C)	175	10	30	50	10	100			P_o=3.4W(f=27MHz, P_i=0.4W, V_{cc}=12V)							97B	
★ 〃 1240	〃	RF	〃	40	3	50	350	175	0.1	25	70	10	10	10	−10					600*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 5pS	138B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)														外形	備考
					V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	偏置情况 V_{CE}(V)	I_C(mA)	V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)		
	2SC1241	東芝	PA	Si. EP	40	4	1.5A	10W (T_c=25°C)	175	100	15	>10	5	500	10	−250	P_o>6W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=1W)				400*	18	7*	135	
	〃 1242	〃	〃	〃	40	4	3A	20W (T_c=25°C)	175	250	15	>10	5	800	10	−500	P_o=14W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=2.5W)				350*	40	5*	135	
	〃 1243	三菱	SW, PA	〃	25	5	1.5A	7W (T_c=25°C)	150	1	16	100	4	500				t_{on}<0.2μS, t_{off}<1.2μS, t_{stg}<1μS						132	2SA703之対偶
	〃 1244																								
	〃 1245																								
★	〃 1246	富士通	RF	Si. EP	30	5	500	400	175	1	12	160	2	100	6	−1					60*	12	70*	138	
★	〃 1247	〃	〃	〃	50	5	500	400	175	1	12	160	2	100	6	−1					60*	12	70*	138	
	〃 1248	日電	LN	Si. E	20	3	30	300	150	0.1	10	100	10	7	10	−7	NF=2dB (f=60MHz, 10V, 7mA)				2500*	1.2		145	
	〃 1249	〃	RF	〃	45	3	300	2.8W 50×50×1 放熱板使用	150	1	25	80	15	65	15	−65	KF_2>53dB, KF_3>85dB (15V, 65mA, 60kHz, P_o=0dB)				1700*	3		146	
	〃 1250	〃	〃	〃	45	3	300	2.8W 50×50×1 放熱板使用	150	1	25	80	15	65	15	−65	KF_2>70dB, KF_3>100dB (15V, 65mA, 60kHz, P_o=0dB)				1900*	3		146	
	〃 1251	〃	〃	〃	45	3	300	7W (T_c=25°C)	200	0.1	30	80	10	50	15	−50	G_p=15dB (f=500MHz)				2200*	NF=3.5dB (f=200MHz)		202	
	〃 1252	〃	〃	〃	45	3	300	800	200	0.5	20	80	15	50	15	−70	G_p=17dB (f=200MHz)				1700*	NF=3dB (f=200MHz)		84B	
	〃 1253	〃	〃	〃	45	3	300	800	200	0.5	20	80	15	50	15	−50	G_p=18dB (f=200MHz)				2000*	NF=3dB (f=200MHz)		84B	
	〃 1254	〃	〃	〃	45	4	30	250	200	0.1	30	100	6	6	6	−6	G_p=22dB (f=200MHz)				1000*	NF=3dB (f=200MHz)		50C	
	〃 1255	〃	〃	〃	30	3	100	3.5W (T_c=25°C)	200	0.1	20	100	10	50	15	−50	G_p=10dB (f=2GHz)							202	
★	〃 1256	〃	PA	〃	36	4	800	5.5W (T_c=25°C)	200	10	20	50	10	300			P_o=3W (f=175MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.3W)							84B	
★	〃 1257	〃	〃	〃	36	4	1.5A	14W (T_c=25°C)	200	20	20	50	10	800			P_o=6W (f=175MHz, V_{CC}=12V, P_i=1W)							184	
★	〃 1258	〃	〃	〃	36	4	3A	28W (T_c=25°C)	200	50	20	50	10	1.5A			P_o=14W (f=175MHz, V_{CC}=12V, P_i=3W)							184	
★	〃 1259	〃	〃	〃	36	4	6A	58.3W (T_c=25°C)	200	1mA	20	50	10	3A			P_o=30W (f=175MHz, V_{CC}=12V, P_i=10W)							203	
	〃 1260	〃	RF	〃	45	4	30	250	200	0.1	30	100	6	6	6	−6	G_p=14dB (f=500MHz)				2000*	NF=3dB (f=500MHz)		50C	
	〃 1261	富士通	LN	Si. EP	20	3	20	300	150	0.1	10	100	10	7	10	−7	NF=2dB (f=60MHz, 10V, 7mA)				2500*	1.2		147	
	〃 1262	〃	RF	〃	45	3	300	1.8W 50×50×1 放熱板使用	150	1	25	80	15	65	15	−65	KF_2>70dB, KF_3>100dB (15V, 65mA, 60kHz, P_o=0dB)				1700*	3		148	
	〃 1263	〃	〃	〃	45	3	300	1.8W 50×50×1 放熱板使用	150	1	25	80	15	65	15	−65	KF_2>70dB, KF_3>100dB (15V, 65mA, 60kHz, P_o=0dB)				1900*	3		148	
	〃 1264	〃	〃	〃	30	3	100	400	150	0.5	25	100	10	40	10	−40					2000*	2.3	25*	147	
	〃 1265	日電	Diff	Si. E	20	3	50	300	175	0.5	10	100	5	1	5	−15	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0, ΔV_{BE}<5mV (V_{CE}=5V, I_C=1mA)				3000*	1.5	30*	189	再登録
	〃 1266	〃	SW	〃	100	5.5	1.5A	2W	175	25	80	60	1	400	1	−100	t_{on}<63nS, t_{off}<210nS, t_{stg}<19nS				150*	30		83	
	〃 1267	〃	RF	〃	45	3	300	7W (T_c=25°C)	200	0.1	30	80	15	50	15	−50	G_p=15dB (f=200MHz)							202	
	〃 1268	〃	〃	〃	20	3	30	200	200	0.01	8	100	8	10	8	−10	G_{pe}=7dB (f=4GHz)				6500*	NF=5.5dB (f=4GHz)		190	
	〃 1269	〃	〃	〃	20	3	30	200	200	0.01	8	100	8	10	8	−10	G_{pe}=6.5dB (f=4GHz)				6500*	NF=6dB (f=4GHz)		190	
	〃 1270	〃	〃	〃	20	3	30	200	200	0.01	8	100	8	10	8	−10	G_{pe}=7dB (f=4GHz)				6500*	NF=6.5dB (f=4GHz)		190	
	2SC1271	日電	RF	Si. E	20	3	30	200	200	0.01	8	100	8	10	8	−10	G_{pe}=6.5dB (f=4GHz)					NF=8dB (f=4GHz)		190	
	〃 1272	〃	〃	〃	20	3	30	200	200	50nA	15	80	10	40	10	−60	G_{pe}=4dB (f=4GHz)							190	
	〃 1273	〃	〃	〃	20	3	100	1W (T_c=25°C)	175	50nA	15	80	10	40	10	−60	G_{pe}=4dB (f=4GHz)							190	
	〃 1274	〃	SW	〃	40	5	300	300	175	0.25	20	70	1	30	8	−10	t_{on}<50nS, t_{off}<80nS, t_{stg}<65nS				350*	2.5		49C	
	〃 1275	〃	RF	〃	30	3	50	250	200	50nA	15	80	10	10	10	−10	G_p<15dB (f=500MHz) NF=3dB (f=500MHz, 3mA)				2000*	1.1		50C	
	〃 1276	〃	RF, SW	〃	40	5	100	200	125	0.1	30	120	1	10	10	−10	t_{on}<20nS, t_{off}<40nS, t_{stg}<20nS				600*	3	60*	138	
	〃 1277	〃	RF	〃	60	5	500	250	125	0.5	30	140	2	100	10	−20					60*	20	30*	138	
	〃 1278	〃	RF, SW	〃	150	5	50	250	125	0.1	100	130	3	15	10	−10					150*	4.5	15	138	
	〃 1279	〃	〃	〃	180	5	50	250	125	0.1	100	130	3	15	10	−10					150*	4.5	15	138	
	〃 1280	〃	RF	ダーリントン Si. E	15	10	300	250	125	0.1	10	20,000	5	100	10	−10					180*	5	220*	138	
	〃 1281	沖	〃	Si. P	20	5	20	300	175	0.1	15	200	1	10μA	5	−1					120*	2	60*	49C	
	〃 1282	〃	〃	〃	70	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	−1					120*	2	60*	49C	
	〃 1283	〃	〃	〃	110	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	−1					120*	2	60*	49C	
	〃 1284																								
	〃 1285	三洋	RF, AF	Si. EP	40	5	100	200	125	1	35	200	6	1	6	−1	180	2000	0.8	12	140*	3	$C_c r_{bb'}$ 200pS	138	
	〃 1286																								
	〃 1287																								
	〃 1288	沖	RF, SW	Si. EP	7	3	60	200	175	0.5	6	50	1	20	4	−20	t_d<400pS, t_f<650pS, t_r<650pS				4500*	1	50*	144	
	〃 1289																								
	〃 1290	沖	PA	Si. EP	40	3	200	750	175	0.5	20	70	10	100	10	−50					1500*	2	35*	84B	
	〃 1291																								
★	〃 1292	三菱	PA, SW	Si. EMe	300	5	2.5A	80W (T_c=25°C)	150	200	300	25	10	500	t_r<1.5μS, t_f<3μS, t_{stg}<2μS									102	
	〃 1293																								
	〃 1294																								
	〃 1295																								
	〃 1296																								
	〃 1297	日電	PA	Si. EP	50	4	3.5A	50W (T_c=25°C)	175	1mA	30	50	10	2A	10	−700	P_o=20W (f=175MHz, V_{CC}=18V, P_i=10W)				190*	75		149	
	〃 1298	〃	〃	〃	50	4	5A	80W (T_c=25°C)	175	2mA	30	50	10	3A	10	−1A	P_o=37W (f=175MHz, V_{CC}=18V, P_i=10W)				130*	110		149	
	〃 1299	富士通	SW	Si. TMe	300	5	30A	200W (T_c=25°C)	175	50	150	40	5	10A	5	−2A	t_{on}<2.5μS, t_f<2.5μS, t_{stg}<4μS				25*			191	
	〃 1300	〃	〃	〃	500	5	30A	200W (T_c=25°C)	175	50	150	25	5	15A	5	−2A	t_{on}<4μS, t_f<2.5μS, t_{stg}<4μS				20*			191	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電氣的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC1301	富士通	SW	Si.TMe	250	5	30 A	200W (T_c=25°C)	175	200	150	40	5	10A	5	−2A	t_{on}<2.5μS, t_f<2.5μS, t_{stg}<4μS				25*			191	
〃 1302	〃	〃	〃	400	5	30 A	200W (T_c=25°C)	175	200	150	25	5	15A	5	−2A	t_{on}<4μS, t_f<2.5μS, t_{stg}<4μS				20*			191	
〃 1303	松下	PA	Si.EP	40	4	300	600	175	1	20	70	13.5	100	10	−30	P_o=0.6W (f=175MHz, V_{cc}=15V, P_i=0.05W)				700*	6.5	15	84	
〃 1304	日立	〃	Si.T	300	5	500	20W (T_c=25°C)	150	I_{CBX} 100	300	60	10	100	10	−50					7*	16	20*	153	
〃 1305																								
〃 1306	日電	PA	Si.E	65	4	3 A	12W (T_c=25°C)	150	10	40	80	10	500	10	−150	P_o=5.5W (f=50MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.5W)				300*	20		151	
〃 1307	〃	〃	〃	70	4	8 A	25W (T_c=25°C)	150	20	40	60	10	2 A	10	−500	P_o=15W (f=50MHz, V_{cc}=12V, P_i=3W)				150*	80		151	
〃 1308																								
〃 1309	三菱	SW	Si.EMe	1200	6	5 A	80W (T_c=25°C)	150	1mA	1200	20	10	5 A			t_r<1.5μS, t_f<3μS, t_{stg}<2μS							102	
〃 1310	〃	RF.AF.LN SW	Si.EP	30	4	100	100	125	0.1	25	250	6	1	6	−1		8500	0.6	40	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 200pS	175	
〃 1311	〃	RF.AF.SW	〃	30	4	100	100	125	0.1	25	250	6	1	6	−1		8500	0.6	40	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 200pS	175	
〃 1312	〃	RF.AF.LN	〃	35	4	100	200	125	0.1	35	500	6	1	6	−1		19k	1.3	22	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 230pS	138B	
〃 1313	〃	〃	〃	50	4	100	200	125	0.1	50	350	6	1	6	−1		19k	1.3	22	180*	2	$C_c r_{bb'}$ 230pS	138B	
〃 1314	〃	PA	〃	40	4.5	5 A	45W (T_c=25°C)	175	2mA	15	30	10	200			P_o=34W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=9W)							127	
〃 1315	〃	〃	〃	35	4.5	500	4W (T_c=25°C)	175	50	15	50	10	100			P_o=0.5W (f=150MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.2W)							84B	
〃 1316	SON	PA.SW	Si.TMe	750	10	2 A	23W (T_c=25°C)	120	50	50	8	3	2 A	10	−200					8.5*	120	$C_c r_{bb'}$ 410pS	100	
〃 1317	松下	PA	Si.EP	30	5	500	400	125	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5*	138	2SA719之對稱
〃 1318	〃	〃	〃	60	5	500	400	125	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5*	138	2SA720之對稱
★ 〃 1319	日電	RF	Si.P	40	4	25	250	125	0.1	20	90	10	3	10	−3					600*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 12pS	138	正向AGC
★ 〃 1320	〃	〃	Si.E	50	4	30	250	125	0.1	20	100	10	10	10	−10					850*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 9pS	138	
〃 1321	〃	RF.Conv. Mix.Osc	〃	30	4	10	100	125	0.1	25	90	6	2	6	−2					1000*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 3pS	176	
〃 1322	富士通	SW	Si.TMe	250	5	4 A	100W (T_c=25°C)	175	100	150	50	5	5 A	5	−1A	t_{on}<1μS, t_f<1.5μS, t_{stg}<4μS				27*			102	
〃 1323	三菱	PA	Si.EP	30	4	500	5W (T_c=25°C)	175	50	15	70	15	30			PG=14.2dB (f=220MHz, I_C=30mA, V_{cc}=13.5V)							125	
〃 1324	〃	〃	〃	35	4	150	800	175	50	25	70	10	30			P_o=10W (f=770MHz, I_C=30mA, V_{cc}=15V)							85B	
★ 〃 1325	日電	SW	Si.TMe	1500	6	6 A	80W (T_c=25°C)	150	20	1000	19	15	1 A			t_r<2.5μS, t_f<1μS, t_{stg}<1.5μS							102	
〃 1326	松下																							
〃 1327	〃	RF, LN	Si.EP	35	5	50	150	125	0.1	10	540	5	2	5	−2		5500	0.4	25	250*	2.2	70	138	
〃 1328	〃	〃	〃	55	5	50	150	125	0.1	10	540	5	2	5	−2		5500	0.4	25	250*	2.2	70	138	
〃 1329	日電	RF	〃	50	5	8 A	60W (T_c=25°C)	200	2mA	30	100	10	5 A				P_o=32W (f=70MHz, V_{cc}=12V, P_i=8W)						203	
〃 1330	〃	RF.AF	Si.E	50	5	100	400	125	0.1	40	150	6	1	6	−1		4800	4.5	17	250*	4.5	25*	44	
2SC1331	日電	RF.Conv. Mix.Osc	Si.P	20	3	20	150	150	50nA	10	100	5	4	10	−4					750*	C_{re} 0.37	$C_c r_{bb'}$ 10pS	50C	
〃 1332																								
〃 1333	日電	PA	Si.EP	45	3	1 A	8.3W (T_c=25°C)	175	100	30	60	10	300	10	−200	G_{pe}=5dB (f=1GHz, V_{cc}=18V, P_i=1W)				1200*	7		115	
〃 1334	〃	〃	Si.E	45	3	1 A	11.5W (T_c=25°C)	200	100	30	60	10	300			G_{pe}=4dB (f=1GHz, V_{cc}=24V, P_i=2W)							184	
〃 1335	日立	LN	Si.EPs	30	5	100	200	125	0.5	18	500	12	2	NF=3dB (f=120Hz, I_C=0.1mA)			110k	95	12	230*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 12pS	37	
〃 1336	日電	RF	〃	20	3	25	250	200	0.5	10	100	10	10	10	−10	G_{pe}=11dB (f=2GHz)				4500*	NF=3dB (f=2GHz)		190	
〃 1337	三菱	PA	Si.EP	35	4.5	2 A	20W (T_c=25°C)	175	200	15	50	10	100			P_o=8.5W (f=485MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=2W)							183	
〃 1338	〃	〃	〃	35	4.5	3 A	30W (T_c=25°C)	175	500	15	50	10	100			P_o=16W (f=485MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=6W)							183	
〃 1339	〃	〃	〃	35		5 A	40W (T_c=25°C)	175	1mA	15	50	10	100			P_o=28W (f=485MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=12W)							183	
〃 1340	〃	〃	〃	35	4	1 A	5W (T_c=25°C)	175	100	25	70	10	100			G_{pe}=19dB (f=220MHz, V_{cc}=18V, I_C=100mA)							157	
〃 1341																								
〃 1342	日立	RF.Conv. Mix.Osc	Si.P	30	4	30	100	125	0.5	10	100	6	1	6	−1					250*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 20pS	37	
〃 1343	〃	RF.PA	Si.T	150	5	10A	100W (T_c=25°C)	150	1mA	30	100	5	1 A	5	−1A					14*	240	7*	102	2SA753之對稱
〃 1344	〃	RF.LN	Si.EPs	30	5	100	200	125	0.5	18	500	12	2	NF=0.5dB (f=1kHz, I_C=0.1mA)			110k	9.5	12	230*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 12pS	37	
〃 1345	〃	〃	〃	55	5	100	200	125	0.5	18	500	12	2	NF=0.5dB (f=1kHz, I_C=0.1mA)			110k	9.5	12	230*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 12pS	37	
〃 1346	松下	PA	Si.EP	30	5	500	600	125	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5*	171	
〃 1347	〃	〃	〃	60	5	500	600	125	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5*	171	
〃 1348	SON	SW	Si.TMe	1000		4 A	125W (T_c=25°C)	120	2mA	800	8	3	2 A	10	−2A					5*	175	$C_c r_{bb'}$ 200pS	102	
〃 1349																								
〃 1350																								
〃 1351																								
〃 1352																								
〃 1353																								
〃 1354	松下	PA	Si.EP	55	4	5 A	60W (T_c=25°C)	175	1mA	20	50	13.5	1 A			P_o=37W (f=175MHz, V_{CE}=24V, P_i=8W)							143	
〃 1355	富士通	〃	〃	40	3.5	700	7W (T_c=25°C)	175	100	20	80	5	200	12	−200	P_o=2W (f=700MHz, V_{cc}=18V, P_i=0.5W)				1800*	5		192	
〃 1356	〃	〃	〃	40	3.5	1 A	12W (T_c=25°C)	175	200	20	80	5	500	12	−300	P_o=6W (f=700MHz, V_{cc}=18V, P_i=2W)				1800*	8		192	
〃 1357																								
〃 1358	日電	SW	Si.TMe	1400	6	4.5A	50W (T_c=25°C)	150	20	1000	19	15	500			t_r<2.5μS, t_f<1μS, t_{stg}<1.5μS							102	
〃 1359	松下	RF	Si.EP	30	5	30	250	125	0.1	10	100	10	1	10	−1					300*	Cre 0.9pF	22	138	
〃 1360	〃	〃	〃	50	4	50	650	135	0.1	20	50	10	10	10	−10					500*	1.5	20	165	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB} (V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE} (V)	I_C (mA)	偏置情況 V_{CB} (V)	I_E (mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} / h_{ob}* (μΩ)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{rb}* (Ω)	外形	備考
2SC1361	SON	LN		25	6	200	320	120	0.2	25		3	1			h_{fe}=3dB (f=100MHz)					4.5	$C_c r_{bb}$ 300pS		
〃 1362	〃	〃	Si.PaMe	50	6	200	320	120	0.2	25		3	1			h_{fe}=3dB (f=100MHz)					4.5	$C_c r_{bb}$ 300pS	138	
〃 1363	〃	RF	Si.E	25	6	200	250	120	0.2	25	200	3	1	6	−2	h_{fe}=3dB (f=100MHz)					4.5	$C_c r_{bb}$ 300pS	138	
〃 1364	〃	〃	Si.PaMe	50	6	200	320	120	0.2	25	200	3	1	6	−2	〃					4.5	$C_c r_{bb}$ 300pS	138	
〃 1365	日電	〃	Si.E	45	3	300	800	200	0.5	20	80	15	50	15	−70	G_p=17dB (f=200MHz)				1700*	NF=3dB (f=200MHz)		84B	
〃 1366	〃	〃	〃	45	3	300	800	200	0.5	20	80	10	50	15	−50	G_p=18dB (f=200MHz)				2000*	NF=3dB (f=200MHz)		84B	
〃 1367	日立	PA	Si.TMe	1000	5	1A	50W (T_c=25°C)	125	10	500	45	10	200	15	−200					6*	60	25	102	
〃 1368	〃	RF.PA	Si.EP	25	5	1.5A	8W (T_c=25°C)	150	20	25	130	2	500	2	−200					180*	30	9.5*	160	2SA738 之related
〃 1369																								
〃 1370																								
〃 1371																								
〃 1372	富士通	RF.SW	Si.EP	30	5	200	200	125	0.5	10	100	1	10	6	−2					250*	4	80*	138	
〃 1373	日立	SW	〃	25	4	100	300	175	1	20	90	4	35			t_{on}<100nS, t_{off}<325nS, t_{stg}<290nS							49C	
〃 1374	〃	〃	〃	25	4	100	300	175	0.25	20	70	1	70			t_r<14nS, t_f<12nS, t_{stg}<20nS							49C	
〃 1375	〃	〃	〃	25	4	100	300	175	0.2	5	80	0.4	50			t_{on}<45nS, t_{off}<60nS, t_{stg}<50nS							49C	
〃 1376	〃	〃	〃	40	4	150	300	175	1	20	70	1	150			t_{on}<25nS, t_{off}<60nS, t_{stg}<30nS							49C	
〃 1377	東芝	PA	〃	90	4	6A	20W (T_c=25°C)	150	10	60	>20	5	1A	5	−200	P_o>8W (f=27MHz, V_{CC}=13V, P_i=1W)				100*	60		119	
〃 1378	〃	〃	〃	40	4	4A	35W (T_c=25°C)	175	100	15	>10	5	10A	10	−200	P_o=25W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=6W)				150*	65	2*	135	
〃 1379	〃	〃	〃	40	4	7A	70W (T_c=25°C)	175	100	15	>10	5	1A	10	−200	P_o=40W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=12W)				150*	130	1*	193	
〃 1380	〃	RF	〃	55	5	100	200	150	0.1	18	200~700	6	2	6	−1		15k	1.3	13	80*	6	100	49C	
〃 1381	〃	RF.PA	〃	100	5	1A	800	150	1	30	70~240	2	150	2	−150					50*	20	10	164	
〃 1382	〃	〃	〃	80	5	750	800	150	0.5	30	120	2	150	2	−150					100*	15		164	
〃 1383	松下	PA	〃	30	5	1A	750	135	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	165	
〃 1384	〃	〃	〃	60	5	1A	750	135	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	165	
〃 1385	日立	SW	〃	60	5	500	800	175	0.5	30	80	1.1	300			t_{on}<40nS, t_{off}<60nS, t_{stg}<50nS							84B	
〃 1386	〃	〃	〃	70	5	700	800	175	100	60	80	1	60			t_{on}<35nS, t_{off}<55nS, t_{stg}<50nS							84B	
〃 1387																								
〃 1388																								
〃 1389																								
〃 1390																								
2SC1391	日立	PA	Si.T	300	4	100	6.5W (T_c=25°C)	150	100	300	60	10	50	50	−20					25*	5	20*	153	
〃 1392																								
〃 1393	日電	RF.LN	Si.E	30	5	20	250	125	0.1	20	100	10	2	10	−3		NF=2dB (f=200MHz)			700*	0.35	$C_c r_{bb}$ 10pS	138C	
〃 1394	〃	RF.Conv. Mix.Osc	〃	30	5	20	250	125	0.1	20	100	10	2	10	−3					700*	0.35	$C_c r_{bb}$ 10pS	138C	
〃 1395	〃	〃	Si.EP	30	5	20	250	125	0.1	12	100	10	5	10	−5					1100*	1.2	$C_c r_{bb}$ 12pS	138	
〃 1396	〃	〃	〃	30	5	20	250	125	0.1	12	100	10	5	10	−5					1100*	1.2	$C_c r_{bb}$ 12pS	138	
〃 1397																								
〃 1398	松下	RF.PA	Si.EP	70	5	2A	15W (T_c=25°C)	150	1	40	130	5	1A	5	−500					150*	50	3*	172	
〃 1399																								
〃 1400	日電	LN	Si.EPa	85	5	50	300	125	0.1	60	500	6	1	6	−1	NF=0.5dB (f=1kHz)	15K	6	35	100*	2.5	50*	138	
〃 1401	富士通	SW	Si.TMe	400	5	30A	200W (T_c=25°C)	175	200	150	25	5	15A	5	−2A	t_{on}<4μS, t_f<2.5μS, t_{stg}<4μS				20*			191	
〃 1402	SAK	PA	Si.TMe	140	6	8A	70W (T_c=25°C)	150	1mA	140	60	4	3A	12	−500					10*	130	7*	102	
〃 1403	〃	〃	〃	160	6	8A	70W (T_c=25°C)	150	1mA	160	60	4	3A	12	−500					10*	130	7*	102	
〃 1404	松下	〃	Si.EP	36	4	3.5A	50W (T_c=25°C)	200	25mA	36	30	5	1A	5	−1A	P_o=18W (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=6.8W)				1000*	55		229	
〃 1405	〃	〃	〃	36	4	750	10W (T_c=25°C)	175	50	20	40	10	100	10	−100	P_o=3.5W, G_{pe}=10dB (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.35W)				350*	13		228	
〃 1406	〃	〃	〃	30	5	1A	1W	135	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	173	
〃 1407	〃	〃	〃	60	5	1A	1W	135	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	173	
〃 1408																								
〃 1409	日立	PA	Si.TMe	200	6	2A	12.5W (T_c=25°C)	150	1	30	100	10	50	10	−50					20*	95	20	158	
〃 1410	〃	〃	〃	200	6	2A	12.5W (T_c=25°C)	150	1	30	100	10	50	10	−50					20*	95	20	159	
〃 1411	富士通	SW	Si.EP (配対向)	6	6	50	200	150	0.1	5	100					t_r<300nS, t_f<500nS, t_{stg}<600nS					6		49C	
〃 1412																								
〃 1413	日立	PA	Si.T	1200	6	5A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	10	10	3.5A	15	−200					4*	175	10	102	
〃 1414	富士通	〃	Si.EP	40	3.5	2A	20W (T_c=25°C)	175	400	20	80	5	1A	12	−500	P_o=10W (f=100MHz, V_{CC}=18V, P_i=4W)				1500*	13		192	
〃 1415	〃	〃	〃	40	3.5	3A	25W (T_c=25°C)	175	600	20	80	5	2A	12	−500	P_o=18W (f=100MHz, V_{CC}=18V, P_i=7.5W)				1200*	18		192	
〃 1416	東芝	RF	〃	55	5	50	200	150	0.1	30	350	6	2	6	−1	NF=2dB (f=100Hz, V_{CE}=6V, I_E=−0.1mA)				100*	3	45	195	
〃 1417	日立	RF.Conv. Mix.Osc	Si.P	20		30	100	125	1	10	100	6	1	6	−1					300*	1.4	$C_c r_{bb}$ 24pS	37	
〃 1418																								
〃 1419																								
〃 1420	富士通	RF	Si.EP	15	3	70	300	150	0.5	10	80	6	40	6	−40					6000*	1	25*	199	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{re}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC1421	富士通	RF	Si.EP	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	10	6	-10	NF = 6 dB (f = 2GHz, Ic = 4mA)				5500*	0.7	25*	199	
〃 1422	〃	〃	〃	15	3	40	250	150	0.5	10	80	6	20	6	-20	〃				5500*	0.8	25*	199	
〃 1423	〃	〃	〃	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	15	6	-15	NF = 3.5dB (f = 2GHz, Ic = 4mA)				7000*	0.7	25*	199	
〃 1424	日電	〃	Si.E	30	3	50	250	200	50nA	15	80	10	10	10	-10	Gp = 15dB (f = 500MHz)				2000*	1.1		50C	
〃 1425	〃	PA	〃	45	3	1 A	11.6W (Tc=25°C)	200	100	30	60	10	300			Gpe = 5 dB (f = 1GHz, Vcc = 18V, Pi = 1W)							184	
〃 1426	〃	RF	〃	35	3	200	3.5W (Tc=25°C)	200	0.1	20	100	10	50	10	-50	Gp = 20dB (f = 200MHz)				2500*	1		85B	
〃 1427	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	30	4	10	100	125	0.1	25	120	6	2	6	-2					1000*	0.7	Cc rbb' 3 pS	176	
〃 1428	〃	〃	〃	50	5	50	150	125	0.1	15	110	3	0.5	6	-1					250*	1.5	Cc rbb' 25pS	176	
〃 1429	SON	PA	Si.E PaMe	12	6	2 A	950	120	0.1	16	200	2	100	2	-10					80*	26	Cc rbb' 300pS	174	
〃 1430	〃	RF.PA	Si.EMe	110		1.5A	500	150	100	50	100	2	400	2	-200					50*	50	Cc rbb' 25pS	181	
〃 1431	〃	〃	〃	110		1.5A	1.5W	150	0.1	50	100	2	400	2	-200					50*	25	Cc rbb' 25pS	99	
〃 1432	新日無	SW	Si.EP	30	10	300	150	125	0.1	20	40,000	6	100			ton < 600nS, toff < 1.2μS tstg < 600nS							194	
〃 1433	東芝	PA.SW	Si.TMe	600	5	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	500	20~300	5	1 A			ton < 2μS, tf < 1.5μS tstg < 10μS					100		102	
〃 1434	〃	〃	〃	600	5	15A	150W (Tc=25°C)	150	500	500	30~300	5	3 A			ton < 2μS, tf < 2.5μS tstg < 15μS					200		102	
〃 1435	〃	〃	〃	600	5	40A	300W (Tc=25°C)	150	1mA	500	30~300	5	10A			ton < 11μS, tf < 1.5μS tstg < 10μS					600		196	
〃 1436	SAK	SW	Si.T	230	6	15A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	230	20	4	5 A	12	-500	tr < 1.5μS, tf < 1μS tstg < 4μS, td < 0.5μS				10*			102	
〃 1437	〃	〃	〃	230	6	50A	200W (Tc=25°C)	150	1mA	230	20	4	10A	12	-500	tr < 1.5μS, tf < 1μS tstg < 4μS				10*			230	
〃 1438																								
〃 1439																								
〃 1440	SAK	SW	Si.T	150	6	15A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	150	20	4	5 A	12	-500	tr < 1.5μS, tf < 1μS tstg < 4μS, td < 0.5μS				10*			102	
〃 1441	〃	〃	〃	200	6	15A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	200	20	4	5 A	12	-500	tr < 1.5μS, tf < 1μS tstg < 4μS, td < 0.5μS				10*			102	
〃 1442	〃	〃	〃	150	6	50A	200W (Tc=25°C)	150	1mA	150	20	4	10A	12	-500	tr < 1.5μS, tf < 1μS tstg < 4μS				10*			230	
〃 1443	〃	〃	〃	200	6	50A	200W (Tc=25°C)	150	1mA	200	20	4	10A	12	-500	tr < 1.5μS, tf < 1μS tstg < 4μS				10*			230	
〃 1444	〃	PA	〃	80	6	6 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	80	80	4	1 A	10	-500					10*	85	12*	99	
〃 1445	〃	〃	〃	100	6	6 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	100	80	4	1 A	10	-500					10*	85	12*	99	
〃 1446	松下	〃	Si.TP	300	5	100	10W (Tc=25°C)	150	100	300	70	10	50	30	-20					55*	8	10	78	
〃 1447	東芝	RF.PA	〃	300	5	100	30W (Tc=25°C)	150	1	240	100	10	50	50	-20					50*	7	30	119	
〃 1448	〃	〃	Si.TMe	150	5	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	20	100	75	10	500	10	-500					5*	50	25	119	
〃 1449	日電	PA	Si.E	40	5	2 A	5W (Tc=25°C)	150	0.5	35	90	2	300	5	-100					65*	20	40*	225	
〃 1450	松下	〃	Si.Me	150	5	400	20W (Tc=25°C)	150	30	60	70	5	100	10	100					15*	50	25	99	
2SC1451	富士通	RF	Si.EP	150	5	50	700	175	1	140	150	5	10	5	-10	ton < 1μS, toff < 10μS tstg < 9.5μS				130*	2	70*	248	
〃 1452	〃	〃	〃	150	5	50	700	175	1	140	150	5	10	5	-10	ton < 1μS, toff < 10μS tstg < 9.5μS				130*	2	70*	248	
〃 1453	東芝	〃	〃	55	5	100	200	150	0.1	30	120	1	10	10	-1					150*	5	20	195	
〃 1454	SAK	PA	Si.T	300	7	4 A	50W (Tc=25°C)	150						12	-100					10*			102	
〃 1455																								
〃 1456	日電	PA	Si.TP	300	7	200	15W (Tc=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10					80*	3.8	30	99	
〃 1457	〃	RF	Si.E	35	3	150	600	200	0.1	20	100	10	50	10	-50	NF = 2.5dB (f = 200MHz, VCE = 10V, IC = 20mA)				2700*	1	45*	85B	
〃 1458	〃	〃	〃	20	3	50	300	200	0.1	10	100	5	30	5	-15	|S21e|² = 9 dB (f = 1GHz)				3000*	0.9	30*	197	
〃 1459	富士通	〃	Si.EP	15	3	70	300	150	0.5	10	80	6	40	6	-40					5000*	1	25*	199	
〃 1460	〃	〃	〃	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	10	6	-10	NF = 6 dB (f = 2GHz, VCE = 6V, IC = 4mA)				4500*	0.7	25*	199	
〃 1461	〃	〃	〃	15	3	40	250	150	0.5	10	80	6	20	6	-20	〃				4500*	0.8	25*	199	
〃 1462	〃	〃	〃	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	15	6	-15	NF = 3.5dB (f = 2GHz, VCE = 6V, IC = 4mA)				6500*	0.7	25*	199	
〃 1463	〃	SW	Si.T	450	5	4 A	75W (Tc=25°C)	175	10	150	18	5	1 A	6	-300	tr < 5μs tf < 3μs tstg < 5μs				25*	125	5*	102	
〃 1464	〃	PA	Si.EP	50	3.5	500	4W (Tc=25°C)	175	250	20	80	5	200	12	-100	Po = 1.2W (f = 175MHz, Vcc = 12V Pi = 50mW)				1300*	3.5		84C	
〃 1465	〃	〃	〃	50	3.5	500	7W (Tc=25°C)	175	250	20	80	5	200	12	-100	Po = 1.8W, η = 55% (f = 0.7GHz, Vcc = 24V, Pi = 0.2W)				1600*	4.5		231	
〃 1466	新電元	SW	Si.DB	450	4	3 A	30W (Tc=25°C)	150	5mA	450	16	5	1.5A	10	1 A	ton < 2μS, tf < 2μS tstg < 4μS				10*	60		204	
〃 1467	〃	〃	〃	500	4	3 A	30W (Tc=25°C)	150	5mA	500	12	5	1.5A	10	1 A	〃				10*	60		204	
〃 1468	〃	〃	〃	450	4	10 A	100W (Tc=25°C)	150	10mA	450	16	5	5 A	10	1 A	〃				10*	300		118	
〃 1469	〃	〃	〃	500	4	10 A	100W (Tc=25°C)	150	10mA	500	12	5	5 A	10	2 A	〃				10*	300		118	
〃 1470	〃	〃	〃	450	4	30 A	200W (Tc=25°C)	150	10mA	450	16	5	10 A	10	2 A	〃				10*	700		191	
〃 1471	〃	〃	〃	500	4	30 A	200W (Tc=25°C)	150	10mA	500	12	5	10 A	10	2 A	〃				10*	700		191	
〃 1472	日立	RF	Si.EP	40		300	500	125	0.1	30	10,000	5	10	5	-10					150*	3.5	220	170	
〃 1473																								
〃 1474	SON	RF.PA	Si.PaMe	16	6	2 A	750	120	0.2	16	300	2	100	2	-10					60*	30	Cc rbb' 600pS	259	
〃 1475	〃	〃	〃	100	6	1 A	750	120	0.2	25	300	2	100	2	-10					80*	16	Cc rbb' 300pS	259	
〃 1476	東芝	PA	Si.EP	38		5 A	40W (Tc=25°C)	175	1mA	15	50	5	1 A			Po = 28W (f = 470MHz, Vcc = 12.5V, Pi = 12W)							135	
〃 1477	SAK	SW	Si.T	230	6	9 A	80W (Tc=25°C)	150	1mA	230	20	4	5 A	〃		tr < 1.5μS, tf < 1μS tstg < 4μS							102	
〃 1478	松下	RF.LN	Si.EP	35	5	50	150	175	0.1	10	540	5	2	5	-2		5500	0.4	25	150*	2.2	70	54	
〃 1479	富士通	PA	〃	36	3.5	500	3W (Tc=25°C)	175	100	12	50	2	200	12	-100	Po = 1.2W (f = 175MHz, Vcc = 12.5V, Pi = 50mW)				1000*	4		84B	
〃 1480	〃	〃	〃	36	3.5	500	7W (Tc=25°C)	175	100	12	50	2	500	12	-100	Po = 2.4W, η = 60% (f = 470MHz, Vcc = 12.5V, Pi = 0.3W)				1200*	5		246	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ (Ω)	外形	備考
2SC1481	富士通	PA	Si.EP	36	3.5	1 A	12W (T_c=25°C)	175	200	12	50	2	1A	12	−200	P_o=5W, η=60% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=1W)				1000*	10		246	
〃 1482	〃	〃	〃	36	3.5	2 A	20W (T_c=25°C)	175	500	12	50	2	2A	12	−500	P_o=8.5W, η=70% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=2W)				800*	18		246	
〃 1483	〃	LN	〃	20	3	40	300	150	0.1	10	100	6	10	6	−10	NF=2dB (f=100MHz, V_{CE}=6V, I_C=5mA)				3000*	0.9	25*	214	
〃 1484	〃	RF	〃	45	3	300	5W (T_c=25°C)	150	1	25	80	15	65	15	−65					2000*	2.8	25*	215	
〃 1485	〃	SW	Si.T	250	6	125	350	175	1	30	90	4	10			t_r<2μS, t_f<2.5μS, t_{stg}<6μS							49C	
〃 1486	ALP	PA	Si.EP	36	4	400	5W (T_c=25°C)	200	1mA	15	80	5	100			G_{pe}=10dB, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, I_C=0.24A)					11		216	2N5944
〃 1487	〃	〃	〃	36	4	800	15W (T_c=25°C)	200	1mA	15	80	5	200			G_{pe}=9dB, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, I_C=0.6A)					18		216	2N5945
〃 1488	〃	〃	〃	36	4	2 A	37.5W (T_c=25°C)	200	2mA	15	80	5	500			G_{pe}=7dB, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, I_C=1.3A)					38		216	2N5946
〃 1489	〃	〃	〃	36	4	6 A	60W (T_c=25°C)	200	2.5mA	15	80	5	1 A			G_{pe}=4.3dB, η>65% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=10W)					55		217	2N6136
〃 1490	〃	〃	〃	36	4	1 A	12W (T_c=25°C)	200	250	15	80	5	250			G_{pe}=13dB, η>50% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.25W)					15		217	2N6080
〃 1491	〃	〃	〃	36	4	2.5 A	31W (T_c=25°C)	200	500	15	50	5	500			G_{pe}=7dB, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=3.6W)					70		217	2N6081
〃 1492	〃	〃	〃	36	4	4 A	65W (T_c=25°C)	200	1mA	15	50	5	1 A			G_{pe}=7dB, η>65% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=6W)					110		217	2N6082
〃 1493	〃	〃	〃	36	4	4 A	65W (T_c=25°C)	200	1mA	15	50	5	1 A			G_{pe}=6.5dB, η>65% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=8.1W)					110		217	2N6083
〃 1494	〃	〃	〃	36	4	6 A	80W (T_c=25°C)	200	2.5mA	15	40	5	1 A			G_{pe}=5dB, η>70% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=14.3W)					170		217	2N6084
〃 1495	〃	〃	〃	36	4	400	2W (T_c=25°C)	200	500	15	80	5	50			G_{pe}=9dB, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.1W)					6		218	2N6256
〃 1496																								
〃 1497																								
〃 1498	ALP	PA	Si.EP	36	4	2.5 A	45W (T_c=25°C)	200	1mA	15	60	5	1 A			G_{pe}=7dB, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=3.75W)					65		219	
〃 1499	〃	〃	〃	36	4	6 A	115W (T_c=25°C)	200	20mA	15	60	5	4 A			G_{pe}=6dB, η>55% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=7.6W)					85		219	
〃 1500	〃	〃	〃	36	4	8 A	115W (T_c=25°C)	200	20mA	15	60	5	4 A			G_{pe}=4.9dB, η>55% (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=13W)					85		219	
〃 1501	松下	PA	Si.TP	300	5	100	10W (T_c=25°C)	150	100	300	70	10	50	30	−20					55*	8	10	232	
〃 1502																								
〃 1503	東芝	PA	Si.EP	50		3 A	30W (T_c=25°C)	175	500	20	50	5	1 A			P_o=13W (f=260MHz, V_{CC}=20V, P_i=1W)							135	
〃 1504	SAK	SW	Si.T	400	6	2 A	40W (T_c=25°C)	150	1mA	400	60	4	1 A	12	−100	t_r<2μS, t_f<5μS, t_{stg}<9μS				10*			99	
〃 1505	日電	PA	〃	300	7	200	15W (T_c=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80*	4	30	151	
〃 1506	〃	〃	〃	300	7	200	15W (T_c=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80*	4	30	152	
〃 1507	〃	〃	〃	300	7	200	15W (T_c=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80*	4	30	250	
〃 1508																								
〃 1509	松下	PA	Si.EP	80	5	500	750	135	0.1	20	160	10	150	10	−50					120*	11		165	
〃 1510	三菱	〃	〃	47	4.5	1 A	10W (T_c=25°C)	175	200	30	50	25	100			P_o=4.5W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i=1.2W)						2k*	220	
2SC1511	日電	PA	Si.E	50	4	3.5A	50W (T_c=25°C)	175	2mA	30	60	10	1 A			P_o=25W (f=275MHz, V_{CC}=18V, P_i=6W)							233	
〃 1512	〃	〃	〃	50	4	5 A	63.2W (T_c=25°C)	175	3mA	30	60	10	1.5A			P_o=37W (f=275MHz, V_{CC}=18V, P_i=10W)							233	
〃 1513	日立	RF	Si.Pa	40	3	300	800	175			35~250	15	30	15	−30	G_{pe}>15dB, NF=3.5dB (f=200MHz, I_E=30mA)				1600*	C_{re}<3pF		85C	
〃 1514	〃	RF.PA	Si.T	V_{CEO} 300	5	100	1.25W	150	I_{CEO} 0.5	V_{CE} 250	30~200	20	20										234	
〃 1515	〃	RF	Si.T	200	5	50	200	125	0.1	20	80	6	10	6	−10					110*	3	$C_c r_{bb'}$ 40pS	170	
〃 1516	〃	RF.PA	Si.EP	35		1.5A	10W (T_c=25°C)	150	20	30	150	2	500	2	−200					110*	35	10*	234	
〃 1517	〃	〃	Si.T	50	4	1 A	10W (T_c=25°C)	150	5	30	160	4	50	4	−50					10*	30	50*	234	
〃 1518	松下	PA	Si.EP	25	5	1 A	750	135	0.1	25	160	2	500	10	−50					150*	12	3.5k*	165	
〃 1519																								
〃 1520																								
〃 1521																								
〃 1522																								
〃 1523	日立	RF.PA	Si.Pa	40	3	300	3.5W (T_c=25°C)	175	10	15	35~250	15	50			G_{pe}>17dB, NF<5dB (f=200MHz, V_{CE}=15V)				2000*	C_{re} 3		269	
〃 1524	富士通	PA	Si.EP	50	3.5	1 A	12W (T_c=25°C)	175	500	20	50	5	500	12	−250	P_o=6W, η=55% (f=700MHz, V_{CC}=24V, P_i=2W)				800*	8		246	
〃 1525	〃	〃	〃	50	3.5	2 A	20W (T_c=25°C)	175	1mA	20	50	5	1 A	12	−500	P_o=13W, η=55% (f=700MHz, V_{CC}=24V, P_i=4W)				800*	13		246	
〃 1526	〃	〃	〃	50	3.5	3 A	25W (T_c=25°C)	175	600	20	50	5	2 A			P_o=20W, η=55% (f=700MHz, V_{CC}=24V, P_i=7.5W)					18		246	
〃 1527																								
〃 1528	三菱	PA	Si.EP	40	4.5	2.5A	25W (T_c=25°C)	175	500	25	40	10	100			P_o=16W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=3.5W)							186	
〃 1529	〃	RF	〃	30	4	20	120	150	0.1	12	60	10	5			G_{pe}=13dB (f=770MHz, V_{CC}=10V, I_C=5mA)							50C	
〃 1530	〃	PA	〃	50	4.5	350	5W (T_c=25°C)	150	100	30	50	10	100			P_o=1.5W (f=1GHz, V_{CC}=28V, P_i=0.25W)							221	
〃 1531																								
〃 1532																								
〃 1533	富士通	PA	Si.EP	45	3.5	500	7W (T_c=25°C)	175	100	20	50	5	200	12	−200	P_o=2.2W (f=700MHz, V_{CC}=18V, P_i=0.5W)				1.8GHz*	5		246	
〃 1534	〃	〃	〃	45	3.5	1 A	12W (T_c=25°C)	175	200	20	50	5	500	12	−300	P_o=7W (f=700MHz, V_{CC}=18V, P_i=2W)				1.6GHz*	8		246	
〃 1535	〃	〃	〃	45	3.5	2 A	25W (T_c=25°C)	175	400	20	50	5	1 A	12	−500	P_o=12W (f=700MHz, V_{CC}=18V, P_i=4W)				1.2GHz*	13		246	
〃 1536	〃	〃	〃	45	3.5	4 A	40W (T_c=25°C)	175	800	20	50	5	3 A	12	−700	P_o=24W (f=700MHz, V_{CC}=18V, P_i=10W)				800*	23		246	
〃 1537	東洋電具	RF.ConV.Mix Osc.AF.PA.SW	〃	50	5	30	150	125	1	30	330	3	0.5	6	−1		13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	235	
〃 1538	〃	RF.ConV.Mix Osc.AF.PA.LN	〃	50	5	30	150	125	1	30	330	3	0.5	6	−1	NF=3dB (f=1kHz)	13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	235	
〃 1539	〃	RF.ConV.Mix Osc.AF.PA	〃	25	5	30	150	125	1	15	330	3	0.5	6	−1		13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	235	
〃 1540	〃	RF.ConV.Mix Osc.AF.PA.LN	〃	25	5	30	150	125	1	15	330	3	0.5	6	−1	NF=3dB (f=1kHz)	13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	235	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC1541	東洋電具	RF. Conv. Mix Osc. AF. PA	Si. EP	40	5	150	300	125	1	24	330	3	10	6	−1		25.9k	0.8	7.7	250*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 150pS	235	
〃 1542	〃	〃	〃	25	5	150	300	125	1	15	330	3	10	6	−1		25.9k	0.8	7.7	250*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 150pS	235	
〃 1543	〃	SW. AF	〃	40	5	20	150	125	1	24	220	3	10	6	−1		20k	0.585	5.8	t_{on} < 200nS, t_{off} < 300nS t_{stg} < 200nS			235	
〃 1544	〃	〃	〃	25	5	20	150	125	1	15	220	3	10	6	−1		20k	0.585	5.8	t_{on} < 200nS, t_{off} < 300nS t_{stg} < 200nS			235	
〃 1545	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	40	6	300	300	125	1	24	10,000	5	100	5	−10					200*	5	$C_c r_{bb'}$ 100pS	235	
〃 1546	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA. SW	〃	25	6	300	300	125	1	15	10,000	5	100	5	−10					200*	5	$C_c r_{bb'}$ 100pS	235	
〃 1547	松下	RF	Si. P	30	3	20	150	150	0.1	25	100	10	2	10	−2	G_{pb} = 16dB, NF = 4dB (f = 800MHz, I_C = 3mA)				900*	0.8	60*	50C	
〃 1548	東芝	PA	Si. EP	50		5 A	45W (T_c=25°C)	175	1mA	20	50	5	1 A			P_o = 23W (f = 260MHz, V_{CC} = 20V, P_i = 4W)							213	
〃 1549																								
〃 1550	松下	PA	Si. TP	250	5	100	10W (T_c=25°C)	150	100	250	100	50	5	30	−20					100*	3.5	15	236	
〃 1551	東芝	LN	Si. EP	20	2	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	−10	G_{pe} = 7dB NF = 4.5dB (f = 4GHz, I_C = 5mA)				6.5GHz*	0.7	15*	237	
〃 1552	〃	〃	〃	20	3	30	250	175	0.1	10	70	10	10	10	−10	G_{pe} = 10.5dB NF = 3.5dB (f = 2GHz, I_C = 5mA)				4.5GHz*	0.8	15*	237	
〃 1553	〃	〃	〃	20	3	30	175	175	0.1	10	100	10	5	10	−10	G_{pe} = 15dB NF = 1.2dB (f = 500MHz, I_C = 5mA)				4.5GHz*	0.9	40*	50C	
〃 1554	〃	RF	〃	30	3	120	1.2W (T_c=25°C)	175	1	10	100	5	50	10	−50	G_{pe} = 13.5dB (f = 1GHz, I_C = 30mA)				4GHz*	1.7	15*	238	
〃 1555	〃	〃	〃	30	3	120	1.2W (T_c=25°C)	175	1	10	100	5	50	10	−50	G_{pe} = 12.5dB (f = 1GHz, I_C = 30mA)				4GHz*	1.7	15*	239	
〃 1556	〃	〃	〃	30	3	120	1.2W (T_c=25°C)	175	1	10	100	5	50	10	−30	G_{pe} = 14dB (f = 500MHz)				3.5GHz*	2	25*	85B	
〃 1557	〃	PA	〃	40	3.5	180	3W (T_c=25°C)	175	1	10	150	5	50	18	−50	P_o = 1.1W (f = 1GHz, V_{CC} = 18V, P_i = 0.1W)				3GHz*	2.2	10*	85B	
〃 1558	〃	LN	〃	15	3	80	250	175	0.1	10	75	8	50	5	−30	G_{pe} = 10dB (f = 2GHz)				7GHz*	1.1	20*	237	
〃 1559	〃	〃	〃	15	3	80	400	175	0.1	10	75	3	50	5	−30	G_{pe} = 10dB (f = 2GHz)				7GHz*	1.1	20*	238	
〃 1560																								
〃 1561	富士通	PA	Si. EP	55	3.5	500	7W (T_c=25°C)	175	100	20	50	5	200	12	200	P_o = 3W (f = 700MHz, V_{CC} = 28V, P_i = 0.5W)				1.8GHz*	4.5		246	
〃 1562	〃	〃	〃	55	3.5	1 A	12W (T_c=25°C)	175	200	20	50	5	500	12	300	P_o = 6W (f = 700MHz, V_{CC} = 28V, P_i = 2W)				1.6GHz*	7		246	
〃 1563	〃	〃	〃	55	3.5	2 A	25W (T_c=25°C)	175	400	20	50	5	1 A	12	500	P_o = 15W (f = 700MHz, V_{CC} = 28V, P_i = 4W)				1.2GHz*	12		246	
〃 1564	〃	〃	〃	55	3.5	4 A	40W (T_c=25°C)	175	800	20	50	5	3 A	12	700	P_o = 30W (f = 700MHz, V_{CC} = 28V, P_i = 10W)				800*	23		246	
〃 1565	松下	PA	Si. P	150	5	250	10W (T_c=90°C)	150	30	60	120	10	100	10	−50					150*	10	15	236	
〃 1566	〃	RF	Si. TP	250	5	100	1 W	150	1mA	250	100	20	4	10	−3	35	300	0.4	2.7	100*	3.2	$C_c r_{bb'}$ 60pS	222	
〃 1567	〃	PA	Si. EP	100	5	500	1.2W	150	1	100	160	10	150	10	−50					120*	11	3.5k*	222	
〃 1568	〃	〃	〃	18	5	1 A	1.2W	150	0.1	18	200	2	500	6	−50					150*	12	3.5k*	222	
〃 1569	東芝	〃	Si. TP	300	5	150	1.5W	150	0.1	100	100	10	50	10	−30					100*	5	10	119	
〃 1570																								
2SC1571																								
〃 1572																								
〃 1573	松下	AF	Si. TP	250	5	70	600	135	2	12	100	10	5	10	−3	35	300	0.4	2.7	80*	5	$C_c r_{bb'}$ 60pS	165	
〃 1574	東芝	LN	Si. EP	20	2	30	400	175	0.1	10	70	10	5	10	−10	G_{pe} = 15dB (f = 500MHz), NF = 12dB (f = 500MHz, I_C = 3mA), 4.5GHz					11.5	20*	85B	
〃 1575																								
〃 1576	東芝	RF. PA	Si. TMe	450	6	8 A	100W (T_c=25°C)	150	100	450	50	5	1 A	10	−100					10*	80	25	102	
〃 1577	SAK	SW	〃	500	6	8 A	80W (T_c=25°C)	150	1mA	500	30	4	3 A	12	−500					7*	55	4*	102	
〃 1578	〃	〃	〃	600	6	8 A	80W (T_c=25°C)	150	1mA	600	30	4	3 A	12	−500					7*	55	4*	102	
〃 1579																								
〃 1580																								
〃 1581	東芝	PA	Si. EP	65		7 A	80W (T_c=25°C)	175	3mA	30	30	10	5 A			P_o = 50W (f = 30MHz, V_{CC} = 28V, P_i = 2W)							223	
〃 1582	〃	〃	〃	65		13 A	140W (T_c=25°C)	175	6mA	30	30	10	10 A			P_o = 100W (f = 30MHz, V_{CC} = 28V, P_i = 8W)							223	
〃 1583	三菱	Diff. LN	〃	450	5	100	200 unit	125	0.1	35	350～1200	6	−1	6	−1	ΔV_{BE} = 10mVmax h_{FE}小/h_{FE}大 = 0.8				100*	3.0		274	複合管
〃 1584	SAK	PA	Si. TMe	150		15 A	150W (T_c=25°C)	150	1mA	150	60	4	5 A	12	−500					10*	110	10*	102	
〃 1585	〃	〃	〃	200		15 A	150W (T_c=25°C)	150	1mA	200	60	4	5 A	12	−500					10*	110	10*	102	
〃 1586	〃	〃	〃	250		15 A	150W (T_c=25°C)	150	1mA	250	60	4	5 A	12	−500					10*	110	10*	102	
〃 1587	三菱	〃	Si. EP	45	4.5	3 A	50W (T_c=25°C)	175	1mA	30	50	25	200			P_o = 30W (f = 295MHz, V_{CC} = 23V, P_i = 6W)							224	
〃 1588	日電	〃	Si. E	36	4	300	1.7W (T_c=25°C)	125	100	30	55	10	100	10	−30	P_o = 0.4W (f = 225MHz, V_{CC} = 12V, P_i = 10W)				900*	<10			
〃 1589	〃	〃	〃	36	4	700	2.5W (T_c=25°C)	150	100	30	55	10	300	10	−50	P_o = 1.5W (f = 225MHz, V_{CC} = 12V, P_i = 0.2W)				700*	<15		225	
〃 1590	〃	〃	〃	36	4	1.2A	13.5W (T_c=25°C)	175	1mA	30	50	10	500	10	−300	P_o = 6.5W (f = 225MHz, V_{CC} = 12V, P_i = 0.7W)				400*	<25		226	
〃 1591	〃	〃	〃	36	4	2.5A	30W (T_c=25°C)	175	2mA	30	50	10	1 A	10	−500	P_o = 15.5W (f = 225MHz, V_{CC} = 12V, P_i = 4W)				250*	<40		226	
〃 1592																								
〃 1593																								
〃 1594																								
〃 1595																								
〃 1596	富士通	RF	Si. EP	150	5	50	450	175	1	140	150	5	10	5	−10	t_{on} < 1μS, t_{off} < 10μS t_{stg} < 9.6μS				130*	2	70*	55C	
〃 1597																								
〃 1598																								
〃 1599																								
〃 1600																								

型名	社名	用途	構造	V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (µA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} / h_{ob}* (µƱ)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
				最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)															
2SC1601	新日無	RF,AF,LN	Si.EP	35		100	200	175	0.05	20	150	6	1	6	−0.1	NF=2dB (f=1kHz)	50k	5	15	200*	2	$C_c r_{bb'}$ 60pS	243	
〃 1602	〃	RF,AF	〃	35		100	150	125	0.05	20	150	6	1	6	−0.1		50k	5	15	200*	2	$C_c r_{bb'}$ 60pS	194	
〃 1603	三菱	PA	〃	18	4	600	6 W (T_c=25°C)	175	100	10	50	7	100			P_o=1.5W (f=485MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=0.3W)							254	
〃 1604	〃	〃	〃	18	4	300	5 W (T_c=25°C)	175	30	10	40	7	50			P_o=0.35W (f=485MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=50mW)							255	
〃 1605	〃	〃	〃	35	4.5	3.5A	30W (T_c=25°C)	175	500	25	50	10	100			P_o=16W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=1.7W)							256	
〃 1606	〃	RF, PA	〃	40	4	0.6A	6 W (T_c=25°C)	175	100	25	10~180	10	0.1A			P_o=3 W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_{in}=0.2W)							271	
〃 1607	富士通	RF	Si.EP	40	3.5	100	180	175	100	20	50	5	50	12.5	−10	G_{pe}=12dB (f=200MHz)					4		50C	
〃 1608	〃	PA	〃	40	3.5	500	5 W (T_c=25°C)	175	100	20	50	5	200			P_o=1.6W (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.3W)					5		231	
〃 1609																								
〃 1610																								
〃 1611																								
〃 1612																								
〃 1613																								
〃 1614																								
〃 1615																								
〃 1616																								
〃 1617	東芝	PA	Si.T	300	5	7 A	50W (T_c=25°C)	150	1mA	250	80	5	1 A	5	−500					10*	100	100*	102	
〃 1618																								
〃 1619																								
〃 1620	松下	PA	Si.EP	36	3	600	10W (T_c=25°C)	175	100	20	50	13.5	100	13.5	−150	P_o=2.6W, G_{pe}=6.3dB (f=500MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.6W)				1200*	7		227	
〃 1621	日電	SW	Si.E	25	5	200	150	125	0.1	15	85	0.5	1			t_{on} $<$ 20µS, t_{off} $<$ 40µS, t_{stg} $<$ 20µS							176	
〃 1622	〃	RF,AF	Si.PsE	30	5	30	150	125	0.05	25	400	3	0.5	3	−1		14k	5.8	23	100*	3.5	50	176	
〃 1623	〃	〃	Si.E	50	5	100	150	125	0.1	40	200	6	1	6	−1		4800	4.5	17	300*	4.5	25*	176	
〃 1624	東芝	RF,PA	Si.Eb	120		750	1.5W	150	0.5	50	130	2	150	2	−150					25*	20	5	119	
〃 1625	〃	〃	〃	100		750	1.5W	150	0.5	50	130	2	150	2	−150					25*	20	5	119	
〃 1626	〃	〃	Si.EP	80		750	1.5W	150	0.5	50	130	2	150	2	−150					25*	15	5	119	
〃 1627	〃	〃	〃	70		200	600	150	0.1	20	130	2	50	2	−50					150*	6	5	131	
〃 1628	〃	〃	Si.TP	180		50	1 W	150	1	100	130	5	10	10	−10					120*	3.5	10	249	
〃 1629																								
〃 1630																								
2SC1631	SON	RF.LN	Si.PsMe	25	6	200	250	100	0.2	25	200	3	1	6	−0.1	170	36k	2.4	3.3	h_{fe}=3dB (f=100MHz)	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300pS	138	
〃 1632	〃	〃	〃	50	6	200	250	100	0.2	25	200	3	1	6	−0.1	170	36k	2.4	3.3	h_{fe}=3dB (f=100MHz)	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300pS	138	
〃 1633	〃	〃	〃	25	6	200	250	100	0.2	25	200	3	1							h_{fe}=1.4dB (f=100MHz)	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300pS	138	
〃 1634	〃	〃	〃	50	6	200	250	100	0.2	25	200	3	1							h_{fe}=1.4dB (f=100MHz)	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300pS	138	
〃 1635																								
〃 1636																								
〃 1637																								
〃 1638																								
〃 1639																								
〃 1640																								
〃 1641																								
〃 1642																								
〃 1643																								
〃 1644																								
〃 1645																								
〃 1646																								
〃 1647																								
〃 1648																								
〃 1649																								
〃 1650																								
〃 1651																								
〃 1652																								
〃 1653	日電	RF.SW	Si.E	150	5	50	150	125	0.1	100	130	3	15	10	−10	t_{on} $<$ 0.6µS, t_{stg} $<$ 1.5µS		t_{off} $<$ 2µS		150*	4.5	15	176	
〃 1654	〃	〃	〃	180	5	50	150	125	0.1	100	100	3	15	10	−10	t_{on} $<$ 0.6µS, t_{stg} $<$ 1.5µS		t_{off} $<$ 2µS		150*	4.5	15	176	
〃 1655																								
〃 1656																								
〃 1657																								
〃 1658																								
〃 1659																								
〃 1660																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC1661																								
〃 1662																								
〃 1663																								
〃 1664	SAK	PA	Si.TMe	70	6	6 A	40W (Tc=25°C)	150	10	70	1200	4	1 A	10	−0.5A					10*	75	12	99	
〃 1665																								
〃 1666																								
〃 1667	松 下	RF.PA	Si.EMe	80	5	4 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	50	100	4	1 A	10	−0.5A					10*	120	10	102	
〃 1668	東 芝	PA	Si.EP	35	3.5	6 A	40W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	40	5	1 A	10	−200					400*	60	3*	135	
〃 1669	〃	〃	Si.TMe	150	5	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	20	100	100	10	500	10	−500					5*	50	25	268	
〃 1670																								
〃 1671																								
〃 1672																								
〃 1673	日 電	PA	Si.E	35	3	300	7 W (Tc=25°C)	200	5	20	60	10	100			G_{pe}=3.5dB (f=2.3GHz, V_{CC}=18V, P_i=1W)							129	
〃 1674	〃	RF Conv Mix.Osc	〃	30	4	20	125	125	0.1	30	90	6	1	6	−1					600*	1	$C_c r_{bb'}$ 12pS	138	
〃 1675	〃	〃	〃	50	5	30	125	125	0.1	50	90	6	1	6	−1					250*	1.9	$C_c r_{bb'}$ 10pS	138	
〃 1676																								
〃 1677	東 芝	PA	Si.EP	50	4	5 A	45W (Tc=25°C)	175	200	20	40	5	1 A	10	−400					260*	50	3*	260	
〃 1678	〃	〃	〃	65	4	3 A	10W (Tc=25°C)	150	10	30	40	5	500	5	−100					150*	30	5	268	
〃 1679	〃	〃	〃	65	4	1.5A	1.5W	150	10	30	30	5	500	5	−100					550*	20	5	268	
〃 1680																								
〃 1681																								
〃 1682																								
〃 1683	松 下	PA	Si.TMe	200	5	500	20W (Tc=25°C)	150	500	200	120	10	400	10	−200					6*	35	25	268	
〃 1684	〃	RF.AF	Si.EP	30	5	100	250	135	1	10	250	10	2	10	−2	250	5000	0.4	20	150*	3.5	70	138	
〃 1685	〃	〃	〃	60	5	100	250	135	1	10	250	10	2	10	−2	250	5000	0.4	20	150*	3.5	70	138	
〃 1686	〃	RF	Si.P	40	4	25	250	135	10	40	80	10	−4	10	−4					330*	1	$C_c r_{bb'}$ 45pS	138	
〃 1687	〃	〃	Si.EP	40	4	30	400	135	10	40	100	10	7	10	−5					550*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 80pS	138	
〃 1688	〃	〃	〃	50	4	30	400	135	10	50	100	10	7	10	−5					550*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 80pS	138	
〃 1689	三 菱	PA	〃	55	4	3 A	45W (Tc=25°C)	175	1 mA	40	50	10	100			P_o=26W (f=220MHz, V_{CC}=28V, P_i=5W)							224	
〃 1690																								
2SC1691																								
1692																								
1693																								
1694																								
1695																								
1696																								
1697																								
1698																								
1699																								
1700																								
1701																								
1702																								
1703																								
1704																								
1705																								
1706																								
1707																								
1708	三 菱	AF.LN.RF	Si.EP	90	5	50	200	125	0.1	50	250~1200	6	−1	6	−1					100*	2.5		138B	2SA847之对偶
1709																								
1710	富士通	RF	Si.EP	15	3	130	1 W (Tc=25°C)	175	0.5	10	80	6	60	6	−60					7GHz*	0.8	20*	261	
1711	〃	LN	〃	20	3	30	200	175	0.5	10	80	8	10	8	−10	G_{pe}=10dB, NF=3dB (f=2GHz, 8V, 5mA)				7.5GHz*	0.25	30*	262	
1712	〃	RF	〃	16	3	30	200	175	0.5	10	80	3	10	6	−15					8GHz*	0.3	30*	262	
1713	〃	Diff	〃	16	3	30	200	175	0.5	10	80 (h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0)	3	10	6	−15	ΔV_{BE} < 20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$ < 60μV/°C (3V, 10mA)				8GHz*	0.45	40*	263	
1714	〃	〃	〃	16	3	30	200	175	0.5	10	80 (h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0)	3	10	6	−15	ΔV_{BE} < 20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$ < 60μV/°C (3V, 10mA)				8GHz*	0.45	40*	264	
1715	〃	〃	〃	16	3	30	200	175	0.5	10	80 (h_{FE1}/h_{FE2}=0.5~1.0)	3	10	6	−15	ΔV_{BE} < 20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$ < 60μV/°C (3V, 10mA)				8 GHz*	0.45	40*	265	
1716	〃	〃	〃	16	3	30	200	175	0.5	10	80 (h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0)	3	10	6	−15	ΔV_{BE} < 20mV, γV_{BE} < 60μV/°C (3V, 10mA)				8GHz*	0.45	40*	264	
1717	東 芝	PA	〃	40	4	1 A	10W (Tc=25°C)	175	1	15	50	5	100	10	−50	P_o=2.2W (f=220MHz, V_{CC}=10V, I_E=50mA)				600*	6.5	25*	97C	
1718	〃	〃	〃	35	3.5	4.5A	30W (Tc=25°C)	175	100	15	50	5	1.5A	10	−200	P_o=14W (f=220MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=1.5W)				600*	35	4*	135	
1719																								
1720																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC1721																								
〃 1722																								
〃 1723																								
〃 1724	東芝	PA	Si.EP	35	3.5	800	7.5W (T_c=25°C)	175	500	15	100	5	500	10	−100	P_o=4W (f=470MHz, V_{cc}=12.6V, P_i=0.4W)				2000*	10	4*	135	
〃 1725	〃	〃	〃	35	3.5	1.4A	15W (T_c=25°C)	175	1mA	15	100	5	1A	10	−100	P_o=7W (f=470MHz, V_{cc}=12.6V, P_i=1W)				1600*	15	3.5*	135	
〃 1726	〃	〃	〃	35	3.5	2.8A	30W (T_c=25°C)	175	1.5mA	15	100	5	1.5A	10	−100	P_o=13W (f=470MHz, V_{cc}=12.6V, P_i=3W)				1200*	25	3*	135	
〃 1727																								
〃 1728																								
〃 1729	三菱	RF. PA	Si.EP	35	4	3.5A	3.5W (T_c=25°C)	175	1mA	25V	10~180	10	0.1			P_o=16W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_{in}=1.4W)							272	
〃 1730																								
〃 1731																								
〃 1732																								
〃 1733																								
〃 1734																								
〃 1735	三菱	AF Drive	Si.EP	100	5	300	800	135	1	50	50~300	6	10	6	10					130			242	
〃 1736																								
〃 1737																								
〃 1738																								
〃 1739																								
〃 1740																								
〃 1741																								
〃 1742																								
〃 1743																								
〃 1744																								
〃 1745																								
〃 1746																								
〃 1747																								
〃 1748																								
〃 1749																								
〃 1750																								
2SC1751																								
〃 1752																								
〃 1753																								
〃 1754																								
〃 1755																								
〃 1756																								
〃 1757																								
〃 1758																								
〃 1759																								
〃 1760																								
〃 1761																								
〃 1762																								
〃 1763																								
〃 1764																								
〃 1765																								
〃 1766																								
〃 1767																								
〃 1768																								
〃 1769																								
〃 1770																								
〃 1771																								
〃 1772																								
〃 1773																								
〃 1774																								
〃 1775																								
〃 1776																								
〃 1777																								
〃 1778																								
〃 1779																								
〃 1780																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μʊ)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
SC1781																								
〃1782	SAK	PA	Si.TMe	140	6	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	140	60	4	3 A	12	−500					10 *	165	13 *	102	
〃1783	〃	〃	〃	180	6	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	180	60	4	3 A	12	−500					10 *	165	13 *	102	
〃1784	〃	〃	〃	150	6	15A	100W (T_c=25°C)	150	100	150	20	4	5 A			t_r<1.5μS t_f<1μS t_{stg}<4μS							102	
〃1785	〃	〃	〃	200	6	15A	100W (T_c=25°C)	150	100	200	20	4	5 A			t_r<1.5μS t_f<1μS t_{stg}<4μS							102	
〃1786	〃	〃	〃	230	6	15A	100W (T_c=25°C)	150	100	230	20	4	5 A			t_r<1.5μS t_f<1μS t_{stg}<4μS							102	
〃1787																								
〃1788																								
〃1789																								
〃1790																								
〃1791																								
〃1792																								
〃1793																								
〃1794																								
〃1795																								
〃1796																								
〃1797																								
〃1798																								
〃1799																								
〃1800																								
〃1801																								
〃1802																								
〃1803																								
〃1804	三菱	RF,PA	Si.EP	47	4	1 A	10W (T_c=25°C)	175	200	30	10~180	25	0.1A			P_O=4.5W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_{in}=1W)							273	
〃1805	〃	〃	〃	45	4	2 A	30W (T_c=25°C)	175	1mA	35	10~180	25	0.1A			P_O=12W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_{in}=3.5W)							273	
〃1806	〃	〃	〃	45	4	4 A	50W (T_c=25°C)	175	2mA	35	10~180	25	0.2A			P_O=25W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_{in}=8W)							273	
〃1807	〃	〃	〃	18	4	0.1A	300	175	30	10	10~180	7.2	20			P_O=25mW (f=485MHz, V_{CC}=7.2V, P_{in}=5mW)								
〃1808	〃	〃	〃	35	3.5	1 A	10W (T_c=25°C)	175	100	15	10~180	10	0.1A			P_O=3.5W (f=485MHz, V_{CC}=13.5V, P_{in}=0.4W)							274	
〃1809																								
〃1810																								

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脈沖下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μʊ)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ (Ω)	外形	備考
★	2SD 11	日電	SW	Ge.A	25	15	300	150	85	10	25	70	1	20	6	−1					2.5			84A	
★	〃 12	松下	PA	Si.Me	75	4	2.5A	60 W (Tc=25°C)	150	10mA	75	50	4	1 A										103	
★	〃 13	〃	〃	〃	35	4	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	40mA	35	40	10	2.5A										109	
★	〃 14	〃	〃	〃	75	4	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	45mA	75	30	4	10 A										109	
	〃 15	SAK	PA.SW	Si.DJ	60	10	6 A	80 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
	〃 16	〃	〃	〃	100	10	6 A	60 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
	〃 17	〃	〃	〃	150	10	6 A	80 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
	〃 18	〃	PA	〃	200	10	6 A	80 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
★	〃 19	日電	〃	Ge.A	25	10	300	150	85	12	12	31	1	20	6	−1					>1			84A	2SB219之對稱
★	〃 20	〃	〃	〃	25	10	300	150	85	12	12	50	1	20	6	−1					>1			84A	2SB220之對稱
★	〃 21	〃	〃	〃	25	10	300	150	85	12	12	72	1	20	6	−1					>1			84A	2SB221之對稱
★	〃 22	〃	〃	〃	25	10	300	150	85	12	12	97	1	20	6	−1					>1			84A	2SB222之對稱
★	〃 23	〃	〃	〃	25	10	300	150	85	12	12	150	1	20	6	−1					>1			84A	2SB223之對稱
	〃 24	三洋	〃	Si.Me	300	2	100	6 W (Tc=70°C)	110	1.5	100	60	10	50	30	−20					25*	17		99	
★	〃 25	日電	〃	Ge.A	25	10	100	110	75	14	12	70	1	50	6	−1					1			12A	
★	〃 26	三菱	PA.SW	Si.EP	40	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}=120 (4V, 1A)							103	
★	〃 26A	〃	〃	〃	60	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}=120 (4V, 1A)							103	
★	〃 26B	〃	〃	〃	100	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}=120 (4V, 1A)							103	
★	〃 26C	〃	〃	〃	150	5	7 A	50 W (Tc=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}=120 (4V, 1A)							103	
	〃 27	松下	PA	Ge.A	32	10	500	280	90	10	0.5	95	0.5	300										12A	
	〃 28	SON	〃	Si.DJ	70		3 A	18 W (Tc=25°C)	150	20	30	100	1	100										100	
	〃 29	〃	〃	〃	70		3 A	18 W (Tc=25°C)	150	20	30	100	1	100										100	
	〃 30	三洋	〃	Ge.A	25	12	200	300	85	15	20	100	1.5	100	6	−1					1			63	2SB22之對稱
★	〃 31	松下	〃	〃	25	10	125	125	75	15	10	50	1	100				NF = 3dB						12B	2SB172之對稱
★	〃 32	〃	〃	〃	25	10	125	125	75	15	10	90	1	100				NF = 3dB						12B	2SB176之對稱
	〃 33	富士通	〃	〃	20	2.5	50	150	85	14	12	70	1	50	6	−1	60	1780	3.8	17.3	2			12A	2SB33之對稱
	〃 34	〃	〃	〃	20	2.5	150	250	85	14	12	100	1	150	6	−1	60	1800	5	20	2			71A	2SB34之對稱
★	〃 35	松下	〃	〃	20	10	60	83	75	10	10	72	1	18										4	
★	〃 36	〃	〃	〃	20	10	60	83	75	10	10	150	1	37.5										4	
	〃 37	富士通	〃	〃	30	12	50	150	85	14	30	7	1	50	6	−1	60	1780	3.8	17.3	2			12A	2SB37之對稱
	2SD 38	富士通	PA	Ge.A	30	12	150	250	85	16	30	75	1	150	6	−1	60	1800	5	20	2			71A	2SB38之對稱
	〃 39																								
	〃 40																								
	〃 41	東芝	PA	Si.DJ	80	10	10 A	200 W (Tc=25°C)	150	200	50	60	5	1 A										102	
	〃 42																								
★	〃 43	東芝	PA	Ge.A	25	12	50	110	75	14	12	70	1	50	6	−1					24	1		12A	
★	〃 43A	〃	〃	〃	45	12	150	110	75	14	12	70	1	50	6	−1					24	1		12A	
★	〃 44	〃	AF	〃	25	12	50	80	75	14	12				6	−1	85	2500	5	30	>0.5	25		12A	
	〃 45	SON	PA	Si.Me	150	6	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5mA	50	40	10	1 A										102	
	〃 46	〃	〃	〃	150	6	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5mA	50	40	10	1 A										102	
	〃 47	〃	〃	〃	100	6	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5mA	15	40	10	1 A										102	
	〃 48	富士通	〃	Si.DJ	100	10	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	15	30	50	4	750							1.5			83	
	〃 49	SON	〃	〃	100	10	3 A	18 W (Tc=25°C)	150	20	30	50	3	1 A	10	−0.5A					2			100	
	〃 50	富士通 日立	〃	〃	100	10	6 A	50 W (Tc=25°C)	175	15	30	30	4	1.5A							1.5			102	
	〃 51	SON	〃	Si.Me	100	6	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5mA	15	60	3	2 A	10	−0.5A					10			102	
	〃 52	SAK	PA.SW	Si.DJ	100	10	6 A	80 W (Tc=25°C)	175	10	40	20	4	3 A	12	−0.5A					2			102	
	〃 53	富士通	〃	〃	90	12	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−0.5A					1.2			102	
	〃 54	〃	〃	〃	100	12	10 A	150 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−0.5A					1.2			109	
	〃 55	東芝	PA	〃	100	10	20 A	200 W (Tc=25°C)	150	10mA	50	24	5	10 A							1			102	
	〃 56	SON	〃	〃	220	18	3 A	30 W (Tc=25°C)	150	50	50	50	1	100										100	
★	〃 57	三菱	PA.SW	〃	30	10	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	200	20	70	4	1 A										100	
★	〃 58	〃	〃	〃	60	10	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	40	40	70	4	1 A										100	
★	〃 59	〃	〃	〃	100	5	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A										102	
★	〃 60	〃	〃	〃	150	5	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A										102	
	〃 61	SON	AF.PA.LN	Ge.A	30	10	100	120	75	10	25	50	1	10	6	−1	−0.977*	28*	1.2*	0.29*	1	35		58	
	〃 62	〃	SW	〃	30	10	100	120	75	10	25	50	1	10	6	−1	−0.977*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
	〃 63	〃	PA	〃	25		100	120	75	10	25	50	1	10	6	−1					1	35		58	
	〃 64	〃	AF	〃	25		100	120	75	15	25	100	1	10	6	−1	−0.987*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
	〃 65	〃	〃	〃	25		100	120	75	15	25	50	1	10	6	−1	−0.977*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
	〃 66	〃	〃	〃	25		100	120	75	15	25	25	1	10	6	−1	−0.958*	28*	1.2*	0.25*	0.8	35		58	

製名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD 67	三洋	PA	Si. TMe	120	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5 mA	80	80	5	1 A							100 *			102	
〃 68	〃	〃	〃	75	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5 mA	60	80	5	1 A							100 *			102	
〃 69	SON	〃	〃	140		3 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	50	150	3	100										102	
★ 〃 70	日電	PA	Si. EP	40	5	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	24	80	2	1 A										101	
★ 〃 71	〃	〃	〃	100	5	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	40	80	2	0.5 A										101	
〃 72	三洋	〃	Ge. A	25		600	720 (Tc=25°C)	85	50	20	150	1.5	200										12 A	2SB406之對稱
〃 73	日電	〃	Si. EMe	100	5	5 A	60 W (Tc=25°C)	175	5mA	100	50	10	1 A										102	
〃 74	〃	〃	〃	150	5	5 A	60 W (Tc=25°C)	175	5mA	150	50	10	1 A										102	
〃 75	日立	AF	Ge. A	25	12	100	150	85	14	25				6	−1	40	1260	3	15.8	4			12 A	2SB75之對稱
〃 75A	〃	PA	〃	45	12	100	150	85	25	45				6	−1	40	1260	3	15.8	4			12 A	2SB77A之對稱
〃 76																								
〃 77	日立	PA	Ge. A	25	12	100	150	85	14	25	55	1.5	50	6	−1	55	1680	3.1	16.3	3.5			12 A	2SB77之對稱
〃 77A	〃	〃	〃	45	12	100	150	85	25	45	55	1.5	50	6	−1	55	1680	3.1	16.3	3.5			12 A	
〃 78	日電	PA. SW	Si.EPa	100	12	2 A	1 W	175	1	60	80	2	500										84B	
〃 79	〃	〃	Si. EP	100	12	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	1	60	80	2	500										97C	
〃 80	SAK	PA. SW	Si. DJ	30	10	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	200	20	60	4	1 A	10	−200					3			102	
〃 81	〃	〃	〃	60	10	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	40	60	4	1 A	10	−200					3			102	
〃 82	〃	〃	〃	100	10	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A	10	−200					3			102	
〃 83	〃	〃	〃	150	10	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A	10	−200					3			102	
〃 84	〃	〃	〃	200	10	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A	10	−200					3			102	
〃 85																								
〃 86																								
〃 87																								
〃 88	SON	PA	Si.TMe	100	8	5 A	80 W (Tc=25°C)	150	100	50	80	3	2 A										102	
〃 89																								
〃 90	SAK	PA. SW	Si. DJ	30	10	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	200	20	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	
〃 91	〃	〃	〃	60	10	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	50	40	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	
〃 92	〃	〃	〃	100	10	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	30	50	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	
〃 93	〃	〃	〃	150	10	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	30	50	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	
〃 94	〃	〃	〃	200	10	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	30	50	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	
2SD 95																								
〃 96	日立	PA	Ge. A	25	2.5	250	300 (Tc<45°C)	85	14	25	90	1.5	50	6	−1					4			12 A	2SB[illegible]之對稱
〃 97																								
〃 98																								
〃 99																								
〃 100	東芝	PA	Ge. A	32	12	400	250	85	40	12	75	1	150										77	
〃 100A	〃	〃	〃	45	12	400	250	85	40	12	75	1	150										77	
★ 〃 101	〃	〃	〃	80	6	600	250	75	50	12	70	1	150										77	
〃 102	〃	〃	Si. DJ	110	10	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	20	50	30～300	5	500	10	−500					1 *	200		99	
〃 103	東芝	PA. SW	〃	80	10	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	20	50	30～300	5	500	10	−500					1 *	200		99	
★ 〃 104	〃	PA	Ge. A	20	6	400	150	75	14	12	90	0.5	100										12 A	
★ 〃 105	〃	〃	〃	20	6	400	150	75	14	12	60	0.5	100										12 A	
〃 106																								
★ 〃 107	東芝	PA	Si. TP	80	10	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	20	50	4000	5	1 A	10	−500					30 *			102	達林頓管
★ 〃 108	〃	〃	〃	80	10	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	2	50	4000	5	1 A										102	達林頓管
〃 109																								
〃 110	東芝	PA	Si. DJ	130	10	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	0.5 mA	50	30～300	5	1 A	10	−1A					2 *	200		102	
〃 111	〃	〃	〃	100	10	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	0.5 mA	50	30～300	5	1 A	10	−1A					2 *	200		102	
〃 112																								
〃 113	東芝	PA	Si. DJ	100	10	30 A	200 W (Tc=25°C)	150	2 mA	50	12	5	15 A		t_{on} = 3 μS, t_f = 5 μS, t_{stg} = 5 μS					1.5 *	400		102	
〃 114	〃	〃	〃	70	10	30 A	200 W (Tc=25°C)	150	2 mA	50	12	5	15 A		t_{on} = 3 μS, t_f = 5 μS, t_{stg} = 5 μS					1.5 *	400		102	
〃 115																								
〃 116	富士通	PA	Si. TMe	100	6	7 A	75 W (Tc=25°C)	175	15	30	100	4	1 A										102	
〃 117	〃	〃	〃	150	6	7 A	75 W (Tc=25°C)	175	15	30	100	4	1 A										102	
〃 118	東芝	〃	Si. DJ	130	10	7 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	50	30～200	5	1 A	10	−500					2 *	200		102	
〃 119	〃	〃	〃	100	10	7 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	50	30～200	5	1 A	10	−500					2 *	200		102	
〃 120	日立	〃	〃	60	12	1.5A	4 W (Tc=25°C)	175	10	30	40	4	200	12	−50			t_d = 0.2 μS, t_s = 3 μS, t_r = 0.7 μS, t_f = 1.2 μS		>0.8			84 A	
〃 121	〃	〃	〃	100	12	1.5A	4 W (Tc=25°C)	175	10	30	40	4	200	12	−50			t_d = 0.2 μS, t_s = 3 μS, t_r = 0.7 μS, t_f = 1.2 μS		>0.8			84 A	
〃 122	〃	〃	〃	60	12	3 A	15 W (Tc=25°C)	175	15	30	40	4	750	12	−50			t_d = 0.25 μS, t_s = 1.6 μS, t_r = 2.6 μS, t_f = 1.6 μS		>0.6			83	
〃 123	〃	〃	〃	100	12	3 A	15 W (Tc=25°C)	175	15	30	40	4	750	12	−50			t_d = 0.25 μS, t_s = 1.6 μS, t_r = 2.6 μS, t_f = 1.6 μS		>0.6			83	

2SD

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電氣的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb} (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD124	日立	PA	Si.DJ	60	10	6 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	30	4	1.5A	12	−50		t_d=0.15μS, t_s=1.8μS t_r=1.3μS t_f=1.4μS			>0.5			102	
〃 124A	〃	〃	Si.DB	75	10	7 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	30	4	1.5A	4	−1A					1			102	
〃 125	〃	〃	〃	100	10	6 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	30	4	1.5A	12	−50		t_d=0.15μS, t_s=1.8μS t_r=1.3μS t_f=1.4μS			>0.5			102	
〃 125A	〃	〃	〃	100	10	7 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	30	4	1.5A	4	−1A					1			102	
〃 126	〃	PA.SW	Si.DJ	150	5	7 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	10	4	6 A	4	−1A		t_{on}=1.6μS, t_{off}<5μS t_{stg}=2.2μS			$f_{\alpha e}$ 12kc			102	
★ 〃 127	SON	PA	Ge.A	23		500	250	85	15	15	82	1	20	6	−1		28*	2.5*	0.4*	4			12A	
★ 〃 127A	〃	〃	〃	23		500	250	85	15	15	82	1	20	6	−1		28*	2.5*	0.4*	4			12A	
★ 〃 128	〃	〃	〃	32		500	250	85	15	15	82	1	20	6	−1		28*	2.5*	0.4*	4			12A	
★ 〃 128A	〃	〃	〃	32		500	250	85	15	15	82	1	20	6	−1		28*	2.5*	0.4*	4			12A	
〃 129	東芝	〃	Si.DJ	90	10	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	1 mA	50	30~200	5	500	10	−500					1*	250		99	
〃 130	〃	〃	〃	60	10	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	1 mA	50	30~200	5	500	10	−500					1*	250		99	
〃 131	〃	〃	Si.T	100	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	50	60	5	1 A										102	
〃 132	日電	〃	Si.EMe	100	6	20 A	150 W (Tc=25°C)	175	5 mA	65	40	5	20 A										106	
〃 133																								
★ 〃 134	SON	SW	Ge.A	60	3	5	30	65	8	15	40	5	3								2		18	
〃 135																								
〃 136	富士通	PA	Si.T	200	3	100	4 W (Tc=25°C)	150	10	150	80	10	50										98A	
〃 137	〃	〃	〃	300	3	100	4 W (Tc=25°C)	150	10	150	80	10	50										98A	
〃 138	〃	PA.SW	〃	200	3	1 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5A										101	
〃 139	〃	〃	〃	300	3	1 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5A										101	
〃 140																								
★ 〃 141	日電	PA	Si.EP	20	5	3 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	12	80	2	1 A										101	
★ 〃 142	〃	〃	〃	40	5	3 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	20	80	2	1 A										101	
★ 〃 143	〃	〃	〃	80	5	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	40	80	2	0.5A										101	
★ 〃 144	〃	〃	〃	100	5	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	50	80	2	0.5A										101	
〃 145																								
〃 146	富士通	PA.SW	Si.DJ	40	5	1 A	20 W (Tc=25°C)	175	20	30	60	4	500	6	−0.5A					1.4			101	
〃 147	〃	〃	〃	60	5	1 A	20 W (Tc=25°C)	175	20	30	50	4	500	6	−0.5A					1.4			101	
〃 148	〃	SW	〃	70	5	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	20	30	35	4	2 A										101	
〃 149	〃	PA.SW	〃	70	5	1 A	800	175	20	30	40	4	1 A										84B	
★ 2SD150	日電	PA	Si.DB	50	5	1 A	15 W (Tc=25°C)	150	100	40	80	2	1 A										150	2SA611之對稱
〃 151	〃	SW	Si.EMe	100	6	10 A	120 W (Tc=25°C)	175	1 mA	20	35	10	10 A										102	
★ 〃 152	〃	PA	Si.EP	150	6	1 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	70	70	2	0.5A										150	
〃 153	〃	PA.SW	Si.TMe	250	6	10 A	120 W (Tc=25°C)	175	1 mA	200	70	5	1 A										200	
★ 〃 154																								
★ 〃 155	日電	PA	Si.EMe	80	5	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	65	2	2 A										134	2SA616之對稱
〃 156	富士通	〃	Si.T	200	3	100	4 W (Tc=70°C)	150	10	150	80	10	50	30	−10					20*	8	25	99	
〃 157	〃	〃	〃	300	3	100	4 W (Tc=70°C)	150	10	150	80	10	50	30	−10					20*	8	25	99	
〃 158	〃	PA.SW	〃	200	3	1 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5A										99	
〃 159	〃	〃	〃	300	3	1 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5A										99	
〃 160	〃	〃	Si.DJ	100	8	1.5A	25 W (Tc=25°C)	175	10	30	50	10	750										83	
〃 161	〃	PA	〃	120	12	10A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	30	4	5 A										102	
〃 162	〃	AF.PA	Ge.A	20	2.5	30	65	85	12	12	80	1.5	30	6	−1	60	2000	4	17	3			4	2SB262之對稱
〃 163	SAK	PA.SW	Si.DJ	60	10	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					2			102	
〃 164	〃	〃	〃	100	10	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					2			102	
〃 165	〃	〃	〃	150	10	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					2			102	
〃 166	〃	〃	〃	200	10	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					2			102	
〃 167	富士通	AF.PA	Ge.A	20	2.5	500	200	85	20	12	120	1	150										12A	
〃 168	〃	SW	Si.DJ	80	6	10 A	50 W (Tc=25°C)	175	30	30	2500	4	5 A			$V_{CE(sat)}$<3.0V (I_C=5A, I_B=25mA) $V_{BE(sat)}$<3.5V (I_C=5A, I_B=25mA)							102	達林頓管
〃 169																								
〃 170	日立	PA	Ge.A	25	6	500	200	85	20	12	150	1	150										12A	[illegible]之對稱
〃 171	SON	PA	Si.TMe	450		3.5A	125 W (Tc=25°C)	150	100	50	70	3	1 A										102	
〃 172	富士通	PA.SW	Si.DJ	60	6	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										102	
〃 173	〃	〃	〃	100	6	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										102	
〃 174	〃	PA	〃	60	6	5 A	50 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
〃 175	〃	PA.SW	〃	100	6	5 A	50 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
〃 176	〃	〃	〃	90	12	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
〃 177	〃	〃	〃	120	12	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
★ 〃 178	松下	PA	Ge.A	20	6	300	225	75	27	12	90	0.5	300										17	2SB178之對稱
★ 〃 178A	〃	〃	〃	40	6	300	225	75	27	12	90	0.5	300										17	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★ 2SD179	日電	PA. SW	Si. TMe	300	6	40 A	680 W (Tc=25°C)	175	1 mA	300	30	5	20 A										201	
〃 180	〃	PA	Si. EMe	80	7	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	2 mA	60	60	10	3 A							20*			102	2SA626之對偶
★ 〃 181	〃	PA. SW	Si. TMe	150	7	15 A	100 W (Tc=25°C)	175	1 mA	100	60	5	5 A										102	
〃 182	富士通	PA	Si. DB	40	12	1 A	10 W (Tc=25°C)	175	15	30	35	4	750	6	−500					1.5			83	
〃 183	〃	〃	〃	100	12	1 A	10 W (Tc=25°C)	175	15	30	35	4	750	6	−500					1.5			83	
〃 184	〃	SW	〃	60	12	1.5 A	25 W (Tc=25°C)	175	10	30	35	4	750	6	−500					1.5			83	
〃 185	〃	〃	〃	100	12	1.5 A	25 W (Tc=25°C)	175	10	30	35	4	750	6	−500					1.5			83	
〃 186	三洋	PA	Ge. A	25	12	150	200	85	15	20				6	−1	120	2500	10	35	1	60		12 A	
〃 187	〃	〃	〃	25	12	150	200	85	15	20	100	1.5	30	6	−1					1			12 A	2SB187之對偶
〃 188	日電	PA	Si. EMe	100	5	5 A	60 W (Tc=25°C)	150	2 mA	70	70	2	3 A										102	2SA627之對偶
〃 189	松下	PA	Si. TMe	80	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5 mA	80	50	4	4 A	10	−500					12*			102	
〃 189A	〃	〃	〃	100	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5 mA	100	50	4	4 A	10	−500					12*			102	
〃 190	日立	〃	Si. T	300	3	100	4 W (Tc=25°C)	150	100	300	60	10	50										98	
★ 〃 191	東芝	〃	Ge. A	30	12	150	150	75	14	12	80	1	50										84 A	
★ 〃 192	〃	〃	〃	30	12	150	150	75	14	12	80	1	50										84 A	
★ 〃 193	〃	SW	〃	35	12	400	250	85	35	12	100	1	150										84 A	
★ 〃 194	〃	PA	〃	32	12	400	250	85	40	12	75	1	150										84 A	
〃 195	富士通	SW	〃	20	15	50	150	85	14	12	70	1	50	6	−1					>2.5			12 A	
〃 196	〃	〃	Si. DJ	100	12	10 A	125 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										109	
〃 196A	〃	PA. SW	〃	100	12	10 A	150 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										109	
〃 197	〃	SW	〃	130	12	10 A	125 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										109	
〃 197A	〃	PA. SW	〃	130	12	10 A	150 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										109	
〃 198	松下	PA	Si. TMe	300	6	1 A	25 W (Tc=25°C)	150	5 mA	150	120	5	100	10	−100					25*			102	
〃 199	〃	〃	〃	800	6	500	25 W (Tc=25°C)	150	1 mA	800	55	10	200	10	−100					7*			102	
〃 200	〃	SW	Si. Me	1500	5	2.5 A	10 W		1 mA	1500	2.5	5	2 A			t_f<1.5μS							102	
〃 201	SAK	PA. SW	Si. DJ	90	7	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	3 A	12	−500					8			102	
〃 202	〃	〃	〃	110	7	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	3 A	12	−500					8			102	
〃 203	〃	〃	〃	130	7	6 A	60 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	3 A	12	−500					8			102	
★ 〃 204	日電	PA	Si. DB	60	5	700	9 W (Tc=25°C)	150	3	50	80	2	300										84B	
★ 〃 205	〃	〃	Si. EP	60	5	700	1 W	150	3	30	80	2	300										97B	
2SD206	新電元	PA. SW	Si. DJ	50	8	10A	150 W (Tc=25°C)	150	50	30	20	5	5 A	10	1 A					$f_{\alpha e}$ 18kc			102	
〃 207	〃	〃	〃	100	8	10A	150 W (Tc=25°C)	150	50	30	20	5	5 A	10	1 A					$f_{\alpha e}$ 18kc			102	
〃 208	〃	〃	〃	150	8	10A	150 W (Tc=25°C)	150	50	30	20	5	5 A	10	1 A					$f_{\alpha e}$ 18kc			102	
〃 209																								
〃 210																								
〃 211	SAK	PA. SW	Si. DJ	60	7	10A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	35	4	5 A	12	−500					8			102	
〃 212	〃	〃	〃	90	7	10A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	35	4	5 A	12	−500					8			102	
〃 213	〃	〃	〃	110	7	10A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	35	4	5 A	12	−500					8			102	
〃 214	〃	〃	〃	130	7	10A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	35	4	5 A	12	−500					8			102	
〃 215	富士通	PA	〃	40		1 A	800	175	20	30	70	4	500										84B	
〃 216	〃	〃	〃	60		1 A	800	175	20	30	70	4	500										84B	
〃 217	日電	〃	Si. EMe	120	7	7 A	60 W (Tc=25°C)	150	2mA	80	60		4 A										102	2SA648之對偶
〃 218	〃	〃	〃	150	7	7 A	60 W (Tc=25°C)	150	2mA	80	60	5	4 A										102	2SA649之對偶
〃 219	SAK	PA. SW	Si. DJ	40	7	1 A	500	150	1	20	100	4	200	5	−100					8			84B	
〃 220	〃	〃	〃	80	7	1 A	500	150	1	20	80	4	200	5	−100					8			84B	
〃 221	〃	〃	〃	110	7	1 A	500	150	1	20	60	4	200	5	−100					8			84B	
〃 222	〃	〃	〃	40	7	1.5 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	500	5	−100					8			97B	
〃 223	〃	〃	〃	80	7	1.5 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	500	5	−100					8			97B	
〃 224	〃	〃	〃	110	7	1.5 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	20	40	4	500	5	−100					8			97B	
〃 225																								
〃 226	松下	PA	Si. DJ	40	8	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	30	20	50	3	1 A							$f_{\alpha e}$ 25kHz			99	
〃 227	日電	〃	Si. EP	30		300	250	125	0.1	15	120	1	300	10	−10	200							43	2SA642之對偶
★ 〃 228	〃	〃	〃	30		300	400	125	0.1	15	120	1	300	10	−10	200							44	
〃 229																								
〃 230																								
〃 231	富士通	SW. AF	Si. TMe	50	5	30 A	125 W (Tc=25°C)	175	100	30	25	4	10 A										102	
〃 232	〃	〃	〃	120	7	30 A	125 W (Tc=25°C)	175	1 mA	50	25	4	10 A										102	
〃 233																								
〃 234	東芝	PA	Si. DJ	60	10	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	20	80	5	500	10	−500					1*	250		119	
〃 235	〃	〃	〃	50	10	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	20	80	5	500	10	−500					1*	250		119	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ (Ω)	外形	備考
2SD236	SAK	PA. SW	Si. DJ	40	7	1 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	500	5	−100					8			99	
〃 237	〃	〃	〃	80	7	1 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	500	5	−100					8			99	
〃 238	〃	〃	〃	110	7	1 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	20	40	4	500	5	−100					8			99	
〃 239																								
〃 240																								
★ 〃 241	SAK	PA. SW	Si. DJ	60	7	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			100	
★ 〃 242	〃	〃	〃	90	7	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			100	
★ 〃 243	〃	〃	〃	110	7	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	−200					8			100	
★ 〃 244	〃	〃	〃	130	7	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	−200					8			100	
〃 245																								
★ 〃 246	松下	PA. SW	Si. Me	1500	5	4.5 A	16 W (Tc=90°C)	115	1mA	1500	5	10	2.5 A			$V_{CE(sat)}$ < 10 V (4.5A, 2 A)		$V_{BE(sat)}$ < 1.6 V (4.5A, 2 A)					102	
〃 247	芝電	PA	Si. TMe	80	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	30	60	5	1 A										102	
〃 248																								
〃 249	富士通	PA. SW	Si. DJ	50	5	30 A	125 W (Tc=25°C)	175	100	30	25	4	10 A										102	
〃 250	〃	〃	〃	100	7	30 A	125 W (Tc=25°C)	175	100	50	25	4	10 A										102	
〃 251	富士通	SW. AF	Si. TMe	200	5	2 A	30 W (Tc=25°C)	175	5	150	100	10	500										99	
〃 252																								
〃 253																								
★ 〃 254	日電	PA	Si. EMe	70	5	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	65	2	2 A											
★ 〃 255	〃	〃	〃	70	5	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	65	2	2 A										134	2SA615 之對稱
〃 256	SAK	PA. SW	Si. DJ	60	7	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			99	
〃 257	〃	〃	〃	90	7	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			99	
〃 258	〃	〃	〃	110	7	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	−200					8			99	
〃 259	〃	〃	〃	130	7	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	−200					8			99	
〃 260	芝電	PA	Si. TMe	100	5	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	30	60	4	1 A										102	
〃 261	日電	〃	Si. EP	40	5	700	500	125	0.2	15	100	1	500										44	2SA643 之對稱
〃 262	SON	〃	Si. TMe	300		12 A	125 W (Tc=25°C)	150	100	50	50	3	5 A										102	
〃 263																								
〃 264																								
〃 265	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	6 A	100 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	20	5	3 A										102	
2SD266	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	6 A	100 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	40	5	3 A										102	
〃 267																								
〃 268																								
〃 269																								
〃 270																								
〃 271	ORG	PA	Si. T	800	10	2 A	30 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	20	5	1 A	12	500					f_{ae} 150kHz			100	
〃 272	〃	〃	〃	800	10	2 A	30 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	40	5	1 A	12	500					f_{ae} 100kHz			100	
〃 273	〃	PA. SW	〃	800	10	5 A	80 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	20	5	2 A	12	1 A					f_{ae} 150kHz			102	
〃 274	〃	〃	〃	800	10	5 A	80 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	40	5	2 A	12	1 A					f_{ae} 150kHz			102	
〃 275																								
〃 276																								
〃 277																								
〃 278																								
〃 279																								
〃 280																								
〃 281																								
〃 282																								
〃 283	日電	PA. SW	Si. E	120	5	5 A	25 W (Tc=25°C)	150	200	40	55	1	5 A										134	
〃 284	〃	〃	〃	120	5	5 A	25 W (Tc=25°C)	150	200	40	40	1	5 A										134	
〃 285	〃	〃	〃	100	5	5 A	25 W (Tc=25°C)	150	200	40	40	1	5 A										134	
〃 286	〃	PA	Si. TMe	180	7	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	300	100	75	5	2 A										102	
〃 287	〃	〃	〃	200	7	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	300	100	75	5	2 A										102	
〃 288	日電	〃	Si. TP	80	5	2 A	20 W (Tc=25°C)	150	50	50	80	5	500										151	
〃 289	〃	〃	〃	80	5	2 A	20 W (Tc=25°C)	150	50	50	80	5	500										152	
〃 290	SON	PA. SW	Si. TMe	80		5 A	10 W (Tc=25°C)	120	100	150	100	3	2 A										153	
〃 291	〃	RF. PA	Si. DJ	70	10	3 A	10 W (Tc=25°C)	150	20	30	100	1	100										153	
〃 292	〃	PA	〃	70	10	3 A	10 W (Tc=25°C)	150	20	30	100	1	100										153	
〃 293	ORG	〃	Si. T	800	10	10 A	125 W (Tc=25°C)	150	3mA	800	20	5	5 A										102	
〃 294	〃	〃	〃	800	10	10 A	125 W (Tc=25°C)	150	3mA	800	40	5	5 A										102	
〃 295	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	30 A	200 W (Tc=25°C)	150	5 mA	800	20	5	10 A	12	2.5 A					f_{ae} 150kHz			154	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情况 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD296	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	30 A	200 W (T_c=25°C)	150	5 mA	800	40	5	10 A	12	−2.5A					$f_{\alpha e}$ 150kHz			154	
〃 297	日 電	〃	Si. TMe	150	7	5 A	25 W (T_c=25°C)	150	500	80	70	2	2 A										134	
〃 298																								
〃 299	松 下	PA. SW	Si. Me	1500	5	5 A	16W (T_c=30°C)	115	1mA	1500	3	5	4 A			$V_{CE(sat)}$<10V, $V_{BE(sat)}$<1.6V (4.5A, 2A) (4.5A, 2A)							102	
〃 300	〃	〃	〃	1500	5	5 A	16W (T_c=30°C)	115	1mA	1500	5	10	2.5A			$V_{CE(sat)}$<10V, $V_{BE(sat)}$<1.6V (2.5A, 0.65A) (2.5A, 0.65A)							102	
〃 301	富士通	SW	Si. DJ	80	6	10 A	50W (T_c=25°C)	175	30	30	2500	4	5 A			t_r<11μS, t_f<53μS, t_{stg}<16μS							102	達林通管
〃 302																								
〃 303																								
〃 304																								
〃 305																								
〃 306																								
〃 307																								
〃 308																								
〃 309																								
〃 310	ORG	PA. SW	Si. T	800	10	15 A	150W (T_c=25°C)	150	3mA	800	20	5	7.5A	12	2 A					$f_{\alpha e}$ 150kHz				
〃 311	〃	〃	〃	800	10	15 A	150W (T_c=25°C)	150	3mA	800	40	5	7.5A	12	2 A					$f_{\alpha e}$ 150kHz			102	
〃 312	松 下	PA	Si. TMe	800	6	500	25W (T_c=25°C)	150	1 mA	800	60	10	600	10	−100								102	
〃 313	三 洋	〃	Si. T	60	5	3 A	30 W (T_c=25°C)	150	100	20	90	2	1 A										162	
〃 314	〃	〃	〃	60	5	3 A	50 W (T_c=25°C)	150	100	20	90	2	1 A										163	
〃 315	〃	〃	〃	60	5	4 A	35 W (T_c=25°C)	150	100	20	90	2	1 A										99	
〃 316	SON	〃	Si TMe	80	5	7 A	80W (T_c=25°C)	150	100	50	70	2	3 A										102	
〃 317	松 下	PA	Si. T	60	8	3 A	25W (T_c=25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$= 25kHz			155	
〃 318	〃	〃	〃	60	8	3 A	25W (T_c=25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$= 25 kHz			156	
〃 319	〃	〃	Si. DJ	110	7	10 A	100 W (T_c=25°C)	150	30	40	35	4	5 A	10	−500					1 *			102	
〃 320	三 洋	PA. SW	Si. T	300	6	2 A	50 W (T_c=25°C)	150	100	100		15	1 A											
〃 321	松 下	〃	Si. TMe	250	6	6 A	60W (T_c=25°C)	150	2 mA	250	40	5	5 A			t_f<1μS							102	
★ 〃 322	日 電	PA	〃	120	7	7 A	80W (T_c=25°C)	150	300	120	60	5	4 A										102	
★ 〃 323	〃	〃	〃	150	7	7 A	80W (T_c=25°C)	150	300	150	60	5	4 A										102	
〃 324	松 下	〃	〃	300	3	100	10W (T_c=70°C)	150	100	300	80	10	50										153	
〃 325	三 洋	〃	Si. T	35	5	1.5A	10W (T_c=25°C)	150	100	20	90	2	1 A											
2SD326	SON	PA. SW	Si. TMe	330	5	1 A	23W (T_c=25°C)	150	15	100	80	5	100							6.5*			100	
〃 327	日 電	PA	Si. E	40	5	500	250	125	0.2	25	140	1	100										138	2SA723 之對稱
〃 328	〃	PA. SW	Si. EP	100	7	1.5A	800	150	1	60	100	2	200										84B	
〃 329																								
〃 330	三 洋	PA	Si. T	50	5	2 A	20W (T_c=25°C)	150	100	20	90	2	1 A										162	
〃 331	〃	〃	〃	50	5	2 A	20W (T_c=25°C)	150	100	20	90	2	1 A										163	
〃 332																								
〃 333																								
〃 334	松 下	PA	Si. DJ	110	7	6 A	75W (T_c=25°C)	150	1mA	110	100	4	1 A	10	−500					$f_{\alpha e}$ 25kHz			102	
★ 〃 335	日 電	〃	Si. EMe	80	7	3 A	30W (T_c=25°C)	150	300	60	80	5	2 A										102	
〃 336	〃	〃	Si. E	40	5	500	750	135	0.2	25	140	1	100										177	2SA707 之對稱
〃 337																								
〃 338	SON	PA	Si. EMe	70	8	7 A	60W (T_c=25°C)	150	100	50	50	2	3 A										102	
〃 339	〃	〃	〃	90	8	10 A	80 W (T_c=25°C)	150	100	50	50	2	4 A										102	
〃 340	〃	〃	〃	110	8	12 A	100 W (T_c=25°C)	150	100	50	50	2	5 A										102	
〃 341	日 立	PA. SW	Si. DJ	100	7	15 A	115 W (T_c=25°C)	200	5mA	100	40	4	4 A										102	
〃 342	SON	PA	〃	70		3 A	35W (T_c=25°C)	150	100	30	100	1	100										240	
〃 343	〃	〃	〃	70		3 A	35W (T_c=25°C)	150	100	30	100	1	100										241	
〃 344	〃	〃	〃	70		3 A	35W (T_c=25°C)	150	100	30	100	1	100										240	
〃 345	〃	〃	〃	70		3 A	35W (T_c=25°C)	150	100	30	100	1	100										241	
〃 346	〃	〃	Si. EMe	60		5 A	25W (T_c=25°C)	150	100	50	50	2	2.5A										240	
〃 347	〃	〃	〃	60		5 A	25W (T_c=25°C)	150	100	50	50	2	2.5A										241	
〃 348																								
〃 349	日 電	AF	Si. E	30	5	50	150	125	0.1	25	500	3	0.5	3	−1		14k	5.8	23				176	
〃 350	松 下	SW	Si. Me	1500	5	5 A	22W (T_c=90°C)	115	1mA	1500	5	10	4 A			t_f<1μS							102	
〃 351	〃	PA	Si. TMe	650	6	5 A	80W (T_c=25°C)	150	5mA	650	15	5	5 A	10	−500					40 *	150		102	
〃 352	〃	〃	Ge. A	32	10	1 A	650	90	25	10	150	0.5	300	2	−10	NF<25dB (f=1kHz, V_{CB}=5V, I_E=−5mA)				$f_{\alpha e}$>10kHz			12A	
〃 353																								
〃 354																								
〃 355	三 菱	PA	Si. EP	30	4	1 A	800	135	1	25	150	1	500							100*			242	2SB525 之對稱

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之 h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	測量情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ (Ω)	外形	備考
2SD356	三菱	PA	Si.EP	90	5	800	10W (T_c=25°C)	150	10	25	100	4	300										180	2SB526之對稱
〃 357	〃	〃	〃	110	5	800	10W (T_c=25°C)	150	10	25	100	4	300										180	2SB527之對稱
〃 358	〃	〃	〃	130	5	800	10W (T_c=25°C)	150	10	25	100	4	300										180	2SB528之對稱
〃 359	〃	〃	〃	40	5	2 A	10W (T_c=25°C)	150	1	25	120	4	500										180	
〃 360	〃	〃	〃	40	5	2 A	10W (T_c=25°C)	150	1	25	120	4	500										180	
〃 361	〃	〃	〃	60	5	1.5A	10W (T_c=25°C)	150	1	25	100	4	500										180	
〃 362																								
〃 363	日電	SW	Si.TMe	250	6	30A	200W (T_c=25°C)	175	100	200	30	5	15A			t_{on} < 2μS, t_{off} < 6.5μS t_{stg} < 4μS							106	
〃 364	〃	〃	〃	450	6	30A	200W (T_c=25°C)	175	100	400	30	5	15A			t_{on} < 2μS, t_{off} < 6.5μS t_{stg} < 4μS							106	
〃 365	松下	PA	〃	60	5	3 A	25W (T_c=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 70kHz			178	
〃 366	〃	〃	〃	60	5	3 A	25W (T_c=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 70kHz			179	
〃 367	〃	〃	Ge.A	25	6	300	150	85	20	12	150	0.5	150	2	−10	NF < 30dB (f=1kHz, V_{CB}=5V, I_E=−5mA)				$f_{\alpha e}$ > 10kHz			12A	
〃 368																							102	
〃 369																							102	
〃 370																							102	
〃 371	東芝	PA	Si.TMe	90	5	6 A	50W (T_c=25°C)	150	100	50	80	5	1 A										102	
〃 372	日電	SW	〃	150	6	30A	200W (T_c=25°C)	175	100	100	40	5	20A										106	
〃 373	〃	〃	〃	250	6	30A	200W (T_c=25°C)	175	100	200	30	5	15A										106	
〃 374	〃	〃	〃	450	6	30A	200W (T_c=25°C)	175	100	400	30	5	15A										106	
〃 375	〃	PA.SW	〃	150	7	10A	100W (T_c=25°C)	175	100	100	60	5	5 A			t_{on} < 1.5μS, t_{off} < 5μS t_{stg} < 3.5μS							102	
〃 376	〃	〃	〃	250	7	10A	100W (T_c=25°C)	175	100	200	40	5	5 A			t_{on} < 1.5μS, t_{off} < 5μS t_{stg} < 3.5μS							102	
〃 377	〃	〃	〃	450	7	10A	100W (T_c=25°C)	175	100	400	30	5	5 A			t_{on} < 1.5μS, t_{off} < 5μS t_{stg} < 3.5μS							102	
〃 378	日電	PA. SW	Si.E	100	12	2 A	1 W	175	0.5	60	80	2	500										84B	
〃 379	松下	PA	Si.EMe	80	5	5 A	60W (T_c=25°C)	150	1mA	50	100	4	1 A	10	−500					10*			102	
〃 380	〃	SW	Si Me	1500	5	5 A	50W (T_c=25°C)	130	1mA	1500	9	10	5 A			t_f < 0.9μS							102	
〃 381	日電	PA	Si.E	140	5	1.5A	20W (T_c=25°C)	150	1	120	90	5	300										151	
〃 382	〃	〃	〃	140	5	1.5A	20W (T_c=25°C)	150	1	120	90	5	300										152	
〃 383	日立	〃	Si.T	300	6	5 A	100W (T_c=25°C)	150	10	250	80	10	500										102	
〃 384	新電元	PA. SW	Si.DJ [illegible]	80	4	7 A	30W (T_c=25°C)	150	500	80	5000	5	5 A										204	
〃 385	〃	〃	〃	100	4	7 A	30W (T_c=25°C)	150	500	100	5000	5	5 A										204	
2SD386																								
〃 387																								
〃 388	日電	PA	Si.TMe	150	7	8 A	80W (T_c=25°C)	150	100	100	80	5	1 A										102	
〃 389	松下	〃	Si.DJ	60	8	3 A	25W (T_c=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 25kHz			178	
〃 390	〃	〃	〃	60	8	3 A	25W (T_c=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 25kHz			179	
〃 391																								
〃 392	三菱	PA	Si.EP	20	5	300	300	125	1	20	150	2	150	6	−10					150*			138B	2SB542之對稱
〃 393	〃	PA. SW	Si.EbMe	500	5	6 A	100W (T_c=25°C)	150	10	400	7	5	5 A			t_{off} = 4μS (I_C=5A, I_{B1}=−I_{B2}=1.3A)							102	
〃 394	〃	〃	〃	700	5	6 A	100W (T_c=25°C)	150	10	450	7	5	5 A										102	
〃 395	〃	〃	〃	700	5	8 A	100W (T_c=25°C)	150	10	450	8	5	7 A										102	
〃 396	日立	〃	Si.TMe	700	6	15A	125W (T_c=25°C)	150	5	400	30	2	7.5A			t_{on} < 15μS, t_{off} < 40μS t_{stg} < 20μS							102	
〃 397																								
〃 398																								
〃 399																								
〃 400																								
〃 401																								
〃 402																								
〃 403																								
〃 404	東芝	PA	Si.DJ	50	7	6 A	40W (T_c=25°C)	150	100	40	200	1	1 A										119	
〃 405																								
〃 406																								
〃 407																								
〃 408																								
〃 409																								
〃 410																								
〃 411																								
〃 412																								
〃 413	富士通	PA. SW	Si.TMe	200	5	500	800	175	5	150	65	5	200	5	−50	t_r < 2μS, t_f < 2μS t_{stg} < 5μS				25*	12.5		84B	
〃 414	日電	PA	Si.E	120	5	800	5 W (T_c=25°C)	150	1	80	80	5	200										225	
〃 415	〃	〃	〃	120	5	800	5 W (T_c=25°C)	150	1	80	80	5	200										225	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD416																								
〃 417	富士通	SW	Si.TMe	250	5	4 A	75W (T_c=25°C)	175	10	30	25	5	3 A	6	−300	t_{on}<2.5μS, t_f<2μS t_{stg}<2.5μS				30*			102	
〃 418	松下	PA	Si.TMe	1000	5	5 A	80W (T_c=25°C)	150	1mA	1000	15	5	5 A			t_f=1.5μS							102	
〃 419	SAK	〃	Si.DJ	100	6	7 A	40W (T_c=25°C)	150	1mA	100	2500	4	7 A							6*			99	達林頓管
〃 420	〃	〃	〃	120	6	7 A	40W (T_c=25°C)	150	1mA	120	2500	4	7 A							6*			99	〃
〃 421	〃	〃	〃	140	6	7 A	40W (T_c=25°C)	150	1mA	140	2500	4	7 A							6*			99	〃
〃 422	東芝	SW	Si.TMe	250	6	4 A	30W (T_c=25°C)	175	100	150	20	5	3 A	6	−300	t_{on}<2.5μS t_f<2μS t_{stg}<2.5μS				30*			99	
〃 423	〃	〃	Si.TP	250	6	4 A	30W (T_c=25°C)	175	100	150	20	5	3 A			t_r<1.5μS t_f<1μS t_{stg}<1.5μS							99	
〃 424	東芝	PA	Si.TMe	160	5	15A	150W (T_c=25°C)	150	100	80	80	5	2 A										102	
〃 425	〃	〃	〃	140	5	12A	100W (T_c=25°C)	150	100	60	80	5	2 A										102	
〃 426	〃	〃	〃	120	5	12A	100W (T_c=25°C)	150	100	60	80	5	2 A										102	
〃 427	〃	〃	〃	120	5	8 A	80W (T_c=25°C)	150	100	60	80	5	1 A										102	
〃 428	〃	〃	〃	100	5	7 A	60W (T_c=25°C)	150	100	50	80	5	1 A										102	
〃 429	日立	PA. SW	Si.T	800	6	15A	100W (T_c=25°C)	150	5	60	15	5	9 A			t_{on}<20μS t_{off}<15μS t_{stg}<5μS							102	
〃 430	湯浅	PA	Si.TMe	120	10	5 A	50W (T_c=25°C)	150	100	30	60	4	1 A	5	−0.5A					15*			102	
〃 431	〃	〃	〃	120	10	7 A	60W (T_c=25°C)	150	100	30	60	5	1 A	5	−0.5A					20*			102	
〃 432	〃	〃	〃	130	10	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	30	60	5	1 A	5	−0.5A					15*			102	
〃 433	〃	〃	〃	250	10	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	30	60	5	1 A	5	−0.5A					15*			102	
〃 434	〃	〃	〃	200	10	20A	200W (T_c=25°C)	150	100	100	60	5	1 A										102	
〃 435	〃	〃	〃	300	10	20A	200W (T_c=25°C)	150	100	100	60	5	1 A										102	
〃 436	〃	〃	〃	400	10	20A	200W (T_c=25°C)	150	100	100	60	5	1 A										102	
〃 437																								
〃 438																								
〃 439																								
〃 440																								
〃 441																								
〃 442																								
〃 443																								
〃 444																								
〃 445																								
2SD446																								
〃 447																								
〃 448																								
〃 449																								
〃 450																								
〃 451																								
〃 452																								
〃 453																								
〃 454																								
〃 455																								
〃 456																								
〃 457																								
〃 458	松下	PA	Si.TMe	600	5	5 A	80W (T_c=25°C)	150	1mA	600	20	5	5 A										102	
〃 459	新電元	PA. SW	Si.DJ	80	4	7 A	50W (T_c=25°C)	150	10mA	80	5000	5	5 A	10	1 A	t_{on}<10μS t_f<10μS t_{stg}<6μS				$f_{\alpha e}$ 20kc			257	達林頓管
〃 460	〃	〃	〃	100	4	7 A	50W (T_c=25°C)	150	10mA	100	5000	5	5 A	10	1 A	t_{on}<10μS t_f<10μS t_{stg}<6μS				$f_{\alpha e}$ 20kc			257	〃
〃 461	日立	〃	Si.T	250	8	3 A	80W (T_c=25°C)	150	100	250	90	5	1 A										102	
〃 462																								
〃 463	新電元	PA. SW	Si.DJ	80	4	7 A	80W (T_c=25°C)	150	10mA	60	3000	5	5 A	10	1 A	t_{on}<10μS t_f<10μS t_{stg}<6μS				$f_{\alpha e}$ 20kc			102	達林頓管
〃 464	〃	〃	〃	100	4	7 A	80W (T_c=25°C)	150	10mA	80	3000	5	5 A	10	1 A	t_{on}<10μS t_f<10μS t_{stg}<6μS				$f_{\alpha e}$ 20kc			102	〃
〃 465	〃	〃	〃	500	4	50A	400W (T_c=25°C)	150	1mA	500	200	5	50A	5	50A	t_{on}<2.7μS t_f<11μS t_{stg}<12μS				6.5*			258	〃
〃 466	〃	〃	〃	600	4	50A	400W (T_c=25°C)	150	1mA	600	200	5	50A	5	50A	t_{on}<2.7μS t_f<11μS t_{stg}<12μS				6.5*			258	〃
〃 467	日立	PA	Si.EP	25	5	700	500	150	1	20	150	1	150										138	
〃 468	〃	〃	〃	25	5	1 A	900	150	1	20	130	2	500										251	
〃 469																								
〃 470																								
〃 471																								
〃 472																								
〃 473																								
〃 474																								
〃 475																								

製名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流及脉冲下之h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	偏置情況 V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD476																								
〃 477																								
〃 478																								
〃 479	ALP	PA	Si.E	40	5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	500	40	6000	3	2 A					JEDEC 2N6037相当 達林頓管					252	2SB569 之対偶
〃 480	〃	〃	〃	60	5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	500	60	6000	3	2 A					JEDEC 2N6038相当 達林頓管					252	2SB570 之対偶
〃 481	〃	〃	〃	80	5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	500	80	6000	3	2 A					JEDEC 2N6039相当 達林頓管					252	2SB571 対対偶
〃 482	〃	〃	Si.TP	275	6	500	20W (Tc=25°C)	150	10	275	80	10	100					JEDEC 2N5650相当					252	
〃 483	〃	〃	〃	325	6	500	20W (Tc=25°C)	150	10	325	80	10	100					〃 2N5656 〃					252	
〃 484	〃	〃	〃	375	6	500	20W (Tc=25°C)	150	10	375	80	10	100					〃 2N5657 〃					252	
〃 485	〃	〃	Si.E	40	5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	50	2	1.5A					〃 2N5190 〃					252	2SB575 之対偶
〃 486	〃	〃	〃	60	5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	50	2	1.5A					〃 2N5191 〃					252	2SB576 之対偶
〃 487	〃	〃	〃	80	5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	50	2	1.5A					〃 2N5192 〃					252	2SB577 之対偶
〃 488	〃	〃	〃	40	5	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	50	1	500					〃 2N4921 〃					252	2SB572 之対偶
〃 489	〃	〃	〃	60	5	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	50	1	500					〃 2N4922 〃					252	2SB573 之対偶
〃 490	〃	〃	〃	80	5	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	50	1	500					〃 2N4923 〃					252	2SB574 之対偶
〃 491	〃	〃	〃	70	5	10A	90W (Tc=25°C)	150	1mA	70	40	4	4 A					MJE3055 〃					253	2SB578 之対偶
〃 492	〃	〃	〃	100	7	15A	115W (Tc=25°C)	200	1mA	100	40	4	4 A					JEDEC 2N3055 〃					102	
〃 493	〃	〃	〃	60	5	5 A	75W (Tc=25°C)	150	100	60	40	2	2.5A					〃 2N5977 〃					253	2SB579 之対偶
〃 494	〃	〃	〃	80	5	5 A	75W (Tc=25°C)	150	100	80	40	2	2.5A					〃 2N5978 〃					253	2SB580 之対偶
〃 495	〃	〃	〃	100	5	5 A	75W (Tc=25°C)	150	100	100	40	2	2.5A					〃 2N5979 〃					253	2SB581 之対偶
〃 496	〃	〃	〃	60	5	8 A	75W (Tc=25°C)	150	500	60	3000	4	4 A					MJE3043相当 達林頓管					253	2SB582 之対偶
〃 497	〃	〃	〃	80	5	8 A	75W (Tc=25°C)	150	500	80	3000	4	4 A					MJE3044相当 達林頓管					253	2SB583 之対偶
〃 498	〃	〃	〃	100	5	8 A	75W (Tc=25°C)	150	500	100	3000	4	4 A					MJE3045相当 達林頓管					253	2SB584 之対偶
〃 499	〃	〃	〃	60	5	8 A	90W (Tc=25°C)	150	100	60	60	2	4 A					JEDEC 2N5983相当					253	
〃 500	〃	〃	〃	80	5	8 A	90W (Tc=25°C)	150	100	80	60	2	4 A					〃 2N5984 〃					253	
〃 501	〃	〃	〃	100	5	8 A	90W (Tc=25°C)	150	100	100	60	2	4 A					〃 2N5985 〃					253	
〃 502	〃	〃	〃	60	5	8 A	100W (Tc=25°C)	200	500	60	3000	3	4 A					JEDEC 2N6055相当 達林頓管 [illegible]					102	2SB585 之対偶
〃 503	〃	〃	〃	80	5	8 A	100W (Tc=25°C)	200	500	80	3000	3	4 A					JEDEC 2N6056相当 達林頓管					102	2SB586 之対偶
〃 504	〃	〃	〃	60	5	12A	150W (Tc=25°C)	200	500	60	3000	3	6 A					JEDEC 2N6057相当 達林頓管					102	2SB587 之対偶
〃 505	〃	〃	〃	80	5	12A	150W (Tc=25°C)	200	500	80	3000	3	6 A					JEDEC 2N6058相当 達林頓管					102	2SB588 之対偶
2SD506	ALP	PA	Si.E	100	5	12A	150W (Tc=25°C)	200	500	100	3000	3	6 A					JEDEC 2N6059相当 達林頓管					102	2SB589 之対偶
〃 507																								
〃 508																								
〃 509																								
〃 510																								
〃 511																								
〃 512																								
〃 513																								
〃 514																								
〃 515																								
〃 516																								
〃 517																								
〃 518	富士通	SW	Si.TP	220	5	4 A	30W (Tc=25°C)	175	100	150	20	5	3 A			t_s < 2.5μS t_f < 2μS t_{stg} < 2.5μS							99	
〃 519	〃	〃	Si.TMe	400	5	7 A	100W (Tc=25°C)	175	200	150	15	5	5 A			t_{on} < 2.5μS t_f < 2.5μS t_{stg} < 4μS							102	

公司	地址	電話
大利電器行有限公司	香港德輔道中 48-50 號一樓	電話：5-223388
（分行）	九龍彌敦道 300 號七樓	電話：3-853211
寶新無綫電器材公司	香港英皇道 299 號商場No. 5-5A	電話：5-701354
香港寶樹無綫電行	香港中環萬宜里 21 至 23 號一樓	電話：5-253221
蔚和無綫電零件行	九龍油蔴地寧波街 11 號A	電話：3-846415
寶樹無綫電器材公司	香港灣仔道 121 號地下	電話：5-744061　5-744063
偉明無綫電器行	九龍奶路臣街 6 號G	電話：3-855973
香港電子零件行	香港灣仔菲林明道 33 號A地下	電話：5-750867
（分行）	九龍彌敦道 498 — 500 號 泰盛商業大厦 601 室	電話：3-306033
勝利電子有限公司	九龍旺角西洋菜街 36 號	電話：3-881233-4
鈞益無綫電器行	九龍深水埗黃竹街十五號E	電話：3-811190 3-811542
超力霸電子公司	香港中環威靈頓街 31 號 5 樓	電話：5-220744
精工電子貿易公司	九龍旺角花園街 164 號地下	電話：3-945323
總統無綫電器行	香港銅鑼灣景隆街 2 C地下	電話：5-771353
美通無綫電器行	香港北角英皇道 315 號 B	電話：5-701560
永安無綫電器零件	九龍官塘輔仁街 99 號	電話：3-451881
九龍電視工程電子零件公司	九龍山東街 50 號 B1 地下	電話：3-853522
保華電子零件公司	九龍漆咸道 250 號地下	電話：3-640936

無綫電製作1975增刊①
1975年9月5日出版
中華民國六十四年

編輯者　無綫電製作出版社　電話 3-654837　地址 香港九龍土瓜灣道 297 號三樓・督印人　林秋和・承印者　華生印刷廠　九龍新蒲崗彩虹道 202 號二樓・

香港總代理　同德書報社　九龍砵蘭街 269 號　電話 3-962751・星馬婆總代理　東亞文化事業有限公司 星加坡大坡馬路 167 號　電話 76376・台灣總代理 雨辰書報社　台灣台北市中華路二段 75 巷一弄 26 號　電話 3811897　郵政劃撥儲金第13165號雨辰書報社・印尼區代理　椰城集源公司　TOKO SUMBER ANEKA JL. TIANG BENDER 87A, JAKARTA–KOTA, INDONESIA.



登美洋行

BRIGHT TRADING CO.,
18, SHUI WO ST., 3/F
TSUN WAN. H.K.

TEL. 12-424911

電子零件
電工器材

mail order WELCOME
歡迎郵購

總代理 R & S PENCIL SOLDERING IRON



30W 及 50W
110V 或 220V



30W HK$7.50@
50W HK$9.50@

IC 萬用板
BEL 001
至 005
@2.50
BEL 101
@6.00
DIGITAL BOARD
@3.00

玻璃纖維
及
油布通
Dia. 1mm
至 6mm

請到

庇利金街38號地下
新油麻地門市部已開始營業

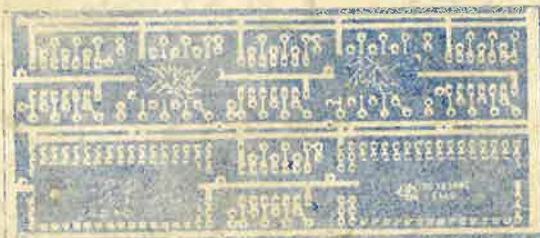
電話：3-685648

ZENER DIODE
BZY 88 Series
2V－91V
@2.00

玻璃纖維及
膠木電路底板
0.5mm
0.8mm
1mm
1.5mm
雙單面銅現貨

新

DIGITAL EXPERIMENTAL BOARD
SPECIAL DESIGNED FOR
DIGITAL PURPOSES



@HK3.00

Calculator Chip
MM5738
DM8864
DM8865
CT5001
CT5005
TMS0105
CZL550

CLOCK PANEL
LD8132
AM/PM
@35.00
CT7001
@40.00
TMS3834
@35.00



西德特力牌 UL Grade 膠木底板，大量到港。
0.8 mm、1 mm、1.6 mm 雙、單面銅膜，特價發售。